

I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1504/2004,**annettu 19 päivänä heinäkuuta 2004,****kaksikäyttötutustuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta
annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta ja ajan tasalle saattamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2000⁽¹⁾ mukaan kaksikäyttötutustuotteita (ohjelmistot ja teknologia mukaan luettuina) on valvottava tehokkaasti silloin, kun niitä vietään yhteisöstä.
- (2) Jotta jäsenvaltiot ja yhteisö voisivat täyttää kansainväliset sitoumuksensa, asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteessä I esitetään kyseisen asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu kaksikäyttötutustuotteita ja -teknologiaa koskeva yhteinen luettelo, jolla pannaan täytäntöön kansainvälisesti sovitut kaksikäyttötutustuotteiden valvontajärjestelyt, mukaan luettuina Wassenaarin järjestely, ohjusteknologian valvontajärjestely (MTCR), ydinalan viejämaitten ryhmä (NSG), Australian ryhmä ja kemiallisten aseiden kieltosopimus (CWC).
- (3) Asetuksen (EY) N:o 1334/2000 11 artiklassa säädetään, että liitteet I ja IV on ajantasaistettava niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja sitoumusten ja niihin tehtyjen muutosten mukaisesti, joita kukin jäsenvaltio on hyväksynyt kansainvälisten asetus- ja vientivalvontajärjestelyjen jäsenenä tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

- (4) Asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liite I olisi muutettava Wassenaarin järjestelyn, Australian ryhmän ja ohjusteknologian valvontajärjestelyn hyväksymien muutosten mukaisesti, koska kyseistä asetusta on muutettu 27 päivänä tammikuuta 2003 annetulla asetuksella (EY) N:o 149/2003⁽²⁾.
- (5) Neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004 on muutettu asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteessä II olevaa 3 osaa niin, että Tšekki, Unkari ja Puola on poistettu voimassa olevasta sellaisten maiden luettelosta, joiden osalta sovelletaan yhteisön vientilupaa.
- (6) Jotta vientivalvontaviranomaisten ja toimijoiden olisi helpompaa saada säännöksistä selvää, on tarpeen julkaista asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteistä ajantasaistettu toisinto, johon on koottu kaikki jäsenvaltioiden kansainvälisissä yhteyksissä joulukuun 2002 ja joulukuun 2003 välisenä aikana hyväksymät muutokset.
- (7) Asetus (EY) N:o 1334/2000 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteet tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. H. DONNER

⁽¹⁾ EYVL L 159, 30.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 885/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 1).

⁽²⁾ EUVL L 30, 5.2.2003, s. 1.

*LIITE I***LUETTELO KAKSIKÄYTTÖTUOTTEISTA JA -TEKNOLOGIASTA****(asetuksen (EY) N:o 1334/2000 3 artiklassa tarkoitettu)**

Tällä luettelolla pannaan täytäntöön kansainvälisesti sovitut kaksikäyttötutteen valvonnat, mukaan lukien Wassenaarin järjestely, ohjusteknologian valvontajärjestely (MTCR), ydinalan viejämaiten ryhmä (NSG), Australia-ryhmä ja kemiallisten aineiden kieltosopimus. Huomiotta on jätetty kohdat, jotka jäsenvaltiot haluavat asettaa ulkopuolelle jätettävien listalle. Huomiotta on jätetty kansalliset valvonnat (järjestelyihin perustumattomat valvonnat), joita jäsenvaltiot saattavat harjoittaa.

YLEISET HUOMAUTUKSET LIITTEeseen I

1. Sotilaskäyttöön suunniteltujen tai muunnettujen tuotteiden valvonnan osalta katso asiaankuuluvaa yksittäisen jäsenmaan ylläpitämää valvontalistaa (-listoja) sotatarvikkeista. Tässä liitteessä viittaukset, jotka toteavat "KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO", viittaavat samoihin listoihin.
2. Tähän liitteeseen sisältyvän valvonnan tarkoitusta ei pidä kumota sellaisten ei-valvonnanalaisien tuotteiden (tuotantolaitos mukaan lukien) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia valvonnanalaisia komponentteja, kun tuo valvonnanalainen komponentti tai ne komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan järkevästi irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.
Huom.: Arvioitaessa sitä onko valvonnanalaista komponenttia tai komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrän, arvon ja sisältyvän teknologisen tieto-aidon tekijöitä sekä muita erityisolosuhteita, jotka voisivat osoittaa valvonnanalaisen komponentin tai komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.
3. Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

YDINTEKNOLOGIAHUOMAUTUS (Ydth)

(Sovelletaan 0 ryhmän E osan yhteydessä.)

0 ryhmän kaikkiin tuotteisiin suoraan liittyvän "teknologian" siirto on saman tasoisen tarkkailun ja valvonnan alainen kuin tuotteetkin.

"Teknologia" valvonnanalaisien tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" ja "käyttöä" varten on valvonnanalaista myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-valvonnanalaisiin tuotteisiin.

Tuotteiden hyväksyminen vientiin oikeuttaa myös tuotteiden käyttöönottoa, toimintaa, ylläpitoa ja korjausta varten tarvittavan vähimmäis"teknologian" viennin samalle loppukäyttäjälle.

"Teknologian" siirron valvonta ei koske "julkista" tietoa tai "tieteellistä perustutkimusta".

YLEINEN TEKNOLOGIAHUOMAUTUS (Ylth)

(Sovelletaan 1–9 ryhmien E osan yhteydessä.)

1–9 ryhmissä valvonnanalaisien tuotteiden "kehitystä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten "tarvittavan" "teknologian" vienti on valvonnanalaista 1–9 ryhmien säännösten mukaisesti.

Valvonnanalaisien tuotteiden "kehitystä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten "tarvittava" "teknologia" on valvonnanalaista myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-valvonnanalaisiin tuotteisiin.

Valvonta ei koske sitä vähimmäis"teknologiaa", joka on välttämätön käyttöönottoa, toimintaa, ylläpitoa (tarkastusta) ja korjausta varten tuotteille, jotka eivät ole valvonnanalaisia tai joiden vienti on saatettu luvalliseksi.

Huom.: Tämä ei vapauta 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ja 8E002.b kohdassa määriteltyä vastaavaa "teknologiaa".

"Teknologian" siirron valvonta ei koske "julkista" tietoa, "tieteellistä perustutkimusta" tai välttämätöntä vähimmäistietoa patenttihakemuksiin.

YLEINEN OHJELMISTOHUOMAUTUS (Yloh)

(Tämä huomautus kumoaa kaiken 0–9 ryhmien D osan asettaman valvonnanalaisuuden.)

Tämän listan 0–9 ryhmät eivät aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja", jotka:

a. Ovat yleisesti yleisön saatavissa:

1. Myydään vähittäismyyntipisteissä varastosta ja rajoituksetta:

- a. Käsikaupassa;
- b. Postimyyntissä;
- c. Elektronisesti tapahtuvassa myyntissä; tai
- d. Puhelinmyyntissä; ja

2. On suunniteltu käyttäjän käyttöönotettaviksi ilman merkittävää toimittajan tukea; tai

Huom.: Yleisen ohjelmistohuomautuksen a kohta ei vapauta 5 ryhmän 2 osassa ("Tiedonsuojaus") määriteltyä "ohjelmistoa".

b. Ovat "julkisia".

JULKAISUISSA NOUDATETTAVAT KÄYTÄNNÖT

Toimielinten yhteisen julkaisukäsikirjan (vuoden 1997 laitos) sivulla 86 hakemistonumeron 102 kohdalla esitettyjen sääntöjen mukaisesti *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* julkaistavissa teksteissä

- käytetään pilkkua erottamaan kokonaisluvut desimaaleista,
- luvun kokonaisosa ryhmitellään kolmen numeron ryhmiin, joiden välissä on ohuke.

TÄSSÄ LIITTEESSÄ KÄYTETTYJEN TERMEN MÄÄRITELMÄT

'Yksinkertaisissa lainausmerkeissä' olevien termien määritelmät on annettu asianmukaisessa teknologiahuomautuksessa.

"Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä" olevien termien määritelmät ovat seuraavat:

Huom.: Viittaukset ryhmiin ovat suluisia termin määrittelyn jälkeen.

"Aiemmin erotettu" (Previously separated) (0 1) tarkoittaa minkä tahansa sellaisen prosessin käyttöä, jolla halutaan lisätä kontrolloidun isotoopin konsentraatiota.

"Aikamoduloitu ultralaajakaista" (Time-modulated ultra-wideband) (5) tarkoittaa tekniikkaa, jossa erittäin lyhyitä tarkasti aikakontrolloituja radiotaajuuspulsseja moduloidaan siirtämällä pulssien paikkaa tietoliikennedatan mukaisesti (ns. pulssipaikkamodulaatio; Pulse Position Modulation, PPM) kanavoimalla tai sekoittamalla PPM-tekniikalla näennäisesti satunnaisten kohinakoodien avulla; sen jälkeen lähetetään ja vastaanotetaan suoraan pulssimuodossa käyttämättä kantoaalto- taajuuksia, mistä johtuen ultralaajoilla taajuuskaistoilla on erittäin matala tehon tiheys. Kutsutaan myös impulssiradioksi.

"Aikavakio" (Time constant) (6) on aika, joka kuluu valoärsytyksen antamisesta siihen kun virran lisäys saavuttaa arvon, joka on $1 - 1/e$ kertaa lopullinen arvo (so. 63 % lopullisesta arvosta).

"Aksiaalsiirtymä" (Camming) (2) on pääkaran aksiaalsiirtymä yhden kierroksen aikana, mitattuna karan tasolaikkaa vastaan kohtisuorassa olevassa tasossa, pisteessä, joka on lähinnä tasolaikan kehää (viite ISO 230/1 1986, 5.63 kohta).

"Aktiivinen pikseli" (Active pixel) (6 8) on solid-state-matriisin pienin (yksittäinen) elementti, jolla on valosähköinen siirtofunktio, kun se altistetaan valolle (sähkömagneettiselle säteilylle).

"Aktiiviset lennonohjausjärjestelmät" (Active flight control systems) (7) ovat järjestelmiä, jotka toimivat "ilma-aluksen" tai ohjuksen ei-toivottujen liikkeiden tai rakenteellisten kuormitusten estämiseksi käsittelemällä itsenäisesti useilta antureilta tulevia tietoja ja antamalla tarvittavia automaattiohjaukseen vaikuttavia ennalta ehkäiseviä komentoja.

"Asettumisaika" (Settling time) (3) tarkoittaa aikaa, joka tarvitaan jotta ulostulo saavuttaa puolen bitin tarkkuudella lopullisen arvon, kun muunnin vaihtaa tilaa minkä tahansa kahden arvon välillä.

"Asiantuntijajärjestelmät" (Expert systems) (7) tarkoittaa järjestelmiä, jotka tuottavat tuloksia soveltamalla käsittelysääntöjä tietoihin, jotka on tallennettu "ohjelmasta" riippumattomasti, ja jotka kykenevät johonkin seuraavista:

- a. Muokkaamaan automaattisesti käyttäjän antamaa "lähdekoodia";
- b. Tuottamaan johonkin ongelma-alueeseen liittyvää tietoa luonnollista muistuttavalla kielellä; tai
- c. Keraamaan tietoa itsensä kehittämiseksi (symbolinen harjaannuttaminen).

"Automaattinen maalin seuranta" (Automatic target tracking) (6) tarkoittaa tietojenkäsittelytekniikkaa, joka automaattisesti määrittää ja tulostaa tosiaikaisesti maalin todennäköisimmän sijainnin extrapoloidun arvon.

"Avaruusalus" (Spacecraft) (7 9) tarkoittaa aktiivisia ja passiivisia satelliitteja sekä avaruusluotaimia.

"Avaruuskelpoinen" (Space qualified) (3 6) viittaa tuotteisiin, jotka on suunniteltu, valmistettu ja testattu kestäämään avaruuden erityisiä sähköisiä, mekaanisia tai ympäristövaatimuksia, jotta niitä voidaan laukaista ja käyttää satelliiteissa tai 100 km tai sitä korkeammalla toimivissa lentojärjestelmissä.

"Bias" (kiihtyvyyssmittari) (7) tarkoittaa ulostulon arvoa kiihtyvyyssmittarissa, kun siihen ei kohdistu mitään kiihtyvyyttä.

"CE" vastaa "laskentaelementtiä".

"CEP" (yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä) (circle of equal probability) (7) on tarkkuuden mitta; tietyllä etäisyydellä sen ympyrän säde, jonka keskipisteessä on maali ja johon 50 % hyötykuormasta iskeytyy.

"CTP" vastaa "yhdistettyä teoreettista tehokkuutta".

"DBRN-järjestelmillä" (Data-Based Referenced Navigation) (7) tarkoitetaan järjestelmiä, joissa käytetään eri lähteistä saatavaa, ennalta mitattua paikkatietoa, joka on yhdistetty tarkan navigointitiedon tuottamiseksi muuttuvissa olosuhteissa. Tietolähteet voivat olla syvyystietokarttoja, tähtikarttoja, painovoimakarttoja, magneetikarttoja tai kolmiulotteisia numeerisia maastokarttoja.

"Diffuusioliittäminen" (Diffusion bonding) (1 2 9) tarkoittaa vähintään kahden eri metallin molekyyli- tai atomitasoisesta jähmeliittämistä yhdeksi kappaleeksi siten, että liitoslujuus vastaa heikoimman materiaalin lujuutta.

"Digitaalinen kokonaissiirtonopeus" (Total digital transfer rate) (5) tarkoittaa toistensa kanssa yhteydessä olevien digitaalisen siirtojärjestelmän laitteiden välillä kulkevien bittien lukumäärää aikayksikössä, mukaan lukien linjan koodaukseen tarvittavat sekä muut lisäbitit.

Huom.: Katso myös "digitaalinen siirtonopeus".

"Digitaalinen siirtonopeus" (Digital transfer rate) tarkoittaa minkä tahansa tyyppistä siirtotietä käyttäen suoraan siirretyn informaation kokonaisbittinopeutta.

Huom.: Katso myös "digitaalinen kokonaissiirtonopeus".

"Digitaalinen tietokone" (Digital computer) (4 5) tarkoittaa laitetta, joka voi suorittaa kaikkia seuraavia toimintoja yhden tai useamman erillisen muuttujan muodossa:

- a. Vastaanottaa tietoa;
- b. Tallettaa tietoa tai käskyjä kiinteille tai muutettaville (kirjoitus-) muistilaitteille;
- c. Käsitellä tietoa tallennetun käskyjonon avulla, joka on muokattavissa; ja
- d. Tulostaa tietoa.

Huom.: Tallennetun käskyjonon muokkaus sisältää pysyväismuistiyksiköiden vaihdon, mutta ei langoituksen tai kytkentöjen fyysistä muuttamista.

"Dynaamisesti adaptiivinen reititys" (Dynamic adaptive routing) (5) tarkoittaa automaattista liikenteen uudelleenreititystä, joka perustuu verkon sen hetkisen todellisen tilanteen anturointiin ja analyysiin.

Huom.: Tähän eivät sisälly reitityksen päätöstilanteet, jotka tehdään ennalta annetun informaation pohjalta.

"Dynaamiset signaalianalysointorit" (Dynamic signal analyzers) (3) tarkoittaa "signaalianalysointoreita", jotka käyttävät digitaalista näytteenotto- ja muunnostekniikkaa muodostaakseen annetulle amplitudi- ja vaiheinformaation sisältävälle aaltomuodolle Fourierin spektrinäytön.

Huom.: Katso myös "signaalianalysointorit".

"Ekvivalenttitiheys" (Equivalent density) (6) tarkoittaa optiikan yksikkömassaa optiselle pinnalle projisoitua optisen pinta-alan yksikköä kohti.

"Elektroninen kokoonpano" (Electronic assembly) (3 4 5) tarkoittaa elektronisten komponenttien (so. 'piirilementtien', 'erilliskomponenttien', integroitujen piirien jne.) joukkoa, joka on kytketty tietyn tehtävän (tai tietyt tehtävät) suorittavaksi kokonaisuudeksi, joka voidaan yksikkönä vaihtaa ja on tavallisesti purettavissa.

Huom. 1: 'Piirilementti' (Circuit element): Yksittäinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori, jne.

Huom. 2: 'Erilliskomponentti' (Discrete component): Erikseen kotoitettu 'piirilementti', jolla on omat ulkoiset kytkentäpisteensä.

"Elektronisesti ohjattavat vaiheistetut ryhmäantennit" (Electronically steerable phased array antennas) (56) tarkoittaa antennia, joka muodostaa keilan vaihekytkennän avulla, so. keilan suuntausta ohjataan säteilevien elementtien yhdistetyillä virityskertoimilla ja säteen suuntaa voidaan sähköisin signaalein muuttella pysty- tai vaakasuunnassa, tai molemmissa suunnissa, niin lähetyksessä kuin vastaanotossakin.

"Epäsymmetrinen algoritmi" (5) tarkoittaa salausalgoritmia, joka käyttää erilaisia matemaattisesti suunniteltuja salaukseen ja salauksen purkuun tarkoitettuja avaimia.

Huom.: "Epäsymmetrisen algoritmin" tavanomainen käyttö on avaimen hallinta.

"Eristetyt elävät viljelmit" (Isolated live cultures) (1) tarkoittaa uinuvassa tilassa ja kuivatuissa preparaateissa olevia eläviä viljelmiä.

"Eristystä" (Insulation) (9) käytetään rakettimoottorien osissa, so. rungossa, suuttimessa, läpivienneissä ja rungon väli-seinissä, ja se käsittää eristäviä tai tulenkestäviä materiaaleja sisältäviä vulkanoidun tai puoli-vulkanoidun seoskumin levykerroksia. Sitä voidaan käyttää myös rasituksen vaimennustuppeina tai -liuskoina.

"Erityinen halkeamiskelpoinen aine" (Special fissile material) (0) tarkoittaa plutonium-239:ää, uraani-233:a, "isotoopeilla 235 tai 233 rikastettua uraania" ja mitä tahansa edellämainittuja sisältävää ainetta.

"Esilanka" (Roving) (1) on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti 12–120) 'säikeistä' muodostuva kimppu.

Huom.: 'Säie' on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti useammasta kuin 200) "monofilamentista" muodostuva kimppu.

"FADEC" vastaa "täyden auktoriteetin digitaalista moottorin ohjausta".

"Fokusoiva tasojärjestelmä" (Focal plane array) (6) tarkoittaa fokusoivassa tasossa toimivista, lukema-elektronikalla varustetuista tai ilman sitä olevista yksittäisistä ilmaisinelementeistä koostuvaa lineaarista tai kaksiulotteista tasopintaa tai tasopintojen yhdistelmää.

Huom.: Tällä ei ole tarkoitus kattaa yksittäisten ilmaisinelementtien pinoa eikä kaksi-, kolme- tai neljäelementtisiä ilmaismia, edellyttäen että aikaviivästystä ja integrointia ei suoriteta elementeissä.

"Hajaspektri" (Spread spectrum) (5) tarkoittaa tekniikkaa, jolla suhteellisen kapeakaistaisen tietoliikennekanavan energia levitetään huomattavasti laajemman energiaspektrin yli.

"Hajaspektri" tutka (Spread spectrum radar) (6) – katso "Tutkan hajaspektri".

"Henkilökohtainen älykortti" (Personalized smart card) (5) tarkoittaa mikropiiriin sisältävää älykorttia, joka on ohjelmoitu erityistä käyttöä varten ja jota käyttäjä ei voi ohjelmoida uudelleen mitään muuta käyttöä varten.

"Hermoverkkotietokone" (Neural computer) (4) tarkoittaa tietokonelaitetta, joka on suunniteltu tai muunnettu jäljittelemään neuronin tai neuroniryhmän käyttäytymistä, so. tietokonetta, jolle on ominaista se, että sen laitteisto kykenee aiempaan tietoon perustuen muuttamaan suurta joukkoa laskennallisten komponenttien välisten kytkentöjen painotusta ja määrää.

"Hetkellinen kaistanleveys" (Instantaneous bandwidth) (3 7) tarkoittaa kaistanleveyttä, jolla lähtöteho pysyy 3 dB:n tarkkuudella vakiona, ilman että muita toimintaparametreja säädetään.

"Huipputeho" (Peak power) (6) tarkoittaa pulssin energiaa jouleina jaettuna pulssin kestolla sekunteina.

"Hybridipiiri" (Hybrid integrated circuit) (3) tarkoittaa integroitujen piirien yhdistelmää, joka käsittää integroidun piirin (tai piirejä) tai integroitua piiriä 'piirielementtien' tai 'erilliskomponenttien' yhteydessä, jotka on kytketty toisiinsa tietyn toiminnon (tai toimintojen) suorittamiseksi, ja jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. Sisältää vähintään yhden koteloimattoman komponentin;
- b. Kytkennot on suoritettu tyypillisiä integroitujen piirien tuotantomenetelmiä käyttäen;
- c. On vaihdettavissa yhtenä kokonaisuutena; ja
- d. Ei yleensä ole purettavissa osiinsa.

Huom. 1: 'Piirielementti' (Circuit element): Yksittäinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori, jne.

Huom. 2: 'Erilliskomponentti' (Discrete component): Erikseen koteloitu 'piirielementti', jolla on omat ulkoiset kytkentäpisteensä.

"Hybriditietokone" (Hybrid computer) (4) tarkoittaa laitetta, joka voi suorittaa kaikkea seuraavaa:

- a. Vastaanottaa tietoa;
- b. Käsitellä tietoa sekä analogisessa että digitaalisessa muodossa; ja
- c. Tulostaa tietoa.

"Ilma-alus" (Aircraft) (1 7 9) tarkoittaa kiinteäsiipistä, kääntyväsiipistä, pyöriväsiipistä (helikopteri) tai kallistuvalla roottorilla tai siivillä varustettua ilmakulkuneuvoa.

Huom.: katso myös "siviililentokone".

"Ilmavirran avulla säädely vastamomenttijärjestelmä tai suunnanohjausjärjestelmä" (Circulation controlled anti-torque or circulation controlled direction control system) (7) ovat järjestelmiä, jotka käyttävät ilma-aluksen aerodynaamisten pintojen ohi virtaavaa ilmaa lisäämään tai säätämään näiden pintojen synnyttämiä voimia.

"Immunotoksiini" (Immunotoxin) (1) on yhden soluspesifisen monoklonaalisen vasta-aineen ja "toksiinin" tai "toksiinialayksikön" muodostama konjugaatti, joka vaikuttaa selektiivisesti sairaisiin soluihin.

"Integroitu kalvopiiri" (Film type integrated circuit) (3) tarkoittaa eristävälle "substraatille" pinnoittamalla muodostettujen ohut- tai paksukalvo 'piirielementtien' ja niiden välisten kytkentöjen muodostamaa kokonaisuutta.

Huom.: 'Piirielementti' on yksittäinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa, kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori jne.

"Integroitu monipalapiiri" (Multichip integrated circuit) (3) tarkoittaa yhteiselle "substraatille" liitettyä kahta tai useampaa "monoliittista integroitua piiriä".

"Isostaattiset puristimet" (Isostatic presses) (2) tarkoittaa laitteita, jotka kykenevät eri väliaineiden avulla (kaasu, neste, kiinteät partikkelit jne.) paineistamaan suljetun tilan, niin että suljetussa tilassa olevaan työkappaleeseen kohdistuu kaikissa suunnissa samansuuruinen paine.

"Isotoopilla 235 tai 233 rikastettu uraani" (Uranium enriched in the isotopes 235 or 233) (0) tarkoittaa uraania, joka sisältää isotooppia 235 tai 233 tai molempia siinä määrin, että näiden isotooppien ylimääräsumman suhde isotooppiin 238 nähden on enemmän kuin luonnossa esiintyvän isotoopin 235 suhde isotooppiin 238 (isotooppisuhde 0,72 %).

"Itseisjohtavuuteen perustuva magneettikentän gradiometri" (Intrinsic Magnetic Gradiometer) (6) on yksittäinen magneettikentän gradienttia ilmaiseva elementti ja siihen liittyvä elektroniikka, jonka tuloste on magneettikentän gradientin mitta.

Huom.: Katso myös "magneettikentän gradiometri".

"ITU:n allokoima" (Allocated by the ITU) (3 5) on taajuuskaistojen allokointia ITU:n radio-ohjesääntöjen mukaisesti (vuoden 1998 laitos) primaari-, sallituille ja sekundaaripalveluille.

Huom.: Ei sisällä lisä- ja vaihtoehtoisia allokointeja.

"Jauhaminen" (Comminution) (1) tarkoittaa prosessia, jossa materiaali hajotetaan hiukkasiksi murskaamalla tai jauhamalla.

"Julkinen" (In the public domain) (Ylth Ydth Yloh) tarkoittaa tässä yhteydessä "teknologiaa" ja "ohjelmistoja", jotka ovat saatavilla ilman edelleenlevitystä koskevia rajoituksia (kustannus oikeudelliset rajoitukset eivät estä "teknologiaa" tai "ohjelmistoa" olemasta "julkisia").

"Kaasuatomisointi" (Gas atomization) (1) tarkoittaa prosessia, jossa korkeapaineisella kaasuvirtauksella sula metalliseosvirta hajotetaan pisaroiksi, joiden halkaisija on 500 mikrometriä tai vähemmän.

"Kaikki kompensatiot käytettävissä" (All compensations available) (2) tarkoittaa, että otetaan huomioon kaikki valmistajan käytettävissä olevat soveltuvat toimenpiteet yksittäisen työstökonemallin kaikkien järjestelmällisten paikannusvirheiden minimoimiseksi.

"Kehitys" (Development) (Ylth Ydth Kaikki) liittyy kaikkiin sarjatuotantoa edeltäviin vaiheisiin kuten: suunnitteluun, suunnittelun tutkimukseen, suunnittelun analysointiin, suunnittelukäsitteisiin, prototyyppien kokoonpanoon ja testaamiseen, pilottituotantohankkeisiin, suunnittelutietoihin, suunnittelutietojen muuntamiseen tuotteeksi, konfigurointisuunnitteluun, integrointisuunnitteluun ja piirustuksiin.

"Kemiallinen laser" (Chemical laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa virittymisen aiheuttaa kemiallisen reaktion antama energia.

"Kemiallinen seos" (Chemical mixture) (1) tarkoittaa kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista tuotetta, joka on valmistettu kahdesta tai useammasta aineesta, jotka eivät reagoi keskenään seoksen säilytysolosuhteissa.

"Keskumuisti" (Main storage) (4) tarkoittaa tietoa tai käskyjä varten tarkoitettua ensisijaista muistia, johon keskusyksiköllä on nopea pääsy. Se koostuu "digitaalisen tietokoneen" sisäisestä muistista ja sen hierarkkisista laajennuksista, kuten välimuistista tai ei-peräkkäissäantisestä laajennusmuistista.

"Kieppikara" (Tilting spindle) (2) tarkoittaa työkalunkäsittelykaraa, joka koneistusprosessin aikana muuttaa keskilinjansa kulma-asentoa mihin tahansa muuhun akseliin nähden.

"Kiertymiskulman poikkeama" (Angular position deviation) (2) tarkoittaa kiertymiskulman ja todellisen, erittäin tarkasti mitatun kiertymiskulman välistä maksimiero, kun pöydän työkappaleen alustaa on käännetty alkuperäisestä asennostaan (viite: VDI/VDE 2617, luonnos: "Rotary tables on coordinate measuring machines").

"Kiinteä" (Fixed) (5) tarkoittaa, ettei koodaus- tai pakkausalgoritmi voi ottaa vastaan ulkopuolelta syötettyjä parametreja (esim. salaus- tai avainmuuttujia) eikä käyttäjä voi sitä muuttaa.

"Kohdekoodi" (Object code) (9) tarkoittaa yhden tai useamman prosessin tarkoituksenmukaisen esitystavan ("lähdekoodi" (lähdekieli)) laitteessa toteutettavaa muotoa, joka on muunnettu ohjelmointijärjestelmällä.

"Kohinataso" (Noise level) (6) tarkoittaa sähköistä signaalia, joka ilmoitetaan tehon spektritiheytenä. "Kohinatason", joka määriteltynä huipusta-huippuun on $S_{pp}^2 = 8N_0(f_2 - f_1)$, jossa S_{pp} on signaalin arvo huipusta-huippuun (esim. nanotesloina), N_0 on tehon spektritiheys (esim. (nanotesla)²/Hz) ja $(f_2 - f_1)$ määrittelee tarkasteltavan kaistanleveyden.

"Kokonaisvirtatiheys" (Overall current density) (3) tarkoittaa kelan ampeerikierrosten kokonaismäärää (ts. kierrosten lukumäärä kerrottuna kunkin kierroksen kuljettaman maksimivirran arvolla) jaettuna kelan kokonaispoikkipinnalla (sisältäen suprajohdatavat säikeet, metallimatriisin, johon säikeet on upotettu, suojaavan materiaalin, kaikki jäädyttävät elementit jne.).

"Komposiitti" (Composite) (1 2 6 8 9) tarkoittaa "matriisia" ja siihen tiettyä tarkoitusta tai tarkoituksia varten lisättyä faasia tai faaseja, jotka koostuvat hiukkasista, whiskerseistä, kuiduista tai mistä tahansa näiden yhdistelmästä.

"Kriittinen lämpötila" (Critical temperature) (1 3 6) (kutsutaan myös joskus transitiolämpötilaksi) tarkoittaa tietyn "suprajohtavan" materiaalin sitä lämpötilaa, jossa materiaali menettää täysin tasavirtavastusarvonsa.

"Kuitu- tai säiemateriaalit" (Fibrous or filamentary materials) (0 1 2 8) sisältävät;

- a. Jatkuvat monofilamentit;
- b. Jatkuvat langat ja rovingit (esilangat);
- c. Teipit, kudokset, matot ja punokset;
- d. Katkeet, tapulikuidut ja yhtenäiset kuituhuovat;
- e. Erilliskuitukiteet (whiskersit), yksi- tai monikiteisinä ja kaiken pituisina;
- f. Aromaattisen polyamidimassan.

"Kuumaisostaattinen puristus" (Hot isostatic densification) (2) tarkoittaa prosessia, jossa valosta paineistetaan yli 375 K (102 °C) asteen lämpötilassa suljetussa tilassa eri väliaineiden avulla (kaasu, neste, kiinteät partikkelit jne.), jotta aikaan-
saadaan kaikissa suunnissa samansuuruinen voima valoksen sisäisten onteloiden vähentämiseksi tai estämiseksi.

"Kuvan parantaminen" (Image enhancement) (4) tarkoittaa ulkopuolelta saatujen informaatiota sisältävien kuvien käsittelyä algoritmeilla kuten aikakompressio, suodatus, poiminto, valinta, korrelaatio, konvoluutio tai muunnokset eri tasoihin (kuten nopea Fourier-muunnos tai Walsh-muunnos). Tämä ei sisällä algoritmeja, jotka käyttävät vain yksittäisen kuvan lineaarisia tai toisen asteen muunnoksia kuten kääntäminen, kuvionerotus, kohdistaminen tai vääräväritys.

"Käyttäjän ohjelmointimahdollisuus" (User-accessible programmability) (6) tarkoittaa ominaisuutta, joka sallii käyttäjän sisällyttää, muuntaa tai vaihtaa "ohjelmia" muulla tavoin kuin:

- a. Langoitusta tai kytkentöjä muuttamalla; tai
- b. Toimintinäppäimistä asettelemalla, parametrien syöttö mukaan lukien.

"Käyttö" (Use) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa käyttöä, asennusta (paikalla suoritettava asennus mukaan lukien), ylläpitoa (tarkastusta), korjausta, huoltoa ja kunnostusta.

"Köyhdytetty uraani" (Depleted uranium) (0) tarkoittaa uraania, joka on köyhdytetty alle luonnossa esiintyvän isotooppi 235:n tason.

"Lanka" (Yarn) (1) on kerratuista 'säikeistä' muodostuva kimppu.

Huom.: 'Säie' on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti useammasta kuin 200) "monofilamentista" muodostuva kimppu.

"Laser" (0 2 3 5 6 7 8 9) on komponenttien muodostama kokonaisuus, joka tuottaa sekä avaruudellisesti että ajallisesti koherenttia valoa, jota vahvistetaan stimuloidulla säteilyemissiolla.

Huom.: Katso myös: "Kemiallinen laser";

"Q-kytkin-laser";

"Suurteholaser";

"Siirtolaser".

"Laskentaelementti" ("CE") (Computing element) (4) tarkoittaa pienintä laskentayksikköä, joka tuottaa aritmeettisia tai loogisia tuloksia.

"Lennon kokonaisohjaus" (Total control of flight) (7) tarkoittaa "ilma-aluksen" tilamuuttujien ja lentoradan automaattista ohjausta vastaamalla lentotehtävän tavoitteiden täyttämiseksi tosiaikaisiin muutoksiin tavoitteiden, uhkien tai muiden "ilma-alusten" tiedoissa.

"Lennonohjauksen optinen anturijärjestelmä" (Flight control optical sensor array) (7) on hajautettujen optisten anturien verkko, joka "laser" säteitä käyttäen tuottaa tosiaikaista lennonohjaustietoa ilma-aluksessa tapahtuvaa prosessointia varten.

"Lentoradan optimointi" (Flight path optimization) (7) on proseduuri, jolla neljässä ulottuvuudessa (avaruus ja aika) minimoidaan poikkeamia lentotehtävien suorittamiseen tai tehokkuuteen perustuvasta halutusta lentoradasta.

"Lineaarisuus" (Linearity) (2) (mitataan normaalisti epälineaarisuutena) tarkoittaa varsinaisen ominaisuuden (keskimääräisen lukeman) positiivista tai negatiivista maksimipoikkeamaa suorasta, joka on asetettu siten, että se tasoiittaa tai minimoi maksimipoikkeamat.

"Luonnonuraani" (Natural uranium) (0) tarkoittaa uraania, joka sisältää luonnossa tavattavia isotooppiseosmääriä.

"Lähdekoodi" (tai lähdekieli) (Source code or source language) (4 6 7 9) on sopiva yhden tai useamman prosessin esitystapa, joka voidaan ohjelmointijärjestelmässä muuntaa laitteessa toteutettavaan muotoon ("kohdekoodiksi" tai kohdekielelle).

"Läimäyssammutus" (Splat Quenching) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetään' jäähdytetyn telan päälle sulaa metallivirtaa, joka muodostaa hiutalemaisen tuotteen.

Huom.: 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1 000 K/s ylittävillä jäähdytysnopeuksilla.

"Maantieteellisesti hajallaan" (Geographically dispersed) (6) tarkoittaa, että jokainen sijainti on missä tahansa suunnassa yli 1 500 m:n päässä kaikista muista. Liikkuvia antureita pidetään aina "maantieteellisesti hajallaan" olevina.

"Magneettikentän gradiometrit" (Magnetic gradiometers) (6) ovat laitteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan instrumentin ulkopuolisten lähteiden magneettikenttien avaruudellista vaihtelua. Ne koostuvat useista "magnetometreista" ja niihin liittyvästä elektroniikasta, joiden tuloste on magneettikentän gradientin mitta.

Huom.: Katso myös "itseisjohtavuuteen perustuva magneettikentän gradiometri".

"Magnetometrit" (Magnetometers) (6) ovat laitteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan instrumentin ulkopuolisten lähteiden magneettikenttiä. Ne koostuvat yhdestä magneettikenttää havaitsevasta elementistä ja siihen liittyvästä elektroniikasta, joiden tuloste on magneettikentän mitta.

"Matriisi" (Matrix) (1 2 8 9) tarkoittaa huomattavan jatkuvaa aineen faasia, joka täyttää hiukkasten, whiskersien tai kuitujen välisen tilan.

"Mekaaninen seostaminen" (Mechanical alloying) (1) tarkoittaa seostamisprosessia, jossa alkuaineiden ja perusmetalliseosten jauheet sidostuvat, hajoavat ja sidostuvat uudelleen mekaanisen törmäyksen voimasta. Ei-metallisia hiukkasia voidaan sisällyttää seokseen tarvittavia jauheita lisäämällä.

"Mikro-organismit" (Microorganisms) (1 2) tarkoittaa bakteereita, viruksia, mykoplasmoja, riketsioita, klamydioita tai sienä, sekä luonnontilaisia, kehitettyjä että muunneltuja, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on tarkoituksella istutettu näitä viljelmiä tai joka on saastutettu niillä.

"Mikroprosessoripiiri" (Microprocessor microcircuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piiriä" tai "monipalapiiriä", joka sisältää ulkoisen muistin yleisluontoisia käskyjä suorittamaan kykenevän aritmetiikkayksikön (ALU).

Huom. 1: "Mikroprosessoripiiri" ei yleensä sisällä sisäistä muistia, johon käyttäjällä olisi pääsy, vaikka se saattaa käyttää samalla lastulla olevaa muistia suorittaessaan loogista toimintaansa.

Huom. 2: Tämä määritelmä sisältää lastuyhdistelmät, jotka on suunniteltu yhdessä toimien huolehtimaan "mikroprosessoripiiri"-toiminnasta.

"Mikrotietokonepiiri" (Microcomputer microcircuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piiriä" tai "monipalapiiriä", joka sisältää sisäisessä muistissa olevia tietoja koskevia sisäisen muistin yleisluontoisten käskyjen sarjoja suorittamaan kykenevän aritmetiikkayksikön (ALU).

Huom.: Sisäistä muistia voidaan laajentaa ulkoisen muistin avulla.

"Mittakerroin" (Scale factor) (gyroskoopissa tai kiihtyvyyssmittarissa) (7) tarkoittaa ulostulon muutoksen suhdetta mitattavaksi aiotun syötteen muutokseen nähden. Mittakerroin ilmaistaan yleisesti sen suoran kaltevuutena, joka voidaan piirtää pienimmän neliösumman menetelmällä syöte- ja tulostearvojen kautta, jotka on saatu vaihtelemalla syötteen arvoa jaksottaisesti syötearvojen alueen yli.

"Mittauksen epävarmuus" (Measurement uncertainty) (2) on ominaisparametri, joka 95 %:n luotettavuustasolla määrittelee, millä alueella saadun tuloksen molemmiin puolin mitattavan suureen oikea arvo sijaitsee. Se sisältää korjaamattomat systemaattiset poikkeamat, korjaamattoman väljyyden ja satunnaiset poikkeamat (viite ISO 10360-2, tai VDI/VDE 2617).

"Monispektriset kuvannusanturit" (Multispectral imaging sensors) (6) ovat kykeneviä hankkimaan kuvatietoa samanaikaisesti tai peräkkäin kahdesta tai useammasta erillisestä spektrikaistasta. Antureita, joilla on enemmän kuin kaksikymmentä spektrikaistaa, kutsutaan toisinaan hyperspektriksiksi kuvannusantureiksi.

"Monitietovirtakäsittely" (Multi-data-stream processing) (4) tarkoittaa 'mikro-ohjelmien' tai laitearkkitehtuurin tekniikkaa, joka mahdollistaa kahden tai useamman tietojonon samanaikaisen käsittelyn yhden tai useamman käskyjonon ohjaamana käyttäen sellaisia keinoja kuten:

- a. Yksi käsky – monta tietoa (SIMD) -arkkitehtuurit, kuten vektori- ja matriisiprosessoreissa;
- b. Monta yksittäistä käskyä – monta tietoa (MSIMD) -arkkitehtuurit;
- c. Monta käskyä – monta tietoa (MIMD) -arkkitehtuurit, tiiviisti kytketyt, läheisesti kytketyt ja väljästi kytketyt mukaan lukien; tai
- d. Strukturoidut tiedonkäsittelyelementtien ryhmät, systoliset ryhmät mukaan lukien.

Huom.: 'Mikro-ohjelma' tarkoittaa peruskäskyjen sarjaa, jota säilytetään erillisessä muistissa, ja jonka suoritus käynnistyy, kun sen viitekäsky tulee käskyrekisteriin.

"Monofilamentti" (Monofilament) (1) tai filamentti on säikeen pienin inkrementti, jonka halkaisija on tavallisesti joitakin mikrometrejä.

"Monoliittinen integroitu piiri" (Monolithic integrated circuit) (3) tarkoittaa passiivisten tai aktiivisten 'piirilementtien' tai molempien yhdistelmää, joka:

- a. On muodostettu diffuusio-, istutus- tai pinnoitusprosesseilla yhden puolijohdepalan (ns. lastun) pintaan tai pinnalle;
- b. Voidaan katsoa erottamattomasti yhteen liitetyksi; ja
- c. Suorittaa piirin tietyn toiminnon (tai toimintoja).

Huom.: 'Piirilementti' (Circuit element) on yksittäinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori jne.

"Muotoaan muuttavat peilit" (Deformable mirrors) (6) (joita kutsutaan myös adaptiivisiksi optisiksi peileiksi) tarkoittaa peilejä, joissa:

- a. Yhtä jatkuvaa optisesti heijastavaa pinnanmuotoa voidaan dynaamisesti muotoilla yksittäisillä momenteilla tai voimilla kompensoimaan peilin kohtaavan optisen aaltomuodon vääristymiä; tai
- b. Useita optisesti heijastavia elementtejä voidaan yksittäin ja dynaamisesti, momentteja tai voimia käyttäen uudelleen asettaa kompensoimaan peilin kohtaavan optisen aaltomuodon vääristymiä.

"Muuttuvan geometrian kantopinnat" (Variable geometry airfoils) (7) tarkoittaa takareunan siivekkeitä tai laippoja, tai johtoreunan solasiivekkeitä tai alaspainuvaa nokkaa, joiden asentoa voidaan lennon aikana ohjata.

"Numeerinen ohjaus" (Numerical control) (2) tarkoittaa prosessin automaattista ohjausta, jossa ohjauslaite käyttää numeerista tietoa, jota se tavallisesti saa toiminnan edetessä (viite: ISO 2382).

"Näyttöalue" (Instrumented range) (6) tarkoittaa tutkan määriteltyä, yksikäsitteistä näyttöaluetta.

"Ohjautusjärjestelmä" (Guidance set) (7) tarkoittaa järjestelmiä, jotka yhdistävät kulkuvälineen paikan ja nopeuden mittaus- ja laskentaprosessin (so. navigoinnin) kulkuvälineen lennonohjautusjärjestelmien lentoradan korjauskomentojen laskenta- ja välitysprosessiin.

"Ohjelma" (Programme) (2) tarkoittaa käskyjonoa, joka voidaan suorittaa tietokoneella tai muuntaa sen suoritettavaksi.

"Ohjelmallisesti ohjattu" (Stored program controlled) (2 3 8) tarkoittaa ohjausta, joka käyttää elektroniseen muistiin tallennettuja käskyjä, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan määriteltyjä toimintoja.

Huom.: Laite voi olla "ohjelmallisesti ohjattu", riippumatta siitä onko elektroninen muisti sisäinen vai ulkoinen.

"Ohjelmisto" (Software) (Yloh Kaikki)

Yhden tai useamman ohjelman tai 'mikro-ohjelman' muodostama kokonaisuus missä tahansa käsitettävässä muodossa.

Huom.: 'Mikro-ohjelma' tarkoittaa peruskäskyjen sarjaa, jota säilytetään erityisessä muistissa, ja jonka suoritus käynnistyy, kun sen viitekäsky tulee käskyrekisteriin.

"Ohjukset" (Missiles) (1 3 6 7 9) tarkoittaa täydellisiä raketijärjestelmiä ja miehittämättömiä lentolaitejärjestelmiä, jotka pystyvät kuljettamaan vähintään 500 kg:n hyötykuorman vähintään 300 km:n etäisyydelle.

"Olennaisin osa" (Principal element) (4) on ryhmää 4 koskien sellainen osa, jonka vaihtoarvo on enemmän kuin 35 % sen järjestelmän kokonaishinnasta, jonka osa se on. Osan arvo on se arvo, jonka järjestelmän valmistaja tai järjestelmän kokoonpanija siitä maksaa. Kokonaisarvo on normaali kansainvälinen myyntihinta vieraille osapuolille valmistuspaikassa tai kuljetuspisteessä.

"Ominaiskimmokerroin" (Specific modulus) (0 1 9) on Youngin kerroin pascaleina ja on yhtä kuin N/m^2 jaettuna ominaispainolla N/m^3 , mitattuna $(296 \pm 2) K ((23 \pm 2) ^\circ C)$ asteen lämpötilassa sekä $(50 \pm 5) \%$:n suhteellisessa kosteudessa.

"Ominaismurtovetolujuus" (Specific tensile strength) (0 1 9) on lopullinen murtovoima pascaleina, joka on yhtä kuin N/m^2 jaettuna ominaispainolla N/m^3 , mitattuna $(296 \pm 2) K ((23 \pm 2) ^\circ C)$ asteen lämpötilassa sekä $(50 \pm 5) \%$:n suhteellisessa kosteudessa.

"Optinen integroitu piiri" (Optical integrated circuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piiriä" tai hybridipiiriä, joka sisältää yhden tai useampia osia, jotka on suunniteltu toimimaan valoanturina tai valolähteenä tai suorittamaan optista tai sähköoptista toimintoa (toimintoja).

"Optinen kytkentä" (Optical switching) (5) tarkoittaa signaalien reititystä tai kytkentää optisessa muodossa muuntamatta niitä sähköisiksi signaaleiksi.

"Optinen tietokone" (Optical computer) (4) tarkoittaa tietokonetta, joka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään valoa tiedon esittämiseen ja jonka laskenta- tai loogiset tiedonkäsittelyelementit perustuvat suoraan toisiinsa kytkettyihin optisiin komponentteihin.

"Optinen vahvistus" (Optical amplification) (5) tarkoittaa optisen tietoliikenteen vahvistustekniikkaa, jossa erillisen optisen lähteen tuottamia signaaleja vahvistetaan muuntamatta niitä sähköisiksi signaaleiksi, ts. käyttäen optisia puolijohdevahvistimia tai valokuitulumesenssivahvistimia.

"Osallistujavaltio" (Participating state) (7 9) on Wassenaarin järjestelyn jäsenmaa. (Katso www.wassenaar.org).

"Paikallisverkko" (Local area network) (4) on tiedonvälitysjärjestelmä, joka:

- a. Sallii määrittelemättömän määrän yksittäisiä 'tietolaitteita' kommunikoida suoraan toistensa kanssa; ja
- b. Rajoittuu maantieteellisesti kohtuullisen kokoiselle alueelle (kuten toimistorakennus, tehdas, korkeakoulu, varasto).

Huom.: 'Tietolaitte': laite, joka pystyy lähettämään tai vastaanottamaan digitaalista informaatiota sisältäviä sekvenssejä.

"Painelähtetimet" (Pressure transducers) (2) ovat laitteita, jotka muuntavat paineen mittaustulokset sähköisiksi signaaleiksi.

"Perusportin etenemisviive" (Basic gate propagation delay time) (3) tarkoittaa etenemisviiveen arvoa, joka vastaa "monoliittisessa integroidussa piirissä" käytetyn perusportin viivettä. Monoliittisten integroitujen piirien "perheelle" tämä voidaan määritellä tietylle joko etenemisviiveenä tyypillistä porttia kohti tietyssä "perheessä" tai tyypillisenä etenemisviiveenä porttia kohti tietyssä "perheessä".

Huom. 1: Perusportin etenemisviivettä ei pidä sekoittaa kompleksisen "monoliittisen integroidun piirin" kokonaisviiveeseen sisäänmenon ja ulostulon välillä.

Huom. 2: "Perhe" (Family) tarkoittaa kaikkia integroituja piirejä, joilla on seuraavia valmistusmenetelmiä ja -spesifikaatioita koskevia ominaisuuksia lukuun ottamatta toimintoja, joita ovat:

- a. yhteinen laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuuri;
- b. yhteinen rakenneperiaate ja prosessiteknologia; ja
- c. yhteiset perusominaisuudet.

"Poikkeama" (Run out, out-of-true-running) (2) tarkoittaa pääkaran säteittäistä poikkeamaa yhden kierroksen aikana mitattuna karan akselia vasten suorassa kulmassa olevalla tasolla pisteessä, joka on pyörivän testattavan kappaleen sisä- tai ulkopinnalla (viite ISO 230/1-1986, 5.61 kohta).

"Primäärinen lennon ohjaus" (Primary flight control) (7) tarkoittaa "ilma-aluksen" stabiilisuuden ja liikkeiden ohjausta, joka käyttää voima-/momenttilähteitä, so. aerodynaamisia ohjauspintoja tai propulsiokäyttöistä vektorivastavoimaa.

"Pulssin kesto" (Pulse duration) (6) on "laserin" pulssin aika, FWHI-tasoilla (Full Width Half Intensity) mitattuna.

"Pulssin kompressointi" (Pulse compression) (6) tarkoittaa pitkäaikaisten tutkasignaalien koodausta ja käsittelyä lyhytaikaisina, korkean pulssienergian suomat edut säilyttäen.

"Pyörivä atomisointi" (Rotary atomisation) (1) tarkoittaa prosessia, jossa keskipakovoimalla sulan metallin virrasta tai lähteestä aikaansaadaan läpimitaltaan korkeintaan 500 mikrometrin pisaroita.

"Päätetyövälineet" (End-effectors) (2) tarkoittavat tarraimia, 'aktiivisia työkaluyksiköjä' ja kaikkia muita työkaluja, jotka kiinnitetään "robotin" tai manipulaattorin käsivarren kiinnityslaippaan.

Huom.: 'Aktiivinen työkaluyksikkö' tarkoittaa laitetta, joka kohdistaa työkappaleeseen liikevoimaa tai prosessienergiaa tai anturoi sitä.

"Q-kytkin-laser" (Q-switched laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa energia varastoidaan populaatio inversiossa tai optisessa resonaattorissa ja sitten emittoidaan pulssina.

"Reitit" (System tracks) (6) tarkoittaa käsiteltyjä, korreloituja (kohteen tutkatiedot yhdistelty lentosuunnitelman mukaiseen sijaintiin) ja ajantasalle saatettuja lentokoneen sijaintiraportteja, joka on lennonjohtokeskuksen valvojen käytettävissä.

"Resoluutio" (Resolution) (2) tarkoittaa mittalaitteen pienintä inkrementtiä; digitaalisissa mittalaitteissa vähiten merkitsevää bittiä (viite ANSI B-89.1.12).

"Robotti" (Robot) (2 8) tarkoittaa manipulointimekanismia, joka voi olla jatkuvaa rataa tai pisteestä-pisteeseen kulkevaa tyyppiä, voi käyttää antureita ja jolla on seuraavat ominaisuudet:

- a. On monitoiminen;
- b. Pystyy muuttuvien liikkein asemoimaan tai suuntaamaan materiaaleja, osia, työkaluja tai erikoislaitteita kolmessa ulottuvuudessa;
- c. Sisältää kolme tai useampia suljetun tai avoimen piirin servolaitteita, jotka voivat sisältää askelmootteoreita; ja
- d. On "käyttäjän ohjelmoitavissa" opetusajo/toistomenetelmällä tai tietokoneella, joka voi olla ohjelmoitava logiikkaohjain, ts. ilman mekaanista väliintuloa.

Huom.: Ylläoleva määritelmä ei sisällä seuraavia laitteita:

1. Manipulaatiomekanismit, jotka ovat ohjattavissa vain manuaalisesti tai kaukokäyttölaitteella;
2. Kiinteän sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaattisesti liikkuvia laitteita ja toimivat mekaanisesti kiinteästi ohjelmoiduilla liikkeillä. Ohjelma on mekaanisesti rajoitettu kiinteillä pysäyttimillä, kuten tapeilla tai toimikäyrillä. Liikkeiden sarja ja liikeradat tai liikekulmat eivät ole muuttuvia tai muutettavissa mekaanisin, elektronisin tai sähköisin keinoin;

3. Mekaanisesti ohjatut muuttuvan sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaattisesti liikkuvia laitteita ja noudattavat kiinteitä mekaanisesti ohjelmoituja ratoja. Ohjelma on mekaanisesti rajoitettu kiinteillä, mutta aseteltavilla pysäyttimillä, kuten tapeilla tai toimikäyrillä. Liikkeiden sarja ja liikeratojen tai liikekulmien valinta on muuteltavissa kiinteän ohjelmamallin rajoissa. Yhden tai useamman akselin ohjelman muutokset (esim. tapeilla tai toimikäyrillä) ovat suoritettavissa vain mekaanisilla operaatioilla;
4. Muut kuin servo-ohjatut muuttuvan sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaattisesti liikkuvia laitteita ja toimivat mekaanisesti kiinteiden ohjelmaliikkeiden mukaisesti. Ohjelma on muunneltavissa, mutta liikejakso etenee vain mekaanisesti kiinnitettyjen sähköisten binaarilaitteiden tai aseteltavien pysäyttimien antamien binaarisignaalien mukaan;
5. Pinoamislaitteet, joita kutsutaan karteesi-manipulaatiojärjestelmiksi ja jotka on valmistettu korkeavarausten kiinteiksi osiksi ja joiden avulla lokeroiden sisältöä käsitellään (lisätään tai poistetaan).

"Rohdin" (Tow) (1) on tavallisesti suunnilleen samansuuntaisten "monofilamenttien" kimppu.

"Rokote" (Vaccine) on lääkevalmisteena oleva lääke, jolla on joko valmistus- tai käyttömaan sääntelyviranomaisten myöntämä lisenssi tai markkinoille saattamista tai kliinistä tutkimusta koskeva lupa ja jonka tarkoituksena on saada aikaan suojaava immuunivaste sairauden ennaltaehkäisemiseksi niissä ihmisissä tai eläimissä, joille rokote annetaan.

"Ryömintänopeus" (gyroskooppi) (Drift rate) (7) tarkoittaa ulostulon ajasta riippuvaa poikkeamaa toivotusta arvosta. Se koostuu satunnaisista ja systemaattisista osista ja ilmaistaan vastaavana sisääntulon kulmapoikkeamana aikayksikköä kohti suhteessa inertia-avaruuteen.

"Salaus" (Cryptography) (5) ilmentää periaatteita, välineitä ja menetelmiä, joilla tietoa muunnetaan sen tietosisällön piilottamiseksi, huomaamatta tapahtuvien muutosten estämiseksi tai luvattoman käytön estämiseksi. Salaus rajoittuu tiedon muuntamiseen yhtä tai useampaa 'salaista parametriä' (esim. salausmuuttujia) tai siihen liittyvää avainta käyttäen.

Huom.: 'Salainen parametri': vakio tai avain, jota ei anneta muiden tiedoksi tai pidetään vain tietyn ryhmän tietona.

"Sekoitettu" (Commingle) (1) tarkoittaa termoplastisten kuitujen ja lujitekuitujen filamenttien sekoittamista kokonaan kuitumuodossa olevan lujitekuitu/"matriisi"-sekoituksen tuottamiseksi.

"SHPL" vastaa "suurteholaseria".

"Signaalianalysaattorit" (Signal analysers) (3) tarkoittaa laitteita, jotka kykenevät mittaamaan ja näyttämään monitaajuisien signaalien yksitaajuisien komponenttien perusominaisuuksia.

"Signaalin käsittely" (Signal processing) (3 4 5 6) tarkoittaa ulkoisesta lähteestä tulevien signaalien käsittelyä algoritmeilla kuten kompressio, suodatus, erotelu, valinta, korrelaatio, konvoluutio tai tasomuunnokset (esim. nopea-Fourier- tai Walsh-muunnos).

"Siirtolaser" (Transfer laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa laseroivat aineslajit viritetään siirtämällä energiaa ei-laseroivan atomin tai molekyylin ja laseroivan atomin tai molekyylin aineslajien yhteentörmäyksellä.

"Sisäpinnanvuoraus" (Interior lining) (9) tarkoittaa kiinteän polttoaineen ja rungon tai eristävän vuorauksen välisenä sidoksena käytettävää vuorausta. Tavallisesti se on tulenkestävien tai eristävien materiaalien nestemäiseen polymeeriin, kuten hiilitäyteinen hydroksyyliipäiteinen polybutadieeni (HTPB) tai muu polymeeri, perustuva dispersio, johon on lisätty vulkanoivia aineita ja joka suihkutetaan tai levitetään rungon sisäpinnalle.

"Siviililentokone" (Civil aircraft) (1 7 9) tarkoittaa "ilma-aluksia", jotka siviili-ilmailuviranomaisten julkaisemien lentokelpoisuuden vahvistavien listojen mukaan on tarkoitettu lentämään kaupallisilla sisäisillä sekä ulkomaan siviililentoreiteillä tai niitä saadaan käyttää lainmukaiseen siviili-, yksityis- tai kaupalliseen käyttöön.

Huom.: Katso myös "ilma-alus".

"Sotilaskäyttöön sovitettu" (Adapted for use in war) (1) tarkoittaa mitä tahansa muuntelua tai valintaa (kuten puhtauden, varastointi-ään, myrkyllisyyden, levittämismominaisuuksien tai UV-säteilyn kestävyysmuuttamista), jolla on tarkoitus lisätä tehokkuutta aiheuttaa tappioita ihmisille tai eläimille, turmella laitteita tai vahingoittaa satoa tai ympäristöä.

"Stabiilisuus" (Stability) (7) tarkoittaa tietyn parametrin variaation (1 sigman) standardipoikkeamaa kalibroidusta arvosta vakiolämpötilaolosuhteissa mitattuna. Se voidaan esittää ajan funktiona.

"Substraatti" (Substrate) (3) tarkoittaa pohjamateriaalin ohutta levyä, jossa on tai ei ole kytkentäkuviota ja jonka päälle tai sisään voidaan sijoittaa 'erilliskomponentteja' tai integroituja piirejä tai molempia.

Huom. 1: 'Erilliskomponentti' (Discrete component): Erikseen koteloitu 'piirilementti', jolla on omat ulkoiset kytkentäpisteensä.

Huom. 2: 'Piirilementti' (Circuit element): Yksittäinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori, jne.

"Substraattiaihio" (Substrate blanks) (6) tarkoittaa monoliittisia yhdisteitä, joiden mitat sopivat optisten elementtien (kuten optiset peilit tai ikkunat) tuotantoon.

"Suhteellinen kaistanleveys" (Fractional bandwidth) (3) tarkoittaa "hetkellistä taajuuskaistaa" jaettuna keskitaajuudella ja prosenttiosuutena ilmaistuna.

"Sulaerotus" (Melt extraction) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetään' ja erotetaan nauhamaisia metalliseostuotteita upottamalla pyörivän jäädytetyyn kappaleen lyhyt segmentti sulaan metalliseoskylpyyn.

Huom.: 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1 000 K/s ylittävillä jäädytysnopeuksilla.

"Sulakehräys" (Melt spinning) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetään' sulaa metallivirtaa antamalla sen törmätä pyörivään jäädytettyyn kappaleeseen, niin että muodostuu hiutalemainen, nauhamainen tai sauvamainen tuote.

Huom.: 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1 000 K/s ylittävillä jäädytysnopeuksilla.

"Suoravaikutteinen hydraulipuristus" (Direct-acting hydraulic pressing) (2) tarkoittaa muovausprosessia, jossa käytetään nesteellä täytettyä joustavaa paljetta suorassa kontaktissa työstettävään kappaleeseen.

"Superplastinen muovaus" (Superplastic forming) (1 2) tarkoittaa muovausprosessia, jossa metalleille, joilla normaalisti huoneen lämpötilassa on alhainen venymä (vähemmän kuin 20 %) tavanomaisessa murtovetolujuuskokeessa, saavutetaan lämpöä käyttämällä prosessin aikana vähintään kaksinkertainen venymä.

"Superseokset" (Superalloys) (2 9) tarkoittaa nikkeli-, koboltti- tai rautapohjaisia seoksia, joiden lujuus yli 922 K (649 °C) asteen lämpötiloissa ja ankarissa ympäristö- ja toimintaolosuhteissa on parempi kuin minkään muun AISI 300-sarjan metalliseosten.

"Suprajohtava" (Superconductive) (1 3 6 8) tarkoittaa materiaaleja, esim. metallit, metalliseokset tai yhdisteet, jotka voivat menettää kokonaan sähköisen vastusarvonsa, ts., jotka voivat saavuttaa äärettömän suuren sähköisen johtavuuden ja kuljettaa hyvin suuria sähkövirtoja ilman Joule-lämpenemistä.

Huom.: Materiaalin "suprajohtavalle" tilalle on yksilöllisesti tunnusomaista "kriittinen lämpötila", kriittinen magneettinen kenttä, joka on lämpötilan funktio, sekä kriittinen virrantiheys, joka on sekä magneettisen kentän että lämpötilan funktio.

"Suurteholaser" (Super High Power Laser) (6) tarkoittaa "laseria", joka pystyy lähettämään ulostuloenergiaa, joka (kokonaisuutena tai minä tahansa annoksena) ylittää 1 kJ 50:ssä millisekunnissa tai jonka keskimääräinen tai CW-teho ylittää 20 kW.

"Symmetrinen algoritmi" (5) tarkoittaa salausalgoritmia, joka käyttää täysin samanlaista avainta sekä salaukseen että salauksen purkuun.

Huom.: "Symmetrisen algoritmin" tavanomainen käyttö on avaimen luottamuksellisuus.

"Systolinen matriisitietokone" (Systolic array computer) (4) tarkoittaa tietokonetta, jossa käyttäjä voi ohjata tiedon virtausta ja muuttamista dynaamisesti loogisten porttien tasolla.

"Taajuuden vaihto aika" (Frequency switching time) (3 5) tarkoittaa maksimiaikaa (so. viivettä), jonka signaali tarvitsee, kun sen valittua lähtötaajuutta vaihdetaan toiselle valitulle lähtötaajuudelle, saavuttaakseen:

a. Taajuuden, joka on 100 Hz sisällä lopullisesta halutusta taajuudesta; tai

b. Ulostulon tason, joka on 1 dB sisällä lopullisesta ulostulon tasosta.

"Taajuushyppely" (Frequency hopping) (5) tarkoittaa "hajaspektri" ominaisuuden muotoa, jossa yksittäisen tiedonsiirto-kanavan lähetystaajuutta vaihdellaan epäjatkuvasti askelittain satunnaisessa tai puolisuunnassa järjestyksessä.

"Taajuussyntesoija" (Frequency synthesiser) (3) tarkoittaa käytetystä tekniikasta riippumatta mitä tahansa taajuuslähdettä tai signaaligeneraattoria, joka tuottaa yhden tai useamman ulostulon kautta useita samanaikaisia tai vuorottelevia lähtötaajuuksia, joita ohjaavat tai jotka on johdettu tai määräytyvät pienemmästä joukosta normi- (tai perus-) taajuuksia.

"Tarkkuus" (Accuracy) (2 6) tarkoittaa näyttöarvon positiivista tai negatiivista maksimipoikkeamaa standardi- tai tosiarvosta.

"Tarvittava" (Required) (Ylth 1–9) viittaa, "teknologiaa" tai "ohjelmistoja" koskien, vain siihen osaan "teknologiaa" tai "ohjelmistoja", jotka nimenomaisesti aikaansaavat valvottuja ominaisuuksia tai toimintoja, tai lisäävät niitä. "Tarvittava" "teknologia" tai "ohjelmisto" voivat olla yhteisiä eri tuotteille.

"Tehollinen gramma", "Erityisen halkeamiskelpoisen aineen" (Effective gramme of special fissile material) (0 1) tarkoittaa:

- a. Plutoniumin isotoopeilla ja uraani-233:lla isotoopin painoa grammoina;
- b. Uraanilla, joka on rikastettu yhteen prosenttiin tai enemmän isotoopilla U-235, alkuaineen painoa grammoina kerrottuna sen desimaalisina paino-osina ilmaistun rikastusmäärän neliöllä;
- c. Uraanilla, joka on rikastettu alle yhteen prosenttiin isotoopilla U-235, alkuaineen painoa grammoina kerrottuna luvulla 0,0001;

"Tehonhallinta" (Power management) (7) tarkoittaa korkeusmittarin lähettämän signaalin tehon muuttamista siten, että "ilma-aluksen" korkeudella vastaanotettu teho on aina pienin mahdollinen korkeuden määrittämiseen.

"Teippi" (Tape) (1) on punotuista tai yhdensuuntaisista "monofilamenteista", 'säikeistä', 'esilangoista', "touveista" tai "langoista" jne. muodostuva tavallisesti hartsilla esikyllästetty materiaali.

Huom.: 'Säie' on suunnilleen samansuuntaisista (tyypillisesti useammasta kuin 200) "monofilamenteista" muodostuva kimppu.

"Teknologia" (Technology) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa erityistä kirjallista tai muussa muodossa olevaa teknistä tietoa, jota tarvitaan tuotteen "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten. Tämä tieto on 'teknisen tiedon' tai 'teknisen avun' muodossa.

Huom. 1: 'Tekninen apu' voi olla muodoltaan ohjeita, taitoja, opetusta, työnsuorustietoutta tai konsultointipalveluja ja saattavat sisältää 'teknisen tiedon' siirtoa.

Huom. 2: 'Tekninen tieto' voi olla muodoltaan piirustuksia, suunnitelmia, kaavioita, malleja, kaavoja, taulukoita, suunnittelukonstruktioita tai määritelmiä, kirjallisia tai muulle medialle tai laitteille, kuten levyille, nauhalle tai lukumuistiin, talletettuja käsikirjoja ja ohjeita.

"Tiedon suojaus" (Information security) (4 5) tarkoittaa kaikkia menetelmiä ja toimintoja, jotka takaavat tiedon tai tiedonvälityksen saatavuuden, luottamuksellisuuden tai eheyden, poislukien menetelmät tai toiminnot, joilla suojaudutaan virhetoiminnoilta. Siihen kuuluu "salaus", 'salauksen analyysi', suojautuminen paljastavia vuotoja vastaan ja tietokone-turvallisuus.

Huom.: 'Salauksen analyysi': salausjärjestelmän tai sen syötteiden tai tulosteiden analysointi, jonka tarkoituksena on selvittää luottamuksellisia muuttujia tai sensitiivistä tietoa, selväkielinen teksti mukaan lukien.

"Tieteellinen perustutkimus" (Basic scientific research) (Ylth Ydth) tarkoittaa kokeellista tai teoreettista työtä, jota tehdään pääasiassa uuden tiedon saamiseksi ilmiöiden tai havaittavien faktojen peruserityksistä, ja joilla ei ensisijaisesti pyritä mihinkään tiettyyn käytännön päämäärään tai tavoitteeseen.

"Tietoliikennekanavan ohjain" (Communications channel controller) (4) tarkoittaa fyysistä liitäntää, joka ohjaa synkronisen tai asynkronisen digitaalisen tiedon kulkua. Se on kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai tietoliikennelaitteisiin tietoliikennetyhteyden luomiseksi.

"Toksiinialayksiköllä" (Sub-unit toxin) (1) tarkoitetaan kokonaisen "toksiinin" rakenteellisesti ja toiminnallisesti erillistä osaa.

"Toksiinit" (Toxins) (1 2) tarkoittaa valmistustavasta riippumatta tarkoituksellisesti eristettyjen preparaattien tai seosten muodossa olevia myrkyllisiä aineita, lukuun ottamatta toksiineja, joita on saasteina muissa materiaaleissa, kuten patologisissa näytteissä, viljassa, ruokatarvoissa tai "mikro-organismien" kylvöissä.

"Tosiainen kaistanleveys" (Real-time bandwidth) (2 3) on "dynaamisten signaalianalysaattorien" laajin taajuuksien alue, jonka analysaattori voi tulostaa näytölle tai muistiin aiheuttamatta katkoja sisääntulevan tiedon analysoinnissa. Analysaattoreissa, joissa on enemmän kuin yksi kanava, laskelmaa varten tulee käyttää sitä kanavien konfiguraatiota, joka antaa laajimman "tosiaikaisen kaistanleveyden".

"Tosiainen käsittely" (Real time processing) (6 7) tarkoittaa tietokonejärjestelmän tiedonkäsittelykykyä, joka käytettävissä olevin resurssein ja järjestelmän kuormituksesta riippumatta turvaa tarvittavan palvelutason taatun vasteajan sisällä, kun ulkoinen tapahtuma käynnistää palvelun.

"Tuotanto" (Production) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa kaikkia tuotantovaiheita, kuten rakentaminen, tuotanto, suunnittelu, valmistus, integrointi, kokoonpano, asennus, tarkastus, testaus, laadunvalvonta.

"Tuotantolaitteet" (Production equipment) (1 7 9) tarkoittaa "kehitystä" tai yhtä tai useampaa "tuotannon" vaihetta varten erikseen suunniteltuja tai muunneltuja työkaluja, mallineita, asettimia, tuurnia, muotteja, suulakkeita, kiinnittimiä, suuntausmekanismeja, testilaitteita sekä muita koneita ja niiden osia.

"Tuotantoympäristö" (Production facilities) (7 9) tarkoittaa laitteita ja niitä varten erityisesti suunniteltuja ohjelmistoja, jotka on yhdistetty kokonaisuudeksi "kehitystä" tai yhtä tai useampaa "tuotannon" vaihetta varten.

"Tutkan hajaspektri" (Radar spread spectrum) (6) tarkoittaa kaikkia modulointitekniikoita, jotka hajauttavat suhteellisen kapean taajuuskaistan signaalien energian laajemman taajuuskaistan yli käyttäen satunnaista tai puolisanunnaista koodausta.

"Tutkan taajuushyppely" (Radar frequency agility) (6) tarkoittaa kaikkia tekniikoita, jotka vaihtavat puolisanunnaissa järjestyksessä pulssitutkan lähettimen kantoaaltotaajuutta pulssien välillä tai pulssiryhmien välillä enemmän kuin mitä on pulssin kaistanleveys.

"Tyhjöatomisointi" (Vacuum atomization) (1) tarkoittaa prosessia, jossa sulasta metallivirrasta aikaansaadaan tyhjössä nopeasti kehittyvän kaasun avulla läpimitaltaan noin 500 mikrometriä tai sitä pienempiä pisaroita.

"Täyden auktoriteetin digitaalinen moottorin ohjaus" ("FADEC") (Full Authority Digital Engine Control) (7 9) tarkoittaa kaasuturbiini- tai yhdistelmätahtimoottorien elektronista ohjausjärjestelmää, joka käyttää digitaalista tietokonetta ohjaamaan moottorin työntövoiman tai akselin ulostulotehon säätämiseen tarvittavia muuttujia koko moottorin toiminta-alueella polttoaineen syötön aloittamisesta sen sulkemiseen.

"UF₆-korroosiota kestäviä aineita" (Materials resistant to corrosion by UF₆) (0) voivat olla kyseessä olevasta erotusprosessista riippuen kupari, ruostumaton teräs, alumiini, alumiinioksidi, alumiiniseokset, nikkeli tai seos, joka sisältää vähintään 60 painoprosenttia nikkeliä sekä UF₆-kestävää fluorattua hiilivetyypolymeeriä.

"Valtiot, jotka ovat (eivät ole) kemiallisten aseiden kieltosopimuksen sopimuspuolia" (States (not) Party to the Chemical Weapon Convention) (1) ovat valtioita, joiden osalta kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä koskeva yleissopimus on (ei ole) tullut voimaan. (Katso www.opcw.org).

"Verkkoiliityntäohjain" (Network access controller) (4) tarkoittaa fyysistä liitäntää hajautettuun tietoliikenneverkkoon. Se käyttää yhteistä siirtotietä, joka toimii kauttaaltaan samalla "digitaalisella siirtonopeudella" ja jakaa päätteille siirtovuoroja (esim. vuoromerkkien tai kuulostelun avulla). Muista riippumatta se valitsee tietopaketit tai tietoryhmät (esim. IEEE 802), jotka sille on osoitettu. Se on kokoonpano, joka voi olla liitettyä tietokone- tai tietoliikennelaitteeseen viestintäyhteyden luomiseksi.

"Vikasietoisuus" (Fault tolerance) (4) on tietokonejärjestelmän kyky minkä tahansa laitteisto- tai "ohjelmisto"komponenttinsa minkä tahansa häiriön jälkeen jatkaa toimintaansa ilman ihmisen väliintuloa tietyllä suoritustasolla, joka takaa toiminnan jatkumisen, tietojen säilymisen ja toiminnan palautumisen ennalleen tietyn ajan kuluessa.

"Viritettävä" (Tunable) (6) tarkoittaa "laserin" kykyä tuottaa jatkuvaa lähtötehoa kaikilla aallonpituuksilla usean "laser" transition alueella. Viiva "laser" tuottaa diskreettejä aallonpituuksia yhdellä "laser"transitiolla eikä sitä katsota "viritettäväksi".

"Ydinreaktori" (Nuclear reactor) (0) tarkoittaa laitteita, jotka ovat reaktoriastian sisällä tai jotka on liitetty suoraan siihen, laitteita, jotka kontrolloivat sydämen tehotasoa sekä komponentteja, jotka normaalisti sisältävät reaktorin sydämen primäärijäähdytettä tai joutuvat suoraan kosketukseen sen kanssa tai ohjaavat sen kulkua.

"Yhdistelmäpyöröpöytä" (Compound rotary table) (2) tarkoittaa pöytää, jolla työkalupaletta voidaan pyörittää tai kallistaa kahden ei-yhdensuuntaisen akselin suhteen, ja joita voidaan ohjata samanaikaisesti "ääriiviiohjausta" varten.

"Yhdistetty teoreettinen tehokkuus" ("CTP") (Composite theoretical performance) (3 4) on laskentatehokkuuden mitta, joka ilmoitetaan miljoonina teoreettisina operaatioina sekunnissa (Mtops), ja joka on saatu "laskentaelementtien" ("CE") laskentatehokkuuksien yhdistämistä käyttäen.

Huom.: Katso ryhmä 4, tekninen huomautus.

"Yhteen kytketyt tutka-anturit" (Interconnected radar sensors) (6) tarkoittaa, että kaksi tai useampi tutka-anturi on kytketty yhteen, kun ne vaihtavat keskenään tietoa tosiaikaisesti.

"Yhteiskanavamerkinanto" (Common channel signalling) (5) on merkinantomenetelmä, jossa puhelinkeskusten välillä yhdellä kanavalla välitetään tunnuksella varustettujen viestien avulla merkinantotietoa, joka koskee useita piirejä tai puhelujä, sekä muuta esim. verkonhallintaan liittyvää tietoa.

"Yksispektriset kuva-anturit" (Monospectral imaging sensors) (6) ovat kykeneviä hankkimaan kuvatietoa yhdestä erillisestä spektrikaistasta.

"Ääriiviiohjaus" (Contouring control) (2) tarkoittaa kahden tai useamman liikkeen "numeerista ohjausta" käskyillä, jotka määrittävät seuraavan vaadittavan aseman sekä tarvittavat syöttönopeudet tähän asemaan siirtymiseksi. Syöttönopeuksia vaihdellaan toistensa suhteen halutun ääriviivan aikaansaamiseksi (viite ISO/DIS 2806-1980).

TÄSSÄ LIITTEESSÄ KÄYTETYT AKRONYYMIT JA LYHENTEET

Akronyyymi tai lyhenne, jota käytetään määritellyistä termeistä löytyy 'tämän liitteen termien määritelmistä'.

Akronyyymi tai lyhenne	Merkitys
ABEC	Annular Bearing Engineers Committee
AGMA	American Gear Manufacturers' Association
AHRS	attitude and heading reference systems (asennon ja suunnan referenssijärjestelmät)
AISI	American Iron and Steel Institute
ALU	arithmetic logic unit (aritmetiikkayksikkö)
ANSI	American National Standards Institute
ASTM	the American Society for Testing and Materials
ATC	air traffic control (lennonjohto)
AVLIS	Atomic Vapour Laser Isotope Separation (atomihöyryn laserviritykseen perustuva isotooppierotus)
CAD	computer-aided-design (tietokoneavusteinen suunnittelu)
CAS	Chemical Abstracts Service
CCITT	International Telegraph and Telephone Consultative Committee (kansainvälinen neuvoo-antava lennätin- ja puhelinkomitea)
CDU	control and display unit (ohjaus- ja näyttöyksikkö)
CEP	circular error probable (yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä)
CNTD	controlled nucleation thermal deposition (säädeltävä ydintymislämpöhajoaminen)
CRISLA	Chemical Reaction by Isotope Selective Laser Activation (isotooppiselektiivisellä laserilla aktivoitu kemiallinen reaktio)
CVD	chemical vapour deposition (kemiallinen kaasufaasipinnoitus)
CW	chemical warfare (kemiallinen sodankäynti)
CW (for lasers)	continuous wave (jatkuva aalto (laserit))
DME	distance measuring equipment (etäisyydenmittauslaite)
DS	directionally solidified (suunnatusti kiinteytetty)
EB-PVD	electron beam physical vapour deposition (elektronisuihkun avulla tapahtuva fysikaalinen kaasufaasipinnoitus)
EBU	European Broadcasting Union
ECM	electro-chemical machining (sähkökemiallinen työstö)
ECR	electron cyclotron resonance (elektroni-syklotroni-resonanssi)

Akronyymi tai lyhenne	Merkitys
EDM	electrical discharge machines (kipinätyöstökoneet)
EEPROMS	electrically erasable programmable read only memory (elektronisesti pyyhittävä ohjelmoitava lukumuisti)
EIA	Electronic Industries Association
EMC	electromagnetic compatibility (sähkömagneettinen mukautuvuus)
ETSI	European Telecommunications Standards Institute (Euroopan telealan standardintilaitos)
FFT	Fast Fourier Transform (Nopea Fourier-muunnos)
GLONASS	global navigation satellite system (globaali navigointisatelliittijärjestelmä)
GPS	global positioning system (globaali paikannusjärjestelmä)
HBT	hetero-bipolar transistors (heterobipolaaritransistori)
HDDR	high density digital recording (suurtiheyksinen digitaalitallennus)
HEMT	high electron mobility transistors (korkean elektroniliikkuvuuden transistorit)
ICAO	International Civil Aviation Organisation (Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö)
IEC	International Electro-technical Commission (Kansainvälinen sähkötekniikan toimikunta)
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers
IFOV	instantaneous-field-of-view (hetkellinen näkökenttä)
ILS	instrument landing system (mittarilaskeutumisjärjestelmä)
IRIG	inter-range instrumentation group (monialueinstrumentointiryhmä)
ISAR	inverse synthetic aperture radar (käänteinen synteettinen apertuuritutka)
ISO	International Organization for Standardization (Kansainvälinen standardisoiemisjärjestö)
ITU	International Telecommunication Union (Kansainvälinen televiestintäliitto)
JIS	Japanese Industrial Standard
JT	Joule-Thomson
LIDAR	light detecting and ranging (valoon perustuva havainnointi ja etäisyyden mittausta)
LRU	line replaceable unit (linjahuollossa vaihdettava yksikkö)
MAC	message authentication code (sanoman autentikointikoodi)
Mach	ratio of speed of an object to speed of sound (after Ernst Mach) (kohteen nopeuden suhde äänen nopeuteen (Ernst Machin mukaan))
MLIS	Molecular laser Isotopic separation (molekyylien laserviritykseen perustuva isotooppien erotus)

Akronyymi tai lyhenne	Merkitys
MLS	microwave landing systems (mikroaaltolaskeutumisjärjestelmät)
MOCVD	metal organic chemical vapour deposition (metalliorgaaninen kemiallinen kaasufaasipinnoitus)
MRI	magnetic resonance imaging (magneettiresonanssikuvaus)
MTBF	mean-time-between-failures (keskimääräinen vikaväli)
Mtops	million theoretical operations per second (miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnissa)
MTTF	mean-time-to-failure (keskimääräinen vioittumisaika)
NBC	Nuclear, Biological and Chemical (ydin-, biologinen tai kemiallinen)
NDT	non-destructive test (ainetta rikkomaton testi)
PAR	precision approach radar (tarkkuuslähestymistutka)
PIN	personal identification number (henkilökohtainen tunnusnumero)
ppm	parts per million (miljoonasosa)
PSD	power spectral density (tehon spektritiheys)
QAM	quadrature-amplitude-modulation (kvadratuuri-amplitudi-modulaatio)
RF	radio frequency (radiotaajuus)
SACMA	Suppliers of Advanced Composite Materials Association
SAR	synthetic aperture radar (synteettinen apertuuritutka)
SC	single crystal (yksikide-)
SLAR	sidelooking airborne radar (sivukulmatutka)
SMPTE	Society of Motion Picture and Television Engineers (Elokuva- ja televisioalan insinöörien yhdistys)
SRA	shop replaceable assembly (korjaamalla vaihdettava kokoonpano)
SRAM	static random access memory (staattinen luku-/kirjoitusmuisti)
SRM	SACMA Recommended Methods (SACMA:n suosittelemat menetelmät)
SSB	single sideband (yksisivukaista)
SSR	secondary surveillance radar (toisiovalvontatutka)
TCSEC	trusted computer system evaluation criteria (luotettavien tietokonejärjestelmien varmennuskriteerit)
TIR	total indicated reading (koko näyttöalue)
UV	ultraviolet (ultravioletti)
UTS	ultimate tensile strength (murtovetolujuus)
VOR	very high frequency omni-directional range (VHF-monisuuntamajakka)
YAG	yttrium/aluminium garnet (yttrium/alumiinigranaatti)

RYHMÄ 0**YDINAINHEET, LAITTEISTOT JA LAITTEET**

0A Järjestelmät, laitteet ja komponentit

0A001 "Ydinreaktorit" ja niitä varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut komponentit seuraavasti:

- a. "Ydinreaktorit", jotka voivat ylläpitää säädettyä jatkuvaa ytimien halkeamisketjureaktiota;
- b. Sellaiset metalliset astiat tai niiden merkittävät rakenne-elementit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisältämään "ydinreaktorin" sydän, mukaan lukien reaktoripaineastian kansi;
- c. Käsittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu polttoaineen viemiseksi "ydinreaktoriin" tai polttoaineen poistamiseksi sieltä;
- d. Sääätösauvat, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu halkeamisprosessin säätämiseksi "ydinreaktorissa", sauvojen tuki- ja ripustusrakenteet, säätösauvojen käyttökoneistot ja ohjausputket;
- e. Paineputket, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisältämään "ydinreaktorin" polttoaine-elementtejä ja primäärijäähdytettä yli 5,1 MPa:n käyttöpaineessa;
- f. Putket tai putkisarjat, jotka on valmistettu zirkoniummetallista tai seoksesta, jossa hafniumin painosuhte zirkoniumiin on pienempi kuin 1:500, ja jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi "ydinreaktorissa";
- g. Jäähdytepumput, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorin" primäärijäähdytteen kierrättämiseksi;
- h. 'Ydinreaktorin sisäosat', jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi "ydinreaktorissa", mukaan lukien sydämen tukirakenteet, polttoainekanavat, termiset suojat, verholevyt, sydänritilät ja diffuuserilevyt;

Huom.: 0A001.h kohdassa 'ydinreaktorin sisäosat' tarkoitetaan mitä tahansa reaktoriastiassa olevaa merkittävää rakennetta, jolla on yksi tai useampi seuraavanlaisista tehtävistä: sydämen tukeminen, polttoaineen paikallaan pitäminen, primäärijäähdytteen virtauksen ohjaus, toimiminen reaktoriastian säteilysuojana ja sydämessä olevien instrumentointilaitteiden ohjaaminen.
- i. Lämmönvaihtimet (höyrystimet), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi "ydinreaktorin" primäärijäähdytyspiirissä;
- j. Neutronien ilmais- ja mittauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorin" sydämessä vallitsevan neutronivuon määrittämiseen.

OB Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

OB001 Laitokset "luonnonuraanin", "köyhdytetyn uraanin" ja "erityisten halkeamiskelpoisten aineiden" isotooppien erotusta varten ja niitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

- a. Laitokset, jotka on erityisesti suunniteltu "luonnonuraanin", "köyhdytetyn uraanin" ja "erityisten halkeamiskelpoisten aineiden" isotooppien erotusta varten, seuraavasti:
 1. Kaasusentrifugierotuslaitos
 2. Kaasudiffuusioerotuslaitos
 3. Aerodynaaminen erotuslaitos
 4. Kemialliseen vaihtoon perustuva erotuslaitos
 5. Ionivaihtoon perustuva erotuslaitos
 6. Atomihöyryn "laser" viritykseen perustuva isotooppierotuslaitos (AVLIS)
 7. Molekyylien "laser" viritykseen perustuva isotooppierotuslaitos (MLIS)
 8. Plasmaerotuslaitos
 9. Sähkömagneettinen erotuslaitos
- b. Kaasusentrifugit sekä rakenteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi kaasusentrifugierotusprosessissa, seuraavasti:

Huom.: OB001.b kohdassa 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineella' tarkoitetaan jotakin seuraavista:

- a. Maraging-teräs, jonka murtovetolujuus on 2 050 MPa tai suurempi;
 - b. Alumiiniseokset, joiden murtovetolujuus on 460 MPa tai suurempi; tai
 - c. "Kuitu- tai säemateriaalit", joiden "ominaiskimmomoduuli" on suurempi kuin $3,18 \times 10^6$ m ja "ominaisvetolujuus" suurempi kuin $76,2 \times 10^3$ m;
1. Kaasusentrifugit;
 2. Täydelliset roottorikokoonpanot;
 3. Roottoriputkisylintrit, joiden seinien paksuus on 12 mm tai pienempi ja halkaisija 75 mm:n ja 400 mm:n välillä ja jotka on valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';
 4. Renkaat tai palkeet, joiden seinämän paksuus on 3 mm tai pienempi sekä halkaisija 75 mm:n ja 400 mm:n välillä ja jotka on suunniteltu tukemaan paikallisesti roottoriputkea tai liittämään useita putkia yhteen ja jotka on valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';
 5. Halkaisijaltaan 75 mm:n ja 400 mm:n välillä olevat ohjauslevyt, jotka on tarkoitettu asennettavaksi roottoriputken sisään ja jotka on valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';
 6. Halkaisijaltaan 75 mm:n ja 400 mm:n välillä olevat roottoriputken ylä- tai alalaipat, jotka on valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';
 7. "UF₆-korroosiota kestäviä aineista" valmistettuun tai sellaisella suojattuun koteloon ripustetut magneettiset ripustuslaakerit, jotka koostuvat rengasmaisesta magneetista ja jotka sisältävät vaimentavan väliaineen ja joissa magneetti kytkeytyy napakappaleeseen tai toiseen roottorin yläkanteen kiinnitettyyn magneettiin;
 8. Erityisvalmisteiset laakerit, jotka koostuvat vaimentimelle asennetusta laakeritappi-kuppi-kokoonpanosta;
 9. Sylintereistä koostuvat molekylaariset pumput, joihin on sisäisesti koneistettu tai puristettu kierrehlaus ja sisäisesti koneistettu porausreikiä;
 10. Monivaiheisten vaihtovirralla toimivien hystereesi- (tai reluktanssi-) moottorien renkaan muotoiset moottoristaattorit tahtikäyttöön tyhjöissä taajuusalueella 600–2 000 Hz ja tehoalueella 50–1 000 VA;

OB001

b. (jatkuu)

11. Kaasusentrifugin roottoriputkikokoonpanon sentrifugikotelo, joka koostuu jäykästä sylinteristä, jonka seinämän paksuus on enintään 30 mm ja jonka päädyt on tarkkuuskoneistettu ja valmistettu "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä;
 12. Sisähalkaisijaltaan enintään 12 mm:n putkista koostuvat kauhakerääjät, jotka on valmistettu "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä, UF₆-kaasun poistamiseksi sentrifugiroottoriputken sisältä Pitot'n putken toimintaperiaatteella;
 13. Taajuusmuuntimet (konvertterit tai invertterit), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu syöttämään kaasusentrifugirakastukseen tarkoitettuja moottorin staattoreita ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja tällaisia muuntimia varten erityisesti suunnitellut komponentit:
 - a. Monivaiheinen ulostulo 600–2 000 Hz;
 - b. Taajuuden hallinta parempi kuin 0,1 %;
 - c. Harmoninen kokonaissärö pienempi kuin 2 % ja
 - d. Hyötysuhde yli 80 %;
- c. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kaasudiffuusioerotusprosessia varten, seuraavasti:
1. Huokoisista metallisista, polymeerisista tai keraamisista "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" valmistetut kaasudiffusiosulut, joiden huokosten koko on 10 nm:n ja 100 nm:n välillä ja paksuus 5 mm tai vähemmän sekä putkimaisten muotojen halkaisija 25 mm tai pienempi;
 2. Kaasudiffusioyksikön kotelot, jotka on valmistettu "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä;
 3. Kompressorit (pakkosyöttö-, keskipakois- ja aksiaalivirtaustyyppiä) tai kaasupuhaltimet, joiden UF₆-imuteho on 1 m³/min tai suurempi ja poistopaine enintään 666,7 kPa ja jotka on tehty "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä;
 4. Pyörivien akselien tiivisteet kompressoreihin ja puhaltimiin, jotka on määritelty OB001.c.3 kohdassa ja suunniteltu salpakaasun sisäänvuotonopeudelle, joka on pienempi kuin 1 000 cm³/min;
 5. Lämmönvaihtimet, jotka on valmistettu alumiinista, kuparista, nikkelistä tai yli 60 prosenttia nikkeliä sisältävistä seoksista taikka näiden metallien kombinaatioista verhoiltuina putkina ja jotka on suunniteltu toimimaan normaalin ilmanpaineen alapuolella vuotonopeudella, joka rajoittaa paineen nousun pienemmäksi kuin 10 Pa tunnissa 100 kPa:n paine-eron vallitessa;
 6. Paljettiivisteillä varustetut venttiilit, jotka on valmistettu "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä ja joiden halkaisija on 40 mm:n ja 1 500 mm:n välillä;
- d. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu aerodynaamista erotusprosessia varten, seuraavasti:
1. Raonmuotoisista kaarevista kanavista tehtyt erotussuuttimet, joiden kaarevuussäde on pienempi kuin 1 mm ja jotka ovat UF₆-korroosiokestoisia sekä joissa on veitsenterä, joka erottaa suuttimen läpi virtaavan kaasun kahdeksi virraksi;
 2. Tangentiaalisen sisäänmenovirtauksen pyörittämät sylinterimäiset tai kartiomaiset putket (pyörreputket), jotka on valmistettu "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä ja joiden halkaisija on 0,5 cm:n ja 4 cm:n välillä, pituus/halkaisija -suhde pienempi kuin 20:1 ja joilla on yksi tai useampi tangentiaalinen sisäänmenoaukko;
 3. Kompressorit (pakkosyöttö-, keskipako- ja aksiaalivirtaustyyppiä) tai kaasupuhaltimet, joiden UF₆-imuteho on vähintään 2 m³/min ja jotka on valmistettu "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä, ja niitä varten tarkoitettujen pyörimisakselien tiivisteet;
 4. "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" valmistetut tai niillä suojatut lämmönvaihtimet;
 5. "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" valmistetut tai niillä suojatut aerodynaamisten erotuselementtien kotelot pyörreputkia tai erotussuuttimia varten;
 6. Paljeventtiilit, jotka on valmistettu "UF₆-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä ja joiden halkaisija on 40 mm:n ja 1 500 mm:n välillä;
 7. Prosessijärjestelmät UF₆-kaasun erottamiseksi kantokaasusta (vety tai helium) 1 ppm:n tai alhaisemman UF₆-pitoisuuteen, mukaan lukien:
 - a. Kryogeeniset lämmönvaihtimet ja kryoerottimet, jotka kykenevät toimimaan 153 K (-120 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;

OB001

d. (jatkuu)

- b. Kryogeeniset jäähditysyksiköt, jotka kykenevät toimimaan 153 K (-120 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
 - c. Erotussuutin- tai pyörreputkiyksiköt UF₆-kaasun erottamiseksi kantokaasusta;
 - d. UF₆-kylmäloukut, jotka pystyvät toimimaan 253 K (-20 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
- e. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kemialliseen vaihtoon perustuvaa erotusprosessia varten, seuraavasti:
- 1. Nopeavaihtoiset neste-neste-pulssikolonnit, joiden saosaika vaihetta kohti on 30 sekuntia tai lyhyempi ja jotka kestävät vahvaa suolahappoa (esim. sopivista muoviaiaineista kuten fluorihilipolymeereistä tai lasista valmistetut tai niillä vuoratut);
 - 2. Nopeavaihtoiset neste-neste-keskipakokontaktorit, joiden saosaika vaihetta kohti on 30 sekuntia tai lyhyempi ja jotka kestävät vahvaa suolahappoa (esim. sopivista muoviaiaineista kuten fluorihilipolymeereistä tai lasista valmistetut tai niillä vuoratut);
 - 3. Vahvoja suolahappoliuoksia kestävät sähkökemialliset pelkistyskennot, jotka soveltuvat yhden valenssitilan uraanin pelkistämiseen toiseen valenssitilaan;
 - 4. Sähkökemialliset pelkistyskennojen syöttölaitteet U⁺⁴-ionien erottamiseksi orgaanisesta virrasta ja ne prosessivirran kanssa kosketuksissa olevat laitteet, jotka on valmistettu sopivista aineista (esim. lasi, fluorihilipolymeerit, polyfenyylisulfaatti, polyeetterisulfoni ja hartsikyllästetty grafiitti) tai suojattu niillä;
 - 5. Hyvin puhdistetun uraanikloridiliuoksen tuottamiseen tarkoitettujen syötön valmistelujärjestelmät, jotka koostuvat puhdistukseen tarkoitetuista liuotus-, uutin- ja/tai ioninvaihtolaitteista sekä U⁺⁶- tai U⁺⁴-uraanin pelkistämiseen U⁺³-uraaniksi soveltuvista elektrolyyttisistä kennoista;
 - 6. Uraanin hapettamisjärjestelmät U⁺³-uraanin hapettamiseksi U⁺⁴-uraaniksi;
- f. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu ioninvaihtoon perustuvaa erotusprosessia varten, seuraavasti:
- 1. Nopeasti reagoivat ioninvaihtohartsit, kalvomaiset tai huokoiset makroverkkomaiset hartsit, joissa aktiiviset kemialliset vaihtoryhmät on rajoitettu ei-aktiivisen huokoisen tukirakenteen pinnoitteeksi, ja muut komposiittirakenteet missä tahansa sopivassa muodossa, mukaan lukien partikkelit ja kuidut, joiden halkaisija on 0,2 mm tai pienempi ja suunniteltu vaihtopuoliintumisaika on alle 10 sekuntia ja jotka kestävät vahvaa suolahappoa ja kykenevät toimimaan 373 K–473 K (100 °C–200 °C) asteen lämpötila-alueella;
 - 2. (Sylinterinmuotoiset) ioninvaihtokolonnit, joiden halkaisija on suurempi kuin 1 000 mm ja jotka on valmistettu vahvaa suolahappoa kestävästä aineista (esim. titaani tai fluorihilimuovit) tai suojattu niillä ja jotka kykenevät toimimaan 373 K–473 K (100 °C–200 °C) asteen lämpötila-alueella ja yli 0,7 MPa:n paineessa;
 - 3. Ioninvaihtokaisinvirtausjärjestelmät (kemialliset tai sähkökemialliset hapetus- tai pelkistysjärjestelmät) kemiallisten pelkistys- tai hapetusaineiden talteenottamiseksi ioninvaihtoon perustuvissa rikastuskaskadeissa;
- g. Atomihöyryn "laser" viritykseen perustuvaa isotooppierotusmenetelmää (AVLIS) varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:
- 1. Uraanin höyryttämiseen soveltuvat suuritehoiset kaista- tai pyyhkäiselektronisuihkut, joiden tuottama teho on enemmän kuin 2,5 kW/cm;
 - 2. Sulan uraanin tai uraaniseosten käsittelyyn soveltuvat sulan uraanimetallin käsittelyjärjestelmät, jotka koostuvat sopivista korroosiota ja lämpöä kestävästä aineista (esim. tantaalista, yttriumoksidilla päällystetystä grafiitista, muiden harvinaisten maametallien oksideilla päällystetystä grafiitista tai niiden seoksista) valmistetuista tai suojatuista upokkaista ja upokkaiden jäähdytyslaitteista;

HUOM.: KATSO MYÖS 2A225 KOHTA.

- 3. Tuote- ja jätekerääjäjärjestelmät, jotka on valmistettu uraanimetallihöyryn tai nestemäisen uraanin korroosiota ja lämpöä kestävästä aineista, kuten yttriumoksidilla päällystetystä grafiitista tai tantaalista, tai pinnoitettu niillä;

0B001

g. (jatkuu)

4. Erotusyksikön kotelot (sylinterinmuotoiset tai suorakulmaiset astiat), joihin voidaan sijoittaa uraanimetallin höyrystin, elektronisuihkutykki ja tuote- ja jätekerääjät;
5. Uraani-isotooppien erottamiseen soveltuvat "laserit" tai "laser"-järjestelmät, joissa oleva taajuusspektrin stabilaattori mahdollistaa pitkäaikaisen käytön;

HUOM.: KATSO MYÖS 6A005 JA 6A205 KOHTA.

- h. Molekyylien "laser"-viritykseen perustuvaa isotooppien erotusprosessia (MLIS) tai isotooppiselektiivisellä laserilla aktivoitua kemiallista reaktiota (CRISLA) varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:
 1. Ääntä nopeammilla virtauksilla toimivat paisuntasuuttimet, joilla voidaan jäähdyttää UF_6 :n ja kantokaasun seokset 150 K (-123 °C) asteeseen tai sitä alhaisempaan lämpötilaan ja jotka on valmistettu " UF_6 -korroosiota kestävästä aineista";
 2. Uraanipentafluoridin (UF_5) kerääjät, jotka koostuvat suodatin-, törmäys-, tai syklonityyppisistä kerääjistä tai niiden yhdistelmistä ja jotka on valmistettu " UF_5 -/ UF_6 -korroosiota kestävästä aineista";
 3. Kompressorit, jotka on valmistettu " UF_6 -korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä, ja niihin soveltuvat pyörimisakselien tiivisteet;
 4. Laitteet UF_5 :n (kiinteä aine) fluoraamiseksi UF_6 :ksi (kaasu);
 5. Prosessijärjestelmät UF_6 :n erottamiseksi kantokaasusta (esim. tyypestä tai argonista) mukaan lukien:
 - a. Kryogeeniset lämmönvaihtimet ja kryogeeniset erottimet, jotka kykenevät toimimaan 153 K (-120 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
 - b. Kryogeeniset jäähdytinkysiköt, jotka kykenevät toimimaan 153 K (-120 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
 - c. UF_6 -kylmäloukut, jotka kykenevät toimimaan 253 K (-20 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
 6. Uraani-isotooppien erottamiseen soveltuvat "laserit" tai "laser"-järjestelmät, joissa oleva taajuusspektrin stabilaattori mahdollistaa pitkäaikaisen käytön;

HUOM.: KATSO MYÖS 6A005 JA 6A205 KOHTA.

- i. Plasmaerotusmenetelmää varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:
 1. Ionien tuottamiseen tai kiihdyttämiseen soveltuvat mikroaaltoteholähteet ja antennit, joiden ulostulotaajuus on enemmän kuin 30 GHz ja keskimääräinen ulostuloteho suurempi kuin 50 kW;
 2. Radiotaajuusioninvirityskelat, jotka toimivat yli 100 kHz:n taajuuksilla ja kykenevät käsittelemään yli 40 kW:n keskimääräisen tehon;
 3. Uraaniplasman synnyttämiseen soveltuvat järjestelmät;
 4. Sulan uraanin tai uraaniseosten käsittelyyn soveltuvat sulan metallin käsittelyjärjestelmät, jotka koostuvat sopivista korroosiota ja lämpöä kestävästä aineista (esim. tantaalista, yttriumoksidilla päällystetystä grafiitista, muiden harvinaisten maametallien oksideilla päällystetystä grafiitista tai niiden seoksista) valmistetuista tai suojatuista upokkaista ja upokkaiden jäähdytyslaitteista;

HUOM.: KATSO MYÖS 2A225 KOHTA.

5. Tuote- ja jätekerääjät, jotka on valmistettu uraanihöyrin korroosiota ja lämpöä kestävästä aineista, kuten yttriumoksidilla päällystetystä grafiitista tai tantaalista, tai suojattu niillä;
6. Erotusyksikön (sylinterimäinen) kotelo, johon voidaan sijoittaa uraaniplasmalähde, radiotaajuinen ajokela ja tuote- ja jätekerääjät, ja joka on tehty sopivasta ei-magneettisesta aineesta (esim. ruostumattomasta teräksestä);
- j. Sähkömagneettista isotooppierotusmenetelmää varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:
 1. Joko yhden tai useita ionisuihkuja synnyttävät ionilähteet, jotka koostuvat höyrylähteestä, ionisaattorista ja suihkun kiihdyttimestä, jotka on valmistettu sopivasta ei-magneettisesta aineesta (esim. grafiitista, ruostumattomasta teräksestä tai kuparista) ja jotka kykenevät tuottamaan 50 mA:n tai suuremman kokonaisionivirran;

OB001 j. (jatkuu)

2. Rikastetun tai köyhdytetyn uraani-ionisuihkun keräyslevyt, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta raosta ja keräystaskusta ja jotka on valmistettu sopivista ei-magneettisista aineista (esim. grafiitista tai ruostumattomasta teräksestä);
3. Uraanin sähkömagneettisten erotusyksiköiden tyhjäkotelot, jotka on valmistettu ei-magneettisista aineista (esim. ruostumattomasta teräksestä) ja suunniteltu toimimaan 0,1 Pa:n tai sitä alhaisemmissa paineissa;
4. Magneettinapakappaleet, joiden läpimitta on suurempi kuin 2 m;
5. Ionilähteisiin tarvittavat suurjänniteteholähteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - a. Kykenevät toimimaan jatkuvasti;
 - b. Ulostulojännite 20 000 V tai suurempi;
 - c. Ulostulovirta 1 A tai suurempi ja
 - d. Jännitteen stabiilisuus parempi kuin 0,01% kahdeksan tunnin jakson aikana;

HUOM.: KATSO MYÖS 3A227 KOHTA.

6. Magneettien teholähteet (suuritehoiset, tasavirta-), joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - a. Kykenevät toimimaan jatkuvasti siten, että ulostulovirta on 500 A tai suurempi jännitteen ollessa 100 V tai suurempi; ja
 - b. Virran tai jännitteen stabiilisuus parempi kuin 0,01 % kahdeksan tunnin jakson aikana.

HUOM.: KATSO MYÖS 3A226 KOHTA.

OB002 Kohdassa OB001 määriteltyjä isotooppierotuslaitoksia varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut, "UF₆-korroosiota kestäviä aineista" tehdyt tai niillä suojatut apujärjestelmät, laitteet ja komponentit seuraavasti:

- a. Autoklaavit, uunit tai järjestelmät, joita käytetään UF₆:n syöttämiseen rikastusprosessiin;
- b. Kiinteyttimet (desublimaattorit) tai kylmäloukut, joita käytetään UF₆:n poistamiseen rikastusprosessista myöhempää lämmittämällä tapahtuvaa siirtoa varten;
- c. Tuote- ja jäteasemat UF₆:n siirtämiseksi säilytysastioihin;
- d. Nesteytys- tai kiinteytysasemat, joita käytetään poistamaan UF₆ väkevöintiprosessista puristamalla ja jäähdyttämällä UF₆ nestemäiseen tai kiinteään olomuotoon;
- e. Putkisto- ja kokoojajärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu UF₆:n käsittelyyn kaasudiffuusio-, sentrifugi- ja aerodynaamisen erotuslaitoksen kaskadissa;
- f.
 1. Tyhjäjakoputket tai tyhjäkokoojat, joiden imukyky on 5 m³/min tai suurempi; tai
 2. Tyhjäpumput, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi UF₆:tta sisältävässä ilmakehässä;
- g. UF₆-massaspektrometrit/ionilähteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu ottamaan jatkuvatoimisesti näytteitä UF₆-kaasun syötteestä, tuotteesta tai jätteestä ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Yhden atomimassayksikön erotuskyky, kun mitattava massa on suurempi kuin 320 atomimassayksikköä;
 2. Ionilähteet, jotka on valmistettu nichrome- tai monel-metallista tai vuorattu niillä taikka päällystetty nikkelillä;
 3. Elektronipommitukseen perustuva ionisointilähde; ja
 4. Isotooppianalyysiin soveltuva kokoojajärjestelmä.

OB003 Uraanin konversiolaitos ja erityisesti sitä varten suunnitellut tai valmistetut laitteet seuraavasti:

- a. Järjestelmät, joilla uraanimikonsentraatit voidaan muuttaa UO₃:ksi;
- b. Järjestelmät, joilla UO₃ voidaan muuttaa UF₆:ksi;
- c. Järjestelmät, joilla UO₃ voidaan muuttaa UO₂:ksi;

OB001 (jatkuu)

- d. Järjestelmät, joilla UO_2 voidaan muuttaa UF_4 :ksi;
- e. Järjestelmät, joilla UF_4 voidaan muuttaa UF_6 :ksi;
- f. Järjestelmät, joilla UF_4 voidaan muuttaa uranimetalliksi;
- g. Järjestelmät, joilla UF_6 voidaan muuttaa UO_2 :ksi;
- h. Järjestelmät, joilla UF_6 voidaan muuttaa UF_4 :ksi;
- i. järjestelmät, joilla UO_2 voidaan muuttaa UCl_4 :ksi.

OB004 Raskaan veden, deuteriumin ja deuteriumyhdisteen tuotanto- tai konsentroidintilaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

- a. Raskaan veden, deuteriumin tai deuteriumyhdisteen tuotantolaitos seuraavasti:
 - 1. Vesi-rikkivety-erotuslaitokset;
 - 2. Ammoniakki-vety-erotuslaitokset;
- b. Laitteet ja komponentit seuraavasti:
 - 1. Hienohiiliteräksestä (esim. ASTM A 516) valmistetut vesi-rikkivety-erotustornit, joiden läpimitta on 6 m:n ja 9 m:n välillä ja jotka voivat toimia 2 MPa:n tai sitä suuremmassa paineessa sekä joiden korroosiovara on 6 mm tai enemmän;
 - 2. Rikkivetykaasun (yli 70 prosenttia H_2S :ää sisältävän kaasun) kierrätykseen soveltuvat yksivaiheiset pienipaineiset (0,2 MPa) keskipakopuhaltimet tai kompressorit, joiden tilavuusvirta on $56 \text{ m}^3/\text{s}$ tai suurempi niiden toimiessa 1,8 MPa:n imua vastaavassa tai suuremmassa paineessa ja jotka on varustettu H_2S -märkäkäyttöön suunnitelluilla tiivisteillä;
 - 3. Ammoniakki-vety-erotustornit, joiden korkeus on 35 m tai suurempi ja läpimitta 1,5 m:n ja 2,5 m:n välillä ja jotka voivat toimia suuremmissa paineissa kuin 15 MPa;
 - 4. Tornien sisäiset osat, mukaan lukien kosketuspinnat, ja vaihepumpput, mukaan lukien upotettavat pumpput, jotka soveltuvat raskaan veden valmistukseen ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;
 - 5. Ammoniakkikrakerit, joiden käyttöpainne on yhtä suuri tai suurempi kuin 3 MPa ja jotka soveltuvat raskaan veden valmistukseen ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;
 - 6. Infrapuna-absorptioanalysaattorit, jotka kykenevät jatkuvaan vety-deuterium-suhteen mittaamiseen, kun deuteriumpitoisuus on 90 prosenttia tai enemmän;
 - 7. Katalyyttipolttimet, joilla väkevöity deuterium muutetaan raskaaksi vedeksi ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;
 - 8. Täydelliset järjestelmät tai niiden kolonnit, joilla parannetaan raskaan veden laatua, raskaan veden deuteriumpitoisuuden konsentroimiseksi reaktoriluokkaan.

OB005 "Ydinreaktorin" polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet.

Huom.: "Ydinreaktorin" polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos sisältää laitteet, jotka:

- a. Tavallisesti ovat suoraan yhteydessä ydinaineiden tuotantovirtaan tai suoraan prosessoivat tai valvovat sitä;
- b. Sulkevat ydinaineet ilmatiiviisti suojakuoren sisään;
- c. Tarkistavat suojakuoren eheyden tai sulkemisen ilmatiiviyden; tai
- d. Tarkistavat suljetun polttoaineen viimeistelyn.

OB006 "Ydinreaktorin" säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit.

Huom.: OB006 kohtaan kuuluvat:

- a. "Ydinreaktorin" säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitos sekä laitteet ja komponentit, jotka tavallisesti ovat suoraan yhteydessä säteilytettyyn polttoaineeseen ja pääasiallisiin ydinaineiden ja fissiotuotteiden prosessivirtoihin ja suoraan ohjaavat niitä;
- b. Polttoaine-elementtien paloittelu- tai pilkkomiskoneet, ts. kauko-ohjatut laitteet, jotka leikkaavat, paloittavat, pilkkovat tai katkavat "ydinreaktorien" säteilytettyjä polttoainekokoonpanoja, -nippuja tai -sauvoja;
- c. Liuotinastiat, kriittisyysturvalliset tankit (esim. pieniläpimittaiset tankit, rengasmaiset tai laattatankit), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorien" säteilytetyn polttoaineen liuottamiseen ja jotka kykenevät kestämaan kuumia, voimakkaasti syövyttäviä nesteitä ja joita voidaan täyttää ja huoltaa kauko-ohjatusti;
- d. Vastavirtauuttimet ja ioninvaihtoprosessilaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi säteilytetyn "luonnonuraanin", "köyhdytetyn uraanin" tai "erityisten halkeamiskelpoisten aineiden" jälleenkäsittelylaitoksissa;
- e. Säilytys- tai varastoastiat, jotka on erityisesti suunniteltu kriittisyysturvalliseksi ja kestämaan typpihapon syövyttäviä vaikutuksia;

Huom.: Säilytys- tai varastoastioilla voi olla seuraavat ominaisuudet:

1. Seinämien tai sisärankenteiden booriekvivalenttipitoisuus (laskettuna OCO04:ää koskevassa huomautuksessa olevan kaavan mukaisesti kaikkien olennaisten elementtien osalta) vähintään kaksi prosenttia;
 2. Sylinterimäisen astian halkaisija korkeintaan 175 mm; tai
 3. Joko laatta- tai rengasmaisen astian leveys korkeintaan 75 mm.
- f. Prosessin valvontainstrumentointi, joka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu säteilytetyn "luonnonuraanin", "köyhdytetyn uraanin" tai "erityisten halkeamiskelpoisten aineiden" jälleenkäsittelyn valvontaan tai ohjaamiseen.

OB007 Plutoniumin konversiolaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet seuraavasti:

- a. Järjestelmät plutoniumnitraatin muuttamiseksi plutoniumoksidiksi;
- b. Järjestelmät plutoniummetallin tuottamiseksi.

- OC** **Materiaalit**
- OC001 "Luonnonuraani" tai "köyhdytetty uraani" tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista;
- Huom.: OC001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:
- Neljä grammaa tai vähemmän "luonnonuraania" tai "köyhdytettyä uraania", kun se on instrumenttien anturoivassa osassa;
 - Erityisesti seuraaviin rauhanomaisiin, ei-ydinteknisiin sovellutuksiin käytetty "köyhdytetty uraani":
 - Suojaus;
 - Pakkaus;
 - Painolastit, joiden massa on pienempi kuin 100 kg;
 - Vastapainot, joiden massa on pienempi kuin 100 kg;
 - Vähemmän kuin viisi prosenttia toriumia sisältävät seokset;
 - Toriumia sisältävät keraamiset tuotteet, jotka on valmistettu muuta kuin ydinteknistä käyttöä varten.
- OC002 "Erityinen halkeamiskelpoinen aine"
- Huom.: OC002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi määrää, joka on neljä "tehollista grammaa" tai vähemmän kyseistä ainetta, kun se on instrumenttien anturoivassa osassa.
- OC003 Deuterium, raskas vesi (deuteriumoksidi) ja muut deuteriumyhdisteet sekä deuteriumia sisältävät seokset ja liuokset, joissa deuterium-vety-isotooppisuhte ylittää arvon 1:5 000.
- OC004 Reaktoriluokan grafiitti, jonka puhtaustaso on vähemmän kuin 5 miljoonasosaa "booriekvivalenttia" ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,5 g/cm³.
- HUOM.: KATSO MYÖS 1C107 KOHTA.**
- Huom. 1: OC004 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi:
- grafiittivalmisteita, joiden massa on pienempi kuin 1 kg, lukuun ottamatta sellaisia jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi ydinreaktorissa,
 - grafiittijauhetta.
- Huom. 2: OC004 kohdassa "booriekvivalentti" (BE) (Boron equivalent) määritellään epäpuhtauksille summana BE_Z :ista (lukuun ottamatta BE_{hiili} :ia, koska hiiltä ei lasketa epäpuhtaudeksi) mukaan lukien boorin, jolloin
- $$BE_Z \text{ (ppm)} = CF \times \text{alkuaineen } Z \text{ konsentraatio ppm-yksiköinä,}$$
- jossa CF on muunnoskerroin $= \frac{\sigma_Z A_B}{\sigma_B A_Z}$
- σ_B ja σ_Z ovat vastaavat boorin ja alkuaineen Z termiset neutronikaappausvaikutusalat (barn-yksiköinä); A_B ja A_Z ovat boorin ja alkuaineen Z atomipainot.
- OC005 Kaasudiffuusiokalvojen valmistukseen erityisesti valmistetut UF₆-korroosiota kestävät yhdisteet tai jauheet (esim. nikkeli tai seos, joka sisältää 60 painoprosenttia tai enemmän nikkeliä, alumiinioksidi ja täysin fluoratut hiilivetypolymeerit), joiden puhtaus on 99,9 painoprosenttia tai enemmän ja joissa keskimääräinen partikkelikoko on vähemmän kuin 10 mikrometriä mitattuna ASTM (American Society for Testing and Materials) B 330 -standardin mukaisesti ja joissa partikkelit ovat hyvin samankokoisia.

0D**Ohjelmistot**

0D001

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu tässä ryhmässä määriteltyjen tavaroiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

0E**Teknologia**

0E001

"Teknologia" ydinteknologiahuomautuksen mukaisesti tässä ryhmässä määriteltujen tavaroiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

RYHMÄ 1**MATERIAALIT, KEMIKAALIT, "MIKRO-ORGANISMIT" JA "TOKSIINIT"**

1A Järjestelmät, laitteet ja komponentit

1A001 Seuraavat fluoratuista yhdisteistä valmistetut komponentit:

- a. "Ilma-aluksiin" tai avaruuskäyttöön erityisesti suunnitellut tiivisteet, tiivisterenkaat, tiivisteaineet tai polttoainekalvot, joiden valmistuksessa on käytetty yli 50 painoprosenttia 1C009.b tai 1C009.c kohdassa määritettyjä materiaaleja;
- b. Pietosähköiset polymeerit ja sekapolymeerit, jotka on valmistettu 1C009.a kohdassa määritellyistä vinyylideenifluorideista:
 1. Levyn tai kalvon muodossa; ja
 2. Joiden paksuus on yli 200 mikrometriä;
- c. "Ilma-aluksiin", "ohjuksiin" tai avaruuskäyttöön erityisesti suunnitellut tiivisteet, tiivisterenkaat, venttiilien istukat tai kalvot, jotka on valmistettu fluoroelastomeerista, joka sisältää ainakin yhden vinyylieetteriryhmän ainesosana.

Huom.: 1A001.c kohdassa "ohjus" tarkoittaa täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä.

1A002 Seuraavat "komposiitti" rakenteet tai -laminaatit:

Huom. KATSO MYÖS 1A202, 9A010 ja 9A110 KOHTA.

- a. Joilla on orgaaninen "matriisi" ja jotka on valmistettu 1C010.c, 1C010.d tai 1C010.e kohdassa määritellyistä materiaaleista; tai
- b. Joilla on metalli- tai hiili "matriisi" ja jotka on valmistettu:
 1. Hiili "kuitu- tai -säiemateriaaleista", joiden:
 - a. "Ominaiskimmokerroin" ylittää $10,15 \times 10^6$ m; ja
 - b. "Ominaismurtovetolujuus" ylittää $17,7 \times 10^4$ m; tai
 2. 1C010.c kohdassa määritellyistä materiaaleista.

Huom. 1: 1A002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi hartsilla kyllästetyistä hiili "kuitu- tai -säiemateriaaleista" valmistettuja komposiitti-rakenteita tai -laminaatteja, jotka on tarkoitettu lentokoneiden rakenteiden tai laminoitien korjaukseen edellyttäen, ettei niiden koko ylitä 1 m^2 .

Huom. 2: 1A002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmiita tai puolivalmiita tuotenumikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu seuraaviin puhtaasti siviilitarkoituksiin:

- a. Urheilutarvikkeisiin;
- b. Autoteollisuuteen;
- c. Työstökoneteollisuuteen;
- d. Lääkinnällisiin käyttötarkoituksiin.

1A003 1C008.a.3 kohdassa määritellyistä fluoraamattomista polymeereistä valmistetut kalvot, levyt, teipit tai nauhat:

- a. Joiden paksuus ylittää 0,254 mm; tai
- b. Jotka on pinnoitettu tai laminoitu hiilellä, grafiitilla, metallilla tai magneettisilla aineilla.

Huom.: 1A003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmisteita, jotka ovat pinnoitettu tai laminoitu kuparilla ja suunniteltu elektronisten piirilevyjen tuotantoon.

1A004 Muut kuin asetarvikelistassa määritellyt suojaus- ja ilmaisinalitteet ja komponentit seuraavasti:

Huom. KATSO MYÖS 2B351 JA 2B352 KOHTA.

- a. Kaasunaamarit, suodatinrasiat ja niiden puhdistuslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suojaamaan biologisia vaikuteaineita tai "sotilaskäyttöön muunneltuja" radioaktiivisia aineita tai kemiallisen sodankäynnin (CW) vaikuteaineita vastaan, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit;
- b. Suojapuvut, käsineet ja jalkineet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suojaamaan biologisia vaikuteaineita tai "sotilaskäyttöön muunneltuja" radioaktiivisia aineita tai kemiallisen sodankäynnin (CW) vaikuteaineita vastaan;

1A004 (jatkuu)

- c. Ydinalan, biologisen ja kemian alan (NBC) ilmaisinjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ilmaisemaan tai tunnistamaan biologisia vaikuteaineita tai "sotilaskäyttöön sovitettuja" radioaktiivisia aineita tai kemiallisen sodankäynnin (CW) vaikuteaineita, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Huom.: 1A004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a. Henkilökohtaisia säteilyannoksen valvontamittareita;

b. Laitteita, joiden suunnittelu tai toiminta on rajoitettu suojaamaan niitä vaaroja vastaan, jotka ovat ominaisia siviiliteollisuudelle, kuten kaivos-, louhinta-, maatalous-, lääke-, lääkekintä-, eläinlääkintä-, ympäristö-, jätteiden käsittelylle tai elintarviketeollisuudelle.

1A005 Suojaliivit, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin ne, jotka on valmistettu sotilasstandardien tai -laatuvaatimusten mukaisesti tai vastaavat suoritusarvoiltaan niitä.

Huom.: KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO

Huom.: Suojaliivien valmistukseen käytettyjen "kuitu- tai säiemateriaalien" osalta katso 1C010 kohta.

Huom. 1: 1A005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi suojaliivejä tai suojavaatteita, kun ne ovat käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista suojautumistaan varten.

Huom. 2: 1A005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi suojaliivejä, jotka on suunniteltu antamaan suojaa vain edestäpäin kohdistuvia, muiden kuin sotilasräjähteiden sirpaleita ja räjähdystä vastaan.

1A102 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin tarkoitetut toistokyllästetyt pyrolisoidut hiili-hiilikomponentit.

1A202 Muut kuin 1A002 kohdassa määriteltyt, komposiittirakenteet putkina, joilla on seuraavat ominaisuudet:

Huom.: KATSO MYÖS 9A010 JA 9A110 KOHTA.

a. niiden sisähalkaisija on 75 ja 400 mm välillä; ja

b. ne on valmistettu 1C010.a tai b tai 1C210.a kohdassa määritellyistä "kuitu- ja säiemateriaaleista" tai 1C210.c kohdassa määritellyistä hiilipregimateriaaleista.

1A225 Platinoidut katalyytit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu edistämään vedyn ja veden välistä isotooppien vaihtoreaktiota tritiumin ottamiseksi talteen raskaasta vedestä tai raskaan veden tuottamiseksi.

1A226 Erikoisaineet, joita voidaan käyttää raskaan veden erottamiseen tavallisesta vedestä ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. ne on tehty fosforipronssiverkosta, joka on käsitelty kemiallisesti vettyvyyden parantamiseksi; ja

b. ne on suunniteltu käytettäväksi tyhjötislauskolonneissa.

1A227 Korkeatiheyksiset (lyijylasista tai muusta aineesta valmistetut) säteilysuojaikkunat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet sekä näitä varten erityisesti suunnitellut puitteet:

a. 'kylmä (säteilyltä suojattu) ala' on suurempi kuin 0,09 m²:

b. tiheys suurempi kuin 3g/cm³; ja

c. paksuus 100 mm tai suurempi.

Tekn. huom.:

1A227 kohdassa termillä 'kylmä ala' tarkoitetaan ikkunan läpinäkyvää alaa, joka on altistuneena alhaisimmalle säteilytasolle mallisovelluksessa.

1B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

1B001 Seuraavat 1A002 tai 1C010 kohdassa määriteltyjen kuitujen, prepregien, preformien tai "komposiittien" tuotantolaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:

Huom.: KATSO MYÖS 1B101 JA 1B201 KOHTA.

- a. Kuitujen käämintäkoneet, joissa käämittävien kuitujen asettelu-, kiedonta- ja käämintäliikkeet ovat koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa kolmen tai useamman akselin suhteen ja jotka on erityisesti suunniteltu "komposiitti" rakenteiden tai -laminaattien valmistukseen "kuitu- tai säiemateriaaleista";
- b. Nauhapäälystys- tai rohdin-asettelukoneet, joissa teipin, rohtimien tai levyjen asemointi- ja asetteluliikkeet ovat koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa kahden tai useamman akselin suhteen ja jotka on erityisesti suunniteltu "komposiittisten" lentokoneenrunko- tai 'ohjus' rakenteiden valmistukseen;

Huom.: 1B001.b kohdassa 'ohjus' tarkoittaa täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä.

- c. "Komposiitti" rakenteiden valmistukseen tarkoitettujen monisuuntaisten ja monidimensioisten kutoma- tai punontakoneiden kuitujen kudontaa, punontaa tai palmikointia varten sekä näiden koneiden adapterit ja muunnossarjat;

Tekn. huom.:

1B001.c kohdassa punontatekniikkaan sisältyy neulonta.

Huom.: 1B001.c kohta ei aseta valvonnalliseksi tekstiilikoneita, joita ei ole muunnettu yllä mainittuja loppukäyttöjä varten.

- d. Seuraavat lujitekuitujen tuotantoa varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut laitteet:

1. Laitteet, joilla polymeerikuituja (kuten polyakryylinitriili, raion, hartsi tai polykarbosilaani) muutetaan hiilikuiduiksi tai piikarbidikuiduiksi, mukaan lukien erikoislaitteet, joilla kuituja jännitetään kuumentamisen aikana;
2. Laitteistot, joilla valmistetaan piikarbidikuituja pinnoittamalla kuumennettuja kuitusubstraatteja alkuaineilla tai yhdisteillä kemiallista kaasufaasipinnoitus-menettelmää (CVD) käyttäen;
3. Laitteet, joilla märkäkehrätään tulenkestäviä keraameja (kuten alumiinioksidia);
4. Laitteet, joilla esikuituja sisältävä alumiini muutetaan lämpökäsittelyllä alumiinioksidikuiduiksi;

- e. Laitteet, joilla tuotetaan kuumasulatusmenetelmällä 1C010.e kohdassa määriteltyjä prepregejä;

- f. Ainetta rikkomattomat tarkastuslaitteet, joilla voidaan tarkastella valmistusvirheitä kolmessa ulottuvuudessa ultraääni- tai röntgentomografiaa käyttäen, ja jotka on erityisesti suunniteltu "komposiitti"-materiaaleja varten.

1B002 Kontaminaation välttämiseen erityisesti suunnitellut, metalliseosten, metalliseosjauheiden tai seostettujen materiaalien tuottamiseen tarkoitettujen laitteiden, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi jossakin 1C002.c kohdassa määritellyistä prosesseista.

Huom.: KATSO MYÖS 1B102 KOHTA.

1B003 Titaanin tai alumiinin tai niiden seosten "superplastista muovausta" tai "diffuusioliittämistä" varten tarkoitettujen työkalut, suuttimet, muotit tai kiinnikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu:

- a. Lentokoneiden runko- tai avaruusaluusten rakenteiden valmistamiseen;
- b. "Lentokoneiden" tai avaruusaluusten moottorien valmistamiseen; tai
- c. Näitä rakenteita tai moottoreita varten erityisesti suunniteltujen komponenttien valmistamiseen.

1B101 Seuraavat, muut kuin 1B001 kohdassa määritellyt laitteet rakenteellisten komposiittien "tuotantoa" varten sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:

Huom.: KATSO MYÖS 1B201 KOHTA.

Huom.: 1B101 kohdassa määriteltyihin komponentteihin ja varusteisiin sisältyvät muotit, tuurnat, suokappaleet, kiinnittimet ja työkalut komposiittirakenteiden, -laminaattien ja niiden valmisteen preformien puristamista, koveuttamista, valamista, sintraamista tai liittämistä varten.

1B101 (jatkuu)

- a. Kuidunkäämintäkoneet, joissa kuidun asemointi-, käärintä- ja käämintäliikkeet voidaan koordinoita ja ohjelmoida kolmen tai useamman akselin suhteen ja jotka on suunniteltu valmistamaan komposiittirakenteita tai -laminaatteja kuitu- tai säiemateriaaleista, sekä koordinoinnin ja ohjelmoinnin ohjaukset;
- b. Nauhapäällystyskoneet, joissa nauhan tai levyn asettelu- ja asemointiliikkeet voidaan koordinoita ja ohjelmoida kahden tai useamman akselin suhteen ja jotka on suunniteltu komposiittisten lentokoneiden ja "ohjusten" runkorakenteiden valmistusta varten;
- c. Seuraavat "kuitu- tai säiemateriaalien" "tuotantoa" varten suunnitellut tai muunnetut laitteet:
 1. Laitteet, joilla muunnetaan polymeerikuituja (esim. polyakryliniitriliä, raionia tai polykarbosilaania), erityisesti kuitua kuumennuksen aikana jännittäen;
 2. Laitteet, joiden avulla kuumennettuja säiesubstraatteja höyrypinnoitetaan alkuaineilla tai yhdisteillä;
 3. Laitteet, joiden avulla voidaan märkäkehretä tulenkestäviä keraameja (kuten esim. alumiinioksidia);
- d. Laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu kuitujen erityispintakäsittelyä varten tai 9C110 kohdassa määriteltyjen preregien ja preformien tuottamista varten.

Huom.: 1B101.d kohtaan sisältyvät valssaimet, venytyslaitteet, päällystyslaitteet, leikkurit ja meistimuotit.

1B102 Muut kuin 1B002 kohdassa määritellyt metallijauheen "tuotantolaitteet" ja komponentit seuraavasti:

Huom.: KATSO MYÖS 1B115.b KOHTA.

- a. Metallijauheen "tuotantolaitteet", joita voidaan käyttää 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 kohdassa tai asetarvikeluettelossa määriteltyjen pallomaisten tai hivennettyjen materiaalien "tuotantoon" valvotussa ympäristössä.
- b. Erityisesti suunnitellut komponentit 1B002 tai 1B102.a kohdassa määriteltyjä "tuotantolaitteita" varten.

Huom.: 1B102 kohtaan sisältyvät:

- a. Plasmageneraattorit (suuritaajuinen kaarisuihku), joita voidaan käyttää aikaansaamaan sputteroituja tai pallomaisia metallijauheita siten, että prosessi tehdään argon-vesiympäristössä;
- b. Sähköpurkauslaitteistot, joita voidaan käyttää aikaansaamaan sputteroituja tai pallomaisia metallijauheita siten, että prosessi tehdään argon-vesiympäristössä;
- c. Laitteet, joita voidaan käyttää pallomaisten alumiinijauheiden "tuotantoon" pulverisoimalla sula suojakaasussa (esim. työssä).

1B115 Seuraavat muut kuin 1B002 tai 1B102 kohdassa määritellyt laitteet ajoaineiden ja niiden ainesosien tuotantoa varten ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

- a. "Tuotantolaitteet" 1C011.a, 1C011.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa määriteltyjen neste-mäisten ajoaineiden ja niiden ainesosien "tuotantoa", käsittelyä tai vastaanottotestausta varten;
- b. "Tuotantolaitteet" 1C011.a, 1C011.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa määriteltyjen kiinteiden ajoaineiden ja niiden ainesosien "tuotantoa", käsittelyä, sekoittamista, kovettamista, valamista, prässäystä, työstämistä, puristamista tai vastaanottotestausta varten.

Huom.: 1B115.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi eräsekoittimia, jatkuvatoimisia sekoittimia tai neste-energiamylyjä. Eräsekoittimien, jatkuvatoimisten sekoittimien ja neste-energiamylyjen valvonnan osalta katso 1B117, 1B118 ja 1B119 kohta.

Huom. 1: Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu asetarvikkeiden tuotantoa varten: katso asetarvikeluettelo.

Huom. 2: 1B115 kohta ei aseta valvonnallaiseksi boorikarbidin "tuotantoon", käsittelyyn ja hyväksymistestaukseen tarkoitettuja laitteita.

1B116 Erityisesti suunnitellut suuttimet, joilla tuotetaan pyrolyysimenetelmällä muodostuvia aineita muotille, tuurnalle tai muulle substraatille välituotekaasuista, jotka hajoavat 1 573 K (1 300 °C)–3 173 K (2 900 °C) asteen lämpötila-alueella ja 130 Pa:n–20 kPa:n paineessa.

- 1B117 Eräsekoittimet, joiden on pystyttävä sekoittamaan tyhjässä painealueella nollasta 13 326 kPa:iin ja joiden sekoituskammion lämpötilaa voidaan säätää ja joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista, ja tällaisia sekoittimia varten erityisesti suunnitellut komponentit:
- Kokonaistilavuuskapasiteetti 110 litraa tai enemmän; ja
 - Ainakin yksi keskustasta sivuun asennettu sekoitus/vaivausvarsi.
- 1B118 Jatkuvatoimiset sekoittimet, joiden on pystyttävä sekoittamaan tyhjässä painealueella nollasta 13 326 kPa:iin ja joiden sekoituskammion lämpötilaa voidaan säätää ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja tällaisia sekoittimia varten erityisesti suunnitellut komponentit:
- Kaksi tai useampia sekoitus/vaivausvarsia; tai
 - Yksi värähtelevä pyörivä varsi sekä vaivaushampaat/piikit varressa ja sekoituskammion vuorauksen sisäpuolella.
- 1B119 Neste-energiamyllyt, joita voidaan käyttää 1C011.a, 1C011.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa määriteltyjen aineiden jauhamiseen tai hienontamiseen, ja tällaisia myllyjä varten erityisesti suunnitellut komponentit.
- 1B201 Seuraavat muut kuin 1B001 tai 1B101 kohdassa määritellyt kuidunkäämintäkoneet ja niihin liittyvät laitteet:
- Kuidunkäämintäkoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - kuitujen asemointi, käärintä ja käämintä on koordinoitu ja ohjelmoitu kahden tai useamman akselin suhteen;
 - ne on erityisesti suunniteltu komposiittirakenteiden tai -laminaattien valmistamiseen "kuitu- tai säiemateriaaleista"; ja
 - ne pystyvät käämimään 75–400 mm:n läpimittaisia ja 600 mm:n pituisia tai suurempia lieriömäisiä roottoreita,
 - 1B201.a kohdassa määriteltyjen kuidunkäämintäkoneiden koordinointi- ja ohjelmointilaitteet;
 - 1B201.a kohdassa määriteltyjen kuidunkäämintäkoneiden tarkkuustuurnat.
- 1B225 Elektrolyysikennnot fluorin tuotantoa varten, joiden tuotantokapasiteetti on suurempi kuin 250 g fluoria tunnissa.
- 1B226 Sähkömagneettiset isotooppierottimet, jotka on suunniteltu toimimaan tai varustettu yhdellä tai useilla ionilähteillä, joilla voidaan saada aikaan 50 mA:n tai suurempi ionisuihkun kokonaisvirta.
- Huom.: 1B226 kohta sisältää erottimet:
- Jotka pystyvät rikastamaan pysyviä isotooppeja;
 - Joissa ionilähteet ja -kerääjät ovat kummatkin magneettikentässä, sekä ne konfiguraatiot, joissa ne ovat kentän ulkopuolella.
- 1B227 Ammoniakin syntetisointikonvertterit tai ammoniakin syntetisointiyksiköt, joissa synteetikaasu (typpi ja vety) saadaan korkeapaineisesta ammoniakki/vety-vaihtokolonista ja syntetisoitu ammoniakki palautetaan samaan kolonniin.
- 1B228 Kryogeeniset vetytislaukolonnit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
- Ne on suunniteltu toimimaan 35 K (–238 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa sisäisissä lämpötiloissa;
 - Ne on suunniteltu toimimaan 0,5–5 MPa:n sisäisessä paineessa;
 - Ne on valmistettu joko:
 - 300-sarjan vähärikkisestä ruostumattomasta teräksestä, jonka austeniittinen ASTM:n (tai vastaavan standardin) mukainen raekokoluku on 5 tai suurempi; tai
 - Vastaavista kryogeenisistä ja vetyä (H₂) kestävästä materiaaleista; ja
 - Sisähalkaisija on 1 m tai suurempi ja tehollinen pituus 5 m tai pitempi.

- 1B229 Seuraavat vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnit sekä niiden 'sisäkosketuspinnat':
- Huom.:* Erityisesti raskaan veden tuottamista varten suunnitellut tai valmistetut kolonnit: katso OB004 kohta.
- a. Vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. niiden käyttöpainne on 2 MPa tai suurempi;
 2. ne on valmistettu hiiliteräksestä, jonka austeniittinen ASTM:n (tai vastaavan standardin) mukainen raekokoluku on 5 tai suurempi; ja
 3. niiden halkaisija on 1,8 m tai suurempi;
- b. 1B229.a kohdassa määriteltyjen vesi-rikkivety-erotuspohjakolonniin 'sisäkosketuspinnat'.
- Tekn. huom.:*
- Kolonniin 'sisäkosketuspinnat' ovat segmentoituja pohjia, joiden tehollinen halkaisija koottuna on 1,8 m tai enemmän; ne on suunniteltu helpottamaan vastavirtakosketusta ja ne on valmistettu ruostumattomista teräksistä, joiden hiilipitoisuus on 0,03 prosenttia tai vähemmän. Pohjat voivat olla seula-, venttiili-, kello-, ja rutiläpohjia.
- 1B230 Nesteammoniakkiin liuotetun väkevän tai laimean kaliumamidikatalyytin (KNH_2/NH_3) kierrättämiseen kykenevät pumput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
- a. Ne ovat ilmatiiviitä (so. hermeettisesti suljettuja);
- b. Pumppausteho on suurempi kuin $8,5 \text{ m}^3/\text{h}$; ja
- c. Jompi kumpi seuraavista ominaisuuksista:
1. Ne on tarkoitettu väkevien (1 % tai suurempi pitoisuus) kaliumamidiliuosten kierrättämiseen 1,5–60 MPa:n käyttöpainneella; tai
 2. Laimeiden (pitoisuus vähemmän kuin 1 %) kaliumamidiliuosten kierrättämiseen 20–60 MPa:n käyttöpainneella.
- 1B231 Seuraavat tritiumlaitokset tai -tehtaat ja niissä käytettävät laitteet:
- a. Laitokset tai tehtaat, joissa tuotetaan, otetaan talteen, uutetaan, rikastetaan tai käsitellään tritiumia,
- b. Tritiumlaitosten tai -tehtaiden laitteet seuraavasti:
1. Vedyn tai heliumin jäähdytysyksiköt, joissa lämpötila saadaan lasketuksi 23 K (-250°C) asteeseen tai alhaisemmaksi ja joiden lämmönpoistokyky on suurempi kuin 150 W;
 2. Vetyisotooppien varastointi- ja puhdistusjärjestelmät, joissa varastointiin tai puhdistukseen käytetään metallihydridejä.
- 1B232 Turbohöyrystimet tai turbohöyrystin-kompressorihdistelmät, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- a. Ne on tarkoitettu käytettäväksi siten, että ulostulolämpötila on 35 K (-238°C) tai alhaisempi; ja
- b. Ne on tarkoitettu tuottamaan vetykaasua 1 000 kg/h tai enemmän.
- 1B233 Litiumisotooppien erotukseen käytettävät laitokset tai tehtaat ja niissä käytettävät laitteet seuraavasti:
- a. Laitokset tai tehtaat litiumisotooppien erottamiseen;
- b. Laitteet litiumisotooppien erottamiseen seuraavasti:
1. Erityisesti litiumamalgaameja varten suunnitellut pakatut neste-neste erotuskolonnit,
 2. Elohopea- tai litiumamalgaamipumput,
 3. Litiumamalgaamielektrolyysikennot,
 4. Haihduttimet väkeviä litiumhydroksidiliuoksia varten.

1C

MateriaalitTekn. huom.:

Metallit ja metalliseokset:

Ellei toisin säädetä, 1C001–1C012 kohdassa sanat 'metalli' ja 'metalliseos' kattavat seuraavat raa'at ja puoli-valmistemuodot:

Raa'at muodot:

Anodit, harkot, kanget (mukaan lukien lovetut kanget ja lankaharkot), valanteet, lohkareet, raakatangot, brikitit, katodit, kiteet, kuutiot, rouheet, jyväset, valuharkot, kokkareet, pelletit, raakametalliharkot, pulveri, sulakuoret, valurakeet, valssausaihiot, puristusharkot, sieni, sauvat;

Puolivalmistemuodot (riippumatta siitä ovatko ne pinnoitettuja, päällystettyjä, porattuja tai lävistettyjä):

- a. Taotut tai työstetyt materiaalit, jotka on valmistettu valssaamalla, vetämällä, suulakepuristamalla, takomalla, kylmäpursottamalla, meistäällä, rouhimalla, hiventämällä, ja jauhamalla, so.: kulmakiskot, kourut, pyörylät, kiekot, pöly, hiutaleet, foliot ja ohutlevy, taos, levy, pulveri, puristeet ja meistot, nauha, renkaat, tangot (mukaan lukien paljaat hitsauslangat, valssilangat, ja valssivanungit), muotometallit, profiilit, levyt ja putket (mukaan lukien putkikehät, neliökanget, ja ontot palkit), vedetyt tai puristetut langat;
- b. Valettu materiaali, joka on tuotettu valamalla hiekka-, suulake-, metalli-, kipsi- tai muun tyyppisellä muotilla, mukaan lukien korkeapainevalokset, sintratut muodot ja pulverimetallurgialla aikaansaadut muodot.

Valvonnan tavoitetta ei tule kumota viemällä muita kuin lueteltuja muotoja, joiden väitetään olevan lopullisia tuotteita, vaikka ne käytännössä ovat raakoja muotoja tai puolivalmistemuotoja.

1C001

Seuraavat sähkömagneettisia aaltoja absorboiviksi erityisesti suunnitellut materiaalit tai itseisjohtavat polymeerit:

Huom.: KATSO MYÖS 1C101 KOHTA.

- a. Materiaalit, jotka absorboivat yli 2×10^8 , mutta alle 3×10^{12} hertsin taajuuksia;

Huom. 1: 1C001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

- a. Luonnon- tai synteettisistä kuiduista rakentuvia hiustyyppisiä absorboivia materiaaleja, joiden absorptiokyky on saatu aikaan ei-magneettisella täyteaineella;
- b. Absorboivia materiaaleja, joilla ei ole lainkaan magneettista häviötä, ja joiden kohtauspinta ei ole muodoltaan taso, mukaan lukien pyramidi-, kartio-, kiila- sekä poimuiset pinnat;
- c. Tasopintaisia absorboivia materiaaleja:

1. Jotka on valmistettu:

- a. Taipuisista tai jäykistä vaahtomuoveista, joissa täyteaineena on hiili, tai orgaanisista materiaaleista, sideaineet mukaanlukien, jotka antavat metalliin verrattuna yli 5 %:n kaiun kaistalla, joka on yli $\pm 15\%$ kohtaavan energian keskitaajuudesta, ja jotka eivät kestä yli 450 K (177 °C) asteen lämpötiloja; tai
- b. Keraamisista materiaaleista, jotka antavat metalliin verrattuna yli 20 %:n kaiun kaistalla, joka on yli $\pm 15\%$ kohtaavan energian keskitaajuudesta, ja jotka eivät kestä 800 K (527 °C) asteen ylittäviä lämpötiloja;

Tekn. huom.:

1C001.a kohdan 1.c.1 huomautuksessa tarkoitettujen absorptiotestinäytteiden tulee olla neliöitä, joiden sivun pituus on vähintään 5 keskitaajuuden aallonpituutta, ja ne tulee asettaa säteilevän elementin kaukokenttään.

2. Joiden vetolujuus on pienempi kuin 7×10^6 N/m²; ja3. Puristuslujuus on pienempi kuin 14×10^6 N/m²;

1C001

a. (jatkuu)

d. Sintratusta ferriitistä valmistetut tasopintaiset absorboivat materiaalit joiden:

1. Ominaispaino ylittää 4,4; ja
2. Maksimitoimintalämpötila on 548 K (275 °C) astetta.

Huom. 2: Mikään 1C001.a kohtaa koskevassa huomautuksessa 1 ei vapauta maaliin sisällytettyjä magneettisia materiaaleja, joiden tarkoitus on tehdä se absorptiokykyiseksi.

- b. Materiaalit, jotka absorboivat yli $1,5 \times 10^{14}$ Hz:n, mutta alle $3,7 \times 10^{14}$ Hz:n taajuuksia, ja jotka eivät läpäise näkyvää valoa;
- c. Itsejohtavat polymeerimateriaalit, joiden 'kokonaissähkönjohtokyky' ylittää 10 000 S/m (siemensä metriä kohti) tai 'pintaresistiivisyys' on alle 100 ohmia/m², ja jotka perustuvat johonkin seuraavista polymeereistä:
1. Polyaniliini;
 2. Polypyroli;
 3. Polytiofeeni;
 4. Polyfenyleenivinyleeni; tai
 5. Polytienyleenivinyleeni.

Tekn. huom.:

'Kokonaissähkönjohtokyky' ja 'pintaresistiivisyys' tulee määritellä ASTM D-257:n tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

1C002

Seuraavat metalliseokset, metalliseosjauheet tai seostetut materiaalit:

Huom.: KATSO MYÖS 1C202 KOHTA.

Huom.: 1C002 kohta ei aseta valvonnallaiseksi metalliseoksia, metalliseosjauheita tai seostettuja materiaaleja, jotka on tarkoitettu substraattien pinnoitukseen.

Tekn. huom.:

1. Metalliseokset 1C002 kohdassa ovat niitä, joissa mainitun metallin painoprosentti on suurempi kuin minkään muun aineen.
 2. Jännitysmurtumaikä mitataan ASTM-standardin E-139 tai vastaavien standardien mukaisesti.
 3. Väsymisikä mitataan ASTM-standardin E-606 'Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing' mukaisesti tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti. Testauksen tulee olla aksiaalinen, keskimääräisen jännityssuhteen 1 ja jännityksen keskityskertoimen (K_t) 1. Keskimääräinen jännityssuhde määritellään maksimijännityksen ja minimijännityksen erotuksen sekä maksimijännityksen osamääränä.
- a. Seuraavat aluminidit:
1. Nikkelialuminidit, jotka sisältävät vähintään 15 painoprosenttia alumiinia, korkeintaan 38 painoprosenttia alumiinia ja vähintään yhden lisäseoskuuaineen;
 2. Titaanialuminidit, jotka sisältävät 10 painoprosenttia tai enemmän alumiinia ja vähintään yhden lisäseoskuuaineen;
- b. Seuraavat metalliseokset, jotka on valmistettu 1C002.c kohdassa määritellyistä materiaaleista:
1. Nikkeliseokset, joiden:
 - a. Jännitysmurtumaikä on 10 000 tuntia tai enemmän 923 K (650 °C) asteen lämpötilassa rasiituksen ollessa 676 MPa; tai
 - b. Low cycle -väsymisikä on 10 000 jaksoa tai enemmän 823 K (550 °C) asteen lämpötilassa maksimirasiituksen ollessa 1 095 MPa;
 2. Niobiumseokset, joiden:
 - a. Jännitysmurtumaikä on 10 000 tuntia tai enemmän 1 073 K (800 °C) asteen lämpötilassa rasiituksen ollessa 400 MPa; tai
 - b. Low cycle -väsymisikä on 10 000 jaksoa tai enemmän 973 K (700 °C) asteen lämpötilassa maksimirasiituksen ollessa 700 MPa;

1C002

b. (jatkuu)

3. Titaaniseokset, joiden:

- a. Jännitysmurtumaikä on 10 000 tuntia tai enemmän 723 K (450 °C) asteen lämpötilassa rasituksen ollessa 200 MPa; tai
- b. Low cycle -väsymisikä on 10 000 jaksoa tai enemmän 723 K (450 °C) asteen lämpötilassa maksimirasituksen ollessa 400 MPa;

4. Alumiiniseokset, joiden vetolujuus on:

- a. 240 MPa tai enemmän lämpötilan ollessa 473 K (200 °C) astetta; tai
- b. 415 MPa tai enemmän lämpötilan ollessa 298 K (25 °C) astetta;

5. Magnesiumseokset, joiden:

- a. vetolujuus on 345 MPa tai enemmän; ja
- b. syöpymisnopeus on vähemmän kuin 1 mm/vuosi 3 %:ssa natriumkloridin vesiliuoksessa mitattuna ASTM-standardin G-31 tai vastaavan kansallisen standardin mukaisesti;

c. Metalliseosjauhe- tai hiukkasmaiset materiaalit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne on tehty jostakin seuraavista seossysteemeistä:

Tekn. huom.:*Seuraavissa kaavoissa X tarkoittaa yhtä tai useampaa seosalkuainetta.*

- a. Nikkeliseokset (Ni-Al-X, Ni-X-Al), jotka ovat turbiinimoottorien osiksi sopivia, eli joissa on vähemmän kuin 3 (valmistusprosessin aikana lisättyä) kooltaan yli 100 µm olevaa epämetallipartikkeliä 10⁹ seospartikkeliä kohti;
- b. Niobiumseokset (Nb-Al-X tai Nb-X-Al, Nb-Si-X tai Nb-X-Si, Nb-Ti-X tai Nb-X-Ti);
- c. Titaaniseokset (Ti-Al-X tai Ti-X-Al);
- d. Alumiiniseokset (Al-Mg-X tai Al-X-Mg, Al-Zn-X tai Al-X-Zn, Al-Fe-X tai Al-X-Fe); tai
- e. Magnesiumseokset (Mg-Al-X tai Mg-X-Al); ja

2. Ne on valmistettu kontrolloiduissa olosuhteissa jollakin seuraavista prosesseista:

- a. "Tyhjöatomisointi";
- b. "Kaasuatomisointi";
- c. "Pyörivä atomisointi";
- d. "Läimäyssammutus";
- e. "Sulakehäräys" ja "jauhatus";
- f. "Sulaerotus" ja "jauhatus"; tai
- g. "Mekaaninen seostus"; ja

3. Ne voivat muodostaa 1C002.a tai 1C002.b kohdassa määriteltyjä materiaaleja.

d. Seostetut materiaalit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne on tehty 1C002.c.1 kohdassa määritellyistä seossysteemeistä;
2. Ne ovat hienontamattomina hiutaleina, nauhoina tai ohuina tankoina; ja
3. Ne on tuotettu kontrolloidussa ympäristössä jollakin seuraavista menetelmistä:
 - a. "läimäyssammutusmenetelmä",
 - b. "sulakehäräysmenetelmä", tai
 - c. "sulaerotusmenetelmä".

1C003

Kaikentyyppiset ja -muotoiset magneettiset metallit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Suhteellinen alkupermeabiliteetti 120 000 tai enemmän ja paksuus 0,05 mm tai vähemmän;

Tekn. huom.:*Alkupermeabiliteetin mittaaminen on suoritettava täysin hehkutetuilla materiaaleilla.*

1C003 (jatkuu)

b. Magnetostriktiiviset metalliseokset, joiden:

1. Magnetostriktiivinen saturaatio on enemmän kuin 5×10^{-4} ; tai
2. Magnetomekaaninen kytkentäkerroin (k) on enemmän kuin 0,8; tai

c. Amorfiset tai 'nanokiteiset' metalliseosnauhat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Koostumuksesta vähintään 75 painoprosenttia on rautaa, kobolttia tai nikkeliä;
2. Magneettisen induktion saturaatio (B_s) on 1,6 T tai enemmän; ja
3. Jokin seuraavista:
 - a. Nauhapaksuus on 0,02 mm tai vähemmän; tai
 - b. Ominaisresistanssi on 2×10^{-4} ohmi cm tai enemmän.

Tekn. huom.:

1C003.C kohdassa 'nanokiteiset' materiaalit ovat sellaisia materiaaleja, joiden röntgendiffraktiolla määritelty kideraekoko on 50 nm tai vähemmän.

1C004 Uraani-titaaniseokset tai volframiseokset, joilla on rauta-, nikkeli- tai kuparipohjainen "matriisi" ja joiden:

- a. Tiheys ylittää $17,5 \text{ g/cm}^3$;
- b. Elastisuusraja ylittää 880 MPa;
- c. Murtolujuus ylittää 1 270 MPa; ja
- d. Venymä ylittää 8 %.

1C005 Seuraavat yli 100 m pitkät tai yli 100 g:n painoiset "suprajohtavat" "komposiitti"- johtimet:

- a. Monikuituiset "suprajohtavat" "komposiitti"-johtimet, jotka sisältävät yhden tai useamman niobium-titaanikuidun:
 1. Joka on istutettu muuhun "matriisiin" kuin kupari- tai kuparipohjaiseen "matriisiin"; tai
 2. Jonka poikkileikkauksen pinta-ala on vähemmän kuin $0,28 \times 10^{-4} \text{ mm}^2$ (pyöreiden kuitujen halkaisija on vähemmän kuin 6 μm);
- b. Yhdestä tai useammasta, muusta kuin niobium-titaanista valmistetusta "suprajohtavasta" kuidusta koostuvat "suprajohtavat" "komposiitti"-johtimet:
 1. Joiden "kriittinen lämpötila" magneettisen induktion nollassa ylittää 9,85 K ($-263,31^\circ\text{C}$) astetta, mutta on vähemmän kuin 24 K ($-249,16^\circ\text{C}$) astetta;
 2. Joiden poikkileikkauksen pinta-ala on vähemmän kuin $0,28 \times 10^{-4} \text{ mm}^2$; ja
 3. Jotka pysyvät "suprajohtavassa" tilassa 4,2 K ($-268,96^\circ\text{C}$) asteessa, kun ne asetetaan magneettikenttään, jonka magneettinen induktio on 12 T.

1C006 Seuraavat nesteet ja voiteluaineet:

- a. Hydraulinesteet, jotka sisältävät perusainesosanaan jotain seuraavista yhdisteistä tai aineista:
 1. Synteettiset pii-hiili-vety-öljyt, joiden:

Tekn. huom.:

1C006.a.1 kohdassa pii-hiili-vety-öljyt sisältävät pelkästään piitä, vetyä ja hiiltä.

- a. Leimahduspiste ylittää 477 K (204°C) astetta;
- b. Jähmepiste on 239 K (-34°C) astetta tai alempi;
- c. Viskositeetti-indeksi on 75 tai enemmän; ja
- d. Terminen stabiileetti on 616 K (343°C) astetta; tai

1C006

a. (jatkuu)

2. Kloori-fluori-hiili-yhdisteet:

Tekn. huom.:*1C006.a.2 kohdassa kloori-fluori-hiili-yhdisteet sisältävät pelkästään klooria, fluoria ja hiiltä.*

- a. Joilla ei ole leimahduspistettä;
- b. Joiden itsesyttymislämpötila on yli 977 K (704 °C) astetta;
- c. Joiden jäähmepiste on 219 K (– 54 °C) astetta tai alempi;
- d. Joiden viskositeetti-indeksi on 80 tai enemmän; ja
- e. Joiden kiehumispiste on 473 K (200 °C) astetta tai korkeampi;

b. Voiteluaineet, jotka sisältävät perusainesosanaan jotain seuraavista yhdisteistä tai aineista:

- 1. Fenyleeni- tai alkyylifenyleenietterit tai -tioetterit tai niiden seokset, jotka sisältävät enemmän kuin kaksi etteri- tai tioetterifunktiota tai niiden seosta; tai
- 2. Fluoratut silikoninesteet, joiden kinemaattinen viskositeetti on vähemmän kuin 5 000 mm²/s (5 000 senttistokea) 298 K (25 °C) asteen lämpötilassa mitattuna;
- c. Höyrystys- tai vaahdotusnesteet, joiden puhtaus ylittää 99,8 %, jotka sisältävät 100 millilitrassa vähemmän kuin 25 kooltaan 200 µm tai suurempaa partikkelia, ja jotka on valmistettu vähintään 85-prosenttisesti jostakin seuraavista yhdisteistä tai aineista:

- 1. Dibromitetrafluorietaani;
- 2. Polyklooritrifluorietyleni (vain öljyiset tai vahamaiset muunnokset); tai
- 3. Polybromitrifluorietyleni;

d. Elektroniikan fluori-hiili-jäähdytysnesteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

- 1. Sisältävät 85 painoprosenttia tai enemmän jotakin seuraavista tai niiden seoksista:
 - a. Monomeerimuotoisia perfluoripolyalkyलिएetteri-triatsiineja tai perfluorialfaatti-eettereitä;
 - b. Perfluorialkyyliamineita;
 - c. Perfluorisykloalkaaneja; tai
 - d. Perfluorialkaaneja;
- 2. Tiheys 298 K (25 °C) asteessa on 1,5 g/ml tai enemmän;
- 3. Nestemäisessä tilassa 273 K (0 °C) asteessa; ja
- 4. Sisältävät 60 painoprosenttia tai enemmän fluoria.

Tekn. huom.:*1C006 kohdassa:*

- a. Leimahduspiste määritetään ASTM D-92:n kuvaamalla Cleveland Open cup- tai vastaavilla kansallisilla menetelmillä.
- b. Jäähmepiste määritetään ASTM D-97:n kuvaamalla tai vastaavilla kansallisilla menetelmillä.
- c. Viskositeetti-indeksi määritetään ASTM D-2270:n kuvaamalla tai vastaavilla kansallisilla menetelmillä.
- d. Terminen stabiileetti määritetään seuraavalla koemenettelyllä tai vastaavilla kansallisilla menetelmillä:

20 ml testattavaa nestettä asetetaan 46 ml:n vetoiseen ruostumattomasta teräksestä (tyyppiä 317) valmistettuun kammiioon, joka sisältää yhden työkaluteräksisen (M-10), yhden teräksisen (52 100) ja yhden laivapronssisen (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn) nimellisläpimitaltaan 12,5 mm kuulan.

1C006

d. (jatkuu)

Kammio tyhjennetään typen avulla ja suljetaan (yhden) ilmakehän paineeseen, ja lämpötila nostetaan 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) asteeseen kuudeksi tunniksi. Näytettä pidetään termisesti stabiilina, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Kunkin kuulan paino vähenee vähemmän kuin 10 mg kuulan pinnan yhtä mm² kohti;
2. Alkuperäisen, 311 K (38 °C) asteessa määritetyn viskositeetin muutos on vähemmän kuin 25%; ja
3. Kokonaishappo- tai -emäsluku on vähemmän kuin 0,40.

e. Itsesyttymislämpötila määritetään ASTM E-659:n kuvaamalla tai vastaavilla kansallisilla menetelmillä.

1C007

Seuraavat keraamiset perusmateriaalit, keraamiset ei-"komposiitti" materiaalit, keraamiset "matriisi"- "komposiitti" materiaalit ja väliaineet:

Huom.: KATSO MYÖS 1C107 KOHTA.

a. Yksinkertaisten tai kompleksisten titaaniboridien perusmateriaalit, joiden metallisten epäpuhtauksien kokonaismäärä, tarkoituksellisia lisäaineita lukuunottamatta, on vähemmän kuin 5 000 ppm, keskimääräinen partikkelikoko on 5 mikrometriä tai vähemmän, ja korkeintaan 10 % hiukkasista on kooltaan suurempia kuin 10 mikrometriä;

b. Titaaniborideista koostuvat keraamiset ei-"komposiitti" materiaalit raaka-aineena tai puolivalmisteina, joiden tiheys on 98 % tai enemmän teoreettisesta tiheydestä;

Huom.: 1C007.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi hioma-aineita.

c. Keraami-keraami-"komposiitit", joilla on lasi- tai oksidi"matriisi" ja jotka on lujitettu kuiduilla, joilla on kaikki seuraavista:

1. Ne on tehty jostakin seuraavista materiaaleista:

- a. Si-N;
- b. Si-C;
- c. Si-Al-O-N; tai
- d. Si-O-N; ja

2. Niiden ominaismurtovetolujuus ylittää $12,7 \times 10^3$ m;

d. Keraami-keraami-"komposiitti" materiaalit, joilla on tai ei ole jatkuvaa metallifaasia, ja jotka sisältävät hienojakoisena minkä tahansa kuitumaisen tai whiskers-tyyppisen materiaalin hiukkasia tai faaseja, ja joissa "matriisin" muodostavat piin, zirkoniumin tai boorin karbidit tai nitridit;

e. Seuraavat väliaineet (erikoispolymeeri- tai metalliorgaaniset materiaalit), jotka on tarkoitettu 1C007.c kohdassa määriteltyjen materiaalien jonkin faasin tai faasin valmistamiseen:

1. Polydiorganosilaanit (piikarbidin valmistukseen);
2. Polysilatsaanit (piinitridin valmistukseen);
3. Polykarbosilatsaanit (pii-, hiili- ja typpikomponentteja sisältävien keraamisten aineiden valmistukseen).

f. Keraami-keraami "komposiitti" materiaalit, joilla on oksidi- tai lasi"matriisi", joka on lujitettu jonkin seuraavien järjestelmien jatkuvilla kuiduilla:

1. Al₂O₃; tai
2. Si-C-N.

Huom.: 1C007.f kohta ei aseta valvonnallaiseksi "komposiitteja", jotka sisältävät näiden järjestelmien kuituja, joiden vetolujuus on vähemmän kuin 700 Mpa 1 273 K (1 000 °C) asteen lämpötilassa tai virumisvastus on enemmän kuin 1 %:n virumisvenymä 100 Mpa:n kuormalla ja 1 273 K (1 000 °C) asteessa 100 tunnin aikana.

1C008

Seuraavat fluoraamattomat polymeeriset aineet:

- a. 1. Bismaleimidit;
2. Aromaattiset polyamidi-imidit;
3. Aromaattiset polyimidit;

1C008

a. (jatkuu)

4. Aromaattiset polyeetteri-imidit, joiden lasiutumislämpötila (T_g) ylittää 513 K (240 °C) astetta käyttäen standardissa ASTM D 3418 kuvattua kuivamenetelmää;

Huom.: 1C008.a kohta ei aseta valvonnallaiseksi sulamattomia muottipuristusjauheita tai puristeita.

- b. Termoplastiset nestekidesekapolymeerit, joilla pehmenemislämpötila ylittää 523 K (250 °C) astetta mitattuna ASTM D-648:n menetelmä A:n mukaisesti tai vastaavalla kansallisella menetelmällä 1,82 N/mm² kuormituksen alaisena, ja jotka koostuvat:

1. Jostakin seuraavista aineista:

- a. Fenyleeni, bifenyleeni tai naftaleeni; tai
b. Metyyli-, tertiääri-butyyli- tai fenyyli-substituoitu fenyleeni, bifenyleeni tai naftaleeni; ja

2. Jostakin seuraavista hapoista:

- a. Tereftaalihappo;
b. 6-hydroksi-2-naftoehappo; tai
c. 4-hydroksibentsoehappo;

c. Seuraavat polyaryleeni-eetteri-ketonit:

1. Polyeetteri-eetteri-ketoni (PEEK);
2. Polyeetteri-ketoni-ketoni (PEKK);
3. Polyeetteri-ketoni (PEK);
4. Polyeetteri-ketoni-eetteri-ketoni-ketoni (PEKEKK);

d. Polyaryleeniketonit;

e. Polyaryleenisulfidit, joissa aryleeniryhmä on bifenyleeni, trifenyleeni tai jokin niiden yhdistelmistä;

f. Polybifenyleenieetterisulfoni.

Tekn. huom.:

Lasittumislämpötila (T_g) 1C008 kohdan materiaaleille määritetään ASTM D 3418:ssa kuvatulla tavalla kuivamenetelmää käyttäen.

1C009

Seuraavat käsittelemättömät fluoratut yhdisteet:

- a. Vinyylideenifluoridin sekapolymeerit, joilla ilman venytystä on 75 % tai enemmän betakiderakennetta;
b. Fluoratut polyimidit, jotka sisältävät 10 painoprosenttia tai enemmän sitoutunutta fluoria;
c. Fluoratut fosfatseeni-elastomeerit, jotka sisältävät 30 painoprosenttia tai enemmän sitoutunutta fluoria.

1C010

Seuraavat "kuitu- tai säiemateriaalit", joita voidaan käyttää "komposiitti" rakenteissa tai -laminaateissa, joilla on orgaaninen "matriisi", metalli "matriisi" tai hiili "matriisi":

Huom.: KATSO MYÖS 1C210 KOHTA.

a. Orgaaniset "kuitu- tai säiemateriaalit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. "Ominaiskimmokerroin" ylittää $12,7 \times 10^6$ m; ja
2. "Ominaismurtovetolujuus" ylittää $23,5 \times 10^4$ m;

Huom.: 1C010.a kohta ei aseta valvonnallaiseksi polyetyyleeniä.

b. Hiilipohjaiset "kuitu- tai säiemateriaalit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. "Ominaiskimmokerroin" ylittää $12,7 \times 10^6$ m; ja
2. "Ominaismurtovetolujuus" ylittää $23,5 \times 10^4$ m;

Huom.: 1C010.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi lentokoneiden rakenteiden tai laminointien korjaukseen tarkoitettuja kuitu- tai säiemateriaaleista valmistettua kudosta, jonka yksittäisten arkkiäiden koko ei ylitä 50 cm × 90 cm.

1C010

b. (jatkuu)

Tekn. huom.:

1C010.b kohdassa mainittujen materiaalien ominaisuudet tulee määrittää SACMA:n (Suppliers of Advanced Composite Materials Association) suosittamia menetelmiä SRM 12-17 tai vastaavia kansallisia vetokokeita käyttäen, kuten japanilaista JIS-R-7601 (Japanese Industrial Standard) 6.6.2 kohta, ja perustua erän keskiarvoon.

c. Epäorgaaniset "kuitu- tai säiemateriaalit", joiden:

1. "Ominaiskimmokerroin" ylittää $2,54 \times 10^6$ m; ja
2. Sulamis-, hajoamis- tai härmistymispiste on yli 1 922 K (1 649 °C) astetta neutraalissa ympäristössä;

Huom.: 1C010.c kohta ei aseta valvonnallaiseksi:

1. Epäjätkuvia, monifaasisia, monikiteisiä alumiinioksidikuituja katkeena tai mattona, jotka sisältävät 3 painoprosenttia tai enemmän piitä ja joiden ominaiskimmomoduuli on vähemmän kuin 10×10^6 m;
2. Molybdeeni- ja molybdeeniseoskuituja;
3. Boorikuituja;
4. Epäjätkuvia keraamisia kuituja, joiden sulamis-, hajoamis- tai härmistymispiste on alempi kuin 2 043 K (1 770 °C) astetta neutraalissa ympäristössä.

d. "Kuitu- tai säiemateriaalit":

1. Jotka koostuvat joistakin seuraavista:

- a. 1C008.a kohdassa määritellyistä polyeetteri-imideistä; tai
- b. 1C008.b–1C008.f kohdassa määritellyistä materiaaleista; tai

2. Jotka koostuvat joistakin 1C010.d.1.a tai b kohdassa määritellyistä materiaaleista ja joihin on "sekoitettu" muita, 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa määriteltyjä kuituja;

e. Seuraavat muovi- tai hartsikyllästetyt kuidut (prepregit), metalli- tai hiilipinnoitteiset kuidut (preformit) tai hiilikuitu-preformit:

1. Jotka on valmistettu 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa määritellyistä "kuitu- tai säiemateriaaleista";
2. Jotka on valmistettu orgaanisista tai hiilipohjaisista "kuitu- tai säiemateriaaleista":
 - a. Joiden "ominaismurtovetolujuus" ylittää $17,7 \times 10^4$ m;
 - b. Joiden "ominaiskimmokerroin" ylittää $10,15 \times 10^6$ m;
 - c. Joita ei ole määritelty 1C010.a tai 1C010.b kohdassa; ja
 - d. Jotka on kyllästetty 1C008 tai 1C009.b kohdassa määritellyillä materiaaleilla, joiden lasittumislämpötila (T_g) ylittää 383 K (110 °C) astetta, tai fenoli- tai epoksihartseilla, joiden lasittumislämpötila (T_g) on 418 K (145 °C) tai enemmän.

Huom.: 1C010.e kohta ei aseta valvonnallaiseksi:

- a. Epoksihartsin "matriisilla" kyllästettyjä hiili- tai säiemateriaaleja (prepregejä), jotka on tarkoitettu lentokoneiden rakenteiden tai laminaattien korjaamiseen, jossa yksittäisten prepegiarkkien koko ei ylitä 50 cm × 90 cm.
- b. Prepregejä, jotka on kyllästetty fenoli- tai epoksihartseilla ja joiden lasittumislämpötila (T_g) on vähemmän kuin 433 K (160 °C) ja kovettumislämpötila alempi kuin lasittumislämpötila.

Tekn. huom.:

Lasittumislämpötila (T_g) 1C010.e kohdan materiaaleille määritetään ASTM D 3418:ssa kuvatulla tavalla kuivamenetelmää käyttäen. Lasittumislämpötila fenoli- ja epoksihartseille määritetään ASTM D 4065:ssä kuvatulla tavalla 1 Hz taajuudella ja kuumentamisnopeudella 2 K (°C) minuutissa kuivamenetelmää käyttäen.

1C011 Seuraavat metallit ja yhdisteet:

Huom.: KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO JA 1C111 KOHTA.

- a. Metallit, joiden hiukkaskoko on vähemmän kuin 60 µm riippumatta siitä ovatko ne pallomaisia, hivennettyjä, pallomaisia, hiutaloituja tai jauhettuja, jotka on valmistettu materiaalista, joka sisältää 99 % tai enemmän zirkoniumia, magnesiumia ja näiden seoksia;

Tekn. huom.:

Hafniumin luontainen pitoisuus zirkoniumissa (tyypillisesti 2–7 prosenttia) lasketaan zirkoniumin kanssa.

Huom.: 1C011.a kohdassa luetellut metallit tai seokset ovat valvonnanalaisia riippumatta siitä onko metallit tai seokset kapseloitu alumiiniin, magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

- b. Boori tai boorikarbidi, jonka puhtaus on 85 % tai suurempi ja hiukkaskoko 60 mikrometriä tai vähemmän;

Huom.: 1C011.b kohdassa listatut metallit tai seokset ovat valvonnanalaisia riippumatta siitä onko metallit tai seokset kapseloitu alumiiniin, magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

- c. Guanidiininitraatti.

- d. Nitroguanidiini (NQ) (CAS 556-88-7).

1C012 Seuraavat materiaalit:

Tekn. huom.:

Näitä materiaaleja käytetään tyypillisesti ydinlämpölähteissä.

- a. Plutonium missä tahansa muodossa, jonka plutonium-238 isotooppipitoisuus on enemmän kuin 50 % painosta;

Huom.: 1C012.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

- a. Toimituksia, joissa plutoniumsisältö on 1 g tai vähemmän;

- b. Toimituksia, joissa on 3 "tehollista grammaa" tai vähemmän instrumentin anturoivassa osassa.

- b. "Aiemmin erotettu" neptunium-237 missä tahansa muodossa.

Huom.: 1C012.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi toimituksia, joissa neptunium-237 sisältö on 1 g tai vähemmän.

1C101 Muut, kuin 1C001 kohdassa määritellyt, "ohjuksissa" ja niiden alajärjestelmissä käyttökelpoiset materiaalit ja laitteet, jotka pienentävät havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta, ultraviolettia-, infrapuna- tai akustista havaittavuutta.

Huom. 1: 1C101 kohta sisältää:

- a. Rakennemateriaalit ja pinnoitteet, jotka on erityisesti kehitetty pienentämään tutkaheijastavuutta;

- b. Pinnoitteet, mukaan lukien maalit, jotka on erityisesti kehitetty vähentämään tai muuntamaan säteilyn heijastavuutta tai emissiivisyyttä spektrin mikroaalto-, infrapuna- tai ultraviolettialueella;

Huom. 2: 1C101 kohta ei sisällä pinnoitteita, kun niitä käytetään satelliittien lämmön kontrollointiin.

1C102 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin tarkoitetut toistokyllästetyt pyrolisoidut hiili-hiilimateriaalit.

1C107 Seuraavat, muut kuin 1C007 kohdassa määritellyt grafiitti- ja keraamiset materiaalit:

- a. Seuraavat hienorakeiset toistokiteytyt massagrafiitit, joiden kappaleitiheys on 1,72g/cm³ tai suurempi, 288 K (15 °C) asteen lämpötilassa mitattuna, ja joiden hiukkaskoko on 100 mikrometriä tai vähemmän ja joita voidaan käyttää "ohjusten" suuttimissa ja ilmakehään palaamaan suunniteltujen alusten kärki-kartioissa:

1. Sylinterit, joiden halkaisija on 120 mm tai suurempi ja joiden pituus on 50 mm tai enemmän;

2. Putket, joiden sisähalkaisija on 65 mm tai suurempi ja joiden seinämäpaksuus on 25 mm tai enemmän ja joiden pituus on 50 mm tai enemmän;

3. Lohkot, joiden koko on 120 mm × 120 mm × 50 mm tai enemmän.

Huom.: Katso myös 0C004 kohta.

1C107 (jatkuu)

- b. Pyrolyttiset tai kuituvahvisteiset grafiitit, joita voidaan käyttää "ohjusten" suuttimissa ja ilmakehään palamaan suunniteltujen alusten kärkikartioissa.

Huom.: Katso myös OC004 kohta.

- c. Keraamiset komposiittimateriaalit (dielektrisyysvakio pienempi kuin 6 taajuusalueilla 100 Hz–10 000 MHz), joita käytetään "ohjusten" tutka-antennien suojakuissa;
- d. Kokonaisina työstettävät piikarbidivahvisteiset polttamattomat keraamit, joita käytetään "ohjusten" kärkikartioissa.

1C111 Seuraavat, muut kuin 1C011 kohdassa määritellyt ajoaineet tai ajoaineiden raaka-aineina käytettävät kemikaalit:

a. Ajoaineet:

1. Muu kuin asetarvikeluettelossa mainittu alumiinipalloyauhe, jonka tasakokoiset hiukkaset ovat läpimitaltaan alle 200 µm ja alumiinipitoisuus 97 painoprosenttia tai korkeampi, jos vähintään 10 prosenttia kokonaispainosta muodostuu hiukkasista, joiden läpimitta on alle 63 µm, ISO -standardin 2591:1988 tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti;

Tekn. huom.:

Hiukkaskoko 63 µm (ISO R – 565) vastaa raekokoa 250 (Tyler) tai 230 (ASTM – Standardi E – 11).

2. Muut kuin asetarvikeluettelossa mainitut metalliset ajoaineet, joiden pallomaisten, hivennettyjen, sferoidisten, hiutaloitujen tai jauhattujen hiukkasten koko on alle 60 µm ja jotka sisältävät 97 painoprosenttia tai enemmän seuraavista:

- a. Zirkonium;
- b. Beryllium;
- c. Magnesium; tai
- d. Edellä kohdissa a–c määriteltyjen metallien seokset;

Tekn. huom.:

Hafniumin luontainen pitoisuus zirkoniumissa (tyypillisesti 2–7 prosenttia) lasketaan zirkoniumin kanssa.

3. Seuraavat nestemäiset hapettavat aineet:

- a. Dityppitrioksidi
- b. Tyypidioksidi/dityppitetroksidi
- c. Dityppipentoksidi
- d. Typpioksidisekoitukset (MON);

Tekn. huom.:

Typpioksidisekoitukset (MON) ovat typpioksidin (NO) liuoksia dityppitetroksidissa/typpidioksidissa (N_2O_4/NO_2), joita voidaan käyttää ohjusjärjestelmissä. On olemassa joukko koostumuksia, jotka voidaan nimetä lyhenteillä MONi tai MONij, joissa i ja j ovat kokonaislukuja, jotka kuvaavat typpioksidin prosenttiosuutta seoksessa (esim. MON3 sisältää 3 prosenttia typpioksidia, MON25 taas 25 prosenttia typpioksidia. Yläraja on MON40 eli 40 painoprosenttia).

- e. **KATSO ASETARVIKELUETTELO: Inhibioitu punahöyryinen typpihappo (IRFNA);**

- f. **KATSO ASETARVIKELUETTELO JA 1C238: Yhdisteet, jotka muodostuvat fluorista ja yhdestä tai useammasta muusta halogeenista, hapestä tai timestä.**

b. Polymeeriset aineet:

1. Karboksyyliipäätteinen polybutadieeni (CTPB);
2. Hydroksyyliipäätteinen polybutadieeni (HTPB), muu kuin asetarvikeluettelossa määritelty;
3. Polybutadieeniakryylihappon (PBAA);
4. Polybutadieeniakryylihapponakrylonitriili (PBAN);

1C111 (jatkuu)

c. Muut ajoaineiden lisä- ja apuaineet:

1. **KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA karboraanit, dekaboraanit, pentaboraanit ja niiden johdannaiset;**
2. Trietyleeniglykolidinitraatti (TEGDN);
3. 2-nitrodifenyyliamiini;
4. Trimetylolietaanitrinitraatti (TMETN);
5. Dietyleeniglykolidinitraatti (DEGDN);
6. Seuraavat ferroseenijohdannaiset:
 - a. Katso asetarvikeluettelosta katoseeni;
 - b. Etyyliferroseeni;
 - c. Propyyliferroseeni;
 - d. Katso asetarvikeluettelosta n-butyyliferroseeni;
 - e. Pentyyliferroseeni;
 - f. Disyklopentyyliferroseeni;
 - g. Disykloheksyyliferroseeni;
 - h. Dietyyliferroseeni;
 - i. Dipropyyliferroseeni;
 - j. Dibutyyliferroseeni;
 - k. Diheksyyliferroseeni;
 - l. Asetyyliferroseeni;
 - m. Katso asetarvikeluettelosta ferroseenikarboksyylihapot;
 - n. Katso asetarvikeluettelosta butaseeni;
 - o. Muut kuin asetarvikeluettelossa määritellyt ferroseenijohdannaiset, joita voidaan käyttää rakettien ajoaineiden palamisnopeuden muuttamiseen.

Huom.: Muut ajoaineet ja kemialliset ainesosat, joita 1C111 kohdassa ei ole määritelty: katso asetarvikeluettelo.

1C116 Maraging-teräkset (teräkset, joille on tunnusomaista korkea nikkeliipitoisuus, hyvin alhainen hiilipitoisuus sekä seostusaineiden tai erkaumien käyttö vanhenemis-karkenemisen aikaansaamiseksi), levyinä tai putkina, joiden (seinämän) paksuus on 5 mm tai vähemmän ja joiden murtovetolujuus on 1 500 MPa tai suurempi 293 K (20 °C) asteen lämpötilassa mitattuna.

Huom.: KATSO MYÖS 1C216 KOHTA.

1C117 Wolframi, molybdeeni ja näiden metallien seokset tasakokoisina pallomaisina tai atomisoituina hiukkasina, joiden läpimitta on 500 mikrometriä tai pienempi ja pitoisuus 97 % tai suurempi, joita käytetään "ohjusten" moottoreiden komponenttien, esim. lämpösuojusten, suuttimien pohjarakenteiden, suuttimien kurkkujen ja työntövektorin ohjauspintojen valmistukseen.

1C118 Titaanistabiloitu ruostumaton dupleksiteräs (Ti-DSS), jolla on:

a. Kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Sisältää 17,0–23,0 painoprosenttia kromia ja 4,5–7,0 painoprosenttia nikkeliä;
2. Titaanipitoisuus suurempi kuin 0,10 painoprosenttia; ja
3. Ferriittis-austeniittinen mikrorakenne (toiselta nimeltään kaksiosainen mikrorakenne), josta vähintään 10 tilavuusprosenttia on austeniittia (ASTM-standardin E-1181-87 tai vastaavien kansallisten standardien mukaan); ja

b. Jokin seuraavista muodoista:

1. Harkko tai tanko, jonka mitat ovat joka suunnassa 100 mm tai enemmän;
2. Levy, jonka leveys on 600 mm tai enemmän ja paksuus 3 mm vai vähemmän; tai
3. Putki, jonka ulompi halkaisija on 600 mm tai enemmän ja seinämän paksuus 3 mm tai vähemmän.

- 1C202 Seuraavat metalliseokset, joita ei ole määritelty 1C002.b.3 tai b.4 kohdassa:
- Alumiiniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
 - murtovetolujuus voi olla 460 MPa tai enemmän 293 K (20 °C) asteen lämpötilassa; ja
 - ne ovat putkina tai täysmetallisina tankoina (myös takeina), joiden ulkohalkaisija on yli 75 mm;
 - Titaaniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
 - murtolujuus voi olla 900 MPa tai enemmän 293 K (20 °C) asteen lämpötilassa; ja
 - ne ovat putkina tai kiinteinä tankoina (myös takeina), joiden ulkohalkaisija on suurempi kuin 75 mm.
- Tekn. huom.:
Lujuusmääritelmä kattaa seokset sekä lämpökäsittelimättöminä että käsiteltyinä.
- 1C210 Seuraavat, muut kuin 1C010.a, b tai e kohdassa määriteltyt "kuitu- tai säiemateriaalit" tai prepregit:
- Hiili- tai aramidi'kuitu- ja -säiemateriaalit', joilla on jompi kumpi seuraavista ominaisuuksista:
 - "ominaiskimmokerroin" on $12,7 \times 10^6$ m tai suurempi; tai
 - "ominaismurtovetolujuus" on 235×10^3 m tai suurempi;
- Huom.: 1C210.a kohta ei aseta valvonnallaiseksi aramidi 'kuitu- ja -säiemateriaaleja', joissa on 0,25 prosenttia tai enemmän esteripohjaista säiepinnan muuntoainetta;
- Lasikuitupitoiset 'kuitu- ja -säiemateriaalit', joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
 - "ominaiskimmokerroin" on $3,18 \times 10^6$ m tai suurempi; ja
 - "ominaismurtovetolujuus" on $76,2 \times 10^3$ m tai suurempi;
 - 1C210.a tai b kohdassa määritellyistä hiili- tai lasi'kuitu- tai säiemateriaaleista' valmistetut enintään 15 mm:n levyiset (prepregit) Thermoset-hartsikyllästetyt yhtäjaksoiset "langat", "esilangat", "rohtimet" tai "teipit".
- Tekn. huom.:
Hartsit muodostaa komposiitin matriisin.
- Huom.: 1C210 kohdassa 'kuitu- tai säiemateriaaleilla' tarkoitetaan vain yhtäjaksoisia monofilamentteja, "lankoja", "esilankoja", "rohtimia" tai "teippejä".
- 1C216 Muu kuin 1C116 kohdassa määritelty maraging-teräs, jonka murtovetolujuus voi 293 K (20 °C) asteen lämpötilassa ylittää arvon 2 050 Mpa.
- Huom.: 1C216 kohta ei aseta valvonnallaiseksi kappaleita, joiden mikään lineaarinen ulottuvuus ei ole suurempi kuin 75 mm.
- Tekn. huom.:
Lujuusmääritelmä kattaa maraging-teräkset sekä lämpökäsittelimättöminä että lämpökäsiteltyinä.
- 1C225 Boori, joka on rikastettu boori-10-isotoopilla (^{10}B) suurempaan kuin luonnolliseen isotooppipitoisuuteen, seuraavasti: alkuaineboori, yhdisteet, booria sisältävät seokset, niistä valmistetut tuotteet, kaikesta edellä mainitusta syntyvä jäte tai romu.
- Huom.: 1C225 kohdassa booria sisältäviin seoksiin kuuluvat booripitoiset materiaalit.
- Tekn. huom.:
Boori-10:n luonnollinen isotooppipitoisuus on noin 18,5 painoprosenttia (20 atomiprosenttia).
- 1C226 Volframi, volframikarbidi ja seokset, joissa on enemmän kuin 90 painoprosenttia volframia, ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- ne ovat sylinterin muotoisia kappaleita, joiden sisäläpimitta on 100–300 mm (sylinterisegmentit mukaan lukien); ja
 - niiden massa on suurempi kuin 20 kg.
- Huom.: 1C226 ei aseta valvonnallaiseksi tuotteita, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi painoina tai gammasädekolliimaattoreina

- 1C227 Kalsium, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- a. painosta on vähemmän kuin 1 000 miljoonasosaa muita metalliepuhtauksia kuin magnesiumia; ja
 - b. vähemmän kuin 10 miljoonasosaa painosta booria.
- 1C228 Magnesium, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- a. painosta on vähemmän kuin 200 miljoonasosaa muita metalliepuhtauksia kuin kalsiumia; ja
 - b. vähemmän kuin 10 miljoonasosaa painosta booria.
- 1C229 Vismutti, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- a. puhtaus on 99,99 painoprosenttia tai enemmän; ja
 - b. hopeapitoisuus on pienempi kuin 10 miljoonasosaa.
- 1C230 Berylliummetalli, yli 50 painoprosenttia berylliumia sisältävät seokset, berylliumyhdisteet, niistä tehdyt valmisteet sekä kaikista edellä mainituista syntyvä jäte tai romu.
- Huom.: 1C230 kohta ei aseta valvonnallaiseksi seuraavia:
- a. Röntgenlaitteiden metalli-ikkunat tai porarei'issä käytettävät sondit;
 - b. Valmiit tai puolivalmiit oksidiprofiilit, jotka on erityisesti suunniteltu elektronikkakomponenttiosiksi tai elektroniikkapiirien substraateiksi;
 - c. Berylli (beryllium-alumiinisilikaatti) smaragdeina tai akvamariineina.
- 1C231 Hafniummetalli, enemmän kuin 60 painoprosenttia hafniumia sisältävät seokset, enemmän kuin 60 painoprosenttia hafniumia sisältävät hafniumyhdisteet, näistä tehdyt valmisteet sekä kaikesta edellä mainitusta syntyvä jäte tai romu.
- 1C232 Helium-3 (³He), helium-3:a sisältävät seokset ja mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet tai laitteet.
- Huom.: 1C232 kohta ei aseta valvonnallaiseksi tuotetta tai laitetta, joissa on vähemmän kuin 1 g helium-3-isotooppia.
- 1C233 Litium, joka on rikastettu 6-isotoopilla (⁶Li) suurempaan kuin luonnolliseen isotooppipitoisuuteen sekä rikastettua litiumia sisältävät tuotteet tai laitteet, seuraavasti: seokset (lejeeringit), yhdisteet, litiumia sisältävät seokset, näistä tehdyt valmisteet, sekä kaikesta edellä mainitusta syntyvä jäte tai romu.
- Huom.: 1C233 ei aseta valvonnallaiseksi termoluminesenssiannosmittareita.
- Tekn. huom.:
- Litiumin 6-isotoopin pitoisuus luonnossa on noin 6,5 painoprosenttia (7,5 atomiprosenttia).
- 1C234 Zirkonium, jonka hafnium-pitoisuus on vähemmän kuin 1 paino-osa hafniumia per 500 osaa zirkoniumia seuraavasti: metallina, enemmän kuin 50 painoprosenttia zirkoniumia sisältävinä seoksina tai yhdisteinä, näistä tehtyinä valmisteina sekä kaikkena edellä mainitusta syntyvänä jätteenä tai romuna.
- Huom.: 1C234 ei aseta valvonnallaiseksi zirkoniumia, joka on enintään 0,10 mm paksuisena folioina.
- 1C235 Tritium, tritiumyhdisteet ja tritiumia sisältävät seokset, joissa tritiumatomien lukumääräsuhde vetyatomeihin ylittää 1:1000 sekä mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet ja laitteet.
- Huom.: 1C235 ei aseta valvonnallaiseksi tuotteita ja laitteita, joissa on vähemmän kuin $1,48 \times 10^3$ GBq (40 Ci) tritiumia.
- 1C236 Alfa-hiukkasia emittoivat radionuklidit, joiden alfa-hiukkasten puoliintumisaika on 10 päivää tai pitempi mutta lyhyempi kuin 200 vuotta, seuraavissa muodoissa:
- a. Alkuaine,
 - b. Yhdisteet, joiden kokonais-alfa-aktiivisuus on 37 GBq/kg (1 Ci/kg) tai suurempi,
 - c. Seokset, joiden kokonais-alfa-aktiivisuus on 37 GBq/kg (1 Ci/kg) tai suurempi,
 - d. Mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet tai laitteet.
- Huom.: 1C236 kohta ei aseta valvonnallaiseksi tuotteita tai laitteita, jotka sisältävät alle 3,7 GBq (100 millicurietä) alfahiukkasaktiivisuutta.

- 1C237 Radium-226 (^{226}Ra), radium-226-lejeeringit, radium-226-yhdisteet, radium-226:a sisältävät seokset, mistä ja mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet tai laitteet.

Huom.: 1C237 kohta ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

- a. Lääketieteessä käytettävät applikaattorit,
- b. Tuotteet tai laitteet, jotka sisältävät vähemmän kuin 0.37 GBq (10 millicurietä) radium-226:a.

- 1C238 Klooritrifluoridi (ClF_3).

- 1C239 Muut kuin asetarvikeluettelossa määritellyt voimakkaat räjähteet tai niitä enemmän kuin 2 painoprosenttia sisältävät seokset tai aineet, joiden kideiheys on suurempi kuin $1,8 \text{ g/cm}^3$ ja räjähdysnopeus yli 8 000 m/s.

- 1C240 Muut kuin 0C005 kohdassa määritellyt nikkelijauheet ja huokoinen metallinen nikkeli seuraavasti:

- a. Nikkelijauheet, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
 1. nikkelipitoisuus on 99,0 painoprosenttia tai suurempi; ja
 2. keskimääräinen hiukkaskoko on pienempi kuin 10 mikrometriä mitattuna American Society for Testing and Materials (ASTM) B330 -standardilla;
- b. 1C240.a kohdassa määritellyistä materiaaleista tuotettu huokoinen metallinen nikkeli.

Huom.: 1C240 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:

- a. Säikeiset nikkelijauheet;
- b. Yksinkertaiset huokoiset nikkelilevyt, joiden koko on $1\,000 \text{ cm}^2$ tai vähemmän.

Tekn. huom.:

1C240.b kohdassa tarkoitetaan huokoista metallia, joka muodostuu, kun 1C240.a kohdassa tarkoitettuja materiaaleja puhdistetaan kokoon ja sintrataan siten, että saadaan metallista materiaalia, jossa hienot huokokset jatkuvat koko rakenteen läpi.

- 1C350 Seuraavat kemikaalit, joita voidaan käyttää myrkyllisten kemiallisten aineiden lähtöaineina, sekä yhtä tai useampaa niistä sisältävät "kemialliset seokset":

Huom.: KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO JA 1C450 KOHTA.

1. Tiodiglykoli (111-48-8)
2. Fosforioksikloridi (10025-87-3)
3. Dimetyylimetyylifosfonaatti (756-79-6)
4. **Metyylifosfonodifluoridi (676-99-3):
KATSO ASETARVIKELUETTELO**
5. Metyylifosfonodikloridi (676-97-1)
6. Dimetyylifosfiitti (868-85-9)
7. Fosforitrikloridi (7719-12-2)
8. Trimetyylifosfiitti (121-45-9)
9. Tionyylikloridi (7719-09-7)
10. N-metyyli-3-piperidinoli (3554-74-3)
11. 2-N,N-di-isopropyyliamino-etyylikloridi (96-79-7)
12. 2-N,N-di-isopropyyliamino-etaanitioli (5842-07-9)
13. 3-kinuklidinoli (1619-34-7)
14. Kaliumfluoridi (7789-23-3)
15. 2-kloorietanoli (107-07-3)
16. Dimetyyliamiini (124-40-3)
17. Dietyylietyylifosfonaatti (78-38-6)
18. Dietyyli-N,N-dimetyyli-fosforoamidaatti (2404-03-7)
19. Dietyylifosfiitti (762-04-9)

1C350

(jatkuu)

20. Dimetyyliamiinihydrokloridi (506-59-2)
21. Etyylifosfonidikloridi (1498-40-4)
22. Etyylifosfonodikloridi (1066-50-8)
23. **Etyylifosfonodifluoridi (753-98-0):
KATSO ASETARVIKELUETTELO**
24. Vetyfluoridi (7664-39-3)
25. Metyyli-bentsilaatti (76-89-1)
26. Metyylifosfonidikloridi (676-83-5)
27. 2-N,N-di-isopropyyliamino-etanoli (96-80-0)
28. Pinakolyialkoholi (464-07-3)
29. **O-etyyli-2-N,N-di-isopropyyli-aminoetyyli-metyylifosfoniitti (57856-11-8):
KATSO ASETARVIKELUETTELO**
30. Trietyylifosfiitti (122-52-1)
31. Arseenitrikloridi (7784-34-1)
32. Bentsiilihappo (76-93-7)
33. Dietyylimetyylifosfoniitti (15715-41-0)
34. Dimetyylietyylifosfonaatti (6163-75-3)
35. Etyylifosfonidifluoridi (430-78-4)
36. Metyylifosfonidifluoridi (753-59-3)
37. 3-kinuklidinoni (3731-38-2)
38. Fosforipentakloridi (10026-13-8)
39. Pinakoloni (3,3-dimetyyli-2-butanoni) (75-97-8)
40. Kaliumsyaniidi (151-50-8)
41. Kaliumvetyfluoridi (7789-29-9)
42. Ammoniumvetyfluoridi (1341-49-7)
43. Natriumfluoridi (7681-49-4)
44. Natriumvetyfluoridi (1333-83-1)
45. Natriumsyaniidi (143-33-9)
46. Trietanoliamiini (102-71-6)
47. Fosforipentasulfidi (1314-80-3)
48. Di-isopropyyliamiini (108-18-9)
49. Dietyyliaminoetanoli (100-37-8)
50. Natriumsulfidi (1313-82-2)
51. Dirikkidikloridi (10025-67-9)
52. Rikkidikloridi (10545-99-0)
53. Trietanoliamiinihydrokloridi (637-39-8)
54. N,N-di-isopropyyli-2-aminoetyylikloridihydrokloridi (4261-68-1).

Huom. 1: Kemiallisia aineita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C350 kohta ei aseta valvonnallaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C350 kohdan 1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ja 54 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 10 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 2: Kemiallisia aineita koskevaan yleissopimukseen kuului valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C350 kohta ei aseta valvonnallaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C350 kohdan 1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ja 54 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

1C350 (jatkuu)

Huom. 3: 1C350 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C350 kohdan 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ja 53 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 4: 1C350 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

1C351 Ihmispatogeenit, zoonootit ja "toksiinit" seuraavasti:

a. Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelmä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:

1. Chikungunya-virus;
2. Krimin verenvuotokuumevirus;
3. Dengue-virus;
4. Itäinen hevos-enkefaliittivirus (EEE);
5. Ebola-virus;
6. Hantaan-virus;
7. Junin-virus;
8. Lassa-kuumevirus;
9. Lymfosytäärinen korionmeningiittivirus;
10. Machupo-virus;
11. Marburg-virus;
12. Apinarokkovirus;
13. Rift Valley-kuumevirus;
14. Puutiais-enkefaliittivirus;
15. Isorokkovirus (kaikki alatyypit);
16. Venezuelan hevos-enkefaliittivirus (VEE);
17. Läntinen hevos-enkefaliittivirus (WEE);
18. White pox-virus;
19. Keltakuumevirus;
20. Japanin enkefaliittivirus;
21. Kyasanur Forest -virus;
22. Louping ill -virus;
23. Murray Valley -enkefaliittivirus;
24. Omsk-verenvuotokuumevirus;
25. Oropouche-virus;
26. Powassan-virus;
27. Rocio-virus;
28. St. Louis -enkefaliittivirus;
29. Hendra-virus (Equine morbillivirus);
30. Etelä-Amerikan verenvuotokuume (Sabia, Flexal, Guanarito);
31. Keuhko- ja munuaisoireita aiheuttavat verenvuotokuumevirukset (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);
32. Nipah-virus.

1C351

(jatkuu)

- b. Seuraavat riketsiat, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on tarkoituksellisesti istutettu tai joka on saastutettu sellaisilla viljelmillä:
1. Coxiella burnetii;
 2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana; Rickettsia quintana);
 3. Rickettsia prowasecki;
 4. Rickettsia rickettsii.
- c. Seuraavat bakteerit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:
1. Bacillus anthracis;
 2. Brucella abortus;
 3. Brucella melitensis;
 4. Brucella suis;
 5. Chlamydia psittaci;
 6. Clostridium botulinum;
 7. Francisella tularensis;
 8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
 9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
 10. Salmonella typhi;
 11. Shigella dysenteriae;
 12. Vibrio cholerae;
 13. Yersinia pestis;
 14. Clostridium perfringens epsilon -myrkkyä muodostavat tyypit;
 15. Enterohemorraginen Escherichia coli; serotyyppi O157, ja muut verotoksiinia muodostavat serotyyppit.
- d. Seuraavat "toksiinit" ja niiden "toksiinialayksiköt":
1. Botulinus-toksiini;
 2. Clostridium perfringens -toksiini;
 3. Conotoksiini;
 4. Risiini;
 5. Saxitoksiini;
 6. Shigatoksiini;
 7. Staphylococcus aureus -toksiini;
 8. Tetrodotoksiini;
 9. Verotoksiini;
 10. Mikrosystiini (Cyanginosiini);
 11. Aflatoksiini;
 12. Abriini;
 13. Koleratoksiini;
 14. Dasetoksiskirpenolitoksiini;
 15. T-2-toksiini;

1C351 d. (jatkuu)

16. HT-2-toksiini;
17. Modeksiini;
18. Volkensiini;
19. Viscum album Lectin 1 (Viskumiini).

Huom.: 1C351.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmisteen muodossa olevia botulinus-toksiineja tai conotoksiineja, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne ovat ihmisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkevalmisteita;
2. Ne on pakattu lääkevalmisteina jakelua varten;
3. Valtion viranomainen on antanut luvan niiden markkinointiin lääkevalmisteina.

Huom.: 1C351 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "rokotteita" tai "immunotoksiineja".

1C352 Seuraavat eläinpatogeenit:

- a. Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:

1. Afrikkalainen sikaruttovirus;
2. Lintuinfluenssavirukset, jotka ovat:
 - a. Lajittelemattomia; tai
 - b. Seuraavat EY:n direktiivissä 92/40/ETY (EYVL N:o L 167, 22.6.1992, s. 1) erittäin patogeenisina määritellyt:
 1. A-tyypin virukset, joiden IVPI (intravenous pathogenicity index, patogeenisyysindeksi suonsisäisesti annettuna) on 6 viikkoa vanhoissa kanoissa suurempi kuin 1,2; tai
 2. A-tyypin viruksien alatyypit H5 tai H7, joissa on nucleiidisekvenssoinnin avulla osoitettu olevan useita emäksisiä aminohappoja hemagglutiinin katkaisupaikassa;
3. Bluetongue-virus;
4. Suu- ja sorkkatautivirus;
5. Vuohirokkovirus;
6. Valeraivotautivirus (Aujeszkin tauti);
7. Sikaruttovirus;
8. Lyssavirus (rabiesryhmän virukset);
9. Newcastlen tautivirus;
10. Pikkumärehtijärutto-virus (peste des petits ruminants);
11. Sian enterovirus tyyppi 9 (swine vesicular -tautivirus);
12. Nautaruttovirus;
13. Lammasrokkovirus;
14. Teschenin tautivirus;
15. Suutulehdusvirus (VS-virus);
16. Lumpy skin -tauti-virus;
17. Afrikkalainen hevosrutto -virus.

- b. Mycoplasma-mycoidit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä.

Huom.: 1C352 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "rokotteita".

- 1C353 Seuraavat geneettinen materiaali ja geneettisesti muunnetut organismit:
- Geneettisesti muunnetut organismit tai 1C351.a–c, 1C352 tai 1C354 kohdassa määriteltyjen organismien patogeenisuuteen liittyviä nukleiinihapposekvenssejä sisältävä geneettinen materiaali;
 - Geneettisesti muunnetut organismit tai 1C351.d kohdassa määriteltyjä "toksiineja" tai niiden "toksiinialayksiköitä" koodaavia nukleiinihapposekvenssejä sisältävä geneettinen materiaali.

Tekn. huom.:

Geneettinen materiaali sisältää muun muassa joko muunnettua tai muuntamattomia kromosomeja, genomeja, plasmideja, transposoneja ja vektoreja.

Huom.: 1C353 kohtaa ei sovelleta sellaisiin nukleiinihapposekvensseihin, jotka liittyvät enterohemorragisen *Escherichia coli* serotyypin O157:n ja muiden verotoksiinia muodostavien kantojen patogeenisyyteen, lukuun ottamatta niitä, jotka koodaavat verotoksiinia tai sen alayksiköitä.

- 1C354 Seuraavat kasvipatogeenit:
- Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, mukaan lukien elävä materiaali, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:
 - Andien perunan latentti tymovirus;
 - Perunan sukkulamukulauti.
 - Seuraavat bakteerit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:
 - Xanthomonas albilineans*;
 - Xanthomonas campestris* pv. citri, jotka sisältävät *Xanthomonas campestris* pv. citrin tyypeiksi A, B, C, D, E kutsuttuja lajikkeita tai jotka muuten luokitellaan *Xanthomonas citric*si, *Xanthomonas campestris* pv. aurantifoliaksi tai *Xanthomonas campestris* pv. citrumeloksi;
 - Xanthomonas oryzae* pv. *Oryzae* (*Pseudomonas campestris* pv. *Oryzae*);
 - Clavibacter michiganensis* subsp. *Sepedonicus* (*Corynebacterium michiganensis* subsp. *Sepedonicum* tai *Corynebacterium Sepedonicum*);
 - Ralstonia solanacearum* rodut 2 ja 3 (*Pseudomonas solanacearum* rodut 2 ja 3 tai *Burkholderia solanacearum* rodut 2 ja 3).
 - Seuraavat sienet, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:
 - Colletotrichum coffeanum* var. *virulans* (*Colletotrichum kahawae*);
 - Cochliobolus miyabeanus* (*Helminthosporium oryzae*);
 - Microcyclus ulei* (syn. *Dothidella ulei*);
 - Puccinia graminis* (syn. *Puccinia graminis* f.sp.tritici);
 - Puccinia striiformis* (syn. *Puccinia glumarum*);
 - Magnaporthe grisea* (*Pyricularia grisea* / *Pyricularia oryzae*).

- 1C450 Seuraavat toksiset kemikaalit ja toksisten kemikaalien lähtöaineet sekä yhtä tai useampaa niistä sisältävät "kemialliset seokset":

Huom. KATSO MYÖS 1C350, 1C351.d. JA ASETARVIKELUETTELO

- toksiset kemikaalit seuraavasti:
 - amiton: O,O-dietyyli-S-2-N,N-dietyyliaminoetyyli-fosforotiolaatti (78-53-5) ja vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat,
 - PfIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometyyli)-1-propeeni (382-21-8),
 - KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA**
BZ: 3-kinuklidinylibentsilaatti (6581-06-2),
 - fosgeeni: karbonylidikloridi (75-44-5),

1C450

a. (jatkuu)

5. kloorisyanidi (506-77-4),
6. vetysyanidi (74-90-8),
7. klooripikriini: trikloorinitrometaani (76-06-2),

Huom. 1: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.a.1 ja 1C450.a.2 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 1 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 2: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuuluviin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.a.1 ja 1C450.a.2 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 3: 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.a.4, 1C450.a.5, 1C450.a.6 ja 1C450.a.7 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

b. toksisten kemikaalien valmistusaineet seuraavasti:

1. muut kuin asetarvikeluettelossa tai kohdassa 1C350 luetellut kemikaalit, jotka sisältävät fosforiatomin, johon on sitoutunut yksi metyyli-, etyyli-n-propyyli- tai isopropyyli-ryhmä, mutta ei muita hiiliatomeja,

Huom.: 1C450.b.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavaa: Fonofos: O-etyyli-S-fenyylityyliyfosfonotioli-tionaatti (944-22-9),

2. N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-] fosforamidodihalidit,
3. dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-fosforoamidaatit, muut kuin dietyyli-N,N-dimetyyli- fosforoamidaatti, joka luetellaan kohdassa 1C350,
4. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetyylikloridit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi tai N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi hydrokloridi, jotka luetellaan kohdassa 1C350,
5. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetanolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetanolit (96-80-0) ja N,N-dietyyliaminoetanolit (100-37-8), jotka luetellaan kohdassa 1C350,

Huom.: 1C450.b.5 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:

- a. 2-N,N-dimetyyliaminoetanolit (108-01-0) ja vastaavat protonoidut suolat,
- b. 2-N,N-dietyyliaminoetanolit (100-37-8) ja vastaavat protonoidut suolat,
6. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetaanitoliolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetaanitolioli, joka luetellaan kohdassa 1C350,
7. etyyliidietanoliamiini (139-87-7),
8. metyyliidietanoliamiini (105-59-9).

Huom. 1: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 ja 1C450.b.6 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 10 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 2: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuuluviin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 ja 1C450.b.6 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 3: 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.b.7 ja 1C450.b.8 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom.: 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuluttajayödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

1D	Ohjelmistot
1D001	"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 1B001–1B003 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.
1D002	"Ohjelmistot" sellaisten laminaattien tai "komposiittien" "kehittämistä" varten, joilla on orgaaninen "matriisi", metalli "matriisi" tai hiili "matriisi".
1D101	"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 tai 1B119 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.
1D103	"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu analysoimaan pienennettyä havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta, ultraviolett-, infrapuna- tai akustista havaittavuutta.
1D201	"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 1B201 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

1E Teknologia

1E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A001.b, 1A001.c, 1A002–1A005, 1B tai 1C kohdassa määriteltyjen tuotteiden tai materiaalien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

1E002 Muu teknologia:

- a. "Teknologia" polybentsotiatsolien tai polybentsoksatsolien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten;
- b. "Teknologia" vähintään yhden vinyylieetterimonomeerin sisältävien fluoro-elastomeeriyhdisteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten;
- c. "Teknologia" seuraavien perusmateriaalien tai ei- "komposiittisten" keraamisten materiaalien suunnittelua tai "tuotantoa" varten:

1. Perusmateriaalit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Jokin seuraavista koostumuksista:

1. Yksinkertaiset tai kompleksiset zirkoniumoksidit ja kompleksiset pii- tai alumiinioksidit;
2. Yksinkertaiset boorinitridit (kuutiomaiset kidemuodot);
3. Yksinkertaiset tai kompleksiset pii- tai boorikarbidit; tai
4. Yksinkertaiset tai kompleksiset piinitridit;

b. Metallisten epäpuhtauksien kokonaismäärä, haluttuja lisäaineita lukuun ottamatta, on vähemmän kuin:

1. 1 000 ppm yksinkertaisissa oksideissa tai karbideissa; tai
2. 5,000 ppm kompleksisissa yhdisteissä tai yksinkertaisissa nitrideissä; ja

c. Jotka ovat jokin seuraavista:

1. Zirkoniumoksidi, jonka keskimääräinen hiukkaskoko on enintään 1 µm ja jonka hiukkasista enintään 10 prosenttia on suurempia kuin 5 µm;
2. Muu perusmateriaali, jonka keskimääräinen hiukkaskoko on 5 µm tai vähemmän ja korkeintaan 10 % hiukkasista on kooltaan suurempia kuin 10 µm; tai

3. Joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. Hiutaleiden pituuden ja paksuuden suhde ylittää 5;
- b. Erilliskidekuitujen pituuden ja läpimitan suhde ylittää 10 alle 2 µm:n läpimitoilla; ja
- c. Jatkuvat tai katkotut kuidut ovat läpimitaltaan alle 10 µm;

2. Keraamiset ei- "komposiitti" materiaalit, jotka koostuvat 1E002.c.1 kohdassa kuvatuista materiaaleista;

Huom.: 1E002.C.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "teknologiaa" hioma-aineiden kehitystä ja tuotantoa varten.

- d. "Teknologia" aromaattisten polyamidikuitujen "tuotantoa" varten;
- e. "Teknologia" 1C001 kohdassa määriteltyjen materiaalien asennointia, ylläpitoa tai korjausta varten;
- f. "Teknologia" 1A002, 1C007.c tai 1C007.d kohdassa määriteltyjen "komposiitti" rakenteiden, -laminattien tai -materiaalien korjausta varten.

Huom.: 1E002.f kohta ei aseta valvonnanalaiseksi siviililentokoneiden rakenteiden korjaamiseen tarvittavaa "teknologiaa", jossa käytetään hiili "kuitu- tai -säiemateriaaleja" ja hartseja, jotka sisältyvät lentokonevalmistajan käsikirjoihin.

1E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115–1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111–1C117, 1D101 tai 1D103 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

1E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D001, 1D101 tai 1D103 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.

- 1E103 "Teknologia", jonka avulla säädetään lämpötilaa, painetta tai kaasukoostumusta auto- tai hydroklaaveissa silloin kun niitä käytetään "komposiittien" tai osittain käsiteltyjen "komposiittien" valmistukseen".
- 1E104 "Teknologia", jonka avulla tuotetaan pyrolyysimenetelmällä muodostuvia aineita muotille, telineelle tai muulle substraatille välituotekaasuista, jotka hajoavat lämpötilan ollessa 1 573 K (1 300 °C)–3 173 K (2 900 °C) astetta ja paineen 130 Pa–20 kPa.
- Huom.: 1E104 kohta sisältää "teknologian" väliaine kaasujen seostamiseksi, virtausnopeudet ja prosessiohjauksen ajoitukset sekä parametrit.*
- 1E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A002, 1A202, 1A225–1A227, 1B201, 1B225–1B233, 1C002.a.2.c tai d, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225–1C240 tai 1D201 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.
- 1E202 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A202 tai 1A225–1A227 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.
- 1E203 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D201 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.

RYHMÄ 2
MATERIAALIN KÄSITTELY

2A Järjestelmät, laitteet ja komponentit

Huom.: Hiljaiset laakerit: katso asetarvikeluettelo.

2A001 Seuraavat kitkaa vähentävät laakerit ja laakerointijärjestelmät ja niiden komponentit:

Huom.: 2A001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuulia, joille valmistajan määrittelemä toleranssi on ISO 3290:n mukaisesti luokkaa 5 tai huonompi.

- a. Kuulalaakerit tai massiivirullalaakerit, joiden kaikki valmistajan määrittelemät toleranssit ovat ISO 492:n toleranssiluokan 4 (tai ANSI/ABMA Std 20:n toleranssiluokka ABEC-7:n tai RBEC-7:n tai muiden vastaavien kansallisten standardien) mukaiset tai niitä paremmat, ja joiden renkaat ja pyörivät osat (ISO 5593) on valmistettu monelmetallista tai berylliumista;

Huom.: 2A001.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartiorullalaakereita.

- b. Muut kuulalaakerit tai massiivirullalaakerit, joiden kaikki valmistajan määrittelemät toleranssit ovat ISO 492:n toleranssiluokan 2 (tai ANSI/ABMA Std 20:n toleranssiluokka ABEC-9:n tai RBEC-9:n tai muiden vastaavien kansallisten standardien) mukaiset tai niitä paremmat.

Huom.: 2A001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartiorullalaakereita.

- c. Aktiiviset magneettilaakerijärjestelmät, jotka käyttävät jotain seuraavista:

1. Materiaaleja, joiden vuontiheys on 2,0 T tai enemmän ja myötöraja suurempi kuin 414 MPa;
2. Täyssähkömagneettisia 3D yksinapaisia esimagnetointikonstruktioita toimimootoreita varten; tai
3. Korkeita lämpötiloja (430 K (177 °C) tai enemmän) kestäviä asentoantureita.

2A225 Nestemäisiä aktinidimetalleja kestävästä aineista tehdyt upokkaat seuraavasti:

- a. Upokkaat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1. vetoisuus 150 cm^3 – $8\,000 \text{ cm}^3$; ja
2. valmistusaineena tai vuorauksena jokin seuraavista aineista (pitoisuus 98 painoprosenttia tai suurempi):
 - a. Kalsiumfluoridi (CaF_2);
 - b. Kalsiumsirkonaatti (metasirkonaatti) (CaZrO_3);
 - c. Keriumsulfiidi (Ce_2S_3);
 - d. Erbiumoksidi (erbia) (Er_2O_3);
 - e. Hafniumoksidi (hafnia) (HfO_2);
 - f. Magnesiumoksidi (MgO);
 - g. Typetty niobi-titaani-volframiseos (noin 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
 - h. Yttriumoksidi (yttria) (Y_2O_3);
 - i. Zirkoniumoksidi (zirkonia) (ZrO_2);

- b. Upokkaat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1. vetoisuus on 50 cm^3 – $2\,000 \text{ cm}^3$; ja
2. valmistus- tai vuorausaineena on tantaali (pitoisuus 99,9 painoprosenttia tai suurempi);

- c. Upokkaat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. vetoisuus on 50 cm^3 – $2\,000 \text{ cm}^3$;
2. valmistus- tai vuorausaineena tantaali, jonka pitoisuus on 98 painoprosenttia tai suurempi; ja
3. pinnoitettu tantaalikarbidilla, -nitridillä tai -boridilla tai jollakin näiden yhdisteellä.

2A226 Venttiilit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. 'nimelliskoko' 5 mm tai suurempi;
- b. paljettiiviste; ja
- c. kokonaisuudessaan valmistettu tai vuorattu alumiinilla, alumiiniseoksella, nikkelillä tai nikkeliseoksella, jonka painosta on enemmän kuin 60 % nikkeliä.

Tekninen Huom.:

Niiden venttiilien osalta, joiden sisäänmenon ja ulostulon halkaisijat ovat erilaiset, kohdassa 2A226 'nimelliskoolla' tarkoitetaan pienintä halkaisijaa.

2B

Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

Tekn. huom.:

1. Ääriviiva-akselien kokonaismäärään ei lasketa yhdensuuntaisia ääriviivasivuakseleita, (esim. vaakakaraisen avaruskoneen w-akselia, tai pyörivää sivuakselia, jonka keskilinja on samansuuntainen pyörivän pääakselin kanssa). Pyörivien akselien ei tarvitse pyörähtää yli 360 astetta. Pyörivää akselia voi käyttää lineaarinen laite (esim. ruuvi tai hammastanko).
2. 2B kohdassa niiden akselien määrä, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriviivaohjauksessa", on niiden akselien määrä, jotka vaikuttavat minkä tahansa työkappaleen ja työkalun, leikkuupään tai hiomalaikan, joilla leikataan tai työstetään materiaalia työkappaleesta, väliseen suhteelliseen liikkeeseen. Tähän eivät sisälly muut akselit, jotka vaikuttavat muuhun suhteelliseen liikkeeseen koneen sisällä.

Tällaisia aksleita ovat:

- a. Hiomakoneiden laikan pyöristinjärjestelmät;
 - b. Yhdensuuntaiset pyörivät akselit, jotka on suunniteltu erillisten työkappaleiden asentamiseen;
 - c. Kollineaariset pyörivät akselit, jotka on suunniteltu saman työkappaleen käsitteilyyn pitelemällä sitä puristuksessa eri puolilta.
3. Akselien nimeämisen tulee olla ISO 841 standardin (International Standard, Numerical Control Machines – Axis and Motion Nomenclature) mukainen.
 4. 2B001–2B009 kohdassa "kieppikara" katsotaan pyöriväksi akseliksi.
 5. Taattuja paikannustarkkuustasoja, jotka poikkeavat ISO 230/2:n (1988)⁽¹⁾ tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti tehdyistä mittauksista, voidaan käyttää työstökoneille erillisten konetiestien sijasta. Taatulla paikannustarkkuudella tarkoitetaan sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille toimitettua tarkkuusarvoa, johon viejä on sijoittautunut konemallin tarkkuuden edustajana.

Taattujen arvojen määrittäminen

- a. valitse viisi arvioitavan mallin konetta;
- b. Mittaa ISO 230/2:n (1998)⁽¹⁾ mukaisesti lineaarisen akselin tarkkuudet;
- c. Määrittele jokaisen koneen jokaisen akselin A-arvo. A-arvon laskemismenetelmä on kuvattu ISO-standardissa;
- d. Määrittele jokaisen akselin A-arvon keskiarvo. Tästä keskiarvosta $\hat{A}$ tulee mallin kunkin akselin mainittu arvo ($\hat{A}_x \hat{A}_y \dots$);
- e. Koska 2 ryhmää koskevassa luettelossa viitataan jokaiseen lineaariseen akseliin, mainittuja arvoja on oltava yhtä monta kuin lineaarisia aksleita;
- f. Jos sellaisen työstökonemallin, jota ei ole asetettu valvonnallaiseksi 2B001.a–2B001.c tai 2B201 kohdissa, jollekin akselille on määritelty hiomakoneita koskeva 6 mikronin ja jysintäkoneita ja sorveja koskeva 8 mikronin tarkkuus $\hat{A}$ tai tätä parempi tarkkuus, valmistajan olisi vahvistettava tarkkuustaso kerran kahdeksassatoista kuukaudessa.

2B001

Seuraavat työstökoneet ja niiden yhdistelmät, jotka on tarkoitettu työstämään (tai leikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai "komposiitteja" ja jotka valmistajan teknisten eritelmien mukaan voidaan varustaa "numeerisella ohjauksella", ja erityisesti suunnitellut komponentit;

Huom.: KATSO MYÖS 2B201 KOHTA.

Huom. 1: 2B001 kohta ei aseta valvonnan alaiseksi erikoistyöstökoneita, joiden käyttö on rajattu hammaspyörien valmistukseen. Tällaisten koneiden osalta katso 2B003.

Huom. 2: 2B001 kohta ei aseta valvonnan alaiseksi erikoistyöstökoneita, joiden käyttö on rajattu joidenkin seuraavien osien valmistukseen:

- a. Kampiakselit tai nokka-akselit;
- b. Työkalut tai leikkuuterät;
- c. Puristimen syöttöruuvi;
- d. Kaiverretut tai viisteiseksi hiotut korujen osat.

Huom. 3: Työstökone, jolla on ainakin kaksi kaikkiaan kolmesta sorvaamista, jysintää ja hiontaa koskevasta ominaisuudesta (esim. sorvaamiskone, jossa on jysintäominaisuus), on arvioitava kunkin sovellettavan kohdan 2B001a, b tai c osalta.

⁽¹⁾ Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.

2B001 (jatkuu)

a. Työstökoneet sorvaamista varten, joilla on seuraavat ominaisuudet:

1. Paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointineen" on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 6 mikrometriä ISO 230/2:n (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; ja
2. Kaksi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivahjauksessa";

Huom.: 2B001.a kohta ei aseta valvonnallaiseksi kontaktilinssien valmistusta varten suunniteltuja sorveja.

b. Työstökoneet jysintää varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Joilla on kaikki seuraavista:
 - a. Paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointineen" on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 6 mikrometriä ISO 230/2:n (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; ja
 - b. Kolme lineaarista ja yksi pyörivä akseli, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivahjauksessa";
2. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivahjauksessa"; tai
3. Tarkkuusporakoneiden paikannustarkkuus, "kaikkine käytettävissä olevine kompensointineen" on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 4 mikrometriä ISO 230/2:n (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa akselin suuntaan;
4. Nokkateräkoneet, joilla on seuraavat ominaisuudet:
 - a. Karan "poikkeaman" ja "aksiaalisirtymän" kokonaislukema on vähemmän (parempi) kuin 0,0004 mm TIR; ja
 - b. Luistin liikkeen kulmapoikkeaman (kiertymä pysty-, poikittais- ja pituusakselin ympäri) kokonaislukema on 30 mm:n matkalla vähemmän (parempi) kuin 2 kaarisekuntia TIR.

c. Työstökoneet hiontaa varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Joilla on kaikki seuraavista:
 - a. Paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointineen" on saman suuruinen, tai vähemmän (parempi) kuin 4 mikrometriä ISO 230/2:n (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; ja
 - b. Kolme lineaarista ja yksi pyörivä akseli, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivahjauksessa"; tai
2. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivahjauksessa";

Huom.: 2B001.c kohta ei aseta valvonnallaiseksi seuraavia hiomakoneita:

1. Ulkopuolisia, sisäpuolisia tai ulko-sisäpuolisia pyöröhiomakoneita, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - a. Kone on rajoitettu vain pyöröhiontaan; ja
 - b. Hiomakoneen työkappaleen maksimikoko on ulkohalkaisijaltaan tai pituudeltaan 150 mm.
 2. Koneita, jotka on erityisesti suunniteltu mallinehiomakoneeksi, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 - a. C-akselia käytetään pitämään hiomalaikkaa kohtisuorassa työpintaan nähden; tai
 - b. A-akseli on konfiguroitu hiomaan nokkarumpuja;
 3. Pintahiomakoneet.
- d. Langattomat kipinätyöstökoneet (EDM), joilla on kaksi tai useampia pyöriviä akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivahjauksessa";

(1) Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.

2B001 (jatkuu)

e. Metallin, keraamisten aineiden tai "komposiittien" koneistukseen tarkoitetut koneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne käyttävät materiaalin työstämiseen jotakin seuraavista:

a. Vesi- tai muuta nestesuihkua, mukaan lukien ne, jotka käyttävät hiomalisäaineita;

b. Elektronisuihkua; tai

c. "Laser" sädetä; ja

2. Niissä on kaksi tai useampia pyöriäviä akseleita:

a. Joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivahjauksessa"; ja

b. Joiden paikannustarkkuus on vähemmän (parempi) kuin 0,003 astetta.

f. Syväreikäporauskoneet ja sorvit, jotka on muunnettu sopiviksi syväreikäporaukseen, joilla maksimi porausvyvyys ylittää 5 000 mm, sekä niitä varten erityisesti kehitetyt komponentit.

2B002 Numeerisesti ohjatut työstökoneet, joissa käytetään magnetoreologista viimeistelyprosessia [W] (MRF).

Tekn. huom.:

2B002 kohdassa tarkoitetaan "MRF-prosessilla" materiaalin poistoprosessia, jossa käytetään hiovaa magneettista nestettä, jonka viskositeetti muuttuu magneettikentässä.

2B003 "Numeerisesti ohjatut" tai käsiohjatut työstökoneet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, ohjaukset ja lisälaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu höyläämään, viimeistelemään, hiomaan tai hoonaamaan karkaistuja ($R_c = 40$ tai yli) lieriöhammaspyöriä, ruuvipyöriä tai kaksoisruuvipyöriä, joiden jakohalkaisija on enemmän kuin 1 250 mm ja hampaan leveys on 15 % jakohalkaisijasta tai enemmän, ja jotka on koneistettu AGMA 14:n laatuiseksi tai paremmiksi (vastaa ISO 1328:n 3 luokkaa).

2B004 Seuraavat kuuma "isostaattiset puristimet", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja lisälaitteet:

Huom.: KATSO MYÖS 2B104 ja 2B204 KOHTA.

a. Suljetussa tilassaan säädettävä lämpötila, ja kammion tilan sisäläpimitta on 406 mm tai enemmän; ja

b. Jokin seuraavista:

1. Maksimityöpaine ylittää 207 MPa;

2. Säädettävä lämpötila ylittää 1 773 K (1 500 °C); astetta tai

3. Joissa on edellytykset hiilivetykyllästyksen ja syntyvien kaasumaisten hajoamistuotteiden poistoon.

Tekn. huom.:

Kammion sisäläpimitta tarkoittaa sen tilan kokoa, jossa sekä työlämpötila että työpaine saavutetaan, eikä siihen sisällytetä kiinnittimiä. Tämä mitta on joko painekammion sisähalkaisija tai eristetyn kuumakammion sisähalkaisija ja on se, joka on pienempi, riippuen siitä kumpi kammioista on toisen sisällä.

Huom.: Erityisesti suunnitellut suolakkeet, muotit ja laitteet: katso kohdat 1B003, 9B009 ja asetarvikeluettelo.

2B005 Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet pinnoitusta, prosessointia ja pinnoitteen laadun prosessin aikaista ohjausta varten, joilla aikaansaadaan epäorgaanisia pinnoitteita tai pintamodifikaatioita johtamattomille substraateille käyttäen menetelmiä, jotka on kuvattu 2E003.f kohdan jäljessä olevassa taulukossa ja siihen liittyvissä huomautuksissa, sekä näitä laitteita varten erityisesti suunnitellut automaattiset kuljetus-, sijoitus-, käsittely- ja ohjauskomponentit:

a. "Ohjelmallisesti ohjatut" tuotantolaitteet kemiallista kaasufaasipinnoitusta varten (CVD), joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: KATSO MYÖS 2B105 KOHTA.

1. Jokin seuraavista prosessin muunnoksista:

a. Syke-CVD (pulsating CVD);

b. Säädeltävä ydintymis-lämpöhajoaminen (CNTD); tai

c. Plasma-CVD; ja

2B005

a. (jatkuu)

2. Jokin seuraavista:

a. Sisältävät pyörivät tyhjiötiivisteet (0,01 pa tai vähemmän); tai

b. Sisältävät prosessin aikaisen kerrospaksuuden säädön;

b. "Ohjelmallisesti ohjatut" ioni-istutustuotantolaitteet, joiden ionisuihkun virta on 5 mA tai enemmän;

c. "Ohjelmallisesti ohjatut" tuotantolaitteet elektronisuihkun avulla tapahtuvaa fysikaalista kaasufaasipinnoitusta varten (EB-PVD), joihin sisältyvien tehojärjestelmien nimellisteho ylittää 80 kW ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Nestelähteen pinnan "laser" säätöjärjestelmä, joka tarkasti ohjaa tankojen syöttönopeutta; tai

2. Tietokoneohjattu nopeuden seuranta, jolla ohjataan kahta tai useampaa elementtiä sisältävän pinnoitteen kasvunopeutta ja joka perustuu höyryvirrassa olevien ionisoitujen atomien fotoluminesenssiin;

d. "Ohjelmallisesti ohjatut" plasmaruiskutustuotantolaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Toimivat säädettävässä alennetussa paineessa (10 kPa tai vähemmän, mitattuna 300 mm:n sisältä suuttimen ulostulon yläpuolelta) tyhjäkammiassa, joka ennen suihkutusprosessia voidaan tyhjentää 0,01 Pa:iin asti; tai

2. Sisältävät prosessin aikaisen kerrospaksuuden säädön;

e. "Ohjelmallisesti ohjatut" sputterointituotantolaitteet, joiden virtatiheys voi olla 0,1 mA/mm² tai suurempi, kun pinnoitusnopeus on 15 µm tunnissa tai suurempi;

f. "Ohjelmallisesti" ohjatut katodikaaripinnoitustuotantolaitteet, jotka sisältävät sähkömagneeteista koostuvan hilan kaaren pisteen ohjaamiseksi katodilla;

g. "Ohjelmallisesti ohjatut" ionipinnoitustuotantolaitteet, jotka mahdollistavat jonkin seuraavan prosessin aikaisen mittauksen:

1. Kerrospaksuuden mittauksen substraatin päältä ja pinnoitusnopeuden säädön; tai

2. Optisten ominaisuuksien mittauksen.

Huom.: 2B005 kohta ei aseta valvonnallaiseksi leikkaus- tai työstötyökaluja varten erityisesti suunniteltuja kaasufaasipinnoitus-, katodikaari-, sputterointipinnoitus-, ionipäällystys- tai ioni-istutuslaitteita.

2B006

Seuraavat dimensioiden tarkastus- ja mittausjärjestelmät tai -laitteet:

a. Tietokoneohjatut, "numeerisesti ohjatut" tai "ohjelmallisesti ohjatut" koordinaattimittauskoneet (KMK), joiden kolmen dimension (tilavuuden) osoituksen suurin sallittu virhe (MPE_E) koneen toiminta-alueen missä tahansa kohdassa (akselien pituuden puitteissa) on (1,7 + L/1 000) µm tai pienempi (parempi) (L on mitattu pituus millimetreinä) standardin ISO 10360-2 (2001) mukaisesti testattuna;**Huom.**: KATSO MYÖS 2B206 KOHTA.

b. Seuraavat lineaarisen ja kulmasiirtymän mittausinstrumentit:

1. Lineaarisen siirtymän mittausinstrumentit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Tekn. huom.:

2B006.b.1 kohdassa "lineaarisella siirtymällä" tarkoitetaan mittapään ja mitattavan kohteen välisen etäisyyden muutosta.

a. Kosketuksettomat mittausjärjestelmät, joiden "resoluutio" on 0,2 µm tai vähemmän (parempi) 0,2 mm:n mittausalueella;

b. Lineaariset differentiaalimuuntajajärjestelmät, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1. "Lineaarisuus" on 0,1 % tai vähemmän (parempi) mittausalueella, joka on 5 mm tai pienempi; ja2. Ryömintä on 0,1 % tai vähemmän (parempi) päivässä testahuoneen vakioilämpötilassa ± 1 K astetta; tai

2B006

b. 1. (jatkuu)

c. Mittausjärjestelmät, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Sisältävät "laserin"; ja
2. Säilyttävät vähintään 12 tuntia normaalilämpötilan ± 1 K asteen vaihtelualueella ja normaali-paineessa seuraavat ominaisuudet:
 - a. "Resoluution" 0,1 mikrometriä tai vähemmän (parempi) koko mittausalueella; ja
 - b. "Mittauksen epävarmuuden" $(0,2 + L/2\ 000)$ mikrometriä tai vähemmän (parempi) (L on mitattu pituus millimetreinä);

Huom.: 2B006.b.1 kohta ei aseta valvonnallaiseksi interferometrimittausjärjestelmiä, joilla ei ole suljetun tai avoimen piirin takaisinkytkentää, ja jotka sisältävät "laserin" työstökoneen, mittatarkastuskoneen tai vastaavien laitteiden luistin liikkeen virheitä.

2. Kulmasiirtymän mittausinstrumentit, joiden "kiertymiskulman poikkeama" on 0,00025 astetta tai vähemmän (parempi);

Huom.: 2B006.b.2 kohta ei aseta valvonnallaiseksi optisia instrumentteja, kuten autokollimaattoreita, jotka käyttävät kollimoitua valoa (esimerkiksi laservaloa) peilin kulmasiirtymän ilmaisemiseen.

- c. Laitteet, joilla mitataan pinnan epätasaisuutta mittaamalla optista sirontaa kulman funktiona ja joiden herkkyys on 0,5 nm tai vähemmän (parempi).

Huom.: Työstökoneet, joita voidaan käyttää mittausesemina ovat valvonnallaisia, jos niiden ominaisuudet täyttävät tai ylittävät työstökoneille tai mittausasemille määritellyt kriteerit.

2B007

"Robotit" ja niitä varten erityisesti suunnitellut ohjausyksiköt ja "päätevälineet":

Huom.: KATSO MYÖS 2B207 KOHTA.

- a. Kykenevät tosiaikaisesti täyteen kolmiulotteiseen kuvan käsittelyyn tai täyteen kolmiulotteiseen 'näkökentän analysointiin' tuottaakseen tai muuntaakseen "ohjelmia" tai numeerista ohjelmatietoa;

Tekninen Huom.:

'Näkökentän analysointiin' liittyvä rajoitus ei sisällä kolmannen ulottuvuuden approksimointia annetusta kulmasta eikä rajoitettua harmaasävyjen tulkinnan avulla tapahtuvaa syvyyden tai pintarakenteen havaitsemista ($2\ 1/2\ D$) hyväksytyjen tehtävien suorittamiseksi.

- b. On erityisesti suunniteltu vastaamaan kansallisia turvallisuusstandardeja, joita sovelletaan räjähtävien sotatarvikkeiden ympäristössä;
- c. On erityisesti suunniteltu tai mitoitettu kestämaan säteilyä jonka kokonaissäteily määrä on enemmän kuin 5×10^3 Gy (Pii) ilman, että toimivuus huononee.

Tekn. huom.:

Termillä Gy (Pii) tarkoitetaan kilojouleina ilmaistuna energiamäärää, jonka suojaamaton piinäyte imee itseensä, kun se altistetaan ionisoivalle säteilylle.

- d. On erityisesti suunniteltu toimimaan yli 30 000 m:n korkeuksissa.

2B008

Seuraavat erityisesti työstökoneita tai mittojen tarkastus- tai mittausjärjestelmiä tai -laitteita varten suunnitellut kokoonpanot tai yksiköt:

- a. Lineaariset aseman takaisinkytkentäyksiköt (esim. induktiiviset laitteet, kalibroidut asteikot, infrapuna-järjestelmät tai "laser" järjestelmät), joiden kokonaistarkkuus on vähemmän (parempi) kuin $(800 + (600 \times L \times 10^{-3}))$ nm (L on tehollinen pituus millimetreinä);

Huom.: "Laser" järjestelmät: katso myös huomautusta 2B006.b.1 kohdassa.

- b. Pyörähdysaseman takaisinkytkentäyksiköt, esim. induktiiviset laitteet, kalibroidut asteikot, infrapunajärjestelmät tai "laser" järjestelmät, joiden "tarkkuus" on vähemmän (parempi) kuin 0,00025 astetta;

Huom.: "Laser" järjestelmät: katso myös huomautusta 2B006.b.1 kohdassa.

- c. "Yhdistelmäpyöröpöydät" ja "kieppikarat", joilla valmistajan spesifikaatioiden mukaan voidaan parantaa työstökoneiden laatua yli niiden tasojen, jotka on määritelty 2B kohdassa.

2B009

Dreijauessorvit ja painessorvit, jotka valmistajan teknisen eritelmän mukaan voidaan varustaa "numeerisella ohjauks" yksiköillä tai tietokoneohjauksella ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

2B009 (jatkuu)

Huom.: KATSO MYÖS 2B109 JA 2B209 KOHTA.

- a. Niissä on kaksi tai useampi ohjattava akseli, joista vähintään kahta voidaan samanaikaisesti koordinoida "ääriiviiohjauksessa"; ja
- b. Niiden valssausvoima on suurempi kuin 60 kN.

Tekn. huom.:

Koneet, joissa yhdistyvät dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot, katsotaan 2B009 kohdan tarkoituksessa painesorveiksi.

2B104 Muut kuin 2B004 kohdassa määritellyt "isostaattiset puristimet", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Huom.: KATSO MYÖS 2B204 KOHTA.

- a. Suurin toimintapaine on 69 MPa tai enemmän;
- b. Ne on suunniteltu saavuttamaan ja säilyttämään 873 K (600 °C) asteen kontrolloitu lämpötila tai tätä korkeampi lämpötila; ja
- c. kammion sisähalkaisija 254 mm tai suurempi.

2B105 Muut kuin 2B005.a kohdassa määritellyt CVD-uunit, jotka on suunniteltu tai muunneltu hiili-hiilikomposiittien tiivistämiseen.

2B109 Seuraavat, muut kuin 2B009 kohdassa määritellyt painesorvit ja erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYÖS 2B209 KOHTA.

- a. Painesorvit, joilla on seuraavat ominaisuudet:
 1. Ne voidaan valmistajan teknisen eritelmän mukaan voidaan varustaa "numeerisella ohjauksella" tai tietokoneohjauksella, silloinkin kun niitä ei ole varustettu sellaisilla yksiköillä; ja
 2. Niissä on useampi kuin kaksi akselia, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida "ääriiviiohjauksessa".
- b. 2B009 tai 2B109.a kohdassa määritettyjä painesorveja varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Huom.: 2B109 kohta ei aseta valvonnallaiseksi koneita, joita ei voida käyttää 9A005, 9A007.a tai 9A105.a kohdissa määriteltyjen työntövoimakomponenttien ja laitteiden (kuten moottorikoppien) tuottamiseen.

Tekn. huom.:

Koneet, joissa yhdistyvät dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot, katsotaan 2B109 kohdan tarkoituksessa painesorveiksi.

2B116 Seuraavat värähtelyjärjestelmät sekä laitteet ja komponentit niitä varten:

- a. Värähtelyjärjestelmät, joissa käytetään takaisinkytkentä- tai suljetun silmukan tekniikkaa, joissa on digitaalinen ohjain, jolla koejärjestelmää voidaan tärisyttää 10 g:n rms tai suuremmalla tehollisarvolla koko taajuusalueella 20–2 000 Hz ja tuottaa 50 kN:n tai sitä suurempia voimia 'paljaalla alustalla' mitattuna;
- b. Digitaaliset ohjaimet, joissa on erityisesti suunnitellut värähtelyohjelmistot, joiden "tosiaikainen kaistanleveys" on suurempi kuin 5 kHz ja jotka on suunniteltu 2B116.a kohdassa mainittujen värähtelyjärjestelmien käyttöä varten;
- c. Täristimet (täristinyksiköt), vahvistimien kanssa tai ilman, joilla voidaan tuottaa 50 kN:n tai suurempi värähtelyvoima 'paljaalla alustalla' mitattuna ja joita voidaan käyttää 2B116.a kohdassa mainituissa värähtelyjärjestelmissä;
- d. Koekappaleen kannatinrakenteet ja elektroniset yksiköt, jotka on suunniteltu yhdistämään useita erillisiä täristinyksiköitä järjestelmäksi, joka pystyy tuottamaan 50 kN:n tai suuremman yhdistetyn tehollisen voiman 'paljaalla alustalla' mitattuna ja joita voidaan käyttää 2B116.a kohdassa mainituissa värähtelyjärjestelmissä.

Tekn. huom.:

2B116 kohdassa 'paljaalla alustalla' tarkoitetaan tasaista pöytää tai pintaa ilman kiinnittimiä tai sovitteita.

2B117 Prosessiohjauksen- ja muut laitteet, paitsi 2B004, 2B005.a, 2B104 tai 2B105 kohdassa määritellyt, jotka on suunniteltu tai muunneltu rakettien suuttimien ja ilmakehään palaamaan tarkoitettujen alusten kärkikartioiden komposiittirakenteiden tiivistämällä tai pyrolysoimalla tapahtuvaa valmistusta varten.

2B119 Tasapainotuskoneet ja niihin liittyvät laitteet seuraavasti:

Huom.: KATSO MYÖS 2B219 KOHTA.

2B119 (jatkuu)

a. Tasapainotuskoneet, joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

1. Niillä ei voi tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja, joiden massa on suurempi kuin 3 kg;
2. Niillä on voitava tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja nopeuksilla, jotka ovat suurempia kuin 12 500 kierrosta minuutissa;
3. Niillä on voitava korjata epätasapaino kahdessa tai useammassa tasossa; ja
4. Niillä on voitava tasapainottaa siten, että jäännösepatasapaino on 0,2 g mm roottorin massan kutakin kiloa kohden;

Huom.: 2B119.a ei aseta valvonnallaiseksi hammashoitolaitteita tai muita lääkinnällisiä laitteita varten suunniteltuja tai muunnettuja tasapainotuskoneita.

b. 2B119.a kohdassa määriteltyjen koneiden kanssa käytettäväksi suunnitellut tai muunnetut ilmaispäät.

Tekn. huom.:

Ilmaispäät tunnetaan toisinaan nimellä tasapainotuslaitteisto.

2B120 Liikesimulaattorit tai pyörityspöydät, joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

a. Kaksi akselia tai enemmän;

b. Liukurenkaat, joilla voidaan välittää sähkötehoa ja/tai signaalitietoa; ja

c. Joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Yksittäisen akselin osalta kaikki seuraavista:
 - a. Kulmanopeus 400 astetta/s tai enemmän taikka 30 astetta/s tai vähemmän; ja
 - b. Kulmanopeuden erottelukyky 6 astetta/s tai vähemmän ja tarkkuus 0,6 astetta/s tai vähemmän;
2. Huonoin kulmanopeuden stabiilisuus sama tai parempi (vähemmän) kuin plus tai miinus 0,05 prosenttia keskiarvotettuna 10:lle tai useammalle asteelle; tai
3. Asemointitarkkuus 5 kaarisekuntia tai parempi.

Huom.: 2B120 kohta ei aseta valvonnallaiseksi työstökoneita tai lääkinnällisiä laitteita varten suunniteltuja tai muunnettuja pyöröpöytiä. Työstökoneiden pyöröpöytien valvonnan osalta katso 2B008 kohta.

2B121 Muut kuin 2B120 kohdassa määritellyt asemointipöydät (laitteet täsmälliseen pyöröasemointiin minkä tahansa akselin osalta), joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

a. Kaksi akselia tai enemmän; ja

b. Asemointitarkkuus 5 kaarisekuntia tai parempi.

Huom.: 2B121 kohta ei aseta valvonnallaiseksi työstökoneita tai lääkinnällisiä laitteita varten suunniteltuja tai muunnettuja pyöröpöytiä. Työstökoneiden pyöröpöytien valvonnan osalta katso 2B008 kohta.

2B122 Lingot, joilla voidaan saavuttaa yli 100 g:n kiihdytys ja joissa on liukurenkaat, joilla voidaan välittää sähkötehoa ja signaalitietoa.

2B201 Seuraavat, muut kuin 2B001 kohdassa määritellyt työstökoneet, jotka on tarkoitettu työstämään (tai leikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai "komposiitteja" ja jotka valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa elektronisilla laitteilla kahden tai useamman akselin samanaikaista "ääri-
viivahojausta" varten;

a. Työstökoneet jysintää varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointineen" on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 6 µm ISO 230/2:n (1988) ⁽¹⁾ tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; tai
2. Kaksi tai useampi akseli, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida ääri-
viivahojaus-
jauksessa;

Huom.: 2B201.a kohta ei aseta valvonnallaiseksi jysintäkoneita, joilla on seuraavat ominaisuudet:

- a. X-akselin liikkuma on suurempi kuin 2 m; ja
- b. X-akselin kokonaispaikannustarkkuus on enemmän (huonompi) kuin 30 µm.

⁽¹⁾ Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.

2B201 (jatkuu)

b. Työstökoneet hiontaa varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointineen" on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin $4\text{ }\mu\text{m}$ ISO 230/2:n (1988) ⁽¹⁾ tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltäjä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; tai
2. Kaksi tai useampia pyöriviä ääriäkselle.

Huom.: 2B001.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi seuraavia hiomakoneita:

- a. Ulkopuolisia, sisäpuolisia tai ulko-sisäpuolisia pyöröhiomakoneita, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Kone on rajoitettu vain pyöröhiontaan;
 2. Hiomakoneen työkalun maksimikoko on ulkohalkaisijaltaan tai pituudeltaan 150 mm;
 3. Korkeintaan kahta akselia voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriäkselle"; ja
 4. Ei sisällä c-ääriäkselle.
- b. Mallintyöstökoneet, joissa on vain x, y ja c akselit ja c-akselia käytetään pitämään hiomalaikkaa kohtisuorassa työpintaan nähden ja a-akseli on konfiguroitu hiomaan nokkarumpuja;
- c. Työkalu- tai leikkuuterien hiomakoneita, jotka on varustettu erityisesti suunnitellulla "ohjelmistolla" työkalujen tai leikkuuterien valmistusta varten; tai
- d. Kampiakselin tai nokka-akselin hiomakoneet.

2B204 Muut kuin 2B004 tai 2B104 kohdassa määritellyt "isostaattiset puristimet" ja niihin liittyvät laitteet seuraavasti:

- a. "isostaattiset puristimet", joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
 1. kykenevät saavuttamaan 69 MPa tai suuremman maksimitoimintapaineen;
 2. kammion sisähalkaisija on suurempi kuin 152 mm;
- b. 2B204.a kohdassa määriteltäjä "isostaattisia puristimia" varten erityisesti suunnitellut muotit ja ohjauslaitteet.

Tekn. huom.:

2B204 kohdassa kammion sisämitta on sen kammion mitta, jossa saavutetaan sekä toimintalämpötila että toimintapaine, eikä siinä oteta huomioon kiinnittimiä. Ilmoitettu mitta on sisähalkaisijoista pienempi, eli painekammion tai eristetyn uunikammion sisähalkaisija, riippuen siitä, kumpi kammio on toisen sisällä.

2B206 Seuraavat, muut kuin 2B006 kohdassa määritellyt, mittatarkastuskoneet, -instrumentit ja järjestelmät:

- a. Tietokoneohjatut, "numeerisesti ohjatut" tai ohjelmallisesti ohjatut mittatarkastuskoneet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
 1. Kaksi tai useampia akselleita; ja
 2. Yhden dimension pituuden "mittauksen epävarmuus" $(1,25 + L/1\ 000)\text{ }\mu\text{m}$ tai pienempi (parempi) testattuna anturilla, jonka "tarkkuus" on pienempi (parempi) kuin $0,2\text{ }\mu\text{m}$ (L on mitattu pituus millimetreinä); (Viite: VDI/VDE 2617 Osat 1 ja 2);
- b. Lineaarisen ja kulmasiirtymän samanaikaiseen tarkasteluun kykenevät järjestelmät, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
 1. "Mittauksen epävarmuus" mitä tahansa lineaarista akselia pitkin on $3,5\text{ }\mu\text{m}$ tai vähemmän (parempi) 5 mm matkalla; ja
 2. "Kiertymiskulman poikkeama" on 0,02 astetta tai vähemmän.

Huom. 1: Työstökoneet, joita voidaan käyttää mittauskoneina ovat valvonnallaisia, jos niiden ominaisuudet täyttävät tai ylittävät työstökoneille tai mittausasemille määritellyt kriteerit.Huom. 2: 2B206 kohdassa määriteltäjä kone on valvonnallinen, jos se ylittää valvontakynnyksen missä tahansa toiminta-alueellaan.

⁽¹⁾ Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.

- 2B206 (jatkuu)
Tekn. huom.:
1. Mittauksen epävarmuuden määrittämiseen käytetyn anturin tulee olla kuvattu VDI/VDE 2617:n 2, 3 ja 4 osassa.
 2. Kaikki 2B206 kohdassa esitetyt mittausravot tarkoittavat positiivista tai negatiivista poikkeamaa viitearvosta, eivät koko välystä.
- 2B207 Seuraavat muut kuin 2B007 kohdassa määritellyt "robotit", "päätettyövälineet" ja "ohjausyksiköt":
- a. "Robotit" ja "päätettyövälineet", jotka on erityisesti suunniteltu täyttämään voimakkaiden räjähteiden käsittelyä koskevat kansalliset turvamääräykset (täyttävät esimerkiksi voimakkaita räjähteitä koskevat sähkösäännökset);
 - b. ohjausyksiköt, jotka on erityisesti suunniteltu 2B207.a kohdassa määriteltyjä "robotteja" ja "päätettyövälineitä" varten.
- 2B209 Seuraavat, muut kuin 2B009 ja 2B109 kohdassa määritellyt painesorvit ja dreijaussorvit, jotka kykenevät painesorvin toimintoihin, sekä karat:
- a. Koneet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
 1. Kolme tai useampia valsseja (aktiivisia tai ohjaavia); ja
 2. Jotka valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa "numeerisella ohjauksella" yksiköillä tai tietokoneohjauksella;
 - b. Roottorin muotoilukarat, jotka on suunniteltu muotoilemaan lieriömäisiä roottoreita, joiden sisäläpimitta on 75 mm ja 400 mm välillä.
- Huom.: 2B209.a kohta sisältää koneet, joissa on vain yksi metallin muotoiluun suunniteltu valssi ja kaksi lisävalssia, jotka kannattelevat karaa, mutta eivät suoraan osallistu muodonmuutosprosessiin.
- 2B219 Seuraavat kiinteät tai kannettavat, vaaka- tai pystysuuntaiset keskipakovoimaan perustuvat monitasotaspainotuskoneet:
- a. Joustavien, vähintään 600 mm pitkien roottoreiden tasapainottamiseen tarkoitettujen keskipakovoimaan perustuvien monitasotaspainotuskoneiden, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Pyörähdysalkaisija tai akselitapin halkaisija suurempi kuin 75 mm;
 2. Massankäsittelykyky 0,9–23 kg; ja
 3. Kierrosnopeus tasapainotettaessa yli 5 000 kierrosta minuutissa;
 - b. Onttojen lieriömäisten roottorinosien tasapainottamiseen tarkoitettujen keskipakotasapainotuskoneiden, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Akselitapin halkaisija on suurempi kuin 75 mm;
 2. Niiden massankäsittelykyky on 0,9–23 kg;
 3. Ne kykenevät tasapainottamaan niin, että jäännösepätasapaino kussakin tasossa on enintään $0,010 \text{ kg} \times \text{mm/kg}$; ja
 4. Ne ovat hihnakäyttöisiä.
- 2B225 Kaukokäsittelylaitteet, joita voidaan käyttää kaukotyöskentelyyn radiokemiallisessa erotuksessa tai kuumakammioissa, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
- a. Ne pystyvät läpäisemään 0,6 m paksun tai paksumman kuumakammion seinän (seinän läpi työskentely); tai
 - b. Ne pystyvät kurottamaan 0,6 m paksun tai paksumman kammion seinän yli (seinän yli työskentely).
- Tekn. huom.:
- Kaukokäsittelylaitteilla välitetään operaattorin liikkeitä käyttövarteen ja päätettyökaluun. Ne voivat olla 'isäntä-orja'-tyyppisiä tai niitä käytetään ohjaimella tai näppäimistöltä.
- 2B226 Kontrolloidun ympäristön (tyhjiö- tai inerttikaasu)induktiouunit ja niiden teholahteet seuraavasti:
- Huom. KATSO MYÖS 3B KOHTA.**
- a. Uunit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Niitä voidaan käyttää yli 1 123 K (850 °C) asteen lämpötiloissa;
 2. Niiden induktiokelojen halkaisija on 600 mm tai pienempi; ja
 3. Niitä käytetään 5 kW:n tai suuremmalla syöttöteholla;

- 2B226 (jatkuu)
- b. Erityisesti 2B226.a kohdassa määritetyille uuneille suunnitellut teholahteet, joiden määritelty teho on 5 kW tai suurempi.
- Huom.: 2B226.a kohdassa ei tarkoiteta puolijohdekiekkojen valmistukseen suunniteltuja uuneja.
- 2B227 Seuraavat kontrolloidun ympäristön metallurgiset sulatus- ja valu-uunit sekä niihin liittyvät laitteet:
- a. Valokaaritoistosulatus- ja valu-uunit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Niiden sulavaelektrodikapasiteetti on $1\,000\text{ cm}^3$ – $20\,000\text{ cm}^3$; ja
 2. Ne kykenevät toimimaan yli $1\,973\text{ K}$ ($1\,700\text{ °C}$) asteen sulatuslämpötiloissa;
- b. Elektronisuihkusulatusuunit sekä plasmasumutus- ja sulatusuunit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Niiden teho on 50 kW tai suurempi; ja
 2. Ne kykenevät toimimaan yli $1\,473\text{ K}$ ($1\,200\text{ °C}$) asteen sulatuslämpötiloissa;
- c. 2B227 a. tai b. kohdissa olevia uuneja varten erityisesti konfiguroidut tietokoneohjaus- ja valvontajärjestelmät.
- 2B228 Seuraavat roottorien valmistus- tai kokoonpanolaitteet, roottorien suoruuden varmistavat laitteet, sekä paljemuovaustuurnat ja muotit:
- a. Roottorien kokoonpanolaitteet, kaasusentrifugien roottorilohkojen, ohjauslevyjen ja päätylaippojen koaamiseen;
- Huom.: 2B228.a kohtaan sisältyvät tarkkuustuurnat, puristimet ja kutistussovituskoneet;
- b. Roottorien suoruuden varmistavat laitteet, joiden avulla kaasusentrifugien roottorien lohkot linjataan yhteiselle akselille;
- Tekn. huom.:
- 2B228.b kohdassa tällaiset laitteet koostuvat yleensä tietokoneeseen kytketyistä tarkkuusmittapäistä, joiden avulla tietokone ohjaa roottoriputkilohkojen linjaukseen käytettävien, esimerkiksi paineilmakäyttöisten, iskumäntien toimintaa.
- c. Paljemuovaustuurnat ja muotit, joiden avulla valmistetaan yksikierteisiä palkeita.
- Tekn. huom.:
- 2B228.c kohdassa tarkoitetuilla palkeilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Sisähalkaisija 75–400 mm;
 2. Pituus 12,7 mm tai suurempi;
 3. Yhden kierteen syvyys yli 2 mm; ja
 4. Valmistusaineina lujat alumiiniseokset, maraging-teräs tai lujat "kuitu- tai säiemateriaalit".
- 2B230 "Painelähtimet", jotka pystyvät mittaamaan absoluuttista painetta alueella 0–13 kPa ja joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
- a. Painetta anturoiva elementti on valmistettu tai suojattu alumiinilla tai alumiiniseoksella, nikkelillä tai enemmän kuin 60 % nikkeliä sisältävällä nikkeliseoksella; ja
- b. joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Mitta-alue enintään 13 kPa ja 'tarkkuus' parempi kuin $\pm 1\%$ täydestä mitta-alueesta; tai
 2. Kokonaismitta-alue 13 kPa tai suurempi ja 'tarkkuus' parempi kuin $\pm 130\text{ Pa}$.
- Tekn. huom.:
- 2B230 kohdassa 'tarkkuuteen' sisältyy epälineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus ympäristön lämpötilassa.
- 2B231 Tyhjäpumput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
- a. Syöttöliitännän sisähalkaisija on 380 mm tai suurempi;
- b. Pumppausnopeus $15\text{ m}^3/\text{s}$ tai suurempi; ja
- c. Niiden avulla pystytään saamaan aikaan parempi kuin 13 mPa:n lopullinen tyhjö.
- Tekn. huom.:
1. Pumppausnopeus määritetään mittauspisteessä typpikaasulla tai ilmalla.
 2. Lopullinen tyhjö määritellään pumpun syöteputkessa syöteputken ollessa suljettuna.
- 2B232 Monivaiheiset kevyet kaasutytit tai muut suurnopeustyykkijärjestelmät (käämeihin perustuvat, sähkömagneettiset, ja sähkötermiset tyypit ja muut pitkälle kehitetyt järjestelmät), joiden avulla ammuksia voidaan kiihdyttää 2 km/s tai suurempiin nopeuksiin.

2B350

Seuraavat kemikaalien valmistuslaitokset, laitteet ja komponentit:

- a. Sekoittajilla tai ilman niitä varustetut reaktioastiat, joiden sisätilavuus on suurempi kuin $0,1 \text{ m}^3$ (100 l) ja pienempi kuin 20 m^3 (20 000 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
 1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
 2. Fluoripolymeereistä;
 3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
 4. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
 5. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
 6. Titaanista tai titaaneoksista; tai
 7. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;
- b. Sekoittajat, joita käytetään kohdassa 2B350 määritellyissä reaktioastioissa tai reaktoreissa ja tällaisissa sekoittajissa käytettävät juoksupyörät, siivet ja akselit, joissa kaikki sekoittajan pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
 1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
 2. Fluoripolymeereistä;
 3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
 4. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
 5. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
 6. Titaanista tai titaaneoksista; tai
 7. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;
- c. Varastosäiliöt, säiliöt tai keräysastiat, joiden sisätilavuus on suurempi kuin $0,1 \text{ m}^3$ (100 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
 1. Metalliseoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
 2. Fluoripolymeereistä;
 3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
 4. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
 5. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
 6. Titaanista tai titaaneoksista; tai
 7. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;
- d. Lämmönvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lämmönvaihtopinta on suurempi kuin $0,15 \text{ m}^2$ ja pienempi kuin 20 m^2 ja tällaisissa vaihtimissa tai lauhduttimissa käytettävät putket, levyt, kelat tai lohkot (ytimet), joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
 1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
 2. Fluoripolymeereistä;
 3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
 4. Grafiitista tai 'grafiittihiilestä';
 5. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
 6. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
 7. Titaanista tai titaaneoksista;
 8. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;
 9. Piikarbidista; tai

2B350

d. (jatkuu)

10. Titaanikarbidista;

e. Tislaus- tai imeytyskolonnit, joiden sisähalkaisija on suurempi kuin 0,1 m ja tällaisissa tislaus- tai imeytyskolonneissa käytettävät nestejakelijat, höyryjakelijat ja nestekerääjät, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2. Fluoripolymeereistä;

3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4. Grafiitista tai 'grafiittihiilestä';

5. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6. Tantaalista tai tantaaliseoksista;

7. Titaanista tai titaaniseoksista; tai

8. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

f. Kauko-ohjatut täyttölaitteet, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia; tai

2. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

g. Venttiilit, joiden nimelliskoko on suurempi kuin 10 mm ja kammiot (venttiilin rungot) tai muotoon puristetut runkotiivisteet tällaisille venttiileille, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2. Fluoripolymeereistä;

3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

5. Tantaalista tai tantaaliseoksista;

6. Titaanista tai titaaniseoksista; tai

7. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

h. Moniseinäiset putkistot, joihin sisältyy vuodonilmaisuventtiili, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2. Fluoripolymeereistä;

3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4. Grafiitista;

5. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6. Tantaalista tai tantaaliseoksista;

7. Titaanista tai titaaniseoksista; tai

8. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;

i. Monitiivisteiset, hihnavetoiset, magneettivetoiset, palje- tai diafragmapumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m³/h, tai vakuumipumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 5 m³/h (vakioämpötilassa (0 °C, 273 K astetta) ja ilmanpaineessa (101,30 kPa)), ja tällaisissa pumpuissa käytettävät rungot (pumppujen rungot), muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2. Keraameista;

3. Ferropiistä;

4. Fluoripolymeereistä;

- 2B350 i. (jatkuu)
5. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
 6. Grafiitista;
 7. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
 8. Tantaalista tai tantaalseoksista;
 9. Titaanista tai titaanseoksista; tai
 10. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;
- j. Erityisesti suunnitellut, 1C350 kohdassa määriteltyjen kemikaalien hävittämiseen tarkoitetut polttolaitokset, joissa on erityisesti suunnitellut jätteen syöttöjärjestelmät, erityiset käsittelylaitteet ja keskimääräinen polttokammion lämpötila suurempi kuin 1 273 K (1 000 °C) astetta, joissa kaikki jätteensyöttöjärjestelmän pinnat, jotka tulevat suoraan kosketukseen jätetuotteiden kanssa, on valmistettu tai vuorattu (pinnoitettu) seuraavilla materiaaleilla:
1. Seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 prosenttia kromia;
 2. Keraamit; tai
 3. Nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä.

Tekn. huomautus:

'Grafiittihiili' on amorfisesta hiilestä ja grafiitista koostuva seos, jonka koostumuksesta vähintään kahdeksan painoprosenttia on grafiittia.

- 2B351 Myrkyllisten kaasujen valvontajärjestelmät ja niiden erikoisilmaisimet:
- a. Jotka on suunniteltu jatkuvaan toimintaan ja joita käytetään ilmaisemaan kemiallisia taisteluaineita tai 1C350 kohdassa määriteltyjä kemikaaleja pitoisuuksina, jotka ovat vähemmän kuin 0,3 mg/m³; tai
 - b. Jotka on tarkoitettu ilmaisemaan yhdisteitä, joilla on koliinisteraasia estävä aktiivisuus.

- 2B352 Seuraavat biologisten aineiden käsittelyyn soveltuvat laitteet:

- a. Täydelliset biologiset turvatilat, joiden turvataso on P3 ja P4;

Tekn. huom.:

P3 ja P4 (BL3, BL4, L3, L4) turvatasot on määritelty WHO:n (World Health Organization) Laboratorion bioturvakäsikirjassa (Laboratory biosafety manual) (toinen painos, Geneve 1993).

- b. Fermenttorit, joilla voidaan kasvattaa patogeenisia "mikro-organismeja", viruksia tai tuottaa toksineja ilman aerosolien muodostusta, ja joiden kokonaiskapasiteetti on vähintään 20 litraa;

Tekn. huom.:

Fermenttoreihin kuuluvat bioreaktorit, kemostaatit sekä jatkuvan virtausperiaatteen järjestelmät.

- c. Keskipakoerottimet, jotka pystyvät jatkuvaan erotukseen ilman aerosolimuodostusta ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Virtausnopeus ylittää 100 litraa tunnissa;
2. Komponentit ovat kiillotettua ruostumatonta terästä tai titaania;
3. Niissä on yksi tai useampi tiivistesulku höyrysteriloitavalla alueella; ja
4. Ne voidaan steriloida höyryllä paikalla ja suljettuna;

Tekn. huom.:

Keskipakoerottimet sisältävät dekantterit.

- d. Risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteet ja -komponentit seuraavasti:

1. Risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteet, joilla pystytään erottamaan patogeeniset mikro-organismit, virukset, toksiinit tai soluviljelmat ilman aerosolimuodostusta ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

- a. Kokonaissuodatuspinnan koko vähintään 1 m²; ja
- b. Steriloitavissa tai desinfioitavissa paikalla;

Tekn. huom.:

2B352.d.1.b kohdassa tarkoitetaan 'steriloimisella' kaikkien elävien mikrobien poistamista laitteesta käyttämällä joko fysikaalisia (esimerkiksi höyry) tai kemiallisia tekijöitä. 'Desinfioimisella' tarkoitetaan mahdollisen mikrobisen infektiivisyyden tuhoamista laitteesta käyttämällä kemiallisia tekijöitä, joilla on germisidinen vaikutus. Steriloiminen ja desinfioiminen ovat eri asioita kuin sanitointi, jolla tarkoitetaan puhdistusmenettelyjä, joiden tarkoituksena on alentaa laitteen mikrobisisältöä poistamatta välttämättä kaikkea mikrobista infektiivisyyttä tai eläviä mikrobeja.

2B352

d. (jatkuu)

2. Risti(tangentiaali)virtaussuodatin­komponentit (esimerkiksi moduulit, elementit, kasetit, säiliöt, yksiköt tai levyt), joiden suodatus­pinta on vähintään 0,2 m² kunkin komponentin osalta ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi 2B352.d kohdassa mainituissa risti(tangentiaali) virtaussuodatin­laitteissa;

Huom.: 2B352.d kohta ei aseta valvonnallaiseksi käänteisosmoosilaitteita sellaisina kuin valmistaja on ne määritellyt.

- e. Höyrysteriloitavat kylmäkuivauslaitteet, joiden kondensaatiokapasiteetti ylittää 10 kg jäätä 24 tunnissa ja enintään 1 000 kg jäätä 24 tunnissa;
- f. Seuraavat suoja- ja turvalaitteet:

1. Puoli- ja kokosuojapuvut tai huuvut, jotka ovat riippuvaisia niihin kytketystä ulkoisesta ilmansyötöstä ja jotka toimivat ylipaineella;

Huom.: 2B352.f.1 kohdassa ei aseteta valvonnallaisiksi pukuja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi itsenäisen hengityslaitteen kanssa.

2. Biologiset suojakaapit tai eristysvarusteet, jotka täyttävät vastaavat suoritusvaatimukset;

Huom.: 2B352.f.2 kohdassa isolaattoreihin kuuluvat joustavat isolaattorit, kuivakaapit, anaerobikammiot, hansikaskaapit ja laminaarivirtaushuuvut (suljettu pystyvirtauksella).

- g. Kammiot, jotka on suunniteltu "mikro-organismeilla", viruksilla tai "toksiineilla" tehtäviä aerosolialitistuskokeita varten ja joiden kammiotilavuus on 1 m³ tai suurempi.

2C**Materiaalit**

Ei ole.

2D Ohjelmistot

- 2D001 Muut kuin 2D002 kohdassa määritetyt "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2A001 tai 2B001–2B009 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.
- 2D002 Elektronisten laitteiden "ohjelmistot", myös pysyvästi elektroniseen laitteeseen tai järjestelmään sijoitetut, jotka mahdollistavat näiden laitteiden tai järjestelmien toiminnan "numeerisena ohjaus" yksikkönä ja pystyvät koordinoimaan samanaikaisesti useampaa kuin neljää akselia "ääriviivaohjauksessa".
- Huom. 1:* 2D002 kohta ei aseta valvonnallaiseksi "ohjelmistoja", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu työstökoneille, joita ei ole määritelty ryhmässä 2.
- Huom. 2:* 2D002 kohta ei aseta valvonnallaiseksi 2B002 kohdassa mainituille tuotteille tarkoitettuja "ohjelmistoja". Katso 2D001 kohta 2B002 kohdassa mainituille tuotteille tarkoitettujen "ohjelmistojen" valvonnan osalta.
- 2D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 tai 2B119–2B122 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.
- Huom.: KATSO MYÖS 9D004 KOHTA.**
- 2D201 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 tai 2B227 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.
- 2D202 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2B201 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

2E Teknologia

- 2E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A, 2B tai 2D kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.
- 2E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A tai 2B kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.
- 2E003 Seuraavat muut "teknologiat":
- a. "Teknologia" "numeerisen ohjaus" yksikön integroituna osana olevan työstöohjelmien laatimiseksi tai muuntamiseksi tarvittavan interaktiivisen grafiikan kehittämistä varten;
 - b. Seuraavat "teknologiat" metalliteollisuuden valmistusprosesseja varten:
 1. Seuraavia prosesseja varten erityisesti suunniteltujen työkalujen, muottien tai kiinnittimien suunnittelu "teknologia":
 - a. "Superplastinen muovaus";
 - b. "Diffuusioliittäminen"; tai
 - c. "Suoravaikutteinen hydraulipuristus";
 2. Tekninen tieto, joka koostuu alla luetelluista prosessimenetelmistä tai niiden parametreista ja jolla ohjataan:
 - a. Alumiiniseosten, titaaniseosten tai "superseosten" "superplastisen muovauksen":
 1. Pinnan valmistelua;
 2. Jännityksen tasoa;
 3. Lämpötilaa;
 4. Painetta;
 - b. "Superseosten" tai titaaniseosten "diffuusioliittämisen":
 1. Pinnan valmistelua;
 2. Lämpötilaa;
 3. Painetta;
 - c. Alumiiniseosten tai titaaniseosten "suoravaikutteista hydraulipuristuksen":
 1. Painetta;
 2. Jakson aikaa;
 - d. Titaaniseosten, alumiiniseosten tai "superseosten" "kuumaisostaattisen puristuksen":
 1. Lämpötilaa;
 2. Painetta;
 3. Jakson aikaa;
 - c. "Teknologia" "lentokoneen runkorakenteiden valmistukseen tarkoitettujen hydraulisten venytysmuovauskoneiden ja niiden muottien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten;
 - d. "Teknologia" "numeerisessa ohjaus" yksikössä olevasta suunnittelutiedosta tuotettavien työstökonekäskyjen (esim. työstöohjelmien) ohjelmakehittimien "kehittämistä" varten;
 - e. "Teknologia" valmistusosaston toimintojen kehittyneen päätöksenteon tukemiseksi "numeerisiin ohjaus" yksiköihin asiantuntijajärjestelmiä sisällyttävien integrointi "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten;
 - f. "Teknologia", jolla epäorgaanisilla päällystyspinnoitteilla tai epäorgaanisilla pinnanmuunnospinnoitteilla (määritelty seuraavan taulukon 3 sarakkeessa) pinnoitetaan johtamattomia substraatteja (määritelty seuraavan taulukon 2 sarakkeessa) seuraavan taulukon 1 sarakkeessa määritellyillä ja Teknisessä Huomautuksessa kuvatuilla prosesseilla.
- Huom.: Taulukko ja tekniset huomautukset on esitetty 2E301 kohdan jälkeen.
- 2E101 "Teknologia" Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119–2B122 tai 2D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "käyttöä" varten.
- 2E201 "Teknologia" Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225–2B232, 2D201 tai 2D202 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "käyttöä" varten.
- 2E301 "Teknologia" Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B3502–2B352 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

Taulukko

Pinnoitustekniikat

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
A. Kemiallinen kaasu-faasipinnoitus (CVD)	"superseokset"	aluminidit sisäisiin kanaviin
	Keraamiset aineet (19) ja vähän laajenevat lasit (14)	silisidit karbidit dielektriset kerrokset (15) timantti timantin kaltainen hiili (17)
	hiili-hiili-, keraami- ja metalli-"matriisi" "komposiitit"	silisidit karbidit tulenkestävät metallit niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15) aluminidit seostetut aluminidit (2) boorinitridi
	Volframikarbidi-kovametalli(16), piikarbidi (18)	karbidit volframi niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15)
	molybdeeni ja molybdeeniseokset	dielektriset kerrokset (15)
	beryllium ja berylliumseokset	dielektriset kerrokset (15) timantti timantin kaltainen hiili (17)
	anturi-ikkunamateriaalit (9)	dielektriset kerrokset (15) timantti timantin kaltainen hiili (17)
B. Terminen höyrystys-fysikaalinen höyrypinnoitus (TE-PVD)		
B.1. PVD tai EB-PVD	"superseokset"	seostetut silisidit seostetut aluminidit (2) MCrAlX (5) muunnettu zirkoniumoksidi (12) silisidit aluminidit niiden sekoitukset (4)

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
B.1. (jatkuu)	keraamiset aineet (19) ja vähän laajenevat lasit (14)	dielektriset kerrokset (15)
	korroosionkestävä teräs (7)	MCrAlX (5) muunnettu zirkoniumoksidi (12) niiden sekoitukset (4)
	hiili-hiili-, keraami- ja metalli- "matriisikomposiitit"	silisidit karbidit tulenkestävät metallit niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15) boorinitridi
	volframikarbidi-kovametalli (16) piikarbidi (18)	karbidit volframi niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15)
	molybdeeni ja molybdeeniseokset	dielektriset kerrokset (15)
	beryllium ja berylliumseokset	dielektriset kerrokset (15) boridit beryllium
	anturi-ikkunamateriaalit (9)	dielektriset kerrokset (15)
	titaaniseokset (13)	boridit nitridit
B.2. Ioniavusteinen resistiivinen kuumennus PVD (ioni pinnoitus)	Keraamiset aineet (19) ja vähän laajenevat lasit (14)	dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili (17)
	hiili-hiili-, keraamiset ja metalli- "matriisi" "komposiitit"	dielektriset kerrokset (15)
	volframikarbidi-kovametalli (16), piikarbidi	dielektriset kerrokset (15)
	molybdeeni ja molybdeeniseokset	dielektriset kerrokset (15)
	beryllium ja berylliumseokset	dielektriset kerrokset (15)

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
B.2. (jatkuu)	anturi-ikkunamateriaalit (9)	dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili (17)
B.3. "Laser" - PVD	Keraamiset aineet (19) ja vähän laajenevat lasit (14)	silisidit dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili (17)
	hiili-hiili-, keraami- ja metalli- "matriisi" "komposiitit"	dielektriset kerrokset (15)
	volframikarbidi-kovametalli (16), piikarbidit	dielektriset kerrokset (15)
	molybdeeni ja molybdeeniseokset	dielektriset kerrokset (15)
	beryllium ja berylliumseokset	dielektriset kerrokset (15)
	anturi-ikkunamateriaalit (9)	dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili
B.4. Katodikaari-Purkaus PVD	"superseokset"	seostetut silisidit seostetut aluminidit (2) MCrAlX (5)
	polymeerit (11) ja "komposiitit", joilla on orgaaninen "matriisi"	boridit karbidit nitridit timantin kaltainen hiili (17)
C. Hiilletyslaattikko- karkaisu (Katso edellä kohta A. muun kuin laattikko-karkaisun osalta) (10)	hiili-hiili-, keraami- ja metalli- "matriisi" "komposiitit"	silisidit karbidit niiden sekoitukset (4)
	titaaniseokset (13)	silisidit aluminidit seostetut aluminidit (2)
	tulenkestävät metallit ja niiden seokset (8)	silisidit oksidit
D. Plasmaruiskutus	"superseokset"	MCrAlX (5) muunnettu zirkoniumoksidi (12) niiden sekoitukset (4) muovattava nikkeligrafiitti muovattavat Ni-Cr-Al-pitoiset aineet muovattavat Al-Si-polyesteri seostetut aluminidit (2)

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
D. (jatkuu)	alumiiniseokset (6)	MCrAlX (5) muunnettu zirkoniumoksidi (12) silisidit niiden sekoitukset (4)
	tulenkestävät metallit ja seokset (8)	aluminidit silisidit karbidit
	korroosionkestävät teräkset (7)	MCrAlX (5) muunnettu zirkoniumoksidi (12) niiden sekoitukset (4)
	titaaniseokset (13)	karbidit aluminidit silisidit seostetut aluminidit (2) muovattava nikkeligrafiitti muovattavat Ni-Cr-Al-pitoiset aineet muovattava Al-Si-polyesteri
E. Lietepinnoitus	tulenkestävät metallit ja seokset (8)	fuusattut silisidit fuusattut aluminidit paitsi lämmitys- vas-tus-elementit
	hiili-hiili-, keraami- ja metalli- "mat- riisi" "komposiitit"	silisidit karbidit niiden sekoitukset (4)
F. Sputterointi	"superseokset"	seostetut silisidit seostetut aluminidit (2) jalometallimuunnetut aluminidit (3) MCrAlX (5) muunnettu zirkoniumoksidi (12) platina niiden sekoitukset (4)
	keraamiset aineet ja vähän laajenevat lasit (14)	silisidit platina niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili (17)

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
F. (jatkuu)	titaaniseokset (13)	boridit nitridit oksidit silisidit aluminidit seostetut aluminidit (2) karbidit
	hiili-hiili-, keraami- ja metalli- "matriisi" "komposiitit"	silisidit karbidit tulenkestävät metallit niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15) boorinitridi
	volframikarbidi-kovametalli (16) piikarbidi (18)	karbidit volframi niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15) boorinitridi
	molybdeeni ja molybdeeniseokset	dielektriset kerrokset (15)
	beryllium ja berylliumseokset	boridit dielektriset kerrokset (15) beryllium
	anturi-ikkunamateriaalit (9)	dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili (17)
	tulenkestävät metallit ja seokset (8)	aluminidit silisidit oksidit karbidit
G. Ioni-istutus	korkean lämpötilan laakeriteräkset	Kromi-, tantaali- tai niobium-(Columbium) lisäaineet
	titaaniseokset (13)	boridit nitridit
	beryllium ja berylliumseokset volframikarbidi-kovametalli (16)	boridit karbidit nitridit

(*) Suluissa olevat numerot viittaavat tämän taulukon jäljessä oleviin huomautuksiin.

Pinnoitustekniikkoja kuvaavaan taulukkoon liittyvät huomautukset

1. Termi 'pinnoitusprosessi' sisältää, paitsi alkuperäisen pinnoituksen, myös sen korjauksen tai uusimisen.
2. Termi 'seostettu aluminidipinnoitus' sisältää yksi- ja monivaiheiset pinnoitukset, joissa substraatti pinnoitetaan ensin tai samanaikaisesti aluminidipinnoituksen kanssa muulla alkuaineella tai -aineilla silloinkin, kun näillä alkuaineilla pinnoitetaan jotain muuta prosessia käyttäen. Se ei kuitenkaan sisällä yksivaiheista hiiletyslaattokarkaisuprosessia, jota käytetään useampaan kertaan seostetun aluminidin aikaansaamiseksi substraatin pinnalle.
3. Termi 'jalometallimuunnettu aluminidipinnoitus' sisältää monivaiheiset pinnoitukset, joissa jalometallia tai jalometalleja aikaansaadaan substraatin pinnalle jollakin muulla prosessilla ennen aluminidipinnoitusta.
4. Termi 'niiden sekoitukset' sisältää suodatettuja aineita, lajiteltuja seoksia sekä lisä- ja monikerrospinnoitteita ja niitä aikaansaadaan yhden tai useamman taulukossa mainitun prosessin avulla.
5. 'McrAlX' tarkoittaa metalliseospinnoitetta, jossa M vastaa kobolttia, rautaa, nikkeliä tai niiden yhdistelmiä ja X vastaa hafniumia, yttriumia, piitä, tantaalia missä tahansa määrässä tai muuta tarkoituksellista lisäainetta yli 0,01 painoprosenttia erilaisissa suhteissa ja yhdistelmissä, paitsi:
 - a. CoCrAlY-pinnoitteet, jotka sisältävät vähemmän kuin 22 painoprosenttia kromia, vähemmän kuin 7 painoprosenttia alumiinia ja vähemmän kuin 2 painoprosenttia yttriumia;
 - b. CoCrAlY-pinnoitteet, jotka sisältävät 22–24 painoprosenttia kromia, 10–12 painoprosenttia alumiinia ja 0,5–0,7 painoprosenttia yttriumia;
 - c. NiCrAlY-pinnoitteet, jotka sisältävät 21–23 painoprosenttia kromia, 10–12 painoprosenttia alumiinia ja 0,9–1,1 painoprosenttia yttriumia.
6. Termi 'alumiiniseos' tarkoittaa metalliseoksia, joiden murtovetolujuus on 190 MPa tai enemmän mitattuna 20 °C (293 K) asteen lämpötilassa.
7. Termi 'korroosionkestävä teräs' tarkoittaa AISI (American Iron and Steel Institute) 300- sarjaa tai vastaavia kansallisia standarditeräksiä.
8. 'Tulenkestävät metallit ja seokset' sisältävät seuraavia metalleja ja niiden seoksia: niobium (Columbium), molybdeeni, volframi ja tantaali.
9. "Anturi-ikkunamateriaaleja" ovat seuraavat: alumiinioksidi, pii, germanium, sinkkisulfidi, sinkkiseleneidi, galliumarseniidi, timantti, galliumfosfidi, safiiri ja seuraavat metallihalidit: zirkoniumfluoridista ja hafniumfluoridista koostuvat anturi-ikkunamateriaalit, joiden läpimitta ylittää 40 mm.
10. Kiinteiden turbiininsiipilevyjen yksivaiheinen hiiletyslaattokarkaisu "teknologia" ei ole valvonnanaista 2 ryhmässä.
11. Seuraavat polymeerit: polyimidi, polyesteri, polysulfidi, polykarbonaatit ja polyuretaanit.
12. 'Muunnettu zirkoniumoksidi' tarkoittaa, että siinä on muiden metallien oksideja lisäaineena, kuten kalsiumoksidi, magnesiumoksidi, yttriumoksidi, hafniumoksidi ja harvinaisten maametallien oksidit jne. zirkoniin asti, joita käytetään stabiloimaan tiettyjä kiteisiä faaseja ja faasikombinaatioita. Lämpöeristyspinnoitukset, jotka on valmistettu zirkoniumoksidista, joka on muunnettu kalsiumoksidia tai magnesiumoksidia sekoittamalla tai fuusaamalla, eivät ole valvonnanaisia.
13. 'Titaaniseokset' tarkoittaa vain ilmailu- tai avaruuskäyttöön tarkoitettuja seoksia, joiden murtovetolujuus on 900 MPa tai enemmän mitattuna 20 °C (293 K) asteen lämpötilassa.
14. 'Vähän laajenevat lasit' tarkoittaa lasia, joiden lämpölaajenemiskerroin on $1 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$ tai vähemmän mitattuna 20 °C (293 K) asteen lämpötilassa.

15. 'Dielektriset kerrokset' ovat pinnoitteita, jotka rakentuvat eristysmateriaalien useista kerroksista, joissa eri taitekertoimen omaavien materiaalien interferenssiominaisuuksia halutulla tavalla käytetään heijastamaan, lähettämään tai absorboimaan eri aallonpituuskaistoja. Dielektriset kerrokset tarkoittavat enemmän kuin neljää dielektristä kerrosta tai dielektristä/metalli "komposiitti" kerrosta.
16. 'Volframikarbidikovametalli' ei sisällä lastuamis- ja muovaustyökalumateriaaleja, joilla on seuraava koostumus: volframikarbidi/(koboltti, nikkeli), titaanikarbidi/(koboltti, nikkeli), kromikarbidi/nikkeli-kromi tai kromikarbidi/nikkeli.
17. "Teknologiaa", joka on erityisesti tarkoitettu pinnoittamaan timantin kaltaisella hiilellä seuraavia, ei valvota:
- magneettiset levyasemat ja magneettipäät, kertakäyttötuotteiden valmistukseen käytettävät laitteet, hanaventtiilit, kaiuttimien akustiset kalvot, moottorien osat autoihin, terätyökalut, lävistyspuristinmatriisit, toimistoautomaatio-laitteet, mikrofonit tai lääkinnälliset laitteet tai muovien valamiseen tai muovaamiseen tarkoitettut muotit, jotka on valmistettu alle 5 prosenttia berylliumia sisältävistä seoksista.
18. 'Piikarbidit' ei sisällä terätyökaluihin tai muototeriin käytettäviä aineita.
19. Tässä tarkoitettut 'keraamiset substraatit' eivät sisällä keraamisia aineita, joissa on vähintään 5 painoprosenttia savea tai sementtiä erillisinä ainesosina tai yhdisteinä.

Taulukon 1 sarakkeessa mainitut prosessit määritellään seuraavasti:

- a. Kemiallinen kaasufaasipinnoitus (CVD) on pinnoitus- tai pinnan muunnosprosessi, jossa metallia, metalliseosta, "komposiittia", dielektristä ainetta tai keraamia depositoidaan kuumennetulle substraatille. Kaasumaiset reagoivat aineet hajoavat tai yhdistyvät substraatin välittömässä läheisyydessä, jonka seurauksena haluttu alkuaine, metalliseos tai yhdiste asettuu substraatille. Hajoamisen tai kemiallisen reaktioprosessin tarvitsema energia saadaan substraatin lämmöstä, hohtopurkaus plasmasta tai "laser"-säteilytyksestä.

Huom. 1: CVD sisältää seuraavat prosessit: suunnatun kaasuvirtauksen ei-pakkauspinnoitus, sykkivä CVD, säädettävä ydin-työlämpölämpöhoito (CNTD), plasma- tai plasma-avusteinen CVD.

Huom. 2: Pakkaus tarkoittaa jauheseokseen upotettua substraattia.

Huom. 3: Kaasumaiset, reagoivat aineet, joita käytetään ei-pakkausprosessissa tuotetaan käyttämällä samoja perusreaktioita ja parametreja, kuin pakkauspinnoitusprosessissakin, paitsi että siinä pinnoitettava substraatti ei ole kosketuksissa jauheseokseen.

- b. Terminen höyrystys-fysikaalinen höyrypinnoitus (TE-PVD = Thermal Evaporation-Physical Vapour Deposition) on pinnoitusprosessi, joka suoritetaan tyhjiössä paineen ollessa alle 0,1 Pa, jossa termistä energiaa käytetään höyrystämään pinnoitusmateriaalia. Tässä prosessissa höyrystyneet ainesosat kondensoituvat tai depositoituvat sopivasti asetetun substraatin pinnalle.

Kaasujen lisääminen tyhjäkammioon pinnoitusprosessin aikana on tavallinen prosessin muunnos.

Ioni- tai elektronisäteen tai plasman käyttö aktivoimaan tai avustamaan pinnoitusprosessia on myös tavallinen tämän tekniikan muunnos. Monitorien käyttö mahdollistamaan prosessin aikana optisten ominaisuuksien tai pinnoitteen paksuuden mittauksen voi olla näiden prosessien lisäpiirre.

Eri TE-PVD prosessit ovat seuraavat:

1. Elektronisuihku-PVD -prosessissa käytetään elektronisuihkua kuumentamaan ja höyrystämään pinnoitteen muodostavaa materiaalia.
2. Ioniavusteinen resistiivinen-kuumennus-PVD -prosessissa käytetään resistiivisiä kuumennuslähteitä yhdessä iskeytyvän(-vien) ionisäte(id)en kanssa tuottamaan kontrolloidun ja yhtenäisen höyrystyneiden pinnoiteaineksen vuon.

3. "Laser"-höyrystys-(PVD) käyttää joko pulssi- tai jatkuvan aallon lasersäteitä höyryttämään pinnoituksen muodostavia materiaaleja;
4. Katodikaaripinnoitus-(PVD) käyttää kuluva katodia, joka on pinnoitteen muodostavaa materiaalia sekä kaaripurkausta, joka aikaansaadaan koskettamalla hetkellisesti sen pintaa maaliipaisimella. Ohjaamalla kaarta erotetaan katodin pinnasta ionisoitua plasmaa. Anodina voi olla joko kartio, joka on kiinnitetty katodin läheisyyteen, eristeen tai kammion läpi. Substraatin (jännite) biasointia käytetään näkymättömissä tapahtuvaan pinnoitukseen.

Huom.: Tämä määritelmä ei koske satunnaista katodikaaripinnoitusta biasoimattomia substraatteja käytettäessä.

5. Ioni-pinnoitus (-PVD) on TE-PVD -prosessin muunnos, jossa plasma- tai ionilähdettä käytetään ionisoimaan pinnoitettavia aineksia ja negatiivinen biasjännite johdetaan substraattiin pinnoitusaineksien erottamiseksi plasmaa. Reagoivien aineksien käyttäminen, kiinteiden aineiden höyryttäminen prosessikammiossa ja monitorien käyttö mahdollistamaan prosessin aikaisen, pinnoitteen optisten ominaisuuksien ja paksuuden mittaamiseksi ovat tavallisia prosessin muunnoksia.
- c. Pakkasementointi on pinnan muunnos- tai pinnoitusprosessi, jossa substraatti upotetaan jauheseokseen (pakkaan), joka koostuu:
1. Depositioitavista metallijauheista (tavallisesti alumiinia, kromia, piitä tai niiden yhdistelmiä);
 2. Aktivaattorista (tavallisesti halidisuola); ja
 3. Reagoimattomasta aineesta, useimmiten alumiinioksidista.

Substraatti ja jauheseos asetetaan retorttiin, joka kuumennetaan 757 °C (1 030 K) – 1 102 °C (1 375 K) asteeseen riittäväksi ajaksi pinnoitteen aikaansaamiseksi.

- d. Plasmaruiskutus on pinnoitusprosessi, jossa plasmaa tuottavaan ja ohjaavaan sumuttimeen syötetään pinnoitemateriaalia jauheena tai lankana, ne sulatetaan ja kiihdytetään substraattia kohden. Plasmaruiskutus on joko matalapaineessa tai suurinopeuksista plasmaruiskutusta.

Huom. 1: Matalapaineella tarkoitetaan alle ilmakehän painetta.

Huom. 2: Suurinopeuksella tarkoitetaan kaasun lähtönopeutta suuttimesta, kun se ylittää 750 m/s laskettuna 20 °C (293 K) asteen lämpötilassa ja 0,1 MPa paineessa.

- e. Lietepinnoitus on pinnan muunnos- tai pinnoitusprosessi, jossa orgaanisen aineen sitomaa metalli- tai keraamijauhetta riippuu nesteessä ja sumuttamalla, kastamalla tai maalaamalla se aikaansaadaan substraatille, jota seuraa ilmassa tai uunissa tapahtuva kuivaus sekä lämpökäsittely halutun pinnoitteen aikaansaamiseksi.
- f. Sputterointi on pinnoitusprosessi, joka perustuu "liikemäärän siirto" -ilmiöön, jossa positiiviset ionit kiihdytetään sähkökentässä kohti pinnoitemateriaalin pintaa. Iskeytyvien ionien kineettinen energia on riittävä irrottamaan atomeja sen pinnasta ja pinnoittamaan sopivasti asetettua substraattia.

Huom. 1: Taulukko viittaa vain triodi-, magnetroni- tai reaktiiviseen sputterointiin, jota käytetään lisäämään pinnoitteen kiinnittymistä ja depositionopeutta ja radiotaajuudella voimistettuun sputterointiin, jota käytetään mahdollistamaan ei-metallisten pinnoitemateriaalien höyryttämisen.

Huom. 2: Matalaenergisiä (alle 5 keV) ionisäteitä voidaan käyttää aktivoimaan depositiota.

- g. Ioni-istutus on pinnan muunnospinnoitusprosessi, jossa seostettava elementti ionisoidaan, kiihdytetään potentiaaligradientin läpi ja istutetaan substraatin pinnan tietylle alueelle. Tämä sisältää prosessit, joissa ioni-istutus suoritetaan samanaikaisesti elektronisuihku-PVD:llä tai sputteroinnilla.

RYHMÄ 3
ELEKTRONIIKKA

3A Järjestelmät, laitteet ja komponentit

Huom. 1: Sellaisten 3A001 tai 3A002 kohdassa kuvattujen laitteiden, kokoonpanojen ja komponenttien, 3A001.a.3–3A001.a.10 tai 3A001.a.12 kohdassa kuvattuja lukuun ottamatta, jotka on erityisesti suunniteltu, tai joilla on samat toiminnalliset ominaisuudet kuin jollain muulla laitteella, valvonnanalaisuus määräytyy näiden muiden laitteiden mukaan.

Huom. 2: 3A001.a.3–3A001.a.9 tai 3A001.a.12 kohdassa kuvattujen integroitujen piirien, jotka on ohjelmoitu ei-muutettavasti, tai jotka on suunniteltu erityistä toimintoa varten, valvonnanalaisuus määräytyy niiden muiden laitteiden mukaan, joita varten ne on tarkoitettu.

Huom: Milloin valmistaja tai vientiluvan hakija ei pysty määrittelemään näiden muiden laitteiden valvonnanalaisuutta, valvonnanalaisuus määräytyy 3A001.a.3–3A001.a.9 tai 3A001.a.12 kohdan mukaan. Jos integroitu piiri on piipohjainen 3A001.a.3 kohdassa kuvattu "mikrotietokonepiiri" tai mikro-ohjainpiiri, jonka operandin (tiedon) sanan pituus on 8 bittiä tai vähemmän, integroidun piirin valvonnanalaisuus määräytyy 3A001.a.3 kohdan mukaan.

3A001 Elektroniset komponentit seuraavasti:

a. Seuraavat yleiskäyttöiset integroidut piirit:

Huom. 1: (Valmiiden tai puolivalmiiden) piikiekkojen, joissa toiminto on määritelty, valvonnanalaisuus arvioidaan 3A001.a kohdan parametrien mukaan.

Huom. 2: Integroidut piirit sisältävät seuraavat tyypit:

"Monoliittiset integroidut piirit";

"Integroidut hybridipiirit";

"Integroidut monipalapiirit";

"Integroidut kalvopiirit", integroidut pii-safiiripiirit mukaan lukien;

"Optiset integroidut piirit".

1. Integroidut piirit, jotka on suunniteltu tai mitoitettu kestäämään jotakin seuraavista:

a. Säteilyä kokonaisannoksena 5×10^3 Gy (Pii) tai enemmän;

b. Säteilyä, jonka annosnopeus 5×10^6 Gy (Pii)/s tai enemmän; tai

c. Neutronien integroitua vuontiheyttä (1 MeV:n vastaavuus), joka on 5×10^{13} n/cm² tai enemmän piin osalta tai sitä vastaavan aineen osalta muiden materiaalien ollessa kyseessä

Huom.: 3A001.a.1.c kohtaa ei sovelleta metallieristepuolijohteisiin (MIS).

2. "Mikroprosessoripiirit", "mikrotietokonepiirit", mikro-ohjainpiirit, integroidut muistipiirit, jotka on valmistettu yhdistepuolijohteesta, analogia-digitaalimuuntimet, digitaal-analogiamuuntimet, sähköoptiset tai "optiset integroidut piirit" "signaalinkäsittelyä" varten, käyttäjän ohjelmoitavat loogikkapiirit, integroidut hermoverkkopiirit, sellaiset asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon tai jotka on tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on tuntematon, nopea Fourier-muunnos (FFT)-prosessorit, elektronisesti pyyhittävät ohjelmoitavat lukumuistit (EEPROMS), pikamuistipiirit taikka staattiset luku-/kirjoitusmuistit (SRAMit), jotka on joko

a. suunniteltu toimimaan yli 398 K (125 °C) lämpötiloissa;

b. suunniteltu toimimaan alle 218 K (–55 °C) lämpötiloissa; tai

c. mitoitettu toimimaan koko lämpötila-alueella 218 K (–55 °C) – 398 K (125 °C);

Huom.: 3A001.a.2 kohta ei koske siviiliautoihin tai juniin tarkoitettuja integroituja piirejä.

3A001

a. (jatkuu)

3. "Mikroprosessoripiirit", "mikrotietokonepiirit" ja mikro-ohjainpiirit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: 3A001.a.3 kohta sisältää digitaaliset signaaliprosessorit, digitaaliset matriisiprosessorit ja digitaaliset apuprosessorit.

a. Ei käytössä;

b. Valmistettu yhdistepuolijohteesta ja toimii kellotaajuudella, joka ylittää 40 MHz; tai

c. Rinnakkaisten "mikroprosessoripiirien" välillä on suoraa ulkoista liitäntää varten useampia kuin yksi tieto- tai käskyväylä tai sarjaliikenneportti, joiden siirtonopeus ylittää 150 Mbyte/s;

4. Integroidut muistipiirit, jotka on valmistettu yhdistepuolijohteista;

5. Seuraavat integroidut analogia-digitaalimuunnin- tai digitaali-analogiamuunninpiirit:

a. Analogia-digitaalimuuntimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: KATSO MYÖS 3A101 KOHTA.

1. Resoluutio 8 bittiä tai enemmän mutta alle 12 bittiä ja 'kokonaismuuntoaika' alle 5 ns;

2. Resoluutio 12 bittiä ja 'kokonaismuuntoaika' alle 20 ns;

3. Resoluutio yli 12 bittiä mutta enintään 14 bittiä ja 'kokonaismuuntoaika' alle 200 mikrosekuntia; tai

4. Resoluutio yli 14 bittiä ja 'kokonaismuuntoaika' alle 1 µs;

b. Digitaali-analogiamuuntimet, joiden resoluutio on 12 bittiä tai enemmän ja "asettumisaika" alle 10 ns;

Tekn. huom.:

1. $N:n$ bitin resoluutio vastaa $2^n:n$ vertailutason kvantisointia.

2. 'Kokonaismuuntoaika' on näytteenottotaajuuden käänteisluku.

6. Sähköoptiset tai "optiset integroidut piirit" "signaalinkäsittelyä" varten, joilla on kaikki seuraavat:

a. Yksi tai useampi sisäinen "laser" diodi;

b. Yksi tai useampi sisäinen valoa ilmaiseva elementti; a

c. Optisia aaltoputkia;

7. Käyttäjäohjelmoitavat logiikkapiirit, joilla on jokin seuraavista;

a. Ekvivalenttinen käytettävissä oleva porttiluku yli 30 000 (2 sisäänmenoa porttia kohti);

b. Tyypillinen perusportin etenemisviive vähemmän kuin 0,1 ns; tai

c. Tilanvaihtotaajuus ylittää 133 MHz;

Huom.: 3A001.a.7 kohtaan sisältyvät:

— Yksinkertaiset ohjelmoitavat logiikkapiirit (SPLD:t)

3A001 a. 7. c. (jatkuu)

- Monimutkaiset ohjelmoitavat logiikkapiirit (CPLD:t)
- Kentällä ohjelmoitavat porttimatriisipiirit (FPGA:t)
- Käyttäjäohjelmoitavat logiikkaverkot (FPLA:t)
- Kentällä ohjelmoitavat yhdyskomponentit (FPIC:t)

Huom.: 'Käyttäjäohjelmoitavat logiikkapiirit' tunnetaan myös nimellä 'kentällä ohjelmoitavat porttimatriisipiirit' tai 'käyttäjäohjelmoitavat logiikkaverkot'.

8. Ei käytössä;
9. Integroidut hermoverkkoapiirit;
10. Asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon, tai jotka on tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnallaisuus on valmistajalle tuntematon ja joilla on jokin seuraavista:
 - a. Liitospisteiden lukumäärä ylittää 1 000;
 - b. Tyypillinen "perusportin etenemisviive" on vähemmän kuin 0,1 ns; tai
 - c. Toimintataajuus ylittää 3 GHz;
11. Muut digitaaliset integroidut piirit kuin 3A001.a.3–3A001.a.10 tai 3A001.a.12 kohdassa kuvatut, jotka perustuvat yhdistepuolijohteisiin ja joilla on jokin seuraavista:
 - a. Ekvivalenttinen porttiluku on enemmän kuin 3 000 (2 sisäänmenoa porttia kohti); tai
 - b. Kellotaajuus ylittää 1,2 GHz;
12. Nopea-Fourier-muunnos -prosessorit (FFT), joiden nimellinen suoritus aika N:n pisteen kompleksiselle FFT-muunnokselle on vähemmän kuin $(N \log_2 N)/20$ 480 ms, jossa N on pisteiden lukumäärä;

Tekn. huom.:

Kun N on yhtä kuin 1 024 pistettä, 3A001.a.12 kohdan kaavan mukainen suoritus aika on 500 µs.

b. Mikroaalto- tai millimetriaaltolaitteet:

1. Seuraavat elektroniset tyhjöputket ja katodit:

Huom. 1. 3A001.b.1 kohta ei aseta valvonnallaiseksi putkia, jotka on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan taajuuskaistalla, joka täyttää kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. Joka ei ylitä 31,8 GHz; ja
- b. Jonka "ITU on allokoinut" radiaviestintäpalveluille, mutta ei radiomääritykselle.

Huom. 2. 3A001.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnallaiseksi muita kuin "avaruuskelpoisia" putkia, jotka täyttävät kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. Keskimääräinen lähtöteho on 50 W tai vähemmän; ja
- b. suunnitellut tai mitoitettut toimimaan taajuuskaistalla, joka täyttää kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Joka ylittää 31,8 GHz mutta ei ylitä 43,5 GHz; ja
 2. Jonka "ITU on allokoinut" radiaviestintäpalveluille, mutta ei radiomääritykselle.

3A001

b. 1. (jatkuu)

a. Seuraavat kulkuaaltoputket pulssi- tai jatkuville aalloille:

1. Jotka toimivat yli 31,8 GHz:n taajuuksilla;
2. Joiden hehkukatodien käynnistysaika nimelliseen RF-tehoon asti on vähemmän kuin 3 sekuntia;
3. Kytkeytyt onteloputket tai niiden muunnokset, joiden "suhteellinen kaistanleveys" on enemmän kuin 7 % tai huipputeho ylittää 2,5 kW;
4. Kierukkaputket tai niiden muunnokset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 - a. "Hetkellinen kaistanleveys" on enemmän kuin puoli oktaavia tai enemmän ja nimellisen keskimääräisen lähtötehon (kilowatteina) ja maksimitoimintataajuuden (gigahertseinä) tulo on enemmän kuin 0,5;
 - b. "Hetkellinen kaistanleveys" on yksi oktaavia tai alle ja nimellisen keskimääräisen lähtötehon (kilowatteina) ja maksimitoimintataajuuden (gigahertseinä) tulo on enemmän kuin 1; tai

c. Ovat "avaruuskelpoisia";

b. Ristikenttävahvistinputket, joiden vahvistus on enemmän kuin 17 dB,

c. Elektroniputkien kyllästetyt katodit, jotka tuottavat nimellisissä olosuhteissa jatkuvan emissiovirran tiheyden, joka ylittää 5 A/cm²;

2. Monoliittisina integroituina mikroaaltopiireinä (MMIC) toteutetut tehovahvistimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Ne toimivat yli 3,2 GHz:n ja enintään 6 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 4 W (36 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 15 prosenttia;
- b. Ne toimivat yli 6 GHz:n ja enintään 16 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 1 W (30 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 10 prosenttia;
- c. Ne toimivat yli 16 GHz:n ja enintään 31,8 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 0,8 W (29 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 10 prosenttia;
- d. Ne toimivat yli 31,8 GHz:n ja enintään 37,5 GHz:n taajuuksilla;
- e. Ne toimivat yli 37,5 GHz:n ja enintään 43,5 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 0,25 W (24 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 10 prosenttia, tai
- f. Ne toimivat yli 43,5 GHz:n taajuuksilla.

Huom. 1: 3A001.b.2 kohta ei aseteta valvonnanalaiseksi yleisradiolähetysiin tarkoitettujen satelliittien laitteita, jotka on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan 40,5–42,5 GHz:n taajuusalueella.

Huom. 2: Niiden MMIC-piirien valvonta-asema, joiden toimintataajuus ulottuu useammalle kuin yhdelle taajuusalueelle, sellaisina kuin ne on määritetty 3A001.b.2 kohdassa, määräytyy alimman keskimääräisen lähtötehon valvontakynnyksen mukaan.

Huom. 3: Ryhmän 3 johdannossa olevat huomautukset 1 ja 2 tarkoittavat sitä, että 3A001.b.2 kohta ei aseteta valvonnanalaiseksi MMIC-piirejä, jos ne on erityisesti suunniteltu muita sovelluksia, esimerkiksi televiestintää, tutkia tai autoja, varten.

3A001 b. (jatkuu)

3. Mikroaaltotransistorit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Ne toimivat yli 3,2 GHz:n ja enintään 6 GHz:n taajuuksilla ja niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 60 W (47,8 dBm);
- b. Ne toimivat yli 6 GHz:n ja enintään 31,8 GHz:n taajuuksilla ja niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 20 W (43 dBm);
- c. Ne toimivat yli 31,8 GHz:n ja enintään 37,5 GHz:n taajuuksilla ja niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 0,5 W (27 dBm);
- d. Ne toimivat yli 37,5 GHz:n ja enintään 43,5 GHz:n taajuuksilla ja niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 1 W (30 dBm), tai;
- e. Ne toimivat yli 43,5 GHz:n taajuuksilla.

Huom.: Niiden tuotteiden valvonta-asema, joiden toimintataajuus ulottuu useammalle kuin yhdelle taajuusalueelle, sellaisina kuin ne on määritelty 3A001.b.3 kohdassa, määräytyy alimman keskimääräisen lähtötehon valvontakynnyksen mukaan.

4. Puolijohde-mikroaaltovahvistimet ja mikroaaltovahvistimia sisältävät mikroaaltokokoonpanot/moduulit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Ne toimivat yli 3,2 GHz:n ja enintään 6 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 60 W (47,8 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 15 prosenttia;
- b. Ne toimivat yli 6 GHz:n ja enintään 31,8 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 15 W (42 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 10 prosenttia;
- c. Ne toimivat yli 31,8 GHz:n ja enintään 37,5 GHz:n taajuuksilla;
- d. Ne toimivat yli 37,5 GHz:n ja enintään 43,5 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 1 W (30 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 10 prosenttia;
- e. Ne toimivat yli 43,5 GHz:n taajuuksilla; tai
- f. Ne toimivat yli 3 GHz:n taajuuksilla ja niillä on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

- 1. Keskimääräinen lähtöteho (watteina), P, suurempi kuin 150 jaettuna toiseen potenssiin korotetulla suurimmalla toimintataajuudella (GHz:inä) $[P > 150 \text{ W} \cdot \text{GHz}^2 / f_{\text{GHz}}^2]$;
- 2. Suhteellinen kaistanleveys on 5 prosenttia tai suurempi; ja
- 3. Minkä tahansa kahden kohtisuorassa toisiaan vasten olevan sivun pituus d (cm:inä) on yhtä suuri tai pienempi kuin 15 jaettuna alimmalla toimintataajuudella (GHz:inä) $[d = 15 \text{ cm} \cdot \text{GHz} / f_{\text{GHz}}]$.

Huom.: MMIC-tehovahvistimet olisi arvioitava 3A001.b.2 kohdan vaatimuksiin nähden.

Huom. 1.: 3A001.b.4 kohta ei aseteta valvonnanalaiseksi yleisradiolähetyksiin tarkoitettujen satelliittien laitteita, jotka on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan 40,5–42,5 GHz:n taajuusalueella.

Huom. 2.: Niiden tuotteiden valvonta-asema, joiden toimintataajuus ulottuu useammalle kuin yhdelle taajuusalueelle, sellaisina kuin ne on määritelty 3A001.b.4 kohdassa, määräytyy alimman keskimääräisen lähtötehon valvontakynnyksen mukaan.

3A001

b. (jatkuu)

5. Elektronisesti tai magneettisesti viritettävät kaistanpäästö- tai kaistanestosuotimet, joissa on enemmän kuin 5 viritettävää resonaattoria, jotka voidaan viritellä vähemmässä kuin 10 mikrosekunnissa taajuuskaistalle, jonka $f_{\max}/f_{\min}$ on 1,5:1, ja joiden:

a. Päästökaistan leveys on enemmän kuin 0,5 % keskitaajuudesta; tai

b. Estokaistan leveys on vähemmän kuin 0,5 % keskitaajuudesta;

6. Ei käytössä.

7. Sekoittajat ja muuntimet, jotka on suunniteltu ulottamaan 3A002.c, 3A002.e tai 3A002.f kohdassa määriteltyjen laitteiden taajuusalueen kohdissa mainittujen rajojen ulkopuolelle;

8. Mikroaaltotehovahvistimet, jotka sisältävät 3A001.b kohdassa määriteltyjä putkia ja joilla on kaikki seuraavat:

a. Toimintataajuuksien ovat yli 3 GHz;

b. Keskimääräinen ulostulon suhde tiheyteen on 80 W/kg; ja

c. Tilavuus on vähemmän kuin 400 cm³;

Huom.: 3A001.b.8 kohta ei aseta valvonnallaiseksi laitteita, jotka on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan taajuuskaistalla, jonka "ITU on allokoimut" radioviestintäpalveluille, mutta ei radiomääritykselle.

c. Seuraavat akustiset aaltolaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1. Pinta-akustiset aaltolaitteet ja matalatila-akustiset laitteet (eli "signaalinkäsittely" laitteet, jotka käyttävät hyväkseen materiaalien elastisten aaltojen kulkua), joilla on jokin seuraavista:

a. Kantoaallon taajuus ylittää 2,5 GHz;

b. Kantoaallon taajuus ylittää 1 GHz, mutta ei 2,5 GHz ja jolla on jokin seuraavista:

1. Taajuuden sivukeilan vaimennus ylittää 55 dB;

2. Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina ja kaistanleveys megahertseinä) on enemmän kuin 100;

3. Kaistanleveys suurempi kuin 250 MHz; tai

4. Dispersiivinen viive on enemmän kuin 10 mikrosekuntia; tai

c. Kantoaallon taajuus 1 GHz tai vähemmän ja jokin seuraavista:

1. Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina ja kaistanleveys megahertseinä) on enemmän kuin 100;

2. Dispersiivinen viive on enemmän kuin 10 mikrosekuntia; tai

3. Taajuuden sivukeilan vaimennus ylittää 55 dB ja kaistanleveys suurempi kuin 50 MHz;

2. Kappaleakustiset (tila-akustiset) laitteet (eli "signaalinkäsittely" laitteet, jotka käyttävät hyväkseen elastisia aaltoja), jotka sallivat signaalien suoran prosessoinnin yli 1 GHz:n taajuuksilla;

3A001 c. (jatkuu)

3. Akusto-optiset "signaalinkäsittely" laitteet, jotka käyttävät hyväkseen ääniaaltojen (kappale- tai pinta-aaltojen) ja valoaaltojen vuorovaikutusta, ja jotka sallivat signaalien tai kuvien suoran käsittelyn, mukaan lukien spektrianalyysi, korrelaatio tai konvoluutio;
- d. Elektroniset laitteet tai piirit, jotka sisältävät "suprajohtavista" materiaaleista valmistettuja komponentteja, ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan ainakin yhden "suprajohtavan" ainesosansa "kriittisen lämpötilan" alapuolella, ja joilla on jokin seuraavista:
 1. Virtakytkentä digitaalipiireissä, joissa käytetään "suprajohtavia" portteja, joiden porttikohtaisen viiveen (sekunteina) ja porttikohtaisen tehohäviön (watteina) tulo on vähemmän kuin 10^{-14} J; tai
 2. Taajuuden valinta kaikilla taajuuksilla käyttäen resonanssiipiirejä, joiden Q-arvo ylittää 10 000;

e. Seuraavat suurenergialaitteet:

1. Seuraavat paristot ja valosähköiset paneelit:

Huom.: 3A001.e.1 kohta ei aseta valvonnallaiseksi paristoja, joiden tilavuus on 27 cm^3 tai vähemmän (esim. standardoidut C-parit tai R14-paristot).

- a. Ensiöparit tai -paristot, joiden 'energiatiheys' ylittää 480 Wh/kg ja jotka on mitoitettu toimimaan lämpötila-alueella alle 243 K (-30°C) ja yli 343 K (70°C) astetta;
- b. Uudelleenladattavat parit ja paristot, joiden 'energiatiheys' ylittää 150 Wh/kg 75:n lataus- ja purkamiskerran jälkeen, kun purkausvirta on C/5 tuntia (C on nimelliskapasiteetti ampeeritunteina) ja ne toimivat lämpötila-alueella alle 253 K (-20°C) ja yli 333 K (60°C) astetta;

Tekn. huom.:

'Energiatiheys' saadaan kertomalla keskimääräinen teho watteina (keskimääräinen jännite voltteina kertaa keskimääräinen virta ampeereina) ajalla (tunteina), joka kuluu purkautumiseen 75 %:iin avoimen piirin jännitteestä, jaettuna parin (tai pariston) kokonaismassalla kiloina.

- c. "Avaruuskelpoiset" ja säteilyä kestävät valosähköiset paneelit, joiden ominaisteho ylittää 160 W/m^2 301 K (28°C) asteen toimintalämpötilassa ja volframivalaistuksessa, joka on 1 kW/m^2 2 800 K ($2\,527^\circ\text{C}$) asteessa;
2. Seuraavat suurenergiset varauskondensaattorit:

Huom: KATSO MYÖS 3A201.a KOHTA

- a. Kondensaattorit, joiden toistotiheys on alle 10 Hz (kertatoimiset kondensaattorit) ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Nimellisjännite 5 kV tai enemmän;
 2. Energiatiheys 250 J/kg tai enemmän; ja
 3. Kokonaisenergia 25 kJ tai enemmän;

3A001

e. 2. (jatkuu)

b. Kondensaattorit, joiden toistotiheys on 10 Hz tai enemmän (toistuvatoimiset kondensaattorit) ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Nimellisjännite 5 kV tai enemmän;
2. Energiatiheys on 50 J/kg tai enemmän;
3. Kokonaisenergia on 100 J tai enemmän; ja
4. Lataus-purkuikä on 10 000 tai enemmän;

3. "Suprajohtavat" sähkömagneetit tai solenoidit, jotka on erityisesti suunniteltu täysin ladattaviksi tai purettaviksi alle 1 sekunnissa ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Huom: KATSO MYÖS 3A201.b KOHTA

Huom.: 3A001.e.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "suprajohtavia" sähkömagneetteja tai solenoideja, jotka on erityisesti suunniteltu magneettiresonanssikuvausta (MRI) varten lääketieteellisiin laitteisiin.

- a. Purkauksen aikana luovutettu maksimienergia on enemmän kuin 10 kJ ensimmäisen sekunnin aikana;
- b. Virtakäämien sisäläpimitta on yli 250 mm; ja
- c. Magneettisen induktion nimellisarvo on enemmän kuin 8 T tai "kokonaisvirrantiheys" käämissä on yli 300 A/mm²;

f. Pyöriväsyötteiset akselin absoluuttisen asennon kooderit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Resoluutio on parempi kuin 1 osa 265 000:sta (18 bitin resoluutio) koko alueella; tai
2. Tarkkuus on parempi kuin $\pm 2,5$ kaarisekuntia;

3A002

Yleiskäyttöiset elektroniset laitteet:

a. Seuraavat nauhoituslaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut testinauhat:

1. Analogiset instrumentointinauhurit, mukaan lukien ne, jotka mahdollistavat myös digitaalisten signaalien tallentamisen (esim. käyttämällä suuri- ja aleniirityksen digitaalisen tallennuksen (HDDR) mahdollistavaa moduulia), joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Kaistanleveys ylittää 4 MHz kullakin elektronisella kanavalla tai nauhan raidalla;
- b. Kaistanleveys ylittää 2 MHz kullakin elektronisella kanavalla tai nauhan raidalla ja raitojen määrä ylittää 42; tai
- c. Soveltuvan IRIG:n (International Range Instrumentation Group) tai EIA:n (Electronic Industries Association) suosituksen mukaisesti mitattu aika(taso)siirtymävirhe on alle $\pm 0,1$ mikrosekuntia;

Huom.: Analogisia nauhureita, jotka on erityisesti suunniteltu siviilivideotarkoituksiin ei katsota instrumentointinauhureiksi.

2. Digitaaliset videonauhurit, joiden digitaali-liitännän maksimisiirtonopeus ylittää 360 Mbit/s;

Huom.: 3A002.a.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi digitaalisia videonauhureita, jotka on erityisesti suunniteltu televisionauhoituksiin käyttäen sellaista signaalimuotoa, johon saattaa sisältyä ITU:n (International Telecommunication Unit), IEC:n (International Technical Commission), SMPTE:n (Society of Motion Picture and Television Engineers), EBU:n (European Broadcasting Unit), ETSI:n (European Telecommunications Standards Institute) tai IEEE:n (Institute of Electrical and Electronic Engineers) standardien tai suositusten mukainen tiivistetty signaalimuoto siviilitelevisionsovelluksissa.

3A002 a. (jatkuu)

3. Viistopyyhkäisytekniikkaa tai kiinteäpää-tekniikkaa käyttävät digitaaliset instrumentointinauhurit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Digitaaliiliitännän maksimisiirtonopeus ylittää 175 Mbit/s; tai

b. Ovat "avaruuskelpoisia";

Huom.: 3A002.a.3 kohta ei aseta valvonnallaiseksi analogisia nauhureita, jotka on varustettu HDDR-konversioelektronikalla ja jotka on tarkoitettu vain digitaalisen tiedon nauhoittamiseen.

4. Laitteet, joiden digitaalisen liitännän maksimisiirtonopeus ylittää 175 Mbit/s ja jotka on suunniteltu muuntamaan digitaaliset videonauhurit instrumentointinauhureina käytettäväksi;

5. Aaltomuodon digitointilaitteet ja transienttitallentimet, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a. Digitointinopeus on 200 miljoonaa näytteenottoa sekunnissa tai enemmän ja resoluutio 10 bittiä tai enemmän; ja

b. Jatkuva käsittelykyky 2 Gbit/s tai enemmän;

Tekn. huom.:

Laitteille, joissa on rinnakkaisväyläarkkitehtuuri jatkuva käsittelykyky on suurin sanansiirtonopeus kerrottuna sanan bittien lukumäärällä.

Jatkuva käsittelykyky tarkoittaa suurinta tiedonsiirtonopeutta, jonka laite voi tulostaa massamuistiin tietoa menettämättä samalla kun se ylläpitää näytteenottonopeutta ja analogia-digitaalimuunnosta.

6. Digitaaliset instrumentointitietonauhoittimet, joissa käytetään magneettilevymuistitekniikkaa ja joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

a. Digitointinopeus vähintään 100 miljoonaa näytettä sekunnissa ja resoluutio 8 bittiä tai enemmän; ja

b. Jatkuva suorituskkyky, joka on vähintään 1 Gbit/s;

- b. Elektroniset "taajuussyntesoija"kokoonpanot, joiden "taajuuden vaihto aika" yhdeltä valitulta taajuudelta toiselle on vähemmän kuin 1 ms;

- c. Seuraavat radiotaajuus "signaalianalysaattorit":

1. "Signaalianalysaattorit", jotka kykenevät analysoimaan yli 31,8 GHz:n mutta alle 37,5 GHz:n, tai yli 43,5 GHz:n taajuuksia;

2. "Dynaamiset signaalianalysaattorit", joiden "tosiaikainen taajuuskaista" ylittää 500 kHz;

Huom.: 3A002.c.2 kohta ei aseta valvonnallaiseksi niitä "dynaamisia signaalianalysaattoreita", jotka käyttävät vain "vakiosuhteisia kaistasuotimia" (kutsutaan myös oktaavi- tai osaoktaavisuotimiksi).

- d. Taajuussyntesoiivat signaaligeneraattorit, joiden tuottamien lähtötaajuuksien tarkkuus ja lyhyen tai pitkän aikavälin stabiilius on sisäisen perustaajuuden ohjaama, siitä johdettu tai sen määräämä, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Syntesoitu maksimitaajuus ylittää 31,8 GHz mutta ei ylitä 43,5 GHz:iä ja on mitoitettu tuottamaan alle 100 ns:n pulssinkesto;

2. Syntesoitu maksimitaajuus ylittää 43,5 GHz;

3A002

d. (jatkuu)

3. "Taajuuden vaihto aika" yhdeltä valitulta taajuudelta toiselle on vähemmän kuin 1 ms; tai
4. Yksisivukaistan (SSB) vaihekohina on parempi kuin $-(126 + 20 \log_{10} F - 20 \log_{10} f)$, dBc/Hz, jossa F on toimintataajuuden poikkeama hertseinä ja f on toimintataajuus megahertseinä;

Tekn. huom.:

3A002.d.1 kohdassa tarkoitetaan 'pulssinkestolla' aikaa, joka kuluu siitä, kun pulssin etureuna saavuttaa 90 prosenttia huipusta, siihen, kun pulssin takareuna saavuttaa 10 prosenttia huipusta.

Huom.: 3A002.d kohta ei aseta valvonnallaiseksi laitteita, joissa lähtötaajuus aikaansaadaan joko laskemalla yhteen tai vähentämällä toisistaan kahden tai useamman kideoskillaattorin taajuuksia ja kertomalla siten saatu tulos.

- e. Verkkoanalysointilaitteet, joiden maksimitoimintataajuus ylittää 43,5 GHz;
- f. Mikroaaltotestivastaanottimet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Maksimitoimintataajuus ylittää 43,5 GHz; ja
 2. Ne kykenevät mittaamaan samanaikaisesti sekä amplitudia että vaihetta;
- g. Atomitaajuusstandardit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 1. Pitkän aikavälin (vanhenemis-) stabiilius on vähemmän (parempi) kuin 1×10^{-11} kuukaudessa; tai
 2. Ne ovat "avaruuskelpoisia".

Huom.: 3A002.g.1 kohta ei aseta valvonnallaiseksi ei- "avaruuskelpoisia" rubidiumstandardeja.

3A003

Suihkujäähdytteiset lämmönsäätelyjärjestelmät, joissa käytetään suljettua nesteenkäsittely- ja uudelleenkasittelylaitteistoja umpinaisessa rakenteessa ja joissa dielektristä nestettä suihkutetaan elektronisiin komponentteihin käyttäen erityisesti suunniteltuja suihkusuuttimia ja jotka on suunniteltu pitämään elektroniset komponentit niiden käyttölämpötilan alueella sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

3A101

Seuraavat, muut kuin 3A001 kohdassa määritellyt elektroniset laitteet, laitteet ja komponentit:

- a. "Ohjuksissa" käyttökelpoiset analogia-digitaalimuuntimet, jotka on suunniteltu vastaamaan sotilasspesifikaatioiden kovaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden vaatimuksia;
- b. Kiihdyttimet, joilla pystytään lähettämään sähkömagneettista säteilyä, joka tuotetaan 2 MeV:n energiaan tai sen yli kiihdytettyjen elektronien jarrutussäteilyn (bremsstrahlung) avulla, sekä näitä kiihdyttimiä sisältävät järjestelmät.

Huom.: 3A101.b kohdassa ei määritellä laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu lääketieteellisiin tarkoituksiin.

3A201

Seuraavat muut kuin 3A001 kohdassa määritellyt elektroniset komponentit:

- a. Kondensaattorit, joilla on joko 1. tai 2. kohdassa luetellut ominaisuudet:
 1. a. Nimellisjännite suurempi kuin 1,4 kV
 - b. Energian varastointikyky suurempi kuin 10 J
 - c. Kapasitanssi suurempi kuin 0,5 µF ja
 - d. Sarjainduktanssi vähemmän kuin 50 nH; tai
2. a. Nimellisjännite suurempi kuin 750 V
- b. Kapasitanssi suurempi kuin 0,25 µF ja
- c. Sarjainduktanssi vähemmän kuin 10 nH;

3A201 (jatkuu)

b. "Suprajohtavat" solenoidisähkömagneetit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Pystyvät muodostamaan yli 2 T:n magneettikenttiä;
2. Pituuden suhde sisähalkaisijaan on suurempi kuin 2;
3. Sisähalkaisija yli 300 mm; ja
4. Magneettikenttä poikkeaa vähemmän kuin 1 % tasaisesta kentästä sisätilavuuden keskeisen puoliskon (50 %) alueella;

Huom.: 3A201.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi magneetteja, jotka on erityisesti suunniteltu lääketieteellisten ydinmagneettiseen resonanssiin (NMR) perustuvien kuvanmuodostusjärjestelmien 'osiksi'. Sana 'osiksi' ei välttämättä tarkoita saman toimituksen fyysistä osaa; erilliset toimitukset ovat sallittuja eri lähteistä, mikäli niihin liittyvissä vientiasiakirjoissa selvästi mainitaan, että toimitukset lähetetään kuvanmuodostusjärjestelmän 'osiksi'.

c. Seuraavat välähtävät röntgensalamageneraattorit tai pulssitoimitiset elektronikiihdyttimet, joilla on joko a. tai b. kohdassa luetellut ominaisuudet:

1. a. Kiihdyttimen huippuelektronienenergia on 500 keV tai suurempi, mutta pienempi kuin 25 MeV; ja
 - b. "Hyvyysluku" (K) on 0,25 tai suurempi; tai
2. a. Kiihdyttimen huippuelektronienenergia on 25 MeV tai suurempi; ja
 - b. Huipputeho on suurempi kuin 50 MW.

Huom.: 3A201.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kiihdyttimiä, jotka ovat muuhun kuin elektronisuihku- tai röntgensäteilytykseen (esimerkiksi elektronimikroskopiaan) suunniteltujen laitteiden komponentteja eikä niitä, jotka on suunniteltu lääketieteellisiä laitteita varten.

Tekn. huom.:

1. 'Hyvyysluku' K on määritelty seuraavasti:

$$K = 1,7 \times 10^{\{3\}V^{\{2,65\}Q}}$$

V on huippuelektronienenergia miljoonina elektronivolteina.

Jos elektronipulssin kesto on pienempi tai yhtä suuri kuin 1 mikrosekunti, Q on kiihdytetty kokonaisvaraus coulombeina. Jos elektronipulssin kesto on suurempi kuin 1 mikrosekunti, Q on 1 mikrosekunnissa kiihdytetty maksimisähkövaraus.

Q on yhtä kuin elektronivirran i integraali ajan t suhteen ($Q = \int i dt$), jossa i on säteen virta ampeereina ja t aika sekunneissa.

2. 'Huipputeho' = (huippujännite voltteina) $\times$ (säteen huippuvirta ampeereina).
3. Mikroaaltokiihdytysonteloihin perustuvissa koneissa pulssin kesto on pienempi kahdesta seuraavasta: 1 μ s tai yhden mikroaaltomodulaattorin pulssin tuottaman tiivistetyn pulssipaketin kesto.
4. Mikroaaltokiihdytysonteloihin perustuvissa koneissa säteen huippuvirta on tiivistetyn pulssipaketin keskimääräinen virta sen keston aikana.

3A225 Muut kuin 0B001.c.13 kohdassa määritellyt taajuusmuuntimet tai generaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. Monivaiheulostulo kykenee antamaan 40 W tai suuremman tehon;
- b. Kykenee toimimaan 600–2 000 Hz:n taajuusalueella;
- c. Harmoninen kokonaissärö on parempi (pienempi) kuin 10 %; ja
- d. Taajuuden säätö on parempi (pienempi) kuin 0,1 %.

Tekn. huom.:

3A225 kohdan taajuusmuuntimia kutsutaan myös konverttereiksi tai inverttereiksi.

3A226 Muut kuin 0B001.j.6 kohdassa mainitut tasavirtasuurteholähteet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

- a. Ne kykenevät 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan 100 V:n tai korkeamman jännitteen 500 A:n tai suuremmalla virralla; ja
- b. Niiden jännitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 8 tunnin jakson aikana.

3A227 Muut kuin 0B001.j.5 kohdassa määritellyt tasavirtakorkeajännitelähteet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

- a. Ne kykenevät 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan 20 kV tai korkeamman jännitteen 1 A:n tai suuremmalla virralla; ja
- b. Niiden jännitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 8 tunnin jakson aikana

3A228 Seuraavat kytkinlaitteet:

- a. Kylmäkatodiputket, olivatpa ne sitten kaasutäytteisiä tai ei, jotka toimivat kipinävälin tavoin ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne sisältävät kolme tai useampia elektrodeja;
2. Huippuanodijännitteen nimellisarvo on 2,5 kV tai enemmän;
3. Huippuanodivirran nimellisarvo on 100 A tai enemmän; ja
4. Anodin viiveaika on 10 µs tai lyhyempi;

Huom.: 3A228 kohtaan sisältyvät kaasukryptonputket ja tyhjösprytonputket.

- b. Liipaistavat kipinävälit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

1. Anodiviiveaika on 15 µs tai lyhyempi; ja
2. huippuvirran nimellisarvo 500 A tai enemmän;

- c. Nopeatoiset kytkinmodulit tai -kokoonpanot, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Huippuanodijännitteen nimellisarvo on suurempi kuin 2 kV;
2. Huippuanodivirran nimellisarvo on 500 A tai enemmän; ja
3. Kytkeäaika on 1 µs tai vähemmän.

3A229 Seuraavat laukaisulaitteet ja vastaavat suurvirtapulssigeneraattorit:

Huom: KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO.

- a. Räjähävien sytyttimien laukaisulaitteet, jotka on suunniteltu laukaisemaan 3A232 kohdassa määriteltyjä valvonnanalaisia monipistesytyttimiä;
- b. Moduulirakenteiset sähköpulssigeneraattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Ne on suunniteltu liikkuviksi tai vaativissa olosuhteissa käytettäväksi;
 2. Ne on koteloitu pölytiivisti;
 3. Pystyvät luovuttamaan energiansa alle 15 µs:ssa;
 4. Lähtövirta on suurempi kuin 100 A;
 5. 'Nousuaika' on lyhyempi kuin 10 µs alle 40 ohmin kuormituksella.
 6. Mikään ulottuvuus ei ole suurempi kuin 254 mm;
 7. Paino on alle 25 kg; ja
 8. Ne on määritelty käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella (223 K (– 50 °C) 373 K (100 °C) astetta) tai sopiviksi "avaruussovelluksiin".

Huom.: 3A229.b kohtaan sisältyvät ksenonsalamavalon käyttölaitteet.

Tekn. huom.:

3A229.b.5 kohdassa 'nousuaika' on aikaväli, jonka kuluessa virran amplitudi kasvaa 10 prosentista 90 prosenttiin, kun kuorma on resistiivinen.

3A230 Erittäin nopeat pulssigeneraattorit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

- a. Lähtöjännite on yli 6 V alle 55 ohmin resistiivisellä kuormalla; ja
- b. 'Pulssin nousuaika' on lyhyempi kuin 500 ps.

Tekn. huom.:

3A230 kohdassa 'pulssin nousuaika' määritellään ajaksi, jonka kuluessa jännite nousee 10 prosentista 90 prosenttiin jännitteen amplitudista.

3A231 Neutronigeneraattorijärjestelmät, mukaan lukien putket, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

- a. Ne on suunniteltu toimimaan ilman ulkoista tyhjöjärjestelmää; ja
- b. Hyväksikäyttävät sähköstaattista kiihdytystä tritium-deuteriumydinreaktion synnyttämiseen.

3A232 Seuraavat sytyttimet ja monipistesytytinjärjestelmät:

Huom: KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO.

- a. Seuraavat sähköisesti ohjattavat räjähtävät sytyttimet:
 1. Räjähtävä siltajohdin (EB);
 2. Räjähtävä siltajohdinlanka (EBW);
 3. Iskulaukaisin;
 4. Räjähtävät kalvosytyttimet (EFI);
- b. sJärjestelyt, joita käyttäen voidaan yhdellä tai usealla sytyttimellä sytyttää räjähdyspinta yli 5 000 mm²:n alalla yhdellä laukaisusignaalilla lähes samanaikaisesti, sytytyksen ajoitus leviää koko pinta-alalle vähemmässä kuin 2,5 µs:ssa.

3A232 (jatkuu)

Huom.: Tämä kohta ei aseta valvonnallaiseksi sytyttimiä, joissa käytetään vain ensiöräjähteitä, esimerkiksi lyijyatsidia.

Tekn. huom.:

3A232 kohdassa kaikki kyseiset sytyttimet käyttävät pientä sähköjohdinta (siltavastusta, siltavastuslankaa tai kalvoa), joka kaasuuntuu räjähdysmäisesti, kun nopea, voimakas sähköinen pulssi kulkee sen läpi. Muissa kuin iskulaukaisintyypeissä räjähtävä johdin käynnistää kemiallisen räjähdyskäsien yhteydessä olevassa voimakkaassa räjähteessä, esim. PETN:ssä (pentaerytritoltetranitratissa). Iskulaukaisimissa sähköjohtimen kaasuuntuminen työntää piikin tai iskurin sytyttimen välin yli ja iskurin törmäys räjähteeseen käynnistää kemiallisen sytytyksen. Joissakin malleissa iskurin käyttövoimana on magneettinen voima. Termiä räjähtävä kalvo voidaan käyttää joko EB- tai iskurityyppisistä sytyttimistä.

3A233 Seuraavat, muut kuin 0B002.g kohdassa määritelty massaspektrometrit, jotka kykenevät mittaamaan atomipainoltaan 230 tai raskaampia ioneja, ja joiden resoluutio on parempi kuin 2 osaa 230:stä ja niiden ionilähteet:

- a. Induktiivisesti kytketyt plasmamassaspektrometrit (ICP/MS = Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometers);
- b. Hehkupurkausmassaspektrometrit (GDMS = Glow Discharge Mass Spectrometers);
- c. Termistä ionisaatiota käyttävät massaspektrometrit (TIMS = Thermal Ionization Mass Spectrometers);
- d. Elektronipommitusmassaspektrometrit, joiden lähdekammio on tehty, vuorattu tai päällystetty UF₆-kestävillä materiaaleilla;
- e. Molekyylisuihkumassaspektrometrit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 1. Lähdekammio on valmistettu, vuorattu tai päällystetty ruostumattomalla teräksellä tai molybdeenillä ja varustettu kylmäloukulla, joka kykenee jäähtymään 193 K (–80 °C) asteeseen tai sen alle; tai
 2. Lähdekammio on valmistettu, vuorattu tai päällystetty UF₆-kestävillä materiaaleilla;
- f. Massaspektrometrit, jotka on varustettu aktinideja tai aktinidifluorideja varten käytettäväksi suunnitellulla mikrofluorausionilähteellä.

3B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

3B001 Seuraavat puolijohdekomponenttien tai -materiaalien valmistuslaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut osat ja komponentit:

a. Seuraavat epitaksikasvatusta varten suunnitellut laitteet:

1. Laitteet, jotka kykenevät tuottamaan jonkin seuraavista:

a. Vähintään 200 mm:n matkalla silikonikerroksen, jonka kerrospaksuuden vaihtelu on alle $\pm 2,5\%$; tai

b. Vähintään 75 mm:n matkalla kerroksen muuta materiaalia kuin silikonia ja kerrospaksuuden vaihtelu on alle $\pm 2,5\%$;

2. Reaktorit, jotka suorittavat metalliorgaanista kemiallista kaasufaasipinnoitusta (MOCVD) ja jotka on erityisesti suunniteltu yhdistepuolijohdekiteiden kasvatukseen käyttäen kohtien 3C003 tai 3C004 mukaan valvonnanalaisien materiaalien välistä kemiallista reaktiota;

3. Molekyyli-suihku-epitaksikasvatuslaitteet, jotka käyttävät kaasuihku- tai kiinteitä lähteitä;

b. Laitteet, jotka on suunniteltu ioni-istutusta varten ja joilla on jokin seuraavista:

1. Säteen energia (kiihdytysjännite) ylittää 1 MeV;

2. Ne on erityisesti suunniteltu ja optimoitu toimimaan pienemmällä kuin 2 keV:n säteen energialla (kiihdytysjännitteellä);

3. Mahdollistavat kuvion suoran istutuksen; tai

4. Säteen energia vähintään 65 keV ja säteen virta vähintään 45 mA, jotta voidaan suorittaa korkea-energinen happi-istutus kuumennettuun puolijohde "substraattiin";

c. Seuraavat anisotrooppiset plasmakuivasyövytyslaitteet:

1. Laitteet, joissa on kasetista-kasettiin toiminta ja syöttökammiot ja joissa on jokin seuraavista:

a. Ne on suunniteltu tai optimoitu tuottamaan minimiviivanleveyden, joka on 0,3 μm tai vähemmän $\pm 5\%$ 3 sigman tarkkuudella); tai

b. Ne on suunniteltu kehittämään cm^2 :ä kohden vähemmän kuin 0,04 partikkelia, joiden mitattavissa oleva koko on halkaisijaltaan suurempi kuin 0,1 μm ;

2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.e kohdan mukaan valvonnanalaisia laitteita varten ja joissa on jokin seuraavista:

a. Ne on suunniteltu tai optimoitu tuottamaan kriittiset mitat, jotka ovat 0,3 μm tai vähemmän $\pm 5\%$ 3 sigman tarkkuudella); tai

b. Ne on suunniteltu kehittämään cm^2 :ä kohden vähemmän kuin 0,04 partikkelia, joiden mitattavissa oleva koko on halkaisijaltaan suurempi kuin 0,1 μm ;

d. Seuraavat plasma-CVD -laitteet:

1. Laitteet, joissa on kasetista-kasettiin toiminta ja syöttökammiot ja jotka on suunniteltu valmistajan eritelmien mukaan tai optimoitu käytettäväksi sellaisten puolijohdelaitteiden tuotannossa, joiden kriittiset mitat ovat 180 nm tai vähemmän;

3B001

d. (jatkuu)

2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.e kohdan mukaan valvonnanalaisia laitteita varten ja jotka on suunniteltu valmistajan eritelmien mukaan tai optimoitu käytettäväksi sellaisten puolijohdelaitteiden tuotannossa, joiden kriittiset mitat ovat 180 nm tai vähemmän;

e. Automaattisyöttöiset monikammioiset puolijohdekierokkojen käsittelyjärjestelmät, joilla on kaikki seuraavat:

1. Menetelmät kierokkojen syöttöä ja ulosottoa varten ja joihin voidaan liittää enemmän kuin kaksi puolijohdeprosessilaitetta; ja
2. Suunnitelmu muodostamaan tyhjässä toimiva integroitu järjestelmä useiden kierokkojen peräkkäistä prosessointia varten.

Huom.: 3B001.e kohta ei aseta valvonnanalaiseksi automaattisia kierokkojen robotikkäsittelijöitä, joita ei ole suunniteltu toimimaan tyhjässä.

f. Seuraavat litografialaitteet:

1. Askeltavat kohdistus- ja valotuslaitteet (suora kohdistus kiekkoon) tai kohdistus- ja pyyhkäisy- (skanneri) laitteet kierokkojen prosessointia varten, jotka käyttävät foto-optisia tai röntgenmenetelmiä ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Valolähteen aallonpituus lyhyempi kuin 350 nm; tai
- b. Ne pystyvät tuottamaan kuvion, jonka 'pienin erottuva kuvion' koko on 0,35 µm tai vähemmän;

Tekn. huom.:

'Pienimmän erottuvan kuvion' koko lasketaan seuraavalla kaavalla:

$$\text{MRF} = \frac{(\text{aallonpituus mikrometreinä}) \times (K \text{ kerroin})}{\text{numeerinen aukko}}$$

jossa: K kerroin = 0,7

MRF on pienin erottuva kuvion koko.

2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu maskien valmistukseen tai puolijohdekomponenttien prosessointiin käyttäen poikkeutettua ja fokuoitetua elektronisuihkua, ionisuihkua tai "laser" sädettä, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Suihkun tai säteen pisteen koko on pienempi kuin 0,2 µm;
- b. Kykenevät tuottamaan kuvioita, joiden viivaleveys on vähemmän kuin 1 µm; tai
- c. Kohdistustarkkuus on parempi kuin ± 0,20 µm (3 sigma).

g. Maskit tai retikkelit, jotka on suunniteltu 3A001 kohdassa määriteltyjä integroituja piirejä varten;

h. Monikerrosmaskit, joissa on vaihesiirtokerros.

Huom.: 3B001.h kohta ei aseta valvonnanalaiseksi monikerrosmaskeja, joissa on vaihesiirtokerros ja jotka on suunniteltu sellaisten muistilaitteiden valmistukseen, joita ei aseteta valvonnanalaiseksi 3A001 kohdassa.

3B002

Seuraavat "ohjelmallisesti ohjatut" testauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu valmiiden tai puolivalmiiden puolijohteiden ja erityisesti niitä varten suunniteltujen komponenttien ja tarvikkeiden testaamiseen:

- a. Laitteet transistorien S-parametrien testaukseen yli 31,8 GHz:n alueella;

3B002 (jatkuu)

- b. Integroitujen piirien ja niistä muodostuvien kokoonpanojen testauslaitteet, jotka kykenevät suorittamaan toiminnallista (totuustaulu-) testausta yli 667 MHz:n 'bittikuvionopeudella';

Huom.: 3B002.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu testaamaan:

1. Koti- tai viihdekäyttöön tarkoitettujen laitteiden "elektronisia kokoonpanoja" tai "kokoonpano"-luokkia;
2. Valvonnan ulkopuolisia "elektronisia komponentteja", "elektronisia kokoonpanoja" tai integroituja piirejä;
3. Muistit

Tekn. huom.:

Tässä kohdassa 'bittikuvionopeudella' tarkoitetaan testauslaitteen digitaalisen toiminnan suurinta taajuutta. Näin ollen se vastaa suurinta tietonopeutta, jonka testauslaite voi saavuttaa muussa kuin multipleksoidussa toimintatilassa. Se tunnetaan myös nimillä testinopeus, suurin digitaalinen taajuus ja suurin digitaalinen nopeus.

- c. Laitteet 3A001.b.2 kohdassa määriteltyjen integroitujen mikroaaltopiirien testaukseen.

3C Materiaalit

3C001 Hetero-epitaksimateriaalit, jotka koostuvat "substraatista", jonka päälle on epitaksiasti kasvatettu useita kerroksia seuraavia aineita:

- a. Pii;
- b. Germanium;
- c. Piikarbidi; tai
- d. Galliumin tai indiumin III/V-yhdisteet.

Tekn. huom.:

III/V-yhdisteet ovat monikiteisiä valmisteita tai binaarisia tai kompleksisia yksikiteisiä valmisteita, jotka koostuvat Mendelejevin jaksollisen luokitusaulun ryhmien IIIA ja VA alkuaineista (esim. galliumarsenidi, galliumalumiiniarsenidi, indiumfosfidi).

3C002 Seuraavat estopinnoitemateriaalit ja valvonnanalaisilla estopinnoitemateriaaleilla pinnoitetut "substraatit":

- a. Positiiviestopinnoitteet, joiden spektrivaste on erityisesti sovitettu (optimoitu) alle 350 nm:n aallonpituuksille;
- b. Kaikki estopinnoitteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi elektroni- tai ionisuihkun kanssa ja joiden herkkyys on 0,01 mikrocoulombia/mm² tai parempi;
- c. Kaikki röntgenestopinnoitteet, joiden herkkyys on 2,5 mJ/mm² tai parempi;
- d. Kaikki pintakuvausteknologiaa varten optimoidut estopinnoitteet, 'piitetyt' resistit mukaan lukien.

Tekn. huom.:

'Piittämis' tekniikka on prosessi, jossa käytetään estopinnoitteen pinnan oksidointia parantamaan sen ominaisuuksia sekä märkä- että kuivakehityksessä.

3C003 Seuraavat orgaanis-epäorgaaniset yhdisteet:

- a. Metallorgaaniset alumiini-, gallium- tai indiumyhdisteet, joiden (perusmetallin) puhtaus (metalleista) on parempi kuin 99,999 %;
- b. Arseeniorgaaniset, antimoni-orgaaniset ja fosfori-orgaaniset yhdisteet, joiden puhtaus (epäorgaanisista aineista) on parempi kuin 99,999 %.

Huom.: 3C003 kohta asettaa valvonnanalaiseksi vain yhdisteet, joiden metallinen, osittain metallinen tai ei-metallinen elementti on suoraan liittynyt hiileen molekyylin orgaanisessa osassa.

3C004 Fosfori-, arseeni- tai antimonihydrit, joiden puhtaus on parempi kuin 99,999 %, myös jalokaasuilla tai vedyllä laimennettuina.

Huom.: 3C004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi hydridejä, jotka sisältävät 20 mooliprosenttia tai enemmän jalokaasuja tai vetyä.

3D Ohjelmistot

3D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 3A001.b–3A002.g tai 3B kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

3D002 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu jonkin seuraavista "käyttöä" varten:

a. 3B001.a–f kohdassa tarkoitetut laitteet; tai

b. 3B002 kohdassa tarkoitetut laitteet.

3D003 Fysiikkapohjaiset simulaatio-"ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu sellaisten litografia-, syövytys- ja pinnoitusprosessien "kehittämiseen", jotka muuntavat maskin kuviot erityisiksi topografisiksi johtimien, eristeiden ja puolijohdemateriaalien kuvioiksi.

Tekn. huom.:

'Fysiikkapohjaisella' tarkoitetaan 3D003 kohdassa laskelmien käyttämistä fysikaalisten syy ja seuraus -tapahtumien jakson määrittämiseen fysikaalisten ominaisuuksien perusteella (esimerkiksi lämpötila, paine, diffuusiokvot ja puolijohdemateriaalien ominaisuudet).

Huom.: Kirjastot, suunnitteluparametrit sekä niihin liittyvät tiedot puolijohdekomponenttien ja integroitujen piirien suunnittelua varten käsitetään "teknologiaksi".

3D004 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 3A003 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä" varten.

3D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 3A101.b kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

3E Teknologia

3E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A, 3B tai 3C kohdassa määriteltyjen laitteiden ja materiaalien "kehittämistä" ja "tuotantoa" varten.

Huom. 1: 3E001 kohta ei aseta valvonnallaiseksi 3A003 kohdassa valvottujen laitteiden tai komponenttien "tuotantoa" varten tarvittavaa teknologiaa.

Huom. 2: 3E001 kohta ei aseta valvonnallaiseksi sellaisten 3A001.a.3–3A001.a.12 kohtien mukaan valvonnan-alaisten integroitujen piirien, "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten tarvittavaa "teknologiaa", joilla on seuraavat ominaisuudet:

1. Perustuvat 0,5:n mikrometrin tai karkeampaan "teknologiaan"; ja
2. Eivät sisällä "monikerrosrakenteita".

Tekn. huom.:

Termi "monikerrosrakenteet" ei sisällä komponentteja, joissa on korkeintaan kolme metallikerrosta ja kolme monikerrosta piikerrosta.

3E002 Muu kuin 3E001 kohdassa määritelty "teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti sellaisten "mikroprosessoripiirien", "mikrotietokonepiirien" ja mikro-ohjainpiirien "kehittämistä" ja "tuotantoa" varten, joiden "yhdistetty teoreettinen tehokkuus" ("CTP") on 530 miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnissa (Mtops) tai enemmän ja joiden aritmeettisloogisen yksikön hakuleveys on 32 bittia tai enemmän.

Huom.: 3E001 kohtaa koskeva valvonnan soveltamatta jättämistä koskeva huomautus 2 koskee myös 3E002 kohtaa.

3E003 Muu "teknologia" seuraavien komponenttien "kehittämistä" ja "tuotantoa" varten:

- a. Tyhjö-mikroelektroniset komponentit;
- b. Heterorakenteiset puolijohdekomponentit, kuten korkean elektroniliikkuvuuden transistorit (HEMT), heterobipolaaritransistorit (HBT), kvanttikuoppa- tai superhilakomponentit;

Huom.: 3E003.b kohdassa ei aseteta valvonnallaiseksi teknologiaa alle 31,8 GHz:n taajuuksilla toimivia HEMT-transistoreja varten ja alle 31,8 GHz:n taajuuksilla toimivia heteroliitosbipolaaritransistoreja (HBT) varten.

- c. "Suprajohtavat" elektroniset komponentit.
- d. Elektronisten komponenttien timanttifilmisubstraatit.
- e. Piieristysubstraatit integroiduille piireille, joissa eristysaineena on piidioksidi.
- f. Piikarbidisubstraatit elektronisille komponenteille.
- g. Elektroniset tyhjöputket, jotka toimivat 31,8 GHz:n tai suuremmilla taajuuksilla.

3E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A001.a.1 tai 2, 3A101 tai 3D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden ja "ohjelmistojen" "käyttöä" varten.

3E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3D101 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.

3E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A201, 3A225–3A233 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

RYHMÄ 4
TIETOKONEET

Huom. 1: Tietokoneet, niihin liittyvät laitteet tai "ohjelmistot", jotka suorittavat tietoliikenteen tai "paikallisverkon" toimintoja, tulee arvioida myös 5 ryhmän 1 osa (Tietoliikenne) toimintaparametreja vasten.

Huom. 2: Ohjausyksiköitä, jotka yhdistävät suoraan keskusyksikön, "keskusmuistin" tai levyohjaimien väyliä tai kanavia, ei katsota 5 ryhmän 1 osa (Tietoliikenne) määrittelemiksi tietoliikennelaitteiksi.

Huom.: Pakettikytkentää varten erityisesti suunniteltujen "ohjelmistojen" valvonnallaisuus: katso 5D001 kohta.

Huom. 3: Tietokoneet, niihin liittyvät laitteet tai "ohjelmistot", jotka suorittavat salausta, salauksen analysointia tai sertifoitavissa olevaa monitasoista turvallisuuden valvontaa tai sertifoitavissa olevaa käyttöoikeuden rajaamista tai jotka rajoittavat sähkömagneettista mukautuvuutta (EMC), tulee arvioida myös 5 ryhmän 2 osa ("Tiedon suojaus") toimintaparametreja vasten.

4A Järjestelmät, laitteet ja komponentit

4A001 Seuraavat elektroniset tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet sekä niitä varten erityisesti suunnitellut "elektroniset kokoonpanot" ja komponentit:

Huom.: KATSO MYÖS 4A101 KOHTA.

a. Jotka on erityisesti suunniteltu niin, että niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Mitoitettu toimimaan ympäröivässä lämpötilassa alle 228 K (–45 °C) astetta tai yli 358 K (85 °C) astetta;

Huom.: 4A001.a.1 kohta ei koske siviilijoukko- tai -rautatiesovelluksiin erityisesti suunniteltuja tietokoneita.

2. Kestävät säteilyä yli jonkin seuraavista rajoista:

- | | |
|------------------|---|
| a. Kokonaisannos | 5×10^3
Gy (Pii); |
| b. Annosnopeus | 5×10^6
Gy (Pii)/s; <u>tai</u> |
| c. Kertahäiriö | 1×10^{-7}
virhettä/bit/vrk; |

b. Joilla on 5 ryhmän 2 osassa ("Tiedon suojaus") määritellyt rajat ylittäviä ominaisuuksia tai toimintoja.

Huom.: 4A001.b kohdassa ei aseteta valvonnallaisiksi elektronisia tietokoneita ja niihin liittyviä laitteita, kun käyttäjällä on ne mukanaan henkilökohtaista käyttöä varten.

4A003 Seuraavat "digitaaliset tietokoneet", "elektroniset kokoonpanot" ja niihin liittyvät laitteet sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom. 1: 4A003 kohta sisältää seuraavat:

- a. Vektoriprosessorit;
- b. Matriisiprosessorit;
- c. Digitaaliset signaaliprosessorit;

4A003 (jatkuu)

- d. Logiikkaprosessorit;
- e. Laitteet "kuvan laadun parantamista" varten;
- f. Laitteet "signaalinkäsittelyä" varten.

Huom. 2: Muihin laitteisiin tai järjestelmiin sisältyvien 4A003 kohdassa kuvattujen "digitaalisten tietokoneiden" ja niihin liittyvien laitteiden valvonnallaisuus määräytyy näiden muiden laitteiden tai järjestelmien valvonnallaisuuden mukaan edellyttäen, että:

- a. "Digitaaliset tietokoneet" tai niihin liittyvät laitteet ovat näiden muiden laitteiden tai järjestelmien toiminnan kannalta välttämättömiä;
- b. "Digitaaliset tietokoneet" tai niihin liittyvät laitteet eivät ole näiden muiden laitteiden tai järjestelmien olennaisin osa; ja

Huom. 1: Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen "signaalin käsittely"- tai "kuvan laatua parantavien" laitteiden valvonnallaisuuden määrittelee näiden muiden laitteiden valvonnallaisuus, vaikka ne ylittäisivätkin olennaisimman osan kriteerin, mikäli ne suorittavat vain näiden muiden laitteiden vaatimia toimintoja.

Huom. 2: Tietoliikenteessä käytettävien "digitaalisten tietokoneiden" ja niihin liittyvien laitteiden valvonnallaisuus: katso 5 ryhmä 1 osa (Tietoliikenne).

- c. "Digitaalisten tietokoneiden" ja niihin liittyvien laitteiden "teknologia" on määritelty 4E kohdassa.

- a. Jotka on suunniteltu tai muunnettu "vikasietoisiksi";

Huom.: 4A003.a kohdan tarkoituksia varten ei "digitaalisia tietokoneita" tai niihin liittyviä laitteita katsota suunnitelluiksi tai muunnetuiksi "vikasietoisiksi", jos ne käyttävät:

1. "Keskusmuistin" virheenpaljastus- tai virheenkorjausalgoritmeja;
2. Kahden "digitaalisen tietokoneen" välistä kytkentää siten, että aktiivisen keskusyksikön pettäessä vapaana oleva ja sen toimintaa peilaava keskusyksikkö voi jatkaa järjestelmän toimintaa;
3. Kahden keskusyksikön välistä tiedonsiirtokytkentää tai yhteistä muistiyksikköä siten, että yksi keskusyksikkö voi suorittaa muita tehtäviä kunnes toinen keskusyksikkö pettää, jolloin ensinmainittu ottaa hoitaakseen järjestelmän toiminnan; tai
4. Kahden keskusyksikön synkronointia "ohjelmistojen" avulla siten, että yksi keskusyksikkö huomaa milloin toinen pettää ja voi ottaa huolehtiakseen sen tehtävät.

- b. "Digitaaliset tietokoneet", joiden "yhteenlaskettu teoreettinen tehokkuus" ("CTP") ylittää 190 000 miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnissa (Mtops);

- c. Seuraavat "elektroniset kokoonpanot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu nostamaan tehokkuutta laskentayksiköitä ("CE") lisäämällä siten, että yhdistetty "yhteenlaskettu teoreettinen tehokkuus" ylittää 4A003.b kohdan rajan;

Huom. 1: 4A003.c kohtaa sovelletaan ainoastaan kokoonpanoihin ja ohjelmoitaviin keskinäisiin kytkentöihin, jotka eivät ylitä 4A003.b kohdassa määriteltyä rajaa, kun ne toimitetaan erillisinä "elektronisina kokoonpanoina". Sitä ei sovelleta "elektronisiin kokoonpanoihin", joiden rakenne rajoittaa niiden käytön 4A003.d tai 4A003.e kohdan määrittelemiin liittyvinä laitteina.

Huom. 2: 4A003.c kohdassa ei aseteta valvonnallaisiksi tuotteita tai tuoteperheitä varten erityisesti suunniteltuja elektronisia kokoonpanoja, jotka maksimikokoonpanossaan eivät ylitä 4A003.b kohdan rajaa.

- d. Ei käytössä;

4A003 (jatkuu)

- e. Laitteet, jotka suorittavat analogia-digitaalimuunnoksia tai digitaali-analogiamuunnoksia ja jotka ylittävät 3A001.a.5 kohdassa mainitut rajat;
- f. Ei käytössä;
- g. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu "digitaalisten tietokoneiden" tai niihin liittyvien laitteiden välistä ulkoista keskinäisliitintä varten, joka sallii viestiliikenteen tiedonsiirtonopeudella, joka ylittää 1,25 Gbyte/s.

Huom.: 4A003.g kohdassa ei aseteta valvonnallaisiksi sisäisiä liitintälaiteita (esim. emolevyjä ja väyliä), passiivisia kytkentälaiteita, "verkkoliityntäohjaimia" tai "tietoliikenneohjaimia".

4A004 Seuraavat tietokoneet ja niitä varten erityisesti suunnitellut niihin liittyvät laitteet, "elektroniset kokoonpanot" ja komponentit:

- a. "Systoliset matriisitietokoneet";
- b. "Hermoverkkotietokoneet";
- c. "Optiset tietokoneet".

4A101 Muut kuin 4A001.a.1 kohdassa määritellyt analogiset tietokoneet, "digitaaliset tietokoneet" tai digitaaliset differentiaalianalyysaattorit, jotka on suunniteltu kovaan käyttöön ja suunniteltu tai muunneltu 9A004 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettävien kantorakettien tai 9A104 kohdassa määriteltyjen luotainrakettien käyttöä varten.

4A102 Hybriditietokoneet, jotka on erityisesti suunniteltu 9A004 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettävien kantorakettien tai 9A104 kohdassa määriteltyjen luotainrakettien mallintamista, simulointia tai konstruktioiden integrointia varten.

Huom.: Tätä valvonnallaisuutta sovelletaan ainoastaan, kun laitteita toimitetaan 7D103 tai 9D103 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" kanssa.

4B **Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**
Ei ole.

4C**Materiaalit**

Ei ole.

4D**Ohjelmistot**

Huom.: Muissa ryhmissä kuvattujen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten tarkoitettujen "ohjelmistojen" valvonnanalaisuutta käsitellään kyseisissä ryhmissä. Tässä ryhmässä kuvattujen laitteiden "ohjelmistojen" valvonnanalaisuutta käsitellään tässä kohdassa.

- 4D001 a. 4A001–4A004 tai 4D kohdassa määriteltyjen laitteiden, materiaalien tai "ohjelmistojen" "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut "ohjelmistot".
- b. Muut kuin 4D001.a kohdassa määriteltyt "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu seuraavien "kehittämiseen" tai "tuotantoon":
1. "Digitaaliset tietokoneet", joiden "yhdistetty teoreettinen tehokkuus" ("CTP") on yli 28 000 miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnissa (Mtops); tai
 2. "Elektroniset kokoonpanot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suorituskyvyn tehostamiseksi yhdistämällä "laskentaelementtejä" ("CE") siten, että yhdistelmän "CTP" ylittää 4D001.b.1 kohdassa määritellyn rajan;

4D002 4E kohdassa määritellyn "teknologian" tukemiseen erityisesti suunnitellut tai muunnetut "ohjelmistot".

4D003 Seuraavat erityiset "ohjelmistot":

- a. "Lähdekieliset" käyttöjärjestelmä "ohjelmistot", "ohjelmistojen" kehittämisökalut ja kääntäjät, jotka on erityisesti suunniteltu "monitietovirtakäsittelyä" varten;
- b. Ei käytössä;
- c. "Ohjelmistot", joilla on 5 ryhmän 2 osassa ("Tiedon suojaus") määritellyt rajat ylittäviä ominaisuuksia tai toimintoja;

Huom.: 4D003.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi ohjelmistoa, kun käyttäjällä on se mukanaan henkilökohtaista käyttöä varten.

4E**Teknologia**

- 4E001
- a. Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti "teknologia", joka on tarkoitettu 4A tai 4D kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.
 - b. Muu kuin 4E001.a kohdassa määritelty "teknologia", joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu seuraavien "kehittämiseen" tai "tuotantoon":
 1. "Digitaaliset tietokoneet", joiden "yhdistetty teoreettinen tehokkuus" ("CTP") on yli 28 000 miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnissa (Mtops); tai
 2. "Elektroniset kokoonpanot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suorituskyvyn tehostamiseksi yhdistämällä "laskentaelementtejä" ("CE") siten, että yhdistelmän "CTP" ylittää 4E001.b.1 kohdassa määritellyn rajan;

Yhdistettyä teoreettista tehokkuutta ("CTP") koskeva tekninen huomautus

Tässä teknisessä huomautuksessa käytetyt lyhenteet:

"CE"	"laskentayksikkö" (tyypillisesti aritmetiikkaprosessori)
FP	liukuva pilkku
XP	kiinteä pilkku
t	suoritus aika
XOR	eksklusiivinen OR
CPU	keskussyksikkö
TP	teoreettinen tehokkuus (yhden "laskentaelementin")
"CTP"	"yhdistetty teoreettinen tehokkuus" (useiden "laskentaelementtien")
R	efektiivinen laskentanopeus
WL	sananpituus
L	sananpituuden korjaus
×	kertomerkki

Suoritus aika 't' ilmaistaan mikrosekuntein ja TP ja "CTP" ilmaistaan miljoonina teoreettisina operaatioina sekunnissa (Mtops) ja WL ilmaistaan bitteinä.

"CTP":n laskentatavan kuvaus

"CTP" on laskentatehokkuuden mitta ilmaistuna Mtops:eina. Seuraavat kolme vaihetta tarvitaan yhdistettäessä "CE":t "CTP":n laskemiseksi:

1. Laske kunkin laskentayksikön ("CE") efektiivinen laskentanopeus R;
2. Käytä sanan pituuden korjausta (L) efektiiviselle laskentanopeudelle (R), jolloin saat teoreettisen tehokkuuden (TP) kullekin laskentayksikölle;
3. Mikäli laskentayksiköitä on useampia kuin yksi, yhdistä teoreettiset tehokkuudet "CTP":n saamiseksi.

Yksityiskohdat näille kolmelle vaiheelle on esitetty seuraavissa kappaleissa.

Huom. 1.: Jos usealla "CE":llä on sekä yhteisiä että omia alamuistijärjestelmiä, "CTP":n laskenta suoritetaan hierarkkisesti kahdessa vaiheessa; yhdistä ensin "CE"-ryhmät joilla on yhteistä muistia ja laske sitten ryhmien "CTP" käyttäen laskentatapaa usealle "CE":lle, joilla ei ole yhteistä muistia.

Huom. 2.: "CE":tä, jonka toiminta rajoittuu syöttöön/tulostukseen ja ympäryslaitteiden toimintoihin (esim. levy-yksikön, kommunikointi- ja näyttöpääteohjaimet) ei yhdistetä "CTP"-laskentaan.

YHDISTETTYÄ TEOREETTISTA TEHOKKUUTTA ("CTP") KOSKEVA TEKNINEN HUOMAUTUS

Seuraavassa taulukossa osoitetaan miten kullekin "laskentayksikölle" lasketaan efektiivinen laskentanopeus (R):

Vaihe 1: Efektiivinen laskentanopeus R

"CE":t, joissa on: <i>Huom.: Jokainen "CE" on evaluoitava erikseen</i>	Efektiivinen laskentanopeus R
vain XP	$(R_{xp}) = \frac{1}{3 \times (t_{xp \text{ add}})}$ Jos yhteenlaskukäskyä ei ole: $(R_{xp}) = \frac{1}{(t_{xp \text{ mult}})}$ Jos yhteenlaskua tai kertolaskua ei ole, valitse nopein aritmeettinen operaatio: $(R_{xp}) = \frac{1}{3 \times (t_{xp})}$ ks. huom. X ja Z
vain FP	$(R_{fp}) = \text{Max} \frac{1}{t_{fp \text{ add}}}, \frac{1}{t_{fp \text{ mult}}}$ ks. huom. X ja Y
Sekä FP että XP (R)	Laske molemmat arvot R_{xp} , R_{fp}
Yksinkertaiset logiikkaprosessorit, joissa ei ole aritmetiikkakäskyjä.	$R = \frac{1}{3 \times t_{log}}$ Jossa t_{log} on ekslusiivisen-tai-käskyn toteutusaika tai mikäli sitä ei ole, nopeimman loogisen operaation suoritus-aika. Ks. huom. X ja Z
Erikoislogiikkaprosessorit, jotka eivät käytä mitään mainituista loogisista operaatioista.	$R = R' \times WL/64$ Jossa R' on tulosten lukumäärä sekunnissa, WL on loogisen operaation kohteen bittien lukumäärä ja 64 suure, joka normalisoi tuloksen 64 bitin operaatioksi.

Huom. W: Liukuhihnäkäsitellyä suorittavalle "CE":lle, joka suorittaa yhden aritmeettisen tai loogisen operaation jokaisen kellon jaksolla kanavan tultua täyteen, voidaan määritellä liukuhihnanopeus. Efektiiivinen laskentanopeus (R) sellaiselle "CE":lle on se, kumpi liukuhihna- tai ei-liukuhihnanopeudesta on nopeampi.

Huom. X: "CE":lle, joka suorittaa useita tietäntyyppisiä operaatioita yhden syklin aikana (esim. kaksi yhteenlaskua tai kaksi samanlaista loogista operaatiota), toteutusaika t saadaan:

$$t = \frac{\text{syklin aika}}{\text{identtisten operaatioiden määrä konesyklin aikana}}$$

"CE":itä, jotka suorittavat useita, erilaisia aritmeettisia operaatioita yhden konesyklin aikana, on käsiteltävä useampana erillisenä "CE":nä (esim. jos "CE" suorittaa yhteenlaskua ja kertolaskua yhden syklin aikana, käsitellään sitä kahtena "CE":nä, joista toinen suorittaa yhteenlaskua ja toinen kertolaskua).

Jos yksi "CE" suorittaa sekä skalaari- että vektorilaskentaa, käytetään niistä nopeamman suoritusajan arvoa.

Huom. Y: Jos "CE":ssä ei ole FP-yhteenlaskua eikä FP-kertolaskua, mutta se suorittaa FP jakolaskun:

$$R_{fp} = \frac{I}{t_{fp \text{ div}}}$$

Jos "CE" suorittaa FP käänteisarvo-operaation, mutta ei FP yhteenlaskua, FP kertolaskua eikä FP jakolaskua, niin

$$R_{fp} = \frac{I}{t_{fp \text{ -käänteisarvo}}}$$

Jos mitään mainituista FP-operaatioista ei ole, $FP = 0$.

Huom. Z: Yksinkertaisissa loogisissa operaatioissa, yksi käsky suorittaa yhden loogisen manipulaation korkeintaan kahden tietynpituisen operandin kesken. Monimutkaisissa loogisissa operaatioissa yksi käsky suorittaa useita loogisia manipulaatioita ja tuottaa yhden tai useamman tuloksen kahdesta tai useammasta operandista.

Tulokset olisi laskettava kaikille operandin pituuksille ottaen huomioon sekä liukuhihna- operaatiot (jos niitä on) että ei-liukuhihnaoperaatiot, käyttäen nopeinta käskyn suoritusaikaa kullekin operandin pituudelle ja perustuen:

1. Liukuhihna- tai rekisteristä-rekisteriin-operaatioon. Epätavallisen lyhyet suoritusajat, etukäteen määrätylle operandille tai operandeille (esim. kertominen 0:lla tai 1:llä) jätetään huomioimatta. Ellei rekisteristä-rekisteriin-operaatioita ole, siirry (2) kohtaan.
2. Nopeampaan rekisteristä-muistiin- tai muistista-rekisteriin-operaatioista; jos näitäkään ei ole, siirry (3) kohtaan.
3. Muistista-muistiin-operaatioon.

Jokaisessa yllämainitussa tapauksessa käytä valmistajan ilmoittamaa nopeinta suoritusaikaa.

Vaihe 2: TP kullekin käytettävissä olevalle operandin pituudelle WL

Muunna efektiivinen nopeus R (tai R') sanan pituuden korjaustermillä L seuraavasti:

$$TP = R \times L,$$

$$\text{jossa } L = (1/3 + WL/96)$$

Huom.: Tässä kaavassa sanan pituus WL on operandin pituus bitteinä. (Jos operaatio käyttää erilaisia operandin pituuksia, valitse niistä pisin sanan pituus.)

"CTP":n laskennassa mantissa-ALUn ja eksponentti-ALUn yhdistelmä liukuvan pilkun prosessorissa tai -yksikössä käsitetään yhdeksi "CE":ksi, jossa sanan pituus (WL) on bittien lukumäärä datan esityksessä (tyypillisesti 32 tai 64).

Tätä korjausta ei suoriteta niille erikoislogiikkaprosessoreille, jotka eivät käytä XOR-käskyä ja siinä tapauksessa $TP = R$.

Valitse maksimiarvot saaduista TP:n arvoista:

jokaiselle vain XP "laskentayksikölle" (R_{xp});

jokaiselle vain FP "laskentayksikölle" (R_{fp});

jokaiselle XP ja FP "laskentayksikölle" (R);

jokaiselle yksinkertaiselle logiikkaprosessorille, joka ei käytä aritmeettisiä operaatioita; ja

jokaiselle erikoislogiikkaprosessorille, joka ei käytä mitään mainittuja aritmeettisiä tai loogisia operaatioita.

Vaihe 3: Keskusyksiköiden "CTP" ja laskentayksiköiden yhdistäminen

Keskusyksikölle, jossa on vain yksi "CE":

$$\text{"CTP"} = TP.$$

("CE":t, jotka suorittavat sekä kiinteän että liukuvan pilkun operaatioita

$$TP = \max (TP_{xp}, TP_{fp})$$

Usean, samanaikaisesti toimivan "CE":n yhdistelmille "CTP" lasketaan seuraavasti:

Huom. 1.: Yhdistelmille, jotka eivät salli kaikkien "CE":iden toimia samanaikaisesti, käytetään suurimman "CTP"-arvon tuottavan kombinaation arvoa. Kunkin osallistuvan "CE":n TP lasketaan teoreettisena maksimiarvona, ennen "CTP"-arvon määrittämistä.

Huom.: Samanaikaisesti toimivien "CE":iden kombinaatioiden määrittelemiseksi, tuota käskysekvenssi, joka käynnistää operaatioita useassa "CE":ssä alkaen hitaimmasta (se, joka tarvitsee eniten syklejä operaation suorittamiseen) ja päättyen nopeimpaan "CE":hen. Jokaisella sekvenssin syklillä kyseisen syklin aikana toiminnassa olevien "CE":iden kombinaatio on mahdollinen kombinaatio. Käskysekvenssin on huomioitava kaikki laitteisto- ja/tai arkkitehtuuriesteet päällekkäisissä operaatioissa.

Huom. 2.: Yksi integroitu piiri tai piirikortti voi sisältää useamman "CE":n.

Huom. 3.: Samanaikaisia operaatioita katsotaan olevan, jos valmistaja tietokoneen käsikirjassa tai esitteessä ilmoittaa rinnakkaisista tai samanaikaisista operaatioista tai suorituksista.

Huom. 4.: "CTP"-arvoja ei yhdistetä "CE"-kombinaatioille, jotka ovat keskenään kytkettyjä paikallisverkkojen, kaukoverkkojen, yhteisten syöttö/tulostus-liitäntöjen/laitteiden, syöttö/tulostus-ohjainten ja minkä tahansa ohjelmalla toteutetun kommunikoinnin kautta.

Huom. 5.: "CTP"-arvot on yhdistettävä usealle "CE":lle, jotka on erityisesti suunniteltu parantamaan tehokkuutta ja jotka toimivat samanaikaisesti ja käyttävät samoja samanaikaisesti toimivia yhden tai useamman muistin ja "CE":n yhdistelmiä käyttäen erityisesti suunniteltua laitteistoa.

Tämä yhdistäminen ei koske kokoonpanoja, jotka on kuvattu kohdassa 4A003c.

$$\text{"CTP"} = TP_1 + C_2 * TP_2 + \dots C_n * TP_n,$$

jossa TP:t on järjestetty arvon mukaan, TP₁:n ollessa suurin, TP₂:n toiseksi suurin, ..., ja TP_n pienin. C_i on kerroin, joka määrittää "CE":iden kytkennän vahvuuden perusteella seuraavasti:

Usealle samanaikaisesti ja samaa muistia käyttävälle "CE":lle:

$$C_2 = C_3 = C_4 = \dots = C_n = 0,75$$

Huom. 1.: Jos ylläolevalla tavalla laskettu "CTP"-arvo ei ylitä 194 MTops, seuraavaa kaavaa voidaan käyttää C_i:n laskemiseen:

$$C_i = \frac{0,75}{\sqrt{m}} \quad (i = 2, \dots, n)$$

jossa m = yhteistä muistia käyttävien "CE":iden tai "CE"-ryhmien määrä.

edellyttäen, että:

1. Minkään "CE":n tai "CE"-ryhmän TP_i ei ylitä 30 MTops,
2. "CE":t tai "CE"-ryhmät käyttävät keskusmuistia (cache-muistia lukuun ottamatta) yhden kanavan kautta,
3. Vain yksi "CE" tai "CE"-ryhmä voi käyttää kanavaa kerrallaan.

Huom.: Tämä ei koske nimikkeitä, jotka ovat 3 ryhmän mukaan valvonnanalaisia.

Huom. 2.: "CE":t käyttävät samaa muistia, jos ne käyttävät yhteistä puolijohdemuistinsegmenttiä. Tämä muisti voi sisältää cache-muistin, keskusmuistin tai muun sisäisen muistin. Ulkoiset muistiyksiköt, kuten levymuistit, nauhamuistit tai RAM-levyt eivät sisälly tähän.

Usealle "CE":lle tai "CE":iden ryhmälle, jotka eivät käytä samaa muistia, mutta liittyvät toisiinsa yhdellä tai useammalla tietoväylällä:

$$C_i = 0,75 \times k_i \quad (i = 2, \dots, 32) \text{ (katso huomautusta alla)}$$

$$= 0,60 \times k_i \quad (i = 33, \dots, 64)$$

$$= 0,45 \times k_i \quad (i = 65, \dots, 256)$$

$$= 0,30 \times k_i \quad (i > 256)$$

C_i:n arvo perustuu "CE":iden lukumäärään, ei solmujen lukumäärään.

jossa

$$k_i = \min (S_i/K_r, 1), \text{ ja}$$

$$K_r = 20 \text{ MByte/s normalisointikerroin}$$

S_i = maksimi kaikkien yhteistä muistia käyttävään i:nteen "CE":hen tai "CE"-ryhmään kytkettyjen tietoväylien tiedonsiirtonopeuksien summasta (MByte/s).

Laskettaessa C_i:tä "CE"-ryhmälle ensimmäisen "CE":n numero määrää asianmukaisen rajan C_i:lle. Esimerkiksi yhdisteltäessä ryhmiä, jotka kukin koostuvat kolmesta "CE":stä, 22. ryhmä sisältää "CE"_{64:n}, "CE"_{65:n} ja "CE"_{66:n}. Asianmukainen raja C_i:lle tässä ryhmässä on 0,60.

Yhdisteleminen ("CE":iden tai "CE"-ryhmien) olisi tehtävä nopeimmasta hitaampaan; eli:

$$TP_1 \geq TP_2 \geq \dots \geq TP_n \text{ ja}$$

siinä tapauksessa, että TP_i = TP_{i+1} suurimmasta pienimpään; eli:

$$C_i \geq C_{i+1}$$

Huom.: Kerrointa k_i ei käytetä "CE":ille 2–12 jos "CE":n tai "CE"-ryhmän TP_i on enemmän kuin 50 Mtops; eli C_i "CE":ille 2–12 on 0,75.

RYHMÄ 5**TIETOLIIKENNE JA "TIEDON SUOJAUS"**

1 OSA

TIETOLIIKENNE

Huom. 1: Tietoliikennelaitteita tai -järjestelmiä varten erityisesti kehitettyjen komponenttien, "laserien", testaus- ja "tuotanto" laitteiden, materiaalien ja ohjelmien valvonnallaisuus on määritelty 5 ryhmän 1 osassa.

Huom. 2: "Digitaaliset tietokoneet", niihin liittyvät laitteet tai "ohjelmistot", milloin ne ovat olennaisia tässä ryhmässä kuvattujen tietoliikennelaitteiden toiminnalle ja tukevat niitä, katsotaan erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitetyiksi komponenteiksi, edellyttäen, että ne ovat valmistajan tavanomaisesti toimittamia vakiotyyppejä. Tämä koskee myös tietokonejärjestelmiä toimintaa, hallintoa, ylläpitoa, teknistä suunnittelua tai laskutusta varten.

5A1 Järjestelmät, laitteet ja komponentit

5A001 a. Tietoliikennelaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai piirteistä:

1. Erityisesti suunniteltu kestäämään ydinräjähdyksestä aiheutuvia hetkellisiä elektronisia vaikutuksia tai sähkömagneettista pulssia;
2. Erityisesti suojattu kestäämään gamma-, neutroni- tai ionisäteilyä; tai
3. Erityisesti suunniteltu toimimaan lämpötila-alueen 218 K (– 55 °C) – 397 K (124 °C) ulkopuolella.

Huom.: 5A001.a.3 kohta koskee vain elektronisia laitteita.

Huom.: 5A001.a.2 ja 5A001.a.3 kohta ei koske satelliiteissa käytettäviksi suunniteltuja tai muutettuja laitteita.

b. Tietoliikenteen siirtolaitteet ja järjestelmät ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit tai tarvikkeet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai piirteistä:

1. Vedenalaiset viestintäjärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 - a. Akustinen kantoaaltotaajuus, joka on alueen 20–60 kHz ulkopuolella;
 - b. Käyttävät sähkömagneettista kantoaaltotaajuutta alle 30 kHz; tai
 - c. Käyttävät elektronista keilanojaustekniikkaa;
2. Radiolaitteet, jotka toimivat 1,5–87,5 MHz:n kaistalla ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 - a. Sisältävät adaptiivisen tekniikan, joka antaa paremman häiriösignaalien vaimennuksen kun 15 dB; tai
 - b. Sisältävät kaikki seuraavat:
 1. Ennakoivat ja valitsevat automaattisesti kanavakohtaisia taajuuksia ja "digitaalisia kokonais-siirtonopeuksia" optimoidakseen lähetystä; ja
 2. Sisältävät lineaarisen tehovahvistinkonfiguraation, joka kykenee tukemaan useampia signaaleja samanaikaisesti 1 kW:n tai suuremmalla lähtöteholla 1,5–30 MHz:n taajuusalueella tai 250 W:n tai suuremmalla lähtöteholla 30–87,5 MHz:n taajuusalueella, yhden tai useamman oktaavin "hetkellisen taajuuskaistan" yli, siten että ulostulon yliaalto- ja särösisältö on parempi kuin – 80 dB;
3. Radiolaitteet, jotka käyttävät "hajaspektritekniikkaa", mukaan lukien "taajuushyppely" tekniikka ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 - a. Hajautuskoodit ovat käyttäjän ohjelmoitavissa; tai
 - b. Lähetettävän kaistan kokonaisleveys on vähintään 100 kertaa minkä tahansa informaatiokanavan kaistan leveys ja se ylittää 50 kHz;

Huom.: 5A001.b.3.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi radiolaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi siviilikäytössä olevissa solukkoradiojärjestelmissä.

Huom.: 5A001.b.3 kohta ei aseta valvonnallaiseksi laitteita, jotka on suunniteltu toimiviksi 1,0 Watin tai sitä alemmalla ulostuloteholla.

5A001

b. (jatkuu)

4. Radiolaitteet, jotka käyttävät aikamoduloituja ultralaajakaistatekniikoita ja joiden kanavointi- tai sekoituskoodit ovat käyttäjän ohjelmoitavissa;
5. Digitaalisesti ohjatut radiovastaanottimet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - a. Yli 1 000 kanavaa;
 - b. Alle 1 ms:n "taajuuden vaihto aika";
 - c. Tutkivat tai pyyhkivät automaattisesti osaa sähkömagneettisesta spektristä; ja
 - d. Jotka identifioivat vastaanotetut signaalit tai lähettimen tyyppin; tai

Huom.: 5A001.b.5 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi radiolaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi siviilikäytössä olevissa solukkoradiojärjestelmissä

6. Käyttävät digitaalisia "signaalin käsittely" toimintoja puheenkoodauksen ulostuloon alle 2 400 bit/s nopeuksilla;

Tekn. huom.:

Nopeudeltaan vaihtelevan puheenkoodauksen osalta sovelletaan 5A001.b.6 kohtaa jatkuvan puheen puheenkoodauksen ulostuloon.

c. Seuraavat optiset tiedonsiirtokaapelit, optiset kuidut ja varusteet niitä varten:

1. Yli 500 m pitkät optiset kuidut, jotka valmistajan ilmoituksen mukaan kykenevät kestämaan vetolujuuskokeessa yli 2×10^9 N/m²:n tai tätä suurempaa vetorasitusta;

Tekn. huom.:

Vetolujuuskoe: on-line tai off-line tuotantotesti, jossa kuituun dynaamisesti kohdistetaan ennalta määrätty vetorasitus 0,5–3 metrin matkalla kuidun kulkiessa nopeudella 2–5 m/s kahden n. 150 mm läpimittaisen vetopyörän välillä ympäristön lämpötilan ollessa 293 K (20 °C) ja suhteellisen kosteuden 40 %. Vastaavia kansallisia standardeja voidaan käyttää vetolujuuskoetta suoritettaessa.

2. Optiset kaapelit ja varusteet vedenalaista käyttöä varten;

Huom.: 5A001.c.2 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi norminmukaisia siviilikäyttöön tarkoitettuja tietoliikennekaapeleita ja varusteita.

Huom. 1: Veden alla käytettävien yhdyskaapeliin ja niiden liittimien osalta katso 8A002a.3 kohta.

Huom. 2: Kuituoptiset aluksen rungon läpiviennit tai liittimet: katso 8A002.c kohta.

d. "Elektronisesti ohjattavat vaiheistetut ryhmäantennit", jotka toimivat yli 31 GHz:n alueella;

Huom.: 5A001.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhmäantenneja" laskeutumisjärjestelmissä, joissa on ICAO:n mikroaalloilla toimivat laskeutumisjärjestelmät (MLS) kattavien standardien mukaiset instrumentit.

5A101

Kaukomittaus- tai kaukohallintalaitteet, mukaan lukien maalaitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu "ohjuksia" varten.

Tekn. huom.:

5A101 kohdassa tarkoitetaan "ohjuksella" täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 kilometriä.

Huom.: 5A101 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi

- a. Laitteita, jotka on suunniteltu tai muunnettu miehitettyjä ilma-aluksia tai satelliitteja varten;
- b. Maassa sijaitsevia laitteita, jotka on suunniteltu tai muunnettu maa- tai merisovelluksia varten;
- c. Laitteita, jotka on suunniteltu kaupallisia, siviili- tai ihmishenkien turvallisuutta koskevia (esimerkiksi eheys, lentoturvallisuus) GNSS-palveluja varten.

5B1 Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

- 5B001 a. Laitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet, jotka on erityisesti suunniteltu 5A001, 5B001, 5D001 tai 5E001 kohdassa määriteltyjen laitteiden, toimintojen tai ominaisuuksien "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

Huom.: 5B001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi optisten kuitujen karakterisointilaitteita.

- b. Laitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet, jotka on erityisesti suunniteltu seuraavien tietoliikenteen tai siirtolaitteiden "kehittämiseen":

1. Laitteet, jotka käyttävät digitaalitekniikkaa ja jotka on suunniteltu toimimaan "digitaalisella siirtonopeudella", joka ylittää 15 Gbit/s,

Tekn. huom.:

Siirtolaitteiden osalta "digitaalinen siirtonopeus" mitataan nopeimmasta portista tai reitistä.

2. Laitteet, jotka käyttävät "laseria" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Siirrossa käytetty aallonpituus ylittää 1 750 nm;
b. Suorittavat "optista vahvistusta";
c. Käyttävät koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista ilmaisutekniikkaa (jota kutsutaan myös optiseksi heterodyne- tai homodynetekniikaksi);
d. Käyttävät analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittää 2,5 GHz;

Huom.: 5B001.b.2.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kaupallisten TV-järjestelmien "kehittämistä" varten erityisesti suunniteltuja laitteita.

3. Laitteet, jotka käyttävät "optista kytkentää";
4. Radiolaitteet, jotka käyttävät kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso ylittää 256; tai
5. Laitteet, jotka käyttävät "yhteiskanavamerkinantoa" ei-liitännäisellä toimintamuodolla.

5C1**Materiaalit**

Ei ole.

5D1

Ohjelmistot

- 5D001
- a. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5A001 tai 5B001 kohdassa määriteltyjen laitteiden, toimintojen tai ominaisuuksien "kehittämistä", "valmistusta" tai "käyttöä" varten;
 - b. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5E001 kohdassa määritellyn "teknologian" tukemiseen;
 - c. Seuraavat erityiset "ohjelmistot":
 1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu toteuttamaan 5A001 tai 5B001 kohdassa määriteltyjen laitteiden ominaisuuksia, toimintoja tai piirteitä;
 2. Ei käytössä;
 3. "Ohjelmistot", muussa kuin konekielisessä muodossa, joka on erityisesti suunniteltu "dynaamisesti adaptiivista reititystä" varten.
 - d. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu seuraavien tietoliikenteen siirto- tai kytkentälaitteiden "kehittämistä" varten:
 1. Laitteet, jotka käyttävät digitaalitekniikkaa ja jotka on suunniteltu toimimaan yli 15 Gbit/s "digitaalisella kokonaissiirtonopeudella";

Tekn. huom.:

Siirtolaitteiden osalta "digitaalinen siirtonopeus" mitataan nopeimmasta portista tai reitistä
 2. Laitteet, jotka käyttävät "laseria" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 - a. Siirrossa käytetty aallonpituus ylittää 1 750 nm; tai
 - b. Käyttävät analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittää 2,5 GHz;

Huom.: 5D001.d.2.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi "ohjelmistoja", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu kaupallisten TV-järjestelmien "kehittämistä" varten.
 3. Laitteet, jotka käyttävät "optista kytkentää"; tai
 4. Radiolaitteet, jotka käyttävät kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso ylittää 256.
- 5D101
- "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5A101 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

5E1 Teknologia

5E001 a. "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, joka on tarkoitettu 5A001, 5B001 tai 5D001 kohdassa määriteltyjen laitteiden, toimintojen tai piirteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten (toimintaa lukuun ottamatta);

b. Seuraavat erityiset "teknologiat":

1. Satelliiteissa käytettäväksi erityisesti suunniteltujen tietoliikennelaitteiden "kehitystä" tai "tuotantoa" varten "tarvittava" "teknologia";
2. "Kehittämistä" tai "käyttöä" varten tarvittava "teknologia" sellaisia "laser" tietoliikennetekniikoita varten, joilla kyetään automaattisesti seuraamaan signaaleja ja ylläpitämään yhteyttä ilmakehän ulkopuolella tai vedenpinnan alla;
3. "Teknologia" sellaisten digitaalisen solukkoradiotukiaseman vastaanottolaitteiden kehittämistä varten, joiden monitaajuus-, monikanava-, monimuoto-, monikoodausalgoritmi- tai monikäytäntökäytön mahdollistavaa vastaanottoa voidaan muuttaa "ohjelmisto" muutoksilla;
4. "Teknologia" "hajaspektri" tekniikoiden, "taajuushyppely" tekniikat mukaan lukien, "kehittämistä" varten.

c. "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, joka on tarkoitettu seuraavien tietoliikenteen siirto- tai kytkentälaitteiden, -toimintojen tai -ominaisuuksien "kehittämiseen" tai "tuotantoon":

1. Laitteet, jotka käyttävät digitaalitekniikkaa ja jotka on suunniteltu toimimaan yli 15 Gbit/s "digitaalisella kokonaissiirtonopeudella";

Tekn. huom.:

Siirtolaitteiden osalta "digitaalinen kokonaissiirtonopeus" mitataan nopeimmasta portista tai reitistä.

2. Laitteet, jotka käyttävät "laseria" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Siirrossa käytetty aallonpituus ylittää 1 750 nm;
- b. Suorittavat "optista vahvistusta" käyttämällä praseodyymikyllästettyjä fluoridikuituvahvistimia (PDFFA);
- c. Käyttävät koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista ilmaisutekniikkaa (jota kutsutaan myös optiseksi heterodyne- tai homodynetekniikaksi);
- d. Käyttävät aallonpituusjakoon perustuvaa kanavointitekniikkaa, jossa on enemmän kuin 8 optista kantoaaltoa yksittäisessä optisessa ikkunassa; tai
- e. Käyttävät analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittää 2,5 GHz;

Huom.: 5E001.c.2.e kohta ei aseta kaupallisten TV-järjestelmien "kehittämiseen" tai "tuotantoon" tarkoitettua "teknologiaa".

3. Laitteet, jotka käyttävät "optista kytkentää".

4. Radiolaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Käyttävät kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso ylittää 256; tai
- b. Joiden tulo- tai lähtötaajuus ylittää 31,8 GHz; tai

Huom.: 5E001.c.4.b ei aseta valvonnallaiseksi ITU:n (International Telecommunication Union) radioviestintäpalvelulle, mutta ei radiomääritykselle allokoimalla taajuuskaistalla toimiviksi suunniteltujen tai muunnettujen laitteiden "kehittämiseen" tai "tuotantoon" tarkoitettua "teknologiaa".

5. Laitteet, jotka käyttävät "yhteiskanavamerkinantoa" ei-liitännäisellä toimintamuodolla.

5E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 5A101 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" ja "käyttöä" varten.

2 OSA

"TIEDONSUOJAUS"

Huom. 1: "Tiedonsuojaus" -laitteiden, -"ohjelmistojen", järjestelmien, sovelluskohtaisten "elektronisten kokoonpanojen", moduulien, integroitujen piirien, komponenttien tai toimintojen valvonnallaisuus määritellään 5 ryhmän 2 osassa, myös siinä tapauksessa, että ne ovat muiden laitteiden komponentteja tai niiden "elektronisia kokoonpanoja".

Huom. 2: 5 ryhmä – 2 osa ei aseta valvonnan alaiseksi tuotteita, jotka ovat käyttäjän hallussa hänen henkilökohtaista käyttöään varten.

Huom. 3: Salausta koskeva huomautus

5A002 ja 5D002 kohdat eivät aseta valvonnallaiseksi tuotteita, jotka täyttävä kaikki seuraavat edellytykset:

a. Ovat yleisesti yleisön ostettavissa rajoituksitta vähittäismyyntipisteissä varastosta jollain seuraavista tavoista:

1. Käsikauppa;
2. Postimyynti;
3. Elektronisesti tapahtuva myynti; tai
4. Puhelinmyynti;

b. Käyttäjä ei voi helposti muuntaa salauksen toiminnallisuutta;

c. Tuotteet on suunniteltu käyttäjän käyttöön otettaviksi ilman merkittävää toimittajan tukea; ja

d. Tuotteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat tarvittaessa saatavilla ja pyynnöstä esitetään toimivaltaisille viranomaisille siinä jäsenvaltiossa, johon viejä on sijoittautunut, jotta voidaan varmistaa edellä a–c kohdassa kuvattujen ehtojen täyttyminen.

Tekn. huom.:

5 ryhmä – 2 osa, pariteettibittejä ei lasketa avaimen pituuteen.

5A2 Järjestelmät, laitteet ja komponentit

5A002 a. Seuraavat järjestelmät, laitteet, sovelluskohtaiset "elektroniset kokoonpanot", moduulit tai integroidut piirit "tiedon suojausta" varten ja muut niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: Satelliittinavigointijärjestelmien vastaanottolaitteet, jotka sisältävät tai käyttävät salauksen purkua (so. GPS tai GLONASS): katso 7A005 kohta.

1. Jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään digitaalitekniikkaan perustuvaa "salausta" suorittamaan mitä tahansa muuta salaustoimintaa kuin autentikointia tai digitaalista allekirjoitusta ja jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Tekn. huom.:

1. Autentikointi ja digitaalinen allekirjoitus sisältävät niihin liittyvät avaimenhallintatoiminnot.
2. Autentikointiin sisältyy kaikki sellainen valvonta, jossa ei salata tiedostoja tai tekstiä lukuun ottamatta sitä, mikä liittyy suoraan salasanojen, henkilökohtaisten tunnusnumeroiden tai vastaavan tiedon suojaamiseen luvattoman pääsyn estämiseksi.
3. "Salaus" ei sisällä "kiinteitä" tiedon pakkaus- tai koodaustekniikoita.

Huom.: 5A002.a.1 kohtaan sisältyvät laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään "salausta", jossa digitaalitekniikan soveltamisessa käytetään analogisia periaatteita.

5A002

a. 1. (jatkuu)

- a. "Symmetrinen algoritmi", joka käyttää yli 56 bitin avaimenpituutta tai
- b. "Epäsymmetrinen algoritmi", jossa algoritmin turvallisuus perustuu johonkin seuraavista:
 1. Yli 512 bitin kokonaislukujen tekijöihin jako (esimerkiksi RSA)
 2. Diskreettien logaritmien laskenta äärellisen kannan suuremmassa kuin 512 bitin yksikköryhmässä (esim. Diffie-Hellman $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$:ssä); tai
 3. Diskreetit logaritmit muissa kuin 5A002.a.1.b.2 kohdassa mainitussa suuremmassa kuin 112 bitin ryhmässä (esimerkiksi Diffie-Hellman elliptisellä käyrällä),
2. Jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan salauksen analysointitoimintoja;
3. Ei käytössä;
4. Jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vähentämään informaatiota kuljettavien signaalien paljastavia vuotoja enemmän kuin on tarpeen terveyden, turvallisuuden tai elektromagneettisia häiriöitä koskevien standardien vuoksi;
5. Jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään salaustekniikkaa "hajaspektri" järjestelmien hajautuskoodin, mukaan lukien "taajuushyppely" järjestelmän hyppelykoodi, tuottamiseksi;
6. Jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään salaustekniikkaa kanavointi- tai sekoituskoodien tuottamiseksi "aikamoduloituja ultralaajakaista" järjestelmiä varten;
7. Ei käytössä;
8. Tiedonsiirtokaapelijärjestelmät, jotka on suunniteltu tai muunnettu salakuuntelun ilmaisemiseen mekaanista, sähköistä tai elektronista tapaa käyttäen.

Huom.: 5A002 kohta ei aseta valvonnallaiseksi:

a. "Henkilökohtaisia älykortteja":

1. Jos salaus on rajoitettu koskemaan niiden käyttöä laitteissa ja järjestelmissä, jotka tämän huomautuksen b-f kohdan mukaan ovat valvonnan ulkopuolella; tai
2. Yleisten julkiseen käyttöön tarkoitettujen sovellusten osalta, jos käyttäjä ei voi vaikuttaa salaukseen ja salaus on erityisesti suunniteltu ja rajoitettu kortille tallennettujen henkilötietojen suojaamiseen.

Huom.: Jos "henkilökohtainen älykortti" soveltuu useisiin toimintoihin, kunkin toiminnon valvonta arvioidaan erikseen.

b. Kuluttajille tarkoitettuja yleisradiolähetysten, maksutelevision tai vastaavien rajoitetun yleisön lähetysten vastaanottolaitteita, joissa ei ole digitaalista salausta, lukuun ottamatta niitä, joita käytetään laskutusta koskevia tai ohjelmakohtaisia tietoja takaisin yleisradiolähetysten lähettäjille;

c. Laitteet, joiden salauskykyyn käyttäjä ei voi vaikuttaa ja jotka on erityisesti suunniteltu ja rajoitettu mahdollistamaan jotain seuraavista:

1. Kopioinnilta suojatun "ohjelmiston" käyttäminen;

2. Pääsy johonkin seuraavista:

a. Kopioinnilta suojattuihin, vain luettavissa oleviin välineisiin tallennettuihin sisältöihin tai

b. Salatussa muodossa välineille tallennettuun informaatioon (esimerkiksi tekijänoikeuksien suojaamisen yhteydessä), kun väline tarjotaan myytäväksi yleisölle täysin samassa muodossa tai

5A002 a. (jatkuu)

3. Tekijänoikeudella suojattujen audio/video-tietojen kopioinnin valvonta.

d. Salauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ja rajoitettu pankki- tai "rahaliikenteen" laitteisiin;

Tekn. huom.:

"Rahaliikenne" 5A002 kohdan huomautuksessa d sisältää maksujen tai luottojen keräämisen ja suoritukset.

e. Siviilikäyttöön tarkoitettuja (esim. kaupallisissa solukkoradiopuhelinjärjestelmissä käytettäviä) salaus-toimintoja sisältäviä kannettavia tai siirrettäviä radiopuhelimia, jotka eivät pysty päästä-päähän-salaukseen;

f. Langattomat puhelimet, jotka eivät pysty päästä-päähän-salaukseen ja joiden suurin tehollinen vahvistamaton langaton toimintaetäisyys (eli yksittäinen linkitön hyppy päätteen ja tukiaseman välillä) on valmistajan antamien tietojen mukaan alle 400 metriä.

5B2 Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

5B002

- a. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu:
1. 5A002, 5B002, 5D002 tai 5E002 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai toimintojen "kehittämistä" varten, mukaan lukien mittaus- tai testauslaitteet;
 2. 5A002, 5B002, 5D002 tai 5E002 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai toimintojen "tuotantoa" varten, mukaan lukien mittaus-, testaus-, huolto- tai tuotantolaitteet;
- b. Mittalaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 5A002 tai 5D002 kohdassa määriteltyjen "tiedon suojaus" toimintojen arviointia ja kelpuuttamista varten.

5C2**Materiaalit**

Ei ole.

5D2 Ohjelmistot

- 5D002
- a. 5A002, 5B002 tai 5D002 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut "ohjelmistot";
 - b. 5E002 kohdassa määriteltyä "teknologiaa" tukemaan erityisesti suunnitellut tai muunnetut "ohjelmistot";
 - c. Seuraavat erityiset "ohjelmistot":
 1. "Ohjelmistot", joilla on 5A002 tai 5B002 kohdassa määriteltyjen laitteiden ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja;
 2. "Ohjelmistot" 5D002.c.1 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" sertifiointia varten.

Huom.: 5D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

- a. "Ohjelmistoja", joita tarvitaan 5A002 kohdan huomautuksen mukaan valvonnan ulkopuolelle jätettyjen laitteiden "käytössä";
- b. "Ohjelmistoja", jotka mahdollistavat 5A002 huomautuksen mukaan valvonnan ulkopuolella olevien laitteiden toimintoja.

5E2**Teknologia**

5E002

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 5A002, 5B002 tai 5D002 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmien" "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

RYHMÄ 6
ANTURIT JA LASERIT

6A Järjestelmät, laitteet ja komponentit**6A001 Akustiikka**

a. Seuraavat meriakustiset järjestelmät, laitteet tai erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:

1. Seuraavat aktiiviset (lähettävät tai lähettävät ja vastaanottavat) järjestelmät, laitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: 6A001.a.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a. Vertikaalisesti laitteesta alaspäin toimivia syvyysluotaimia, jotka eivät sisällä ± 20 astetta ylittävää keilaustoimintoa ja ovat rajoitetut mittaamaan veden syvyyttä tai etäisyyttä uponneisiin tai hautautuneisiin kohteisiin tai paikallistamaan kalaparvia;

b. Seuraavia akustisia majakoita:

1. Akustiset hätämajakat;

2. Äänimajakat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaisen aseman paikantamista tai siihen palaamista varten.

a. Leveäpeittoiset batymetriset kartoitusjärjestelmät merenpohjan topografian kartoitusta varten, joilla on kaikki seuraavat:

1. Suunniteltu mittaamaan vertikaalisesta suunnasta 20 astetta ylittävässä kulmassa;

2. Suunniteltu mittaamaan syvyyksiä yli 600 metriä vedenpinnan alla; ja

3. Suunniteltu mahdollistamaan jonkin seuraavista:

a. Useiden säteiden yhdistämisen, joista jokin on alle 1,9 astetta; tai

b. Parempia kuin 0,3 %:n veden syvyytiedon tarkkuuksia peittoalueella peiton yksittäisten mittausten keskiarvona laskettuna;

b. Kohteen havaitsemis- tai paikantamisjärjestelmät, joilla on jokin seuraavista:

1. Lähetystaajuus alle 10 kHz;

2. Äänenpaineen taso yli 224 dB (vertailuarvo 1 μPa 1 m:ssä) laitteilla, joiden toimintataajuus on 10 kHz:n ja 24 kHz:n välisellä taajuusalueella;

3. Äänenpaineen taso ylittää 235 dB (vertailuarvo 1 μPa 1 m:ssä) laitteilla, joiden toimintataajuus on 24 kHz:n ja 30 kHz:n välisellä taajuusalueella;

4. Muodostavat minkä tahansa akselin suunnassa alle 1:n asteen säteitä ja toimintataajuus on vähemmän kuin 100 kHz;

5. Suunniteltu toimimaan 5 120 m ylittävällä selvän näytön etäisyydellä; tai

6. Suunniteltu kestämaan normaalissa käytössä painetta yli 1 000 metrin syvyyksissä ja sisältävät muuntimia, joilla on jokin seuraavista:

a. Dynaaminen kompensointi painetta vastaan; tai

b. Sisältävät muunninelementissä jotain muuta kuin lyijyzirkonaattititanaattia;

c. Akustiset projektorit, mukaan lukien muuntimet, jotka sisältävät yksittäin tai suunnitellussa kombinaatiossa toimivia pietso-sähköisiä, magnetostriktiivisiä, sähköstriktiivisiä, sähködynaamisia tai hydraulisia elementtejä, ja joilla on jokin seuraavista:

Huom. 1: Erityisesti muita laitteita varten suunniteltujen akustisten projektorien, muuntimien mukaan lukien, valvonnanalaisuus määräytyy näiden muiden laitteiden valvonnanalaisuuden mukaan.

Huom. 2: 6A001.a.1.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi elektronisia äänilähteitä, jotka suuntaavat ääntä vain pystysuunnassa, tai mekaanisia (esim. ilmatykki tai höyryshokkitykki) tai kemiallisia (esim. räjähdde) äänilähteitä.

6A001 a. 1. c. (jatkuu)

1. Hetkellisesti säteilevän 'akustisen tehon tiheys' ylittää $0,01 \text{ mW/mm}^2/\text{Hz}$ laitteilla, jotka toimivat alle 10 kHz:n taajuuksilla;
2. Jatkuvasti säteilevän 'akustisen tehon tiheys' ylittää $0,001 \text{ mW/mm}^2/\text{Hz}$ laitteilla, jotka toimivat alle 10 kHz:n taajuuksilla; tai

Tekn. huom.:

'Akustisen tehon tiheys' saadaan jakamalla akustinen lähtöteho säteilevän pinnan pinta-alan ja toimintataajuuden tulolla.

3. Sivukeilavaimennus ylittää 22 dB;
- d. Akustiset järjestelmät, laitteet ja erityisesti suunnitellut komponentit pinta-alusten tai vedenalaisten alusten sijainnin määrittämistä varten, jotka on suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n etäisyydellä paikannustarkkuudella, joka on parempi kuin 10 m rms (tehollisarvo) 1 000 m:n etäisyydellä mitattuna;

Huom.: 6A001.a.1.d kohta sisältää:

- a. Laitteet, jotka käyttävät koherenttia "signaalinkäsittelyä" kahden tai useamman majakan ja pinta-aluksen tai vedenalaisen aluksen kuljettaman hydrofoniyksikön välillä;
 - b. Laitteet, jotka kykenevät automaattisesti korjaamaan äänen nopeuden etenemisvirheet jonkin pisteen laskemista varten.
2. Seuraavat passiiviset (vastaanottavat, siitä riippumatta, liittyvätkö ne normaalissa käytössä erillisiin aktiivisiin laitteisiin) järjestelmät, laitteet tai erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:
 - a. Hydrofonit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen hydrofonien valvonnanalaisuus määräytyy kyseisten muiden laitteiden valvonnanalaisuuden mukaan.

1. Sisältävät yhtenäisiä taipuisia antureita tai kokoonpanoja erillisistä anturielementeistä, joiden läpimitta tai pituus on vähemmän kuin 20 mm ja etäisyys toisistaan vähemmän kuin 20 mm;
2. Sisältävät jonkin seuraavista anturielementeistä:
 - a. Optisia kuituja; tai
 - b. Taipuisia pietsosähköisiä keraamisia materiaaleja;
3. 'Hydrofonin herkkyys' ilman kiihtyvyysskompensointia on parempi kuin -180 dB missä tahansa syvyydessä;
4. Yli 35 metrin syvyyksissä toimimaan suunnitellussa hydrofonissa, joissa on kiihtyvyysskompensointi; tai
5. Suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissä;

Tekn. huom.:

'Hydrofonin herkkyys' määritellään ulostulojännitteen rms-arvon ja 1 V:n rms vertailuarvon suhteen kaksikymmenkertaisena kymmenlogaritmina, kun hydrofonianturi, ilman etuvahvistinta, asetetaan akustiseen tasoaltokenttään, jonka rms paine on $1 \mu\text{Pa}$. E simerkiksi -160 dB:n hydrofoni (vertailuarvo 1 V mikropascalia kohti) antaisi sellaisessa kentässä 10^{-8} V:n ulostulojännitteen, kun taas toinen -180 dB:n herkkyydellä antaisi vain 10^{-9} V:n ulostulojännitteen. Siten -160 dB on parempi kuin -180 dB .

- b. Hinattavat akustiset hydrofonijärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 1. Hydrofoniryhmien välinen etäisyys on vähemmän kuin 12,5 m tai ne "voidaan muuntaa" siten, että hydrofoniryhmien välinen etäisyys on vähemmän kuin 12,5 m;
 2. Suunniteltu tai "voidaan muuntaa" toimimaan yli 35 metrin syvyyksissä;

6A001 a. 2. b. 2. (jatkuu)

Tekn. huom.:

6A001.a.2.b.1 ja 2 kohdassa termi 'voidaan muuntaa' tarkoittaa varautumista mahdollisuuteen muuttaa kaapelointia tai kytkentöjä hydrofoniryhmien välisen etäisyyden tai niiden toimintasyvyyden rajojen muuttamiseksi. Näitä varautumisia ovat: varakaapelointi, joka ylittää 10 % kaapelien lukumäärästä, hydrofoniryhmien välisen etäisyyden sovitushokot tai sisäiset syvyyden rajoituslaitteet, jotka ovat säädettäviä tai jotka ohjaavat useampaa kuin yhtä hydrofoniryhmää.

3. 6A001.a.2.d kohdan mukaan valvonnalliset suunta-anturit;

4. Pitkittäissuunnassa lujitetut järjestelmäsukat;

5. Kokoonpantu järjestelmä on läpimitaltaan vähemmän kuin 40 mm;

6. Multipleksoidut hydrofoniryhmien signaalit, jotka on suunniteltu toimimaan yli 35:n syvyyksissä tai asetettava tai irrotettava syvyysanturilaitte yli 35 m:n syvyyksissä tapahtuvaa toimintaa varten; tai

7. Hydrofoniominaisuudet ovat 6A001.a.2.a kohdassa määriteltyjä;

c. Hinattavia akustisia hydrofonijärjestelmiä varten erityisesti suunnitellut (signaalien) käsittelylaitteet, jotka ovat "käyttäjän ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- tai taajuusalueen käsittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja säteen muotoilu käyttäen nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai käsittelyjä;

d. Suunta-anturit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Tarkkuus on parempi kuin $\pm 0,5$ astetta; ja

2. Suunniteltu toimimaan yli 35 m:n syvyyksissä tai joilla on säädettävä tai irrotettava syvyysanturilaitte yli 35m:n syvyyksissä tapahtuvaa toimintaa varten;

e. Pohja- tai poukamakaapelijärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Se sisältää 6A001.a.2.a kohdassa määriteltyjä hydrofoneja; tai

2. Multipleksoituja hydrofoniryhmien signaalimoduleja, joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

a. Suunniteltu toimimaan yli 35:n syvyyksissä tai asetettava tai irrotettava syvyysanturilaitte yli 35 m:n syvyyksissä tapahtuvaa toimintaa varten; ja

b. Voidaan vaihtaa hinattavien akustisten hydrofonijärjestelmämoduulien kanssa toiminnallisesti.

f. Pohja- tai poukamakaapelijärjestelmiä varten erityisesti suunnitellut (signaalien) käsittelylaitteet, jotka ovat "käyttäjän ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- tai taajuusalueen käsittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja säteen muotoilu käyttäen nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai käsittelyjä;

b. Nopeuskorrelaatiota suorittavat ääniluotainlokit, jotka on suunniteltu mittaamaan niitä kuljettavan aluksen horisontaalista nopeutta merenpohjan suhteen 500 m ylittävillä aluksen ja merenpohjan välillä etäisyyksillä.

6A002 Optiset anturit

Huom.: KATSO MYÖS 6A102 KOHTA.

a. Seuraavat optiset ilmaisimet:

Huom.: 6A002.a kohta ei aseta valvonnallaiseksi germanium- tai piipohjaisia valoherkkiä komponentteja.

1. Seuraavat "avaruuskelpoiset" solid-state-ilmaisimet:

6A002

a. 1. (jatkuu)

a. "Avaruuskelpoiset" solid-state ilmaisimet, joilla on kaikki seuraavat:

1. Vastehuippu aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm, mutta ei yli 300 nm; ja
2. Vaste yli 400 nm:n aallonpituuksilla vähemmän kuin 0,1 % vastehuipusta;

b. "Avaruuskelpoiset" solid-state ilmaisimet, joilla on kaikki seuraavat:

1. Vastehuippu aallonpituusalueella, joka on yli 900 nm, mutta ei yli 1 200 nm; ja
2. Vasteen "aikavakio" 95 ns tai vähemmän;

c. "Avaruuskelpoiset" solid-state ilmaisimet, joiden vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 1 200 nm, mutta ei yli 30 000 nm;

2. Seuraavat kuvanvahvistinputket ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. Kuvanvahvistinputket, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm, mutta ei yli 1 050 nm;
2. Elektronista kuvanvahvistusta varten mikrokanavalevy, jonka reikätiheys (keskipisteiden välinen etäisyys) on 12 µm tai vähemmän; ja
3. Jokin seuraavista valokatodeista:
 - a. S-20-, S-25- tai monialkaalivalokatodit, joiden valoherkkyys ylittää 350 µA/lm;
 - b. GaAs- tai GaInAs-valokatodit; tai
 - c. Muut III-V yhdistepuolijohteisiin perustuvat valokatodit;

Huom.: 6A002.a.2.a.3.c kohtaa ei sovelleta yhdistepuolijohteisiin perustuviin valokatoideihin, joiden maksimi säteilyherkkyys on 10 mA/W tai vähemmän.

b. Seuraavat erityisesti suunnitellut komponentit:

1. Mikrokanavalevyt, joiden reikätiheys (keskipisteiden välinen etäisyys) on 12 µm tai vähemmän;
2. GaAs- tai GaInAs-valokatodit;
3. Muut III-V yhdistepuolijohteisiin perustuvat valokatodit;

Huom.: 6A002.a.2.b.3 kohta ei aseta valvonnallaiseksi yhdistepuolijohteisiin perustuvia valokatoideja, joiden maksimi säteilyherkkyys on 10 mA/W tai vähemmän.

3. Seuraavat ei- "avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet":

Tekn. huom.:

1. Lineaarisia tai kaksiulotteisia monielementtisiä ilmaisinarakenteita pidetään "fokusoivina tasorakenteina";
2. 6A002.a.3 kohdassa "ristiskannausuunta" määritellään ilmaiselementtien lineaarisen rakenteen suuntaiseksi akseliksi ja "skannausuunta" ilmaiselementtien lineaarista rakennetta vasten kohtisuorassa olevaksi akseliksi.

Huom. 1: 6A002.a.3 kohta sisältää valjohtavat ja valosähköiset rakenteet.

6A002 a. 3. (jatkuu)

Huom. 2: 6A002.a.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

- a. Piipohjaisia "fokusoivia tasorakenteita";
- b. Monielementtisiä (korkeintaan 16 elementtiä sisältäviä) koteloituja valojohtavia pareja, joissa käytetään joko lyijysulfidia tai lyijyselenidiä;
- c. Pyrosähköisiä ilmaisimia, jotka perustuvat joihinkin seuraavista:
 1. Triglysiinisulfaatti ja sen muunnokset;
 2. Lyijylantaanizirkoniumtitanaatti ja sen muunnokset;
 3. Litiumtantalaatti;
 4. Polyvinylideenifluoridi ja sen muunnokset; tai
 5. Strontiumbariumniobaatti ja sen muunnokset;

a. Ei- "avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Yksittäisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 900 nm mutta ei yli 1 050 nm; ja
2. Vasteen "aikavakio" on vähemmän kuin 0,5 ns;

b. Ei- "avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Yksittäisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 1 050 nm mutta ei yli 1 200 nm; ja
2. Vasteen "aikavakio" on 95 ns tai vähemmän;

c. Ei- "avaruuskelpoiset" epälineaariset (kaksiulotteiset) "fokusoivat tasorakenteet", joissa yksittäisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 1 200 nm, mutta ei yli 30 000 nm;

d. Ei- "avaruuskelpoiset" lineaariset (yksiulotteiset) "fokusoivat tasorakenteet", joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

1. Yksittäisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 1 200 nm, mutta ei yli 2 500 nm; ja
2. Jokin seuraavista ominaisuuksista:
 - a. Ilmaisinelementin skannaussuunnan mitan suhde ilmaisinelementin ristiskannaussuunnan mittaan vähemmän kuin 3,8; tai
 - b. Signaalin prosessointi elementissä (SPRITE);

e. Ei- "avaruuskelpoiset" lineaariset (yksiulotteiset) "fokusoivat tasorakenteet", joissa yksittäisten elementtien vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 2 500 nm, mutta ei yli 30 000 nm.

b. Etäishavainnointisovelluksiin suunnitellut "yksispektriset kuvausanturit" ja "monispektriset kuvausanturit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Hetkellinen näkökenttä (IFOV) on vähemmän kuin 200 μ rad (mikroradiaania); tai
2. Ne on määritelty toimimaan aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm, mutta ei yli 30 000 nm, ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - a. Ne antavat kuvatiedon ulostulossaan digitaalisessa muodossa; ja
 - b. Ne ovat jotain seuraavista:
 1. "Avaruuskelpoisia"; tai

6A002

b. 2. b. (jatkuu)

2. Ne on suunniteltu ilmassa tapahtuvaan toimintaan suunniteltuja ja käyttävät muita kuin pii-ilmaisimia, joiden IFOV on vähemmän kuin 2,5 mrad (milliradiaania);

c. 'Suorakatselu'-kuvauslaitteet, jotka toimivat spektrin näkyvällä tai infrapuna-alueella ja jotka sisältävät jonkin seuraavista:

1. 6A002.a.2.a kohdassa määriteltyjä kuvanvahvistinputkia; tai

2. 6A002.a.3 kohdassa määriteltyjä "fokusoivia tasorakenteita";

Tekn. huom.:

Termi 'suorakatselu' viittaa kuvauslaitteisiin, jotka toimivat spektrin näkyvällä tai infrapuna-alueella ja jotka näyttävät visuaalisen kuvan tarkkailijalle muuttamatta kuvaa sähköiseksi signaaliksi televisionäyttöä varten, ja jotka eivät voi tallettaa kuvaa valokuvana, elektronisesti tai millään muullakaan tavalla.

Huom.: 6A002.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia laitteita, jotka sisältävät muita kuin GaAs- tai GaInAs-valokatodeja:

a. Teollisuus- tai siviilikäyttöön tarkoitetut murtohälyttimet, liikenteessä tai teollisuudessa käytettävät liikkeen ohjaus- tai laskentajärjestelmät;

b. Lääketieteelliset laitteet;

c. Teollisuuden laitteet, joita käytetään materiaalien ominaisuuksien tarkastukseen, lajitteluun tai analysointiin;

d. Teollisten uunien liekinilmaisimet;

e. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokäyttöön.

d. Seuraavat optisten anturien toimintaa tukevat erikoiskomponentit:

1. "Avaruuskelpoiset" kryojäähdyttimet;

2. Seuraavat ei-"avaruuskelpoiset" kryojäähdyttimet, joiden kylmälähteen lämpötila on alle 218 K (–55 °C):

a. Suljetulla kierrolla varustetut, joiden määritelty keskimääräinen vioittumisaika (MTTF) tai keskimääräinen vikaväli (MTBF) ylittää 2 500 tuntia;

b. Itsesäätävät Joule-Thomson (JT) -minijäähdyttimet, joiden ulkolämpimitta on vähemmän kuin 8 mm;

3. Optiset anturointikuidut, jotka on erityisesti valmistettu, joko koostumuksellisesti tai rakenteellisesti tai pinnoittamalla, akustisesti, termisesti, inertiaalisesti, sähkömagneettisesti tai ydinsäteilylle herkiksi;

e. "Avaruuskelpoiset" "fokusoivat tasorakenteet", joissa on enemmän kuin 2 048 elementtiä ryhmää kohti ja joiden huippuvaste on aallonpituusalueella, joka on yli 300 nm, mutta ei yli 900 nm.

6A003

Kamerat

Huom.: KATSO MYÖS 6A203 KOHTA.

Huom.: Kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön: katso 8A002.d ja 8A002.e kohta.

a. Seuraavat instrumentointikamerat ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: 6A003.a.3–6A003.a.5 kohdassa määritellyt moduulirakenteiset instrumentointikamerat on arvioitava niiden suurimman suorituskyvyn mukaan käyttäen saatavilla olevia ohjelmalisäkkeitä kameran valmistajan eritelmien mukaisesti.

1. Suurinopeuksiset elokuvakamerat, jotka käyttävät mitä tahansa filmikokoa välillä 8 mm–16 mm, mukaan lukien ne kamerat, joissa filmiä siirretään jatkuvasti kuvausajanjakson aikana, ja jotka kykenevät ottamaan yli 13 150 kuvaa sekunnissa;

Huom.: 6A003.a.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi siviilikäyttöön tarkoitettuja elokuvakameroita.

6A003 a. (jatkuu)

2. Mekaaniset suurinopeuksiset kamerat, joissa filmi ei liiku ja jotka kykenevät ottamaan yli 1 000 000 kuvaa sekunnissa täydellä 35 mm:n filmin kuvan korkeudella tai suhteessa suuremmilla nopeuksilla, kun kuvan korkeus on pienempi tai suhteessa pienemmillä nopeuksilla, kun kuvan korkeus on suurempi;
3. Mekaaniset tai elektroniset juovakamerat, joiden piirtonopeus ylittää 10 mm/µs;
4. Elektroniset yksittäiskuvakamerat, joiden nopeus ylittää 1 000 000 kuvaa sekunnissa;
5. Elektroniset kamerat, joilla on kaikki seuraavat:
 - a. Elektronisen sulkimen nopeus (avainnuskyyky) on vähemmän kuin 1 µs täyttä kuvaa kohti; ja
 - b. Luettavuusaika sallii yli 125 täyden kuvan nopeuden sekunnissa;
6. Ohjelmalisäkkeet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - a. Ne on erityisesti suunniteltu 6A003.a kohdassa määritellyjä moduulirakenteisia instrumentointi-kameroita varten; ja
 - b. Niiden ansiosta nämä kamerat saavuttavat valmistajan eritelmien mukaisesti 6A003.a.3, 6A003.a.4 tai 6A003.a.5 kohdassa määritellyt ominaisuudet.
- b. Seuraavat kuvauskamerat:

Huom.: 6A003.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi televisio- tai videokameroita, jotka on erityisesti suunniteltu televisiolähetyksiä varten.

1. Solid-state-antureita sisältävät videokamerat, joiden vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm, mutta ei yli 30 000 nm ja joilla on kaikki seuraavista:
 - a. Jokin seuraavista:
 1. Enemmän kuin 4×10^6 "aktiivista pikseliä" solid-state-matriisia kohti yksivärikameroissa (mustavalkokameroissa);
 2. Enemmän kuin 4×10^6 "aktiivista pikseliä" solid-state-matriisia kohti värikameroissa, joissa on kolme solid-state-matriisia; tai
 3. Enemmän kuin 12×10^6 aktiivista pikseliä solid-state-matriisia kohti värikameroissa, joissa on yksi solid-state-matriisi; ja
 - b. Jokin seuraavista:
 1. 6A004.a kohdassa valvonnanalaiseksi asetetut optiset peilit;
 2. 6A004.d kohdassa valvonnanalaiseksi asetetut optiikan ohjauslaitteet; tai
 3. Mahdollisuus tallentaa sisäisesti tuotettuja kamera paikannustietoja.

Tekn. huom.:

1. Tässä kohdassa digitaaliset videokamerat olisi arvioitava liikkuvan kuvankaappaukseen käytettyjen "aktiivisten pikselien" enimmäismäärän perusteella.
2. Tässä kohdassa tarkoitetaan 'kamera paikannustiedoilla' tietoja, joita tarvitaan määrittämään kameran tähtäysviivan suunta maahan nähden. Tähän sisältyy: 1) vaakasuora kulma, jonka kameran tähtäysviiva muodostaa suhteessa maan magneettikentän suuntaan ja 2) pystysuora kulma kameran tähtäysviivan ja maan horisontin välillä.
2. Pyyhkäisevät kamerat ja pyyhkäisevät kamerajärjestelmät, joilla on kaikki seuraavat:
 - a. Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm, mutta ei yli 30 000 nm;

6A003

b. 2. (jatkuu)

b. Lineaarisia ilmaisinryhmiä, joissa on enemmän kuin 8 192 elementtiä ryhmää kohti; ja

c. Yhdessä suunnassa mekaaninen pyyhkäisy;

3. Kamerate, jotka sisältävät 6A002.a.2.a kohdassa määriteltyjä kuvanvahvistinputkia;

4. Kamerate, jotka sisältävät 6A002.a.3 kohdassa määriteltyjä "fokusoivia tasorakenteita";

Huom.: 6A003.b.4 kohta ei aseta valvonnallaiseksi seuraaviin käyttötarkoituksiin suunniteltuja kuvauskameroita, joissa on sellaisia lineaarisia 'fokusoivia tasorakenteita', jotka sisältävät 12 elementtiä tai vähemmän, ja joissa ei käytetä aikaviivästystä ja integrointia elementeissä:

a. Teollisuus- tai siviilikäyttöön tarkoitetut murtohälyttimet, liikenteessä tai teollisuudessa käytettävät liikkeen ohjaus- tai laskentajärjestelmät;

b. Teollisuuden laitteet, joita käytetään rakennusten, laitteiden tai teollisuusprosessien lämpövirtojen havaitsemiseen tai seuraamiseen;

c. Teollisuuden laitteet, joita käytetään materiaalien ominaisuuksien tarkastukseen, lajitteluun tai analysointiin;

d. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokäyttöön; tai

e. Lääketieteelliset laitteet.

6A004

Optiikka

a. Seuraavat optiset peilit (heijastimet):

1. "Muotoaan muuttavat peilit", joissa on yhtenäiset tai moni-elementtiset pinnat ja joissa peilipinnan osia voidaan dynaamisesti asetella uudelleen yli 100 Hz:n nopeudella, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut osat;

2. Kevyet monoliittiset peilit, joiden keskimääräinen "ekvivalenttitiheys" on vähemmän kuin 30 kg/m² ja joiden kokonaispaino ylittää 10 kg;

3. Kevyet "komposiitti"- tai vaahtopeilirakenteet, joiden keskimääräinen "ekvivalenttitiheys" on vähemmän kuin 30 kg/m² ja joiden kokonaispaino ylittää 2 kg;

4. Säteen ohjauspeilit, joiden se läpimitta tai sen päähalkaisijan pituus, jolla latteus on $\lambda/2$ tai parempi (λ on 623 nm), on yli 100 mm ja joiden ohjauskaistanleveys ylittää 100 Hz;

b. Sinkkiseleneidistä (ZnSe) tai sinkkisulfidista (ZnS) valmistetut optiset komponentit, joiden lähete on aallonpituusalueella, joka on yli 3 000 nm mutta alle 25 000 nm ja joilla on jokin seuraavista:

1. Tilavuus ylittää 100 cm³; tai

2. Läpimitta tai pääakselin pituus ylittää 80 mm ja paksuus (syvyys) 20 mm;

c. Seuraavat "avaruuskelpoiset" optisten järjestelmien osat:

1. Jotka on kevennetty alle 20 %:iin sellaisen massiivikappaleen ekvivalenttitiheyteen verrattuna, jolla on sama aukko ja paksuus;

2. Raakasubstraattit tai (ynsi- tai monikerroksisella, metallisella tai dielektrisellä, johtavalla, puolijohtavalla tai eristävällä) pinnoitteella pinnoitetut tai suojaavalla kalvolla varustetut substraattit;

3. Peilien segmentit tai kokoonpanot, jotka on suunniteltu koottavaksi avaruudessa optiseksi järjestelmäksi, jonka kokoava aukko on sama tai suurempi kuin yksittäisen läpimitaltaan 1 m:n optiikan;

4. Jotka on valmistettu "komposiitti" materiaaleista, joiden lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on 5×10^{-6} tai pienempi minkä tahansa koordinaatin suunnassa;

d. Seuraavat optiikan ohjauslaitteet:

6A004 d. (jatkuu)

1. Jotka on erityisesti suunniteltu 6A004.c.1 tai 6A004.c.3 kohdassa määriteltyjen "avaruuskelpoisten" komponenttien pinnanmuodon tai asennon ylläpitoon;
2. Joilla ohjauksen, seurannan, stabiloinnin tai resonaattorin kohdistuksen kaistanleveydet ovat 100 Hz tai enemmän ja tarkkuus 10 μ rad (mikroradiaania) tai vähemmän;
3. Kardaanit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - a. Maksimikäntymä ylittää 5 astetta;
 - b. Kaistanleveys 100 Hz tai enemmän;
 - c. Kulmasuuntausvirhe 200 mikroradiaania tai vähemmän; tai
 - d. joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 1. Läpimitta tai pääakselin pituus yli 0,15 m, mutta ei yli 1 m ja kykenevät yli 2 radiaanin/s² kulmakihtyvyyksiin; tai
 2. Läpimitta tai pääakselin pituus on yli 1 m ja kykenevät yli 0,5 radiaanin/s² kulmakihtyvyyteen;
4. Jotka on erityisesti suunniteltu ylläpitämään sellaisten vaiheistettujen peiliryhmiä tai segmenttipiilijärjestelmien linjausta, jotka rakentuvat segmentin halkaisijaltaan tai pääakselin pituudeltaan 1 m:n tai suuremmista peileistä;
- e. 'Ei- pallomaiset optiset elementit', joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:
 1. Optisen aukon suurin mitta on yli 400 mm;
 2. Pinnan epätasaisuus on alle 1 nm (rms) 1 mm:n tai sitä suurempien näytteenottopituuksien osalta; ja
 3. Lineaarisen lämpölaajenemiskertoimen absoluuttinen suuruus on alle $3 \times 10^{-6}/K$ lämpötilassa 25 °C.

Tekn. huom.:

1. 'Ei- pallomainen optinen elementti' on optisessa järjestelmässä käytettävä elementti, jonka kuvapinta- tai pinnat on suunniteltu siten, että ne poikkeavat täydellisen pallomaisesta muodosta.
2. Valmistajia ei velvoiteta mittaamaan 6A004.e.2 kohdassa tarkoitettua pinnan epätasaisuutta, ellei optista elementtiä ole suunniteltu tai valmistettu tarkoituksena täyttää tai ylittää valvontaan liittyvä parametri.

Huom.: 6A004.e kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ei- pallomaisia optisia elementtejä, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Optisen aukon suurin mitta on alle 1 m ja polttovälin suhde aukkoon on 4,5:1 tai suurempi;
- b. Optisen aukon suurin mitta on 1 m tai suurempi ja polttovälin suhde aukkoon on 7:1 tai suurempi;
- c. Ne on suunniteltu Fresnel-, flyeye-, juova-, prisma- tai diffraktiotyyppisiksi optisiksi elementeiksi;
- d. Ne on valmistettu borosilikaattilasista, jonka lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on suurempi kuin $2,5 \times 10^{-6}/K$ lämpötilassa 25 °C; tai
- e. Ne ovat röntgenoptisia elementtejä, joilla on sisäisiä peiliominaisuuksia (esim. putkityyppinen peili).

Huom.: Litografialaitteita varten erityisesti suunniteltujen ei- pallomaisten optisten elementtien osalta katso 3B001 kohta.

6A005 Seuraavat muut kuin 0B001.g.5 tai 0B001.h.6 kohdassa määritellyt "laserit", komponentit ja optiset laitteet:

Huom.: KATSO MYÖS 6A205 KOHTA.

Huom. 1: Pulssi "lasereihin" kuuluvat ne, jotka toimivat pulssitettuna jatkuva-aaltomoodissa (CW).

Huom. 2: Pulssiviritettyihin "lasereihin" kuuluvat ne, jotka toimivat pulssitettuna jatkuvassa viritetyssä moodissa.

Huom. 3: Raman- "laserien" valvonnallisuus määritetään pumppu "laserien" parametrien mukaan. Pumppu- "laserit" voivat olla kaikkia alla kuvattuja "lasereita".

a. Seuraavat kaasulaserit:

1. Excimer-laserit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Lähtöaallonpituus ei ylitä 150 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lähtöenergia ylittää 50 mJ pulssia kohti; tai

2. Keskimääräinen lähtöteho ylittää 1 W;

b. Lähtöaallonpituus ylittää 150 nm, mutta ei ylitä 190 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohti; tai

2. Keskimääräinen lähtöteho ylittää 120 W;

c. Lähtöaallonpituus ylittää 190 nm, mutta ei ylitä 360 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lähtöenergia ylittää 10 J pulssia kohti; tai

2. Keskimääräinen lähtöteho ylittää 500 W; tai

d. Lähtöaallonpituus ylittää 360 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohti; tai

2. Keskimääräinen lähtöenergia ylittää 30 W;

Huom.: Erityisesti litografialaitteita varten suunniteltujen excimer-lasereiden osalta katso 3B001 kohta.

2. Seuraavat metallihöyrylaserit:

a. Kupari(Cu)laserit, joiden keskimääräinen lähtöteho ylittää 20 W;

b. Kulta(Au)laserit, joiden keskimääräinen lähtöteho ylittää 5 W;

c. Natrium(Na)laserit, joiden lähtöteho ylittää 5 W;

d. Barium(Ba)laserit, joiden keskimääräinen lähtöteho ylittää 2 W;

3. Hiilimonoksidi(CO)laserit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Lähtöenergia ylittää 2 J pulssia kohti ja pulssi "huipputeho" ylittää 5 kW; tai

b. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 5 kW;

4. Hiilidioksidi(CO₂)laserit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. CW-lähtöteho ylittää 15 kW;

6A005

a. 4. (jatkuu)

b. Pulssiulostulon "pulssin kesto" ylittää 10 μ s ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Keskimääräinen lähtöteho ylittää 10 kW; tai

2. Pulssi "huipputeho" ylittää 100 kW; tai

c. Pulssiulostulon "pulssin kesto" on 10 μ s tai vähemmän ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Pulssin energia ylittää 5 J pulssia kohti; tai

2. Keskimääräinen lähtöteho ylittää 2,5 kW;

5. Seuraavat "kemialliset laserit":

a. Vetyfluoridi(HF)"laserit";

b. Deuteriumfluoridi(DF)"laserit";

c. Seuraavat "siirtolaserit":

1. Happijodi(O₂-I)"laserit";

2. Deuteriumfluoridihilidioksidi(DF-CO₂)"laserit";

6. Kryptonioni- tai argonioni"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohti ja pulssi "huipputeho" ylittää 50 W; tai

b. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 50 W;

7. Muut kaasu"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: 6A005.a.7 kohta ei aseta valvonnallaiseksi tyyppi "lasereita".

a. Lähtöaallonpituus ei ylitä 150 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lähtöenergia ylittää 50 mJ pulssia kohti ja pulssi "huipputeho" ylittää 1 W; tai

2. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 1 W;

b. Lähtöaallonpituus ylittää 150 nm mutta ei 800 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohti ja pulssi "huipputeho" ylittää 30 W; tai

2. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 30 W;

c. Lähtöaallonpituus ylittää 800 nm mutta ei 1 400 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lähtöenergia ylittää 0,25 J pulssia kohti ja pulssi "huipputeho" ylittää 10 W; tai

2. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 10 W; tai

d. Lähtöaallonpituus ylittää 1 400 nm ja keskimääräinen CW-lähtöteho ylittää 1 W;

b. Seuraavat puolijohde-"laserit":

1. Erilliset yksitransversaalimoodissa toimivat puolijohde"laserit", joilla on jokin seuraavista:

6A005

b. 1. (jatkuu)

- a. Aallonpituus on 1 510 nm tai pienempi ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho on suurempi kuin 1.5 W; tai
 - b. Aallonpituus on suurempi kuin 1 510 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 500 mW;
2. Erilliset, monitransversaalmoodissa toimivat puolijohde "laserit", joilla on jokin seuraavista:
- a. Aallonpituus pienempi kuin 1 400 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 10 W;
 - b. Aallonpituus yhtä suuri tai suurempi kuin 1 400 nm ja pienempi kuin 1 900 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 2,5 W; tai
 - c. Aallonpituus yhtä suuri tai suurempi kuin 1 900 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 1 W.
3. Erilliset puolijohde "laserien" -ryhmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. Aallonpituus pienempi kuin 1 400 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 80 W;
 - b. Aallonpituus yhtä suuri tai suurempi kuin 1 400 nm ja pienempi kuin 1 900 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 25 W; tai
 - c. Aallonpituus yhtä suuri tai suurempi kuin 1 900 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 10 W.
4. Puolijohde "laserien" ryhmien kerrokset, jotka sisältävät vähintään yhden ryhmän, joka on valvonnallinen 6A005.b.3 kohdan perusteella.

Tekn. huom.:

1. Puolijohde "lasereita" kutsutaan tavallisesti "laser" diodeiksi.
2. 'Ryhmä' muodostuu useista puolijohde "laser" emittereistä, jotka on valmistettu yhtenä siruna niin, että säteilevien valonsäteiden keskustat ovat yhdensuuntaisilla reiteillä.
3. 'Ryhmien kerros' on valmistettu kerrostamalla tai muuten kokoamalla 'ryhmät' niin, että säteilevien valonsäteiden keskustat ovat yhdensuuntaisilla reiteillä.

Huom. 1: 6A005.b kohta sisältää puolijohdelaserit, joilla on optinen ulostulo (esim. kuituoptiset häntäkaapelit).

Huom. 2: Erityisesti muita laitteita varten suunniteltujen puolijohdelaserien valvonnallisuus määräytyy näiden muiden laitteiden mukaan.

c. Seuraavat jähme "laserit":

1. "Viritettävät" "laserit", joilla on jokin seuraavista:

Huom.: 6A005.c.1 kohta sisältää titaani-safiiri- ($\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$), tulium-YAG- (Tm:YAG), tulium-YSGG- (Tm:YSGG), aleksandriitti- ($\text{Cr:BeAl}_2\text{O}_4$) ja värikeskus "laserit".

- a. Lähtöaallonpituus on vähemmän kuin 600 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lähtöenergia ylittää 50 mJ pulssia kohti ja pulssi "huipputeho" ylittää 1 W; tai
2. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 1 W;

- b. Lähtöaallonpituus on 600 nm tai enemmän mutta ei ylitä 1 400 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lähtöenergia ylittää 1 J pulssia kohti ja pulssi "huipputeho" ylittää 20 W; tai
2. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 20 W; tai

6A005

c. 1. (jatkuu)

c. Lähtöaallonpituus ylittää 1 400 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Lähtöenergia ylittää 50 mJ pulssia kohden ja pulssi "huipputeho" ylittää 1 W; tai

2. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 1 W;

2. Seuraavat ei- "viritettävät" "laserit":

Huom.: 6A005.c.2 kohta sisältää atomitransitio-jähme "laserit".

a. Seuraavat neodyymilasi "laserit":

1. Q-kytkin "laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Lähtöenergia ylittää 20 J mutta ei 50 J pulssia kohden ja keskimääräinen lähtöteho ylittää 10 W; tai

b. Lähtöenergia ylittää 50 J pulssia kohden;

2. Ei-Q-kytkin "laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Lähtöenergia ylittää 50 J mutta ei ylitä 100 J pulssia kohden ja keskimääräinen lähtöteho ylittää 20 W; tai

b. Lähtöenergia ylittää 100 J pulssia kohden;

b. Seuraavat neodyymiseostetut (muut kuin lasi-) "laserit", joiden lähtöaallonpituus on yli 1 000 nm, mutta alle 1 100 nm:

Huom.: Neodyymiseostetut (muut kuin lasi-) "laserit", joiden ulostulon aallonpituus ylittää 1 000 nm, mutta ei ylitä 1 100 nm: katso 6A005.c.2.c kohta.

1. Pulssiviritetyt, moodilukitut "Q-kytkinlaserit", joiden pulssin kesto on vähemmän kuin 1 ns ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. "Huipputeho" ylittää 5 GW;

b. Keskimääräinen lähtöteho ylittää 10 W; tai

c. Pulssienergia ylittää 0,1 J;

2. Pulssiviritetyt, "Q-kytkinlaserit", joiden "pulssin kesto" on 1 ns tai enemmän ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Yksitransversaalimuodon ulostulon:

1. "Huipputeho" ylittää 100 MW;

2. Keskimääräinen lähtöteho ylittää 20 W; tai

3. Pulssienergia ylittää 2 J; tai

b. Monitransversaalimuodon ulostulon:

1. "Huipputeho" ylittää 400 MW;

2. Keskimääräinen lähtöteho ylittää 2 kW; tai

3. Pulssienergia ylittää 2 J;

3. Pulssiviritetyt, ei- "Q-kytkinlaserit", joiden:

a. Yksitransversaalimuodon ulostulon:

1. "Huipputeho" ylittää 500 kW; tai

6A005

c. 2. b. 3. a. (jatkuu)

2. Keskimääräinen lähtöteho ylittää 150 W; tai

b. Monitransversaalimuodon ulostulon:

1. "Huipputeho" ylittää 1 MW; tai

2. Keskimääräinen teho ylittää 2 kW;

4. Jatkuvasti viritettävät "laserit", joiden:

a. Yksitransversaalimuodon ulostulon:

1. "Huipputeho" ylittää 500 kW; tai2. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 150 W; tai

b. Monitransversaalimuodon ulostulon:

1. Huipputeho ylittää 1 MW; tai

2. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 2 kW;

c. Muut ei-viritettävät "laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Aallonpituus on alle 150 nm ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Lähtöenergia ylittää 50 mJ pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittää 1 W; tai

b. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 1 W;

2. Aallonpituus on 150 nm tai enemmän mutta ei ylitä 800 nm ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittää 30 W; tai

b. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 30 W;

3. Aallonpituus ylittää 800 nm mutta ei ylitä 1 400 nm:

a. "Q-kytkinlaserit", joiden:

1. Lähtöenergia ylittää 0,5 J pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittää 50 W; tai

2. Keskimääräinen lähtöteho ylittää:

a. Yksi-transversaali "lasereilla" 10 W;

b. Moni-transversaali "lasereilla" 30 W;

b. Ei-"Q-kytkinlaserit", joiden:

1. Lähtöenergia ylittää 2 J pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittää 50 W; tai

2. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 50 W;

4. Aallonpituus ylittää 1 400 nm ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Lähtöenergia ylittää 100 mJ pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittää 1 W; tai

b. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 1 W;

d. Väriaine- ja muut neste "laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

6A005

d. (jatkuu)

1. Aallonpituus on alle 150 nm ja:
 - a. Lähtöenergia ylittää 50 mJ pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittää 1 W; tai
 - b. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 1 W;
2. Aallonpituus on 150 nm tai enemmän mutta ei ylitä 800 nm ja jokin seuraavista ominaisuuksista:
 - a. Lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittää 20 W;
 - b. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 20 W; tai
 - c. Sisältävät pitkittäistyyppisen pulssivärhätelijän, jonka keskimääräinen lähtöteho ylittää 1 W ja toistotaajuus ylittää 1 kHz, jos pulssin kesto on vähemmän kuin 100 ns;
3. Aallonpituus ylittää 800 nm mutta ei ylitä 1 400 nm ja jokin seuraavista:
 - a. Lähtöenergia ylittää 0,5 J pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittää 10 W; tai
 - b. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 10 W;
4. Aallonpituus ylittää 1 400 nm ja jokin seuraavista:
 - a. Lähtöenergia ylittää 100 mJ pulssia kohden ja pulssin "huipputeho" ylittää 1 W; tai
 - b. Keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 1 W;

e. Seuraavat komponentit:

1. 'Aktiivisella jäähdytyksellä' tai lämpöputkijäähdytyksellä jäähdytetyt peilit;

Tekn. huom.:

'Aktiivinen jäähdytys' on optisten osien jäähdytystekniikka, jossa käytetään välittömästi optisen komponentin pinnan alla virtaavia nesteitä (nimellisetäisyys optisesta pinnasta vähemmän kuin 1 mm) siirtämään lämpöä optiikasta.

2. Optiset peilit tai läpäisevät tai osittain läpäisevät optiset tai sähköoptiset komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi valvonnalaisten "lasereiden" kanssa;

f. Seuraavat optiset laitteet:

Huom.: "SHPL"-sovelluksissa toimimaan kykenevät yhteisen aukon optiset elementit: katso asetarvikeluettelo.

1. Dynaamiset aaltorintaman (vaiheen) mittausslaitteet, joilla voidaan rekisteröidä ainakin 50 positiota säteen aaltorintamasta, ja joilla on jokin seuraavista:
 - a. Kuvataajuus on 100 Hz tai enemmän ja vaiheen erottelukyky vähintään 5 % säteen aallonpituudesta; tai
 - b. Kuvanopeus on 1 000 Hz tai enemmän ja vaiheen erottelukyky vähintään 20 % säteen aallonpituudesta;
2. "Laserien" diagnostiikkalaitteet, joilla kyetään mittaamaan "SHPL"-järjestelmän säteen ohjauksen kulmavirheitä, jotka ovat 10 µrad tai pienempiä;

6A005 f. (jatkuu)

3. Optiset laitteet, kokoonpanot tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu vaiheistettujen ryhmien koherenttia sädetä kombinoivaa "SHPL"-järjestelmää varten tarkkuudella, joka on seuraavista pienempi: $\lambda/10$ suunnitellulla aallonpituudella tai $0,1 \mu\text{m}$;
4. Erityisesti "SHPL"-järjestelmissä käytettäväksi tarkoitettut projektioteleskoopit.

6A006 Seuraavat "magnetometrit", "magneettikentän gradiometrit", "itseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentän gradiometrit" ja kompensointijärjestelmät sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: 6A006 kohta ei aseta valvonnallaiseksi instrumentteja, jotka on erityisesti suunniteltu lääketieteellisen diagnostiikan biomagneettisia mittauksia varten.

- a. "Magnetometrit", jotka käyttävät "suprajohtavaa", optisesti pumpattua, ydinpresessio- (protoni/Overhauser-) tai kolmikanavaista fluxgate- "teknologiaa", ja joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin $0,05 \text{ nT rms Hz:n neliöjuurta kohti}$;
- b. Induktiokelamagnetometrit, joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin:
 1. $0,05 \text{ nT Hz:n neliöjuurta kohti}$ alle $1 \text{ Hz:n taajuuksilla}$;
 2. $1 \times 10^{-3} \text{ nT Hz:n neliöjuurta kohti}$ taajuuksilla $1 \text{ Hz} - 10 \text{ Hz}$; tai
 3. $1 \times 10^{-4} \text{ nT Hz:n neliöjuurta kohti}$ taajuuksilla yli 10 Hz ;
- c. Kuituoptiset "magnetometrit", joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin $1 \text{ nT rms Hz:n neliöjuurta kohti}$;
- d. "Magneettikentän gradiometrit", jotka käyttävät useita 6A006.a, 6A006.b tai 6A006.c kohdassa määritelyjä "magnetometrejä";
- e. Kuituoptiset "itseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentän gradiometrit", joiden magneettisen gradienttikentän "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin $0,3 \text{ nT/m rms Hz:n neliöjuurta kohti}$;
- f. "Itseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentän gradiometrit", jotka käyttävät muuta kuin kuituoptista "teknologiaa" ja joiden magneettisen gradienttikentän kohinataso (herkkyys) on alempi (parempi) kuin $0,015 \text{ nT/m rms Hz:n neliöjuurta kohti}$;
- g. Magneettiset kompensointijärjestelmät sellaisia magneettisia antureita varten, jotka on suunniteltu toimimaan liikkuvilla alustoilla;
- h. Seuraavat "suprajohtavat" sähkömagneettiset anturit, jotka sisältävät "suprajohtavista" materiaaleista valmistettuja osia ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Ne on suunniteltu toimimaan ainakin yhden "suprajohtavan" ainesosansa "kriittisen" lämpötilan alapuolella (mukaan lukien Josephson-ilmiölaitteet tai suprajohtavat kvantti-interferenssilaitteet (SQUIDS = Superconductive Quantum Interference Devices));
 2. Ne on suunniteltu havaitsemaan sähkömagneettisen kentän vaihteluja $1 \text{ kHz:n taajuudella}$ tai sen alapuolella; ja
 3. Joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 - a. Sisältävät ohutkalvo-SQUIDS-laitteita, joiden minimiviivanleveys on alle $2 \mu\text{m}$ ja jotka on varustettu sisäänmeno- ja ulostuloliitäntäpiireillä;
 - b. Suunniteltu toimimaan magneettikentän muuttumisnopeudella, joka ylittää 1×10^6 magneettivuon kvanttia sekunnissa;
 - c. Suunniteltu toimimaan ilman magneettista suojausta maan magneettikentässä; tai
 - d. Lämpötilakerroin on vähemmän (pienempi) kuin $0,1$ magneettivuon kvanttia/K.

6A007 Seuraavat gravimetrit sekä painovoimagradiometrit:

Huom.: KATSO MYÖS 6A107 KOHTA.

- a. Maalla käytettäväksi suunnitellut tai muunnetut gravimetrit (painovoiman mittarit), joiden staattinen tarkkuus on vähemmän (parempi) kuin 10 µgal;

Huom.: 6A007.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kvartsielementtiä käyttäviä (Worden-tyyppisiä) maapohjan gradiometreja.

- b. Liikkuville alustoille suunnitellut gradiometrit, joiden:

1. Staattinen tarkkuus on parempi kuin 0,7 mgal; ja
2. Toimintatarkkuus käytössä (toiminnassa) on parempi kuin 0,7 mgal ja vakiintumisaika on vähemmän kuin 2 minuuttia kaikissa läsnä olevien korjaavien kompensointien ja liikkeen vaikutusten kombinaatioissa;

- c. Painovoimagradiometrit.

6A008 Tutkajärjestelmät, -laitteet ja -kokoontenot, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYÖS 6A108 KOHTA.

Huom.: 6A008 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

- a. Toisiovalvontatutkia (SSR);
- b. Yhteentörmäyksen estämiseen tarkoitettuja autotutkia;
- c. Näyttöpäätteitä tai monitoreja, joita käytetään lennonjohdossa (ATC), ja joissa ei ole enempää kuin 12 erottuvaa elementtiä mm kohden;
- d. Ilmatieteellisiä (säähavainto-) tutkia.

- a. Jotka toimivat taajuuksilla 40 GHz–230 GHz ja keskimääräinen lähtöteho on yli 100 mW;

- b. Joissa on viritettävä kaistanleveys, joka on yli $\pm 6,25\%$ 'keskitoimintataajuudesta';

Tekn. huom.:

'Keskitoimintataajuuks' on puolet korkeimman ja alhaisimman määritellyn toimintataajuuksien summasta.

- c. Jotka kykenevät toimimaan samanaikaisesti useammalla kuin kahdella kantoaaltotaajuuksella;

- d. Jotka kykenevät toimimaan synteettisessä apertuuri- (SAR), käänteisessä synteettisessä apertuuriutkamoodissa (ISAR) tai sivukulma-tutkamoodissa (SLAR);

- e. Jotka sisältävät "elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhmäantenneja";

- f. Jotka kykenevät ei-yhteistoiminnallisten kohteiden korkeuden määrittämiseen;

Huom.: 6A008.f kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ICAO:n standardien mukaisia tarkkuuslähestymistutkalaitteita (PAR).

- g. Jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi ilmassa (asennettuina ilmapalloon tai lentokoneen rakenteisiin) ja varustettu Doppler- "signaalinkäsittelyllä" liikkuvien kohteiden havaitsemiseksi;

- h. Jotka käsittelevät tutkasignaalia käyttäen:

6A008

h. (jatkuu)

1. "Tutkan hajaspektri" tekniikkaa; tai
 2. "Tutkan taajuushyppely" tekniikkaa;
- i. Jotka takaavat maanpinnalla toimittaessa maksimi "näyttöalueen", joka ylittää 185 km;

Huom.: 6A008.i kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

- a. Kalastusalueiden valvontatutkia;
- b. Maanpinnalla olevia tutkalaitteita, jotka on erikoisesti suunniteltu reittilentoliikenteen ohjausta varten eikä niiden käyttöön erityisesti suunniteltuja ohjelmia, edellyttäen, että:
 1. Sen maksimi "näyttöalue" on 500 km tai vähemmän;
 2. Se on konfiguroitu siten, että tutkan maalitietoa voidaan lähettää vain yhteen suuntaan tutka-asemalta yhteen tai useampaan siviililennonjohtokeskukseen;
 3. Siinä ei ole varauduttu tutkan pyyhkäisy nopeuden kauko-ohjaukseen reitin varrella olevasta lennonjohtokeskuksesta; ja
 4. Sen on oltava kiinteästi rakennettu.
- c. Säähavaintopallojen seurantatutkia.

j. "Laser" tutkat tai valoon perustuvat havainnointi- ja etäisyydenmittauslaitteet (LIDAR), joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Ne ovat "avaruuskelpoisia"; tai
2. Ne käyttävät koherenttia heterodyne- tai homodyneilmaisutekniikkaa ja niiden kulmanerottelukyky on parempi kuin 20 µrad (mikroradiaania);

Huom.: 6A008.j kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartoitukseen tai ilmatieteellisiin havaintoihin erityisesti suunniteltuja LIDAR-laitteita.

k. Sisältävät "signaalinkäsittelyä" varten alajärjestelmiä, jotka käyttävät "pulssikompressio" tekniikkaa ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. "Pulssikompressio" suhde ylittää 150; tai
2. Pulssin leveys on vähemmän kuin 200 ns; tai

l. Sisältävät tiedonkäsittelyn alajärjestelmiä, jotka:

1. Suorittavat "automaattista kohteen seurantaa", joka kullakin antennin kierroksella ennakoii maalin aseman pidemmälle kuin seuraavan antennin säteen ohimenon ajankohtaan;

Huom.: 6A008.l.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi vaaratilanteiden hälytyskykyä lennonjohtojärjestelmissä tai merenkulku- tai satamatutkissa.

2. Laskevat kohteen nopeutta ensiotutkan avulla, jolla on ei-periodinen (vaihtuva) pyyhkäisy nopeus;
3. Suorittavat automaattista kohteiden hahmontunnistusta (piirteiden poimintaa) ja vertaavat kuvioita tietokantoihin talletettuihin kohteiden ominaisuuksiin (aaltomuotoihin tai kuviin) kohteiden tunnistamista tai luokittelua varten; tai
4. Suorittavat kahdesta tai useammasta "maantieteellisesti hajallaan" olevasta ja "toisiinsa kytketystä tutka-anturista" saatujen kohteen tietojen superponointia ja korrelaatiota tai yhdistelyä kohteen selvittämiseksi;

Huom.: 6A008.l.4 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi järjestelmiä, laitteita tai kokoonpanoja, joita käytetään meriliikenteen ohjaamiseen.

- 6A102 Muut kuin 6A002 kohdassa määritellyt säteilyä kestävät 'ilmaisimet', jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suojaamaan ydinaseiden vaikutuksilta (esim. sähkömagneettiselta pulssilta (EMP = Electromagnetic Pulse), röntgensäteilyltä, yhdistetyiltä paineisku- ja lämpövaikutuksilta) ja voidaan käyttää "ohjuksissa", ja jotka on suunniteltu tai mitoitettu kestämaan kokonaisannokseltaan 5×10^5 radin (Pii) tai sen ylittäviä säteilytasoja.

Tekn. huom.:

6A102 kohdassa 'ilmaisimeksi' määritellään mekaaninen, sähköinen, optinen tai kemiallinen laite, joka automaattisesti tunnistaa ja tallentaa tai rekisteröi ärsyksen, kuten ympäristön paineen tai lämpötilan muutoksen, sähköisen tai sähkömagneettisen signaalin tai radioaktiivisesta aineesta lähtevän säteilyn. Tämä sisältää laitteet, jotka tunnistavat kertatoimisesti tai vioittumalla/rikkoutumalla.

- 6A107 Seuraavat painovoiman mittarit (gravimetrit) ja gravimetrien ja painovoimagradiometrien komponentit:
- Muut kuin 6A007.b kohdassa määritellyt gravimetrit, jotka on suunniteltu tai muunnettu ilmassa tai merellä tapahtuvaa käyttöä varten ja joiden staattinen tai operationaalinen tarkkuus on 7×10^{-6} m/s² (0,7milligalia) tai sitä vähemmän (parempi) ja joiden vakiintumisaika on kaksi minuuttia tai vähemmän.
 - Komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu 6A007.b kohdassa tai 6A107.a kohdassa määriteltyjä gravimetrejä ja 6A007.c kohdassa määriteltyjä painovoimagradiometrejä varten.
- 6A108 Seuraavat muut kuin 6A008 kohdassa määritellyt tutkajärjestelmät ja seurantajärjestelmät:
- Tutka- ja lasertutkajärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi 9A004 kohdassa määriteltyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määriteltyissä luotainraketeissa;

Huom.: 6A108.a kohta sisältää seuraavat:

- Maanpinnan muodon kartoituslaitteet;
 - Kuvausanturilaitteet;
 - Näkymäkartoitus- ja korrelointilaitteet (sekä digitaaliset että analogiset);
 - Doppler-navigointitutkalaitteet.
- b. Seuraavat tarkkuusseurantajärjestelmät, joita voidaan käyttää 'ohjuksissa':
- Seurantajärjestelmät, jotka käyttävät koodin kääntäjää yhdessä maanpinnalla tai ilmassa olevien vertailupisteiden tai navigointisatelliitti-järjestelmien kanssa tosiaikaiseen lentosijainnin ja -nopeuden mittausten suorittamiseen;
 - Instrumenttietäisyystutkat, mukaanlukien niihin liittyvät optiset/infrapunaseurantalaitteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - Kulmaresoluutio on parempi kuin 3 milliradiaania (0,5 millia);
 - Toimintaetäisyys on 30 km tai suurempi ja etäisyysresoluutio parempi kuin 10 m rms;
 - Nopeusresoluutio on parempi kuin 3 m/s.

Tekn. huom.:

6A108.b kohdassa tarkoitetaan 'ohjuksella' täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 kilometriä.

- 6A202 Valomonistinputket, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

- valokatodipinta on suurempi kuin 20 cm²; ja
- anodipulssin nousuaika on lyhyempi kuin 1 ns.

- 6A203 Seuraavat muut kuin 6A003 kohdassa määritellyt kamerat ja komponentit:

- Seuraavat mekaaniset pyöriväpeiliset kamerat ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
 - Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden tallennusnopeus on suurempi kuin 225 000 kuvaa/s;

6A203

a. (jatkuu)

2. Juovakamerat, joiden piirtonopeus on suurempi kuin 0,5 mm/ μ s;

Huom.: 6A203.a kohdassa näiden kameroiden komponentteihin sisältyvät niiden synkronointi-elektroniikkayksiköt sekä turbiineista, peileistä ja laakereista koostuvat roottorikokoonpanot.

b. Seuraavat elektroniset juova- ja erilliskuvakamerat, putket ja laitteet:

1. Elektroniset juovakamerat, jotka kykenevät 50 ns:n tai lyhyempään aikaresoluutioon;

2. Juovaputket 6A203.b.1 kohdassa määriteltyjä kameroita varten;

3. Elektroniset (tai elektronisin sulkimin varustetut) erilliskuvakamerat, joiden valotusaika kuvaa kohden on 50 ns tai lyhyempi;

4. Seuraavat erilliskuvaputket tai solid-state-kuvauslaitteet, joita käytetään 6A203.b.3 kohdassa määriteltyjen kameroiden kanssa:

a. Lähitarkenteiset kuvantehostinputket, joissa valokatodi on muodostettu läpinäkyvälle johtavalle pinnoitteelle valokatodin pintavastuksen pienentämiseksi;

b. Piitehostinkohtiolevyllä (SIT = Silicon Intensifier Target) varustetut hilakameraputket, joiden nopeutoiminen järjestelmä mahdollistaa valokatodilta tulevien valosähköisten elektronien veräjäöinnin ennen niiden iskeytymistä SIT-levylle;

c. Kerr- tai Pockel-kennon perustuva sähköoptinen suljin;

d. Muut erilliskuvaputket ja solid-statekuvauslaitteet, joiden pikakuvauksen veräjäointiaika on lyhyempi kuin 50 ns ja jotka on erityisesti suunniteltu 6A203.b.3 kohdassa määriteltyjä kameroita varten;

c. Säteilyä kestävät TV-kamerat tai niissä käytetyt linssit, jotka on erityisesti suunniteltu tai mitoitettu kestäämään yli 50×10^3 Gy:n (Pii) (5×10^6 radin (Pii)) säteilyn kokonaisannosta toiminnallisuuden siitä kärsimättä.

Tekn. huom.:

Termillä Gy (Pii) tarkoitetaan jouleina kilogrammaa kohti ilmaistua energiaa, jonka suojaamaton silikonitestikappale imee itseensä altistuessaan ionisoivalle säteilylle.

6A205

Seuraavat, muut kuin 0B001.g.5, 0B001.h.6 tai 6A005 kohdassa määritellyt "laserit", "laser" vahvistimet ja oskillaattorit:

a. Argonioni "laserit", joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1. toimivat 400 nm:n ja 515 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla; ja

2. keskimääräinen lähtöteho on suurempi kuin 40 W;

b. Viritettävät pulssitoimiset yksimuoto-väriainelaser-oskillaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;

2. 1 W suurempi keskimääräinen lähtöteho;

3. toistotaajuus on suurempi kuin 1 kHz; ja

4. pulssin leveys pienempi kuin 100 ns;

c. Viritettävät pulssitoimiset väriaine "laser" vahvistimet ja oskillaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;

2. keskimääräinen lähtöteho on suurempi kuin 30 W;

- 6A205 c. (jatkuu)
3. toistotaajuus suurempi kuin 1 kHz; ja
 4. pulssin leveys alle 100 ns;
- Huom.: 6A205.c kohta ei aseta valvonnallaiseksi yksimuoto-oskillaattoreita.
- d. Pulssitoimiset hiilidioksidi"laserit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. ne toimivat 9 000 nm:n ja 11 000 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;
 2. toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz;
 3. keskimääräinen lähtöteho suurempi kuin 500 W; ja
 4. pulssin leveys alle 200 ns;
- e. Paravetykäyttöiset Raman-muuntimet, jotka on suunniteltu toimimaan 16 mikrometrin lähtöaaltopituudella ja joiden toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz.
- f. Pulssiviritettävät, neodyymiseostetut "Q-kytkin-laserit" (muut kuin lasi-), joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Lähtöaallonpituus ylittää 1 000 nm, mutta ei ylitä 1 100 nm;
 2. Pulssinkesto on 1 ns tai enemmän; ja
 3. Monitransversaalimoodin ulostulo, jonka keskimääräinen teho ylittää 50 W.
- 6A225 Nopeusinterferometrit yli 1 km/s nopeuksien mittaamiseksi lyhyemmän kuin 10 mikrosekunnin aikajakson kuluessa
- Huom.: 6A225 kohtaan sisältyvät sellaiset nopeusinterferometrit kuten VISAR:it ja DLI:t (dopplerlaserinterferometrit).
- 6A226 Seuraavat paineanturit:
- a. Manganiini-anturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita;
 - b. Kvartsipaineanturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita.

6B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

6B004 Optiset laitteet seuraavasti:

- a. Laitteet, joilla mitataan absoluuttista heijastumissuhdetta $\pm 0,1\%$:n tarkkuudella heijastumissuhteen arvosta;
- b. Muut laitteet kuin optisen pinnan sironnan mittarit, joiden himmentämätön aukko on suurempi kuin 10 cm, ja jotka on erityisesti suunniteltu epätasaisen optisen pinnan kuvan (profiilin) mittaamiseen 2 nm:n tai pienemmällä (paremmalla) "tarkkuudella" tarvittavaa profilia vasten.

Huom.: 6B004 kohta ei aseta valvonnallaiseksi mikroskooppeja.

6B007 Laitteet, joilla tuotetaan, linjataan ja kalibroidaan maalle asennettavia painovoiman mittareita, joiden staat-tinen tarkkuus on parempi kuin 0,1 mgal.

6B008 Tutkan kaikupinnan pulssimittausjärjestelmät, joiden lähetettävien pulssien leveydet ovat 100 ns tai vä-hemmän, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Huom.: KATSO MYÖS 6B108 KOHTA.

6B108 Muut kuin 6B008 kohdassa määritellyt järjestelmät, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja niiden alajär-jestelmissä ja jotka on erityisesti suunniteltu tutkapoikkipintojen mittaamiseen.

6C Materiaalit

6C002 Seuraavat optiset anturimateriaalit:

- a. Telluuri (Te) alkuaineena, jonka puhtausaste on 99,9995 % tai korkeampi;
- b. Yksittäiskiteet (mukaan lukien epitaksiekot) joistakin seuraavista:
 1. Kadmiumsinkkitteluidi (CdZnTe), jonka sinkkipitoisuus on alle 6 'mooliosuus' prosenttia;
 2. Kadmiumtelluridi (CdTe) puhtausasteesta riippumatta; tai
 3. Elohopeakadmiumtelluridi (HgCdTe) puhtausasteesta riippumatta.

Tekn. huom.:

'Mooliosuus' määritellään ZnTe-moolien suhteeksi kiteessä olevien CdTe- ja ZnTe-moolien summaan.

6C004 Seuraavat optiset materiaalit:

- a. Sinkkisenideni (ZnSe)- ja sinkkisulfidi (ZnS)- "substraattiaihiot", jotka on tuotettu kemiallisella kaasufaasipinnoitusmenetelmällä ja joilla on jokin seuraavista:
 1. Tilavuus suurempi kuin 100 cm^3 ; tai
 2. Läpimitta suurempi kuin 80 mm ja paksuus 20 mm tai enemmän;
- b. Seuraavien sähköoptisten materiaalien synteettiset kiteet:
 1. Kaliumtitanyyliarsenaatti (KTA);
 2. Hopeagalliumselenidi (AgGaSe_2);
 3. Talliumarseeniselenidi (Tl_3AsSe_3 , tunnetaan myös nimellä TAS);
- c. Epälineaariset optiset materiaalit, joilla on kaikki seuraavat:
 1. Kolmannen tason susceptibiliteetti ($\chi^{(3)}$) on $10^{-6} \text{ m}^2/\text{V}^2$ tai enemmän; ja
 2. Vasteaika on vähemmän kuin 1 ms;
- d. Piikarbidista tai beryllium-beryllium (Be/Be) -pinnoitetuista materiaaleista valmistetut "substraattiaihiot", joiden läpimitta tai pääakselin pituus on yli 300 mm;
- e. Lasi, mukaan lukien kvartsilasi, fosfaattilasi, fluorofosfaattilasi, zirkoniumfluoridi (ZrF_4) ja hafniumfluoridi (HfF_4), joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 1. Hydroksyyli-ioni(OH⁻)konsentraatio on vähemmän kuin 5 ppm;
 2. Metallisten epäpuhtauksien kokonaistaso on vähemmän kuin 1 ppm; ja
 3. Korkea homogeenisuus (refraktiovarianssin indeksi) on vähemmän kuin 5×10^{-6} ;
- f. Synteettisesti tuotettu timanttimateriaali, jonka absorptio on vähemmän kuin 10^{-5} cm^{-1} aallonpituuksilla, jotka ylittävät 200 nm mutta ovat alle 14 000 nm.

6C005 Seuraavat kiteiset "laserien" perusmateriaalit käsittelemättömässä muodossa:

- a. Titaaniseostettu safiiri;
- b. Aleksandriitti.

6D Ohjelmistot

6D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 6A004, 6A005, 6A008 tai 6B008 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

6D002 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 6A002.b., 6A008 tai 6B008 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

6D003 Seuraavat muut ohjelmistot:

- a. 1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu akustisen säteen muokkaamiseen akustisen tiedon "tosiaikaiseksi käsittelemiseksi" hinattavia hydrofonijärjestelmiä käyttävää passiivista vastaanottoa varten;
2. "Lähdekoodi" akustisen tiedon "tosiaikaiseksi käsittelemiseksi" hinattavia hydrofonijärjestelmiä käyttävää passiivista vastaanottoa varten;
3. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu akustisen säteen muokkaamiseen;
4. "Lähdekoodi" akustisen tiedon "tosiaikaiseksi käsittelemiseksi" pohja- tai poukamakaapelijärjestelmiä käyttävää passiivista vastaanottoa varten;
- b. 1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu magneettisia kompensointijärjestelmiä varten magneettisille antureille, jotka on suunniteltu toimimaan liikkuvilla alustoilla;
2. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu magneettisten poikkeamien ilmaisuun liikkuvilla alustoilla;
- c. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu korjaamaan liikkumisen vaikutuksia painovoimamittareihin tai painovoimagradiometreihin;
- d. 1. Lennonjohto-"ohjelmistojen" sovellus"ohjelmat", jotka toimivat lennonjohtokeskuksiin sijoitetuissa yleiskäyttöisissä tietokoneissa ja kykenevät johonkin seuraavista:
 - a. Käsittelemään ja näyttämään enemmän kuin 150:n samanaikaisen kohteen "reitit"; tai
 - b. Vastaanottamaan kohteiden tutkatietoja useammalta kuin neljältä ensiotutkalta;
2. "Ohjelmistot" sellaisten suojakupujen suunnittelua tai "tuotantoa" varten, jotka:
 - a. On erityisesti suunniteltu suojaamaan 6A008.e kohdassa määriteltyjä, "elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhmä-antenneja"; ja
 - b. Aiheuttavat antennin säteilykuvion, jonka 'keskimääräinen sivukeilataso' on enemmän kuin 40 dB pääsäteen tason alapuolella.

Tekn. huom.:

'Keskimääräinen sivukeilataso' 6D003.d.2.b kohdassa mitataan koko ryhmän yli poislukien pääkeilan ja pääkeilan molemmilla puolilla olevien kahden ensimmäisen sivukeilan kulmasuure.

6D102 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 6A108 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

6D103 "Ohjelmistot", jotka lennon jälkeen prosessoivat nauhoitettua tietoa ja jotka mahdollistavat lentolaitteen aseman määrittämisen sen koko lentoradalla ja jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 'ohjuksia' varten.

Tekn. huom.:

6D103 kohdassa tarkoitetaan 'ohjuksella' täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 kilometriä.

6E Teknologia

6E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A, 6B, 6C tai 6D kohdassa määriteltyjen laitteiden, materiaalien tai "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.

6E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A, 6B tai 6C kohdassa määriteltyjen laitteiden tai materiaalien "tuotantoa" varten.

6E003 Seuraava muu "teknologia":

- a. 1. Optisen pinnan pinnoitus- ja käsittely"teknologia", jota tarvitaan 99,5 %:n tai paremman tasalaatuisuuden saavuttamiseen optisille pinnoitteille, joiden läpimitta tai pääakselin pituus on 500 mm tai enemmän ja joiden kokonaishäviö (absorptio ja sironta) on vähemmän kuin 5×10^{-3} ;

Huom.: Katso myös 2E003.f kohta.

2. Yhden kärjen timanttisorvaustekniikat, joilla tuotetaan parempia pinnan viimeistelytarkkuuksia kuin 10 nm rms yli $0,5 \text{ m}^2$:n ei-tasomaisille pinnoille;

- b. "SHPL"-laserien testaamista tai "SHPL"-säteillä säteilytettyjen materiaalien testaamista tai evaluointia varten erityisesti suunniteltujen diagnostiikka-instrumenttien tai maalien "kehittämiseen", "tuotantoon" tai "käyttöön" "tarvittava" "teknologia";

- c. "Teknologia", jota "tarvitaan" muiden kuin kolmikanavaisten fluxgate-"magnetometrien" tai muiden kuin kolmikanavaisten -"magnetometri"järjestelmien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. "Kohinataso" on vähemmän kuin 0,05 nT rms Hz:n neliöjuurta kohti pienemmällä kuin 1 Hz:n taajuuksilla; tai

2. "Kohinataso" on 1×10^{-3} nT rms Hz:n neliöjuurta kohti 1 Hz:n tai sitä suuremmilla taajuuksilla.

6E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A002, 6A007.b ja c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 tai 6D103 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "käyttöä" varten.

Huom.: 6E101 kohta määrittelee 6A008 kohdassa määriteltyjen laitteiden "teknologian" vain, kun se on suunniteltu ilmailusovelluksiin ja sitä voidaan käyttää "ohjuksissa".

6E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A003, 6A005.a.1.c, 6A005.a.2.a, 6A005.c.1.b, 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 tai 6A226 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

RYHMÄ 7
NAVIGOINTI JA ILMAILU

7A Järjestelmät, laitteet ja komponentit

Huom.: Vedenalaisten kulkuneuvojen automaattiohjaukset: katso 8 ryhmä.

Tutkat: katso 6 ryhmä.

7A001 Lineaariset kiihtyvyyssmittarit, jotka on suunniteltu käytettäväksi inertiasuunnistus- tai ohjausjärjestelmissä ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekä erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYÖS 7A101 KOHTA. Kulma- tai kiertokiihtyvyyssmittareiden osalta katso 7A002 kohta.

- "Biasstabiilisuus" vuoden aikana on vähemmän (parempi) kuin 130 mikro-g suhteessa kiinteään kalibrointiin; tai
- "Mittakertoimen" "stabiilisuus" vuoden aikana on vähemmän (parempi) kuin 130 ppm suhteessa kiinteään kalibrointiin; tai
- Ne on määritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyyssmittareilla.

7A002 Gyroskoopit sekä kulma- tai kiertokiihtyvyyssmittarit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYÖS 7A102 KOHTA.

- "Ryömintänopeuden" "stabiilisuus", mitattuna 1 g:n olosuhteissa kolmen kuukauden aikana ja suhteessa kiinteään kalibrointiin, on:
 - Vähemmän (parempi) kuin 0,1 astetta tunnissa, kun ne on määritelty toimimaan alle 10 g:n lineaarisilla kiihtyvyyssmittareilla; tai
 - Vähemmän (parempi) kuin 0,5 astetta tunnissa, kun ne on määritelty toimimaan lineaarisilla kiihtyvyyssmittareilla 10 g–100 g; tai
- Ne on määritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyyssmittareilla.

7A003 Inertiajärjestelmät ja seuraavat erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYÖS 7A103 KOHTA.

- Inertiasuunnistusjärjestelmät (INS) (kardaaniset ja sidotut) sekä inertialaitteet, jotka on suunniteltu "ilma-aluksen", maakulkuneuvon, aluksen (pinta- tai vedenalaisen) tai "avaruusaluksen" asentoa, ohjausta tai valvontaa varten ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
 - (Vapaa inertiaalinen) navigointivirhe tavanomaisen linjauksen jälkeen on 0,8 merimailin tunnissa 'todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe' tai vähemmän (parempi); tai
 - Ne on määritelty toimimaan yli 10 g:n lineaarisilla kiihtyvyyssmittareilla.
- Hybridi-inertiasuunnistusjärjestelmät, jotka on yhdistetty maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (-mien) (GNSS) kanssa tai DBRN (Data-Based Referenced Navigation) -järjestelmän (-mien) kanssa asentoa, ohjausta tai valvontaa varten tavanomaisen linjauksen jälkeen ja joiden INS-suunnistuspaikannustarkkuus GNSS:n tai DBRN:n menetyksen jälkeen aina neljän minuutin ajan on vähemmän (parempi) kuin 10 metrin "yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä" (CEP).
- Inertialaitteet suuntakulman, ohjaussuunnan tai pohjoisen osoittamista varten, joilla on jokin seuraavista, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
 - Suunniteltu osoittamaan suuntakulma, ohjaussuunta tai pohjoinen tarkkuudella, joka on sama tai pienempi (parempi) kuin 6 kaariminuuttia RMS 45 leveysasteessa; tai
 - Suunniteltu siten, että niillä on 900 g:n tai sitä suurempi iskutaso toimimattomana 1 ms:n tai sitä pidemmän keston ajan.

Huom. 1: 7A003.a ja 7A003.b kohdan parametreja sovelletaan kaikissa seuraavissa ympäristöolosuhteissa:

- Satunnainen syötevärähtely, jonka kokonaissuuruusluokka on 7,7 g rms ensimmäisen puolen tunnin aikana ja kokonaistestitietä puolitoista tuntia kutakin toisiinsa nähden kohtisuoraan olevaa akselia kohti, kun satunnainen värähtely täyttää seuraavat vaatimukset:
 - Vakio voiman spektritiheyden (PSD) arvo on $0,04 \text{ g}^2/\text{Hz}$ taajuuksilla 15–1 000 Hz; ja
 - PSD vaimenee taajuuden mukana $0,04 \text{ g}^2/\text{Hz}$:stä $0,01 \text{ g}^2/\text{Hz}$:iin taajuuksilla 1 000–2 000 Hz;
- Kallistus ja kääntymisnopeus on +2,62 radiaania/s (150 astetta/s); tai
- Edellä 1 tai 2 kohdan vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

7A003 c. (jatkuu)

Huom. 2: 7A003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi inertiaalisuunnistusjärjestelmiä, jotka "osallistujavaltion" siviiliviranomaiset ovat sertifiineet käytettäväksi "siviili-ilma-aluksissa".

Huom. 3: 7A003.c.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi teodoliittijärjestelmiä, joihin sisältyy erityisesti siviilimittaustehtäviin suunniteltuja inertialaitteita.

Tekn. Huom.:

1. 7A003-b koskee järjestelmiä, joissa inertiasuunnistusjärjestelmä ja muut riippumattomat suunnistuksen apujärjestelmät on rakennettu yhdeksi yksiköksi (yhdistetty) suorituskyvyn parantamiseksi.
2. Todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe (CEP) – Tavanomaisessa ympyräjakelussa, ympyrän säde sisältää 50 prosenttia tehdyistä yksittäisistä mittauksista, tai sellaisen ympyrän säde, jossa on 50 prosentin todennäköisyys sijoittua.

7A004 Hyrrätähtikompassit ja muut laitteet, jotka määrittävät aseman tai suunnan seuraamalla automaattisesti taivaankappaleita tai satelliitteja ja joiden atsimuuttitarkkuus on 5 kaarisekuntia tai vähemmän (parempi).

Huom.: KATSO MYÖS 7A104 KOHTA.

7A005 Globaalisista paikanmäärittäysatelliiteista (so. GPS tai GLONASS) vastaanottavat laitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYÖS 7A105 KOHTA.

- a. Käyttävät salauksen avausta; tai
- b. Nolla-ohjattavaa antennia.

7A006 Ilmassa käytettävät korkeusmittarit, jotka toimivat muilla kuin 4,2–4,4 GHz:n taajuuksilla, ne mukaan lukien, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: KATSO MYÖS 7A106 KOHTA.

- a. Suorittavat "tehon hallintaa"; tai
- b. Käyttävät vaihevainnusmodulaatiota.

7A007 Suuntimalaitteet, jotka toimivat yli 30 MHz:n taajuuksilla ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, sekä niitä varten suunnitellut komponentit:

- a. "Hetkellinen kaistanleveys" 1 MHz tai enemmän;
- b. Useamman kuin 100:n kanavan rinnakkaiskäsitteily; ja
- c. Käsitteilynopeus on enemmän kuin 1 000 suuntimatulosta sekunnissa kanavaa kohti.

7A101 Seuraavat muut kuin 7A001 kohdassa määritellyt kiihtyvyyssmittarit, sekä erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit,

- a. Kiihtyvyyssmittarit, joiden kynnys on 0,05 g tai pienempi tai lineaarisuusvirhe enintään 0,25 % täyden mittausalueen näyttämästä, tai molemmat, ja jotka on suunniteltu käytettäväksi inertiasuunnistusjärjestelmissä tai kaikentyyppisissä ohjausjärjestelmissä;

Huom.: 7A101.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kiihtyvyyssmittareita, jotka on erityisesti suunniteltu ja kehitetty MWD-antureiksi (Measurement While Drilling), joita käytetään porausreikien huoltotoiminnassa.

- b. Jatkuvan mittausalueen kiihtyvyyssmittarit, jotka on suunniteltu toimimaan yli 100 g:n kiihtyvyysoilla.

7A102 Muut kuin 7A002 kohdassa määritellyt kaiken tyyppiset gyroskoopit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa", ja joiden nimellis "ryömintänopeuden" "stabiiliisuus" on vähemmän kuin 0,5° (1 sigma tai rms) tunnissa 1 g:n olosuhteissa sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

7A103 Seuraavat muut kuin 7A003 kohdassa määritellyt instrumentit, navigointilaitteet ja -järjestelmät sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

- a. Inertia- tai muut laitteet, joissa käytetään 7A001 tai 7A101 kohdassa määriteltyjä kiihtyvyyssmittareita tai 7A002 tai 7A102 kohdassa määriteltyjä gyroskooppeja, sekä järjestelmät, joihin sisältyy sellaisia laitteita;

7A103 a. (jatkuu)

Huom.: 7A103.a kohta ei määrittele 7A001 kohdan määrittelemiä kiihtyvyyksmittareita sisältäviä laitteita, joiden kiihtyvyyksmittarit on erityisesti suunniteltu ja kehitetty porausreikien huoltotoiminnassa käytettäväksi MWD-antureiksi (Measurement While Drilling).

- b. Integroidut lentoinstrumenttijärjestelmät, jotka sisältävät 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja, 9A012 kohdassa määriteltyjä miehittämättömiä lentolaitteita tai 9A104 kohdassa määriteltyjä luotainraketteja varten suunniteltuja tai muunnettuja hyrrävakauttajia tai automaattiohjauslaitteita;
- c. Integroidut navigointijärjestelmät, jotka on suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja, 9A012 kohdassa määriteltyjä miehittämättömiä lentolaitteita tai 9A104 kohdassa määriteltyjä luotainraketteja varten ja joilla kyetään saamaan aikaan navigaatiotarkkuus, jossa yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä (CEP) on 200 metriä tai vähemmän.

Tekn. Huom.:

Integroituihin navigointijärjestelmään sisältyvät tavallisesti seuraavat komponentit:

1. Inertiamittauslaite (esim. asento- ja suuntaviitejärjestelmä, inertiaviiteyksikkö tai inertianavigointijärjestelmä);
2. Yksi tai useampia ulkoisia ilmaisimia, joita käytetään aseman ja/tai nopeuden päivitykseen joko määrääjain tai jatkuvasti lennon aikana (esim. satelliittinavigointivastaanotin, tutkan korkeusmittari ja/tai Dopplertutka); ja
3. Integroitilaitteistot ja -ohjelmistot.

7A104 Muut kuin 7A004 kohdassa määriteltyt hyrrä-tähtikompassit ja muut laitteet, joiden avulla määritetään asema tai suunta automaattisesti taivaankappaleita tai satelliitteja seuraamalla, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

7A105 Vastaanottolaitteet maailmanlaajuisia satelliittinavigointijärjestelmiä varten (GNSS; esim. GPS, GLONASS tai Galileo), joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista ja erityisesti suunnitellut komponentit niitä varten:

- a. Ne on suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja, 9A012 kohdassa määriteltyjä miehittämättömiä lentolaitteita tai 9A104 kohdassa määriteltyjä luotainraketteja varten; tai
- b. Ne on suunniteltu tai muunnettu lentosovelluksia varten ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 1. Ne pystyvät tuottamaan navigointitietoa nopeuksilla, jotka ovat yli 600 m/s (1 165 meripeninkulmaa/tunti);
 2. Ne käyttävät sotilas- tai hallintokäyttöön suunniteltua tai muunnettua salauksenpurkua voidakseen saada pääsyn GNSS-suojattuihin signaaleihin/tietoon; tai
 3. Ne on erityisesti suunniteltu käyttämään häirinnänestoa (esim. nollaohjausantenni tai elektronisesti ohjattava antenni) toimiakseen aktiivisten tai passiivisten vastatoimien ympäristössä.

Huom.: 7A105.b.2 ja 7A105.b.3 kohta eivät aseta valvonnalliseksi laitteita, jotka on suunniteltu kaupallisia, siviilikäyttöön tarkoitettuja tai ihmishengen turvaavia (esim. tietojen eheys, lentoturvallisuus) GNSS-palveluja varten.

7A106 Muut kuin 7A006 kohdassa määriteltyt tutka- tai lasertutkatyyppiset korkeusmittarit, jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi 9A004 tai 9A104 kohdassa määriteltyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määriteltyissä luotainraketeissa järjestelmissä.

7A115 Passiiviset anturit, joiden avulla määritellään suuntima tiettyihin sähkömagneettisiin lähteisiin (suuntimalaitteet) tai maaston ominaisuuksiin, ja jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi 9A004 kohdassa määriteltyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määriteltyissä luotainraketeissa.

Huom.: 7A115 kohta sisältää anturit seuraavia laitteita varten:

- a. Maanpinnan muodon kartoituslaitteet;
- b. Kuvausanturilaitteet (sekä aktiiviset että passiiviset);
- c. Passiiviset interferometrilaitteet.

- 7A116 Seuraavat lennon ohjausjärjestelmät ja servoventtiilit, jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa:
- a. Hydrauliset, mekaaniset, sähköoptiset tai sähkömekaaniset, mukaan lukien fly-by-wire -tyyppiset järjestelmät;
 - b. Lentoasennon säätölaitteet;
 - c. Lennonohjauksen servoventtiilit, jotka on suunniteltu tai muunnettu 7A116.a tai 7A116.b kohdassa määriteltyjä järjestelmiä varten ja suunniteltu tai muunnettu toimimaan ympäristössä, jossa värähtely on yli 10 g rms koko alueella välillä 20 Hz–2 kHz.
- 7A117 "Ohjautuslaitteet", joita voidaan käyttää "ohjuksissa", jotka kykenevät 3,33 %:n tai parempaan järjestelmätarkkuuteen toimintaetäisyydellä (esim. "CEP" on 10 km tai vähemmän 300 km:n matkalla).

7B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet:

- 7B001 7A kohdassa määriteltyjä laitteita varten erityisesti suunnitellut testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteet;
Huom.: 7B001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ylläpitotasojen I tai II testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteita.
Tekn. Huom.:
1. Ylläpitotaso I
Inertiasuunnistusjärjestelmän jonkin yksikön vikaantuminen huomataan lentokoneen ohjaus- ja näyttöyksiköstä (CDU) tai vastaavan alajärjestelmän tilanneviestistä. Noudattaen valmistajan käsikirjan antamia ohjeita vian syy voidaan paikallistaa epäkuntoisen vaihdettavan yksikön tasolle (LRU) ja operaattori voi vaihtaa varayksikön viallisen tilalle.
2. Ylläpitotaso II
Viallinen linjahuollossa vaihdettava yksikkö (LRU) lähetetään valmistajan (tai tasosta II vastaavan operaattorin) korjauspisteeseen, jossa se testataan erilaisilla soveltuvilla tavoilla ja viallinen kokoonpano (SRA) paikallistetaan. Tämän kokoonpanon (SRA) tilalle vaihdetaan toimiva varaosa ja viallinen kokoonpano (SRA) (tai mahdollisesti koko yksikkö (LRU)) lähetetään valmistajalle.
Huom.: Ylläpitotaso II ei sisällä valvonnalaisten kiihtyvyyssmittarien tai gyroanturien irrottamista kokoonpanosta (SRA).
- 7B002 Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet rengas-"laser"-gyroskooppien peilien karakterisointia varten:
Huom.: KATSO MYÖS 7B102 KOHTA.
a. Sirontamittarit, joiden mittaustarkkuus on vähemmän (parempi) kuin 10 ppm
b. Pinnankarkeusmittarit (profilometrit), joiden mittaustarkkuus on 0,5 nm (5 ångströmiä) tai vähemmän (parempi).
- 7B003 7A kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoon" erityisesti suunnitellut laitteet.
Huom.: 7B003 kohtaan sisältyy:
a. Gyroskooppien virityksen testausasemat;
b. Gyroskooppien dynaamiset tasapainotusasemat;
c. Gyroskooppien totutuskäyttö/moottorin testausasemat;
d. Gyroskooppien tyhjennys/täyttöasemat;
e. Gyroskooppien laakereiden keskipakopitimet;
f. Kiihtyvyyssmittareiden akselien linjausasemat.
- 7B102 "Laser"-gyroskooppien peilien luokitukseen erityisesti suunnitellut heijastusmittarit, joiden mittaustarkkuus on 50 ppm tai vähemmän (parempi).
- 7B103 "Tuotantolaitokset" ja "tuotantolaitteet" seuraavasti:
a. "Tuotantolaitokset", jotka on erityisesti suunniteltu 7A117 kohdassa määriteltyjä laitteita varten;
b. Tuotantolaitteet ja muut kuin 7B001–7B003 kohdassa määritellyt testaus-, kalibrointi- ja linjauslaitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi 7A kohdassa määriteltyjen laitteiden kanssa.

7C**Materiaalit**

Ei ole.

7D Ohjelmistot

7D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 7A tai 7B kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten:

7D002 "Lähekoodi" minkä tahansa tyyppisten inertiasuunnistuslaitteiden "käyttöä" varten, mukaan lukien inertialaitteet, joita ei ole määritelty 7A003 tai 7A004 kohdassa, tai AHRS-järjestelmät (Attitude Heading Reference Systems).

Huom.: 7D002 kohta ei aseta valvonnallaiseksi kardaansia AHRS-järjestelmiä.

Tekn. Huom.:

AHRS-järjestelmät eroavat yleisesti inertiasuunnistusjärjestelmistä (INS = Inertial Navigation Systems) siinä, että AHRS antaa asento- ja suuntatiedon eikä normaalisti anna INS-järjestelmiin liittyviä kiihtyvyy-, nopeus- tai asematietoja.

7D003 Seuraavat muut "ohjelmistot":

- a. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu parantamaan järjestelmien toimintakykyä tai vähentämään niiden navigointivirhettä 7A003 ja 7A004 kohdassa määriteltyille tasoille;
- b. Integroitujen hybridijärjestelmien "lähekoodi", joka parantaa järjestelmien toimintakykyä tai vähentää niiden navigointivirhettä 7A003 kohdassa määriteltylle tasolle yhdistämällä jatkuvasti inertiatietoa johonkin seuraavista:
 1. Doppler-tutkan antama nopeustieto;
 2. Globaalien paikannusjärjestelmien (so. GPS tai GLONASS) referenssitieto; tai
 3. Tieto, joka on peräisin DBRN (Data-based Referenced Navigation) -suunnistusjärjestelmistä;
- c. "Lähekoodi" integroitua ilmailu- tai lentotehtäväjärjestelmiä varten, jotka yhdistävät anturitietoa ja käyttävät "asiantuntijajärjestelmiä";
- d. "Lähekoodi" seuraavien laitteiden tai järjestelmien "kehittämistä" varten:
 1. Digitaaliset lennonhallintajärjestelmät "lennon kokonaisuohjaukseen";
 2. Integroidut moottori- ja lennonohjausjärjestelmät;
 3. Fly-by-wire- tai fly-by-light-ohjausjärjestelmät;
 4. Vikasietoiset tai itsetoipuvat "aktiiviset lennonohjausjärjestelmät";
 5. Ilmassa käytettävät automaattiset suuntimislaitteet;
 6. Staattiseen maanpintatietoon perustuvat lentoarvojärjestelmät; tai
 7. Rasterityyppiset tuulilasinäytöt tai kolmiulotteiset näytöt.
- e. Tietokoneavusteiset suunnitteluohjelmistot (CAD), jotka on erityisesti suunniteltu "aktiivisten lennon-ohjausjärjestelmien", helikopterien moniakseli- fly-by-wire tai fly-by-light ohjausten tai helikopterien "ilmavirran avulla säädellyt vastamomenttijärjestelmät tai ilmavirran avulla säädellyt suunnanohjausjärjestelmät", joiden "teknologia" on määritelty 7E004.b, 7E004.c.1 tai 7E004.c.2 kohdassa.

7D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 7A001–7A006, 7A101–7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 tai 7B103 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

7D102 Integrointi "ohjelmistot" seuraavasti:

- a. Integrointi "ohjelmistot" 7A103.b kohdassa määriteltyjä laitteita varten;
- b. 7A003 tai 7A103.a kohdassa määriteltyjä laitteita varten erityisesti suunnitellut integrointi "ohjelmistot".
- c. Integrointi "ohjelmistot", jotka on suunniteltu tai muunnettu 7A103.c kohdassa määriteltyjä laitteita varten.

Huom.: Integrointi "ohjelmistojen" tavallisissa muodoissa käytetään Kalman-filtteriä.

7D103 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 7A117 kohdassa määriteltyjen ohjauslaitteiden mallintamiseen tai simulointiin tai niiden integroinnin suunnitteluun kohdan 9A004, avaruuteen laukaisussa käytettävät kantoraketit, tai kohdan 9A104, luotainraketit, kanssa.

Huom.: 7D103 kohdassa määritelty "ohjelmistot" jäävät valvonnallaiseksi, kun niitä yhdistetään 4A102 kohdassa määriteltyjen laitteiden kanssa.

7E Teknologia

7E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A, 7B tai 7D kohdassa määriteltyjen laitteiden tai ohjelmien "kehittämistä" varten.

7E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A tai 7B kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.

7E003 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A001–7A004 kohdan laitteiden korjaukseen, kunnostukseen tai huoltoon;

Huom.: 7E003 kohta ei aseta valvonnallaiseksi ylläpito "teknologiaa", joka liittyy suoraan "siviili-ilma-alusten" ylläpitotaso I tai ylläpitotaso II:ssa kuvattuun viallisten tai ei-huollettavien LRU-yksiköiden ja SRA-kokoonpanojen kalibrointiin, poistoon tai vaihtoon.

Huom.: Katso tekn. huom. 7B001 kohdassa.

7E004 Seuraava muu "teknologia":

a. Seuraavien laitteiden tai järjestelmien "kehittämiseen" tai "tuotantoon" tarkoitettu "teknologia":

1. Ilmassa käytettävät automaattiset suuntimalaitteet, jotka toimivat yli 5 MHz:n taajuuksilla;
2. Lentoarvojärjestelmät, jotka perustuvat vain staattiseen maanpintatietoon, ts. jotka korvaavat konventionaaliset ilmatietosondit;
3. "Ilma-alusten" rasterityyppiset tuulilasinäytöt tai kolmiulotteiset näytöt;
4. Inertiasuunnistusjärjestelmät tai hyrrätähtikompassit, jotka sisältävät 7A001 tai 7A002 kohdissa määriteltyjä kiihtyvyyssmittareita tai gyroskooppia;
5. Sähköiset toimilaitteet (so. sähkömekaaninen, sähköhydraattinen ja integroitu toimilaittejärjestelmä), jotka on erityisesti suunniteltu "primääristä lennonohjausta" varten;
6. "Lennonohjauksen optinen anturijärjestelmä", joka on erityisesti suunniteltu "aktiivisten lennonohjausjärjestelmien" toteuttamiseksi.

b. Seuraava "kehittäminen" "teknologia" "aktiivisia lennonohjausjärjestelmiä" varten (mukaanlukien fly-by-wire- tai fly-by-light-järjestelmät):

1. Konfiguraatiosuunnittelu useiden mikroelektronisten prosessointiyksiköiden (on-board-tietokoneiden) yhdistämiseksi suorittamaan tosiaikaista käsittelyä ohjaussääntöjen soveltamiseksi;
2. Anturien paikan tai lentokonerakenteiden dynaamisen kuormituksen ohjaussääntökompensointi, ts. anturien värinäympäristön tai anturien sijainnin vaihtelun kompensointi painopisteen suhteen;
3. Elektroninen redundanttien tietojen tai järjestelmien hallinta vian havaitsemista, vian sietoa, vian eristämistä tai uudelleenkonfigurointia varten;

Huom.: 7E004.b.3 kohta ei aseta valvonnallaiseksi "teknologiaa" fyysisen redundanssin suunnittelua varten.

4. Lennonohjausjärjestelmät, jotka sallivat lennon aikaisen voima- ja momenttiohjausten uudelleenkonfiguroinnin ilma-aluksen tosiaikaista autonomista ohjausta varten;
5. Digitaalisten lennonohjaus-, navigointi- ja moottorinohjaustietojen integrointi digitaalseksi lennonhallintajärjestelmäksi "lennon kokonaisohjusta" varten;

Huom.: 7E004.b.5 kohta ei aseta valvonnallaiseksi:

- a. "Kehittäminen" "teknologiaa" digitaalisen lennonohjauksen, navigoinnin ja työntövoiman ohjaustietojen integroimiseksi digitaalseksi lennonhallintajärjestelmäksi "lentonradan optimointia" varten.
- b. Sellaisten "lentokoneen" instrumenttijärjestelmien "kehittäminen" "teknologiaa", jotka on integroitu ainoastaan seuraavia navigointi- tai laskeutumisjärjestelmiä varten: VOR-, DME, ILS- tai MLS-navigointia tai -lähestymistä varten.

- 7E004 b. (jatkuu)
6. "Täyden auktoriteetin digitaaliset lennonohjausjärjestelmät" tai monianturiset lentotehtävän hallintajärjestelmät, jotka sisältävät "asiantuntijajärjestelmiä";
- Huom.*: "Teknologia" täyden auktoriteetin digitaalista moottorin ohjausta ("FADEC") varten: katso 9E003.a.9 kohta.
- c. "Teknologia" seuraavien helikopterijärjestelmien "kehittämistä" varten:
1. Moniakseliset fly-by-wire- tai fly-by-light-ohjaukset, jotka yhdistävät toiminnot vähintään kahdesta seuraavasta ohjauksesta yhdeksi ohjaavaksi elementiksi:
 - a. Nousu- ja laskuohjaukset;
 - b. Vaakatason ohjaukset;
 - c. Suuntapoikkeaman ohjaukset;
 2. "Ilmavirran avulla säädellyt vastamomentti- tai suunnanohjausjärjestelmät";
 3. Roottorilavat, jotka sisältävät "muuttuvan geometrian kantopintoja" ja joita käytetään yksittäisiä lapoja ohjaavissa järjestelmissä.
- 7E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A001–7A006, 7A101–7A106, 7A115–7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101–7D103 kohdassa määriteltyjen laitteiden käyttöä varten.
- 7E102 Seuraavat "teknologiat" ilmailuelektroniikan ja sähköisten alajärjestelmien suojaamiseksi ulkoisista lähteistä aiheutuvaa sähkömagneettisen pulssin (EMP = Electro Magnetic Pulse) sekä sähkömagneettisen häiriön (EMI = Electro Magnetic Interference) uhkaa vastaan:
- a. Suojausjärjestelmien suunnittelu "teknologia";
 - b. Suunnittelu "teknologia" vahvennettujen sähköisten piirien ja alajärjestelmien konfigurointia varten;
 - c. Suunnittelu "teknologia" 7E102.a ja 7E102.b kohdan vahvennuskriteerien määrittelyä varten.
- 7E104 "Teknologia" lennon ohjaus-, ohjautus- ja työntövoimatietojen integrointiin lennonhallintajärjestelmäksi rakettijärjestelmän lentoradan optimoimiseksi.

RYHMÄ 8
MERITEKNOLOGIA

8A Järjestelmät, laitteet ja komponentit

8A001 Seuraavat vedenalaiset tai pinta-alukset:

Huom.: Vedenalaisten alusten valvonnallisuuden selvittämiseksi, katso myös:

5 ryhmä 2 osa: "Tiedonsuojaus" salattua viestintää suorittavat laitteet;

6 ryhmä: anturit;

7 ja 8 ryhmä: navigointilaitteet;

8A ryhmä: vedenalaiset laitteet.

a. Miehitetyt kytketyt vedenalaiset alukset, jotka on suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissä;

b. Miehitetyt kytkemättömät vedenalaiset alukset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Ne on suunniteltu 'toimimaan itsenäisesti' ja niillä on kaikki seuraavat nostokyvyt:

a. 10 % tai enemmän niiden painosta ilmassa; ja

b. 15 kN tai enemmän;

2. Suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissä; tai

3. Niillä on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Ne on suunniteltu 4:n tai useamman hengen miehistöä varten;

b. Ne on suunniteltu "toimimaan itsenäisesti" 10 tuntia tai pidempään;

c. "Toimintasäde" on 25 merimailia tai enemmän; ja

d. Pituus on 21 m tai vähemmän;

Tekn. huom.:

1. 8A001.b kohdassa "toimii itsenäisesti" tarkoittaa toimintaa täysin sukelluksissa, ilman snorkkelia, kaikki järjestelmät toiminnassa ja kulkemista sillä miniminopeudella, jolla sukelluslaite voi turvallisesti ohjata dynaamisesti syvyyttään käyttämällä vain syvyysohjaimiaan ja tarvitsematta tukialusta tai pinnalla, merenpohjassa tai maalla olevaa tukiasemaa, sekä sukellus- tai pintakäyttöön soveltuvia työntövoimajärjestelmiä.

2. 8A001.b kohdassa 'toimintasäde' tarkoittaa puolta maksimietäisyydestä, josta sukelluslaite voi suoriutua.

c. Miehitettämättömät, kytketyt vedenalaiset alukset, jotka on suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissä ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Ne on suunniteltu itseliikkuviksi 8A002.a.2 kohdassa määriteltyjä työntövoimamoottoreita tai syysäimiä käyttäen; tai

2. Joilla on kuituoptinen tietoyhteys;

d. Miehitettämättömät, kytkemättömät vedenalaiset alukset:

1. Jotka on suunniteltu valitsemaan kurssi minkä tahansa maantieteellisen kohteen suhteen ilman ihmisen tosiaikaista avustusta;

2. Joilla on akustinen tieto- tai komentoyhteys; tai

3. Joilla on kuituoptinen tieto- tai komentoyhteys, joka ylittää 1 000 m;

e. Valtameripelastusjärjestelmät, joiden nostokyky ylittää 5 MN, jotka on tarkoitettu pelastamaan kohteita yli 250 m:n syvyyksistä ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Dynaaminen paikannusjärjestelmä, jolla asema voidaan säilyttää 20 metrin tarkkuudella navigointijärjestelmän antaman pisteen suhteen; tai

2. Merenpohjanavigoinnin ja navigoinnin integraatiojärjestelmät yli 1 000 m metrin syvyyksille, joiden paikannustarkkuus on alle 10 m ennalta annetusta pisteestä;

8A001 (jatkuu)

f. (Täysin helmoitetut) ilmatyynyalukset, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Suunniteltu maksiminopeus täydessä lastissa ylittää 30 solmua merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 1,25 m (merenkäyntitila 3) tai enemmän;
2. Tyynypaine ylittää 3 830 Pa; ja
3. Tyhjän ja täyteen lastatun aluksen uppoumasuhde on alle 0,70;

g. Sivurungoilla varustetut ilmatyynyalukset, joiden suunniteltu maksiminopeus täydessä lastissa ylittää 40 solmua merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 3,25 m (merenkäyntitila 5) tai enemmän;

h. Kantosiipialukset, joissa on aktiiviset järjestelmät kantosiipien automaattiseksi ohjaamiseksi ja joiden maksiminopeus täydessä lastissa on 40 solmua tai enemmän merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 3,25 m (merenkäyntitila 5) tai enemmän;

i. 'Pienen vesiviivapinta-alan alukset':

1. Joiden uppouma täydessä lastissa ylittää 500 tonnia ja joiden suunniteltu maksiminopeus täydessä lastissa ylittää 35 solmua merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 3,25 m (merenkäyntitila 5) tai enemmän; tai
2. Joiden uppouma täydessä lastissa ylittää 1 500 tonnia ja joiden suunniteltu maksiminopeus täydessä lastissa ylittää 25 solmua merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 4 m (merenkäyntitila 6) tai enemmän.

Tekn. huom.:

'Pienen vesiviivapinta-alan alus' määritellään seuraavalla kaavalla: vesiviivapinta-ala suunnitellulla toimintasyvyyksellä on vähemmän kuin $2 \times (\text{uppouman tilavuus suunnitellulla toimintasyvyyksellä})^{2/3}$.

8A002 Seuraavat järjestelmät ja laitteet:

Huom.: Vedenalaiset viestintälaitteet: katso 5 ryhmä 1 osa – Tietoliikenne.

a. Seuraavat järjestelmät ja laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisia aluksia varten ja jotka on tarkoitettu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissä:

1. Paineotelot tai painerungot, joiden sisätilan läpimitta on yli 1,5 m;
2. Tasavirralla toimivat työntövoimalaitteet;
3. Yhdyskaapelit ja niiden liittimet, joissa käytetään optisia kuituja ja joissa on synteettisiä vahvikkeita;

b. Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ohjaamaan automaattisesti 8A001 kohdassa määriteltyjen vedenalaisten alusten liikkeitä käyttäen navigointitietoa ja suljetun säätöpiirin servo-ohjausta ja jotka:

1. Mahdollistavat aluksen liikkumisen 10 m:n sisällä ennalta annetusta vesipatsaan pisteestä;
2. Säilyttävät aluksen paikan 10 m:n sisällä ennalta määritellystä vesipatsaan pisteestä; tai
3. Säilyttävät aluksen etäisyyden 10 m:n tarkkuudella, kun seurataan merenpohjalla tai sen alla olevaa kaapelia;

c. Kuituoptiset runkoläpiviennit ja -liittimet;

d. Seuraavat vedenalaiset näyttöjärjestelmät:

1. Seuraavat televisiojärjestelmät ja televisiokamerat:

a. Televisiojärjestelmät (jotka koostuvat kamerasta, valonlähteistä, monitorointi- ja signaalinvälityslaitteista), joiden rajaerottelu-tarkkuus ilmassa mitattuna ylittää 800 juovaa ja jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen aluksen etäistoimintaan;

8A002 d. 1. (jatkuu)

b. Vedenalaiset televisiokamerat, joiden rajaerottelutarkkuus ilmassa mitattuna ylittää 1 100 juovaa;

c. Heikon valotason televisiokamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön sisältäen kaikki seuraavat:

1. 6A002.a.2.a kohdassa määriteltyjä kuvanvahvistinputkia; ja

2. Enemmän kuin 150 000 "aktiivista pikseliä" puolijohdepinta-alamatriisia kohti;

Tekn. huom.:

Television rajaerottelutarkkuus on horisontaalisen resoluution mitta, joka tavallisesti ilmaistaan testitaulukosta erottuvana maksimijuovalukuna kuvan korkeutta kohti käyttäen IEEE:n standardia 208/1960 tai jotain vastaavaa standardia.

2. Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen aluksen etäistoimintaan ja jotka käyttävät tekniikkaa, jolla minimoidaan takaisinsironnan vaikutuksia, mukaan lukien etäisyyden mukaan toimivat valonlähteet tai "laser"-järjestelmät;

e. Valokuvauskamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön yli 150 m:n syvyydessä, joiden filmikoko on 35 mm tai suurempi ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Joissa filmiin voidaan sisällyttää tietoa kameran ulkopuolisesta lähteestä;

2. Joissa on automaattinen polttovälin taustakorjaus; tai

3. Joissa on automaattinen kompensointiohjaus, joka on erityisesti suunniteltu sallimaan vedenalaisen kameran kotelon käyttö yli 1 000 m:n syvyyksissä;

f. Elektroniset kuvausjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön ja jotka kykenevät tallettamaan digitaalisesti enemmän kuin 50 kuvaa;

g. Seuraavat erityisesti vedenalaiseen käyttöön suunnitellut tai muunnetut valonlähdejärjestelmät:

1. Stroboskoopiset valonlähteet, jotka kykenevät antamaan yli 300 J:n suuruisen valoenergian välähdystä kohti ja joiden välähdysnopeus on enemmän kuin 5 välähdystä sekunnissa;

2. Argonvalokaarijärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi yli 1 000 m:n syvyyksissä;

h. Erityisesti vedenalaiseen käyttöön suunnitellut "robotit", joita ohjataan käyttämällä dedikoitua "ohjelmallisesti ohjattua" tietokonetta ja jotka:

1. Sisältävät järjestelmiä, jotka ohjaavat "robotia" käyttäen tietoa antureilta, jotka mittaavat ulkoiseen kohteeseen kohdistettua voimaa tai momenttia, ulkoisen kohteen etäisyyttä tai "robotin" ja ulkoisen kohteen välistä tuntoaistia; tai

2. Kykenevät aikaansaamaan 250 N:n tai suuremman voiman tai 250 Nm:n tai suuremman momentin ja joiden rakenne-elimissä on käytetty titaanipohjaisia seoksia tai "kuitu- tai säie" "komposiitti"-materiaaleja;

i. Etäisohjatut nivelmanipulaattorit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi vedenalaisissa aluksissa ja:

1. Joissa on järjestelmiä, jotka ohjaavat manipulaattoreita käyttäen antureiden tietoa, jotka mittaavat ulkoiseen kohteeseen kohdistettua voimaa tai momenttia tai tuntoaistia manipulaattorin ja ulkoisen kohteen välillä; tai

2. Joita ohjataan isäntä-orja-suhdesäätötekniikalla tai jotka käyttävät dedikoitua "ohjelmallisesti ohjattua" tietokonetta ja joilla on 5 tai useampia liikkeen vapausasteita;

Huom.: Vain ne toiminnot, joilla on asennon takaisinkytkentää käyttävä suhdesäätö tai jotka käyttävät dedikoitua "ohjelmallisesti ohjattua" tietokonetta otetaan huomioon vapausasteiden lukumäärää määritettäessä.

8A002 (jatkuu)

- j. Seuraavat ilmasta riippumattomat, erityisesti vedenalaiseen käyttöön suunnitellut tehojärjestelmät:
1. Brayton- tai Rankine-moottorien ilmasta riippumattomat järjestelmät, joilla on jokin seuraavista:
 - a. Kemialliset pesuri- tai imeytysjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu poistamaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja ainehiukkasia kierrätetyistä moottorin pakokaasuista;
 - b. Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu käyttämään yksiatomista kaasua;
 - c. Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle 10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat kiinnityslaitteet; tai
 - d. Erityisesti suunnitellut järjestelmät:
 1. Jotka paineistavat reaktiotuotteita tai puhdistavat polttoainetta (reforming-menetelmällä);
 2. Jotka varastoivat reaktiotuotteita; ja
 3. Jotka poistavat reaktiotuotteita 100 kPa:n tai suurempaa painetta vastaan;
 2. Dieselmoottorien ilmasta riippumattomat järjestelmät, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - a. Kemialliset pesuri- tai imeytysjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu poistamaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia tai ainehiukkasia kierrätetyistä moottorin pakokaasuista;
 - b. Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu käyttämään yksiatomista kaasua;
 - c. Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle 10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat kiinnityslaitteet; ja
 - d. Erityisesti suunnitellut pakokaasujärjestelmät, jotka eivät poista palamistuloksia jatkuvasti;
 3. Polttokennojen ilmasta riippumattomat järjestelmät, joiden teho ylittää 2 kW ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
 - a. Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle 10 kHz:n taajuuksien melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat kiinnityslaitteet; tai
 - b. Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu:
 1. Paineistamaan reaktiotuotteita tai uudistamaan polttoainetta;
 2. Varastoimaan reaktiotuotteita; ja
 3. Poistamaan reaktiotuotteet yli 100 kPa:n painetta vastaan;
 4. Stirling-moottorien ilmasta riippumattomat järjestelmät, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 - a. Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle 10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat kiinnityslaitteet; ja
 - b. Jotka poistavat reaktiotuotteita 100 kPa:n tai suurempaa painetta vastaan;
- k. Helmat, tiivisteet tai liuskat:
1. Jotka on suunniteltu 3 830 Pa:n tai suurempia tyynypaineita varten, jotka toimivat merkitsevässä 1,25 m:n (merenkäyntitila 3) tai korkeammassa aallokossa ja jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.f kohdassa määriteltäviä kokonaan helmoitettuja ilmatyynyaluksia varten; tai
 2. Jotka on suunniteltu 6 224 Pa:n tai suurempia tyynypaineita varten, jotka toimivat aallokossa, jonka merkitsevä aallonkorkeus on 3,25 metriä (merenkäyntitila 5) tai enemmän, ja jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.g kohdassa määriteltäviä jäykillä sivuseinillä varustettuja ilmatyynyaluksia varten;

8A002 (jatkuu)

- l. Nostopuhaltimet, jotka on mitoitettu yli 400 kW:lle ja jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.f tai 8A001.g kohdassa määriteltyjä ilmatyynyaluksia varten;
- m. Täysin veden alla toimivat kavitoimattomat tai ylikavitoivat kantosiivet, jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.h kohdassa määriteltyjä aluksia varten;
- n. Aktiiviset järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu automaattisesti kontrolloimaan aallokon aiheuttamaa liikettä 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h tai 8A001.i kohdassa määritellyissä aluksissa;
- o. Seuraavat potkurit, tehonsiirtojärjestelmät, tehontuottojärjestelmät tai melunvaimennusjärjestelmät:
 1. Seuraavat potkuri- tai tehonsiirtojärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h tai 8A001.i kohdassa määriteltyjä ilmatyynyaluksia (kokonaan helmoitettuja tai jäykkä-sivulaitaisia), kantosiipialuksia tai pienen vesiviivapinta-alan aluksia varten:
 - a. Ylikavitoivat, ylituuletetut, osittain vedenalaiset tai pintaa leikkaavat yli 7,5 MW:lle mitoitettut potkurit;
 - b. Vastakkain pyörivät potkurijärjestelmät, jotka on mitoitettu yli 15 MW:lle;
 - c. Järjestelmät, jotka käyttävät tulopyörre- tai jättöpyörretekniikkaa tasoittamaan potkurivirtausta;
 - d. Erikoisveyet, korkeakapasiteettiset (K-arvo ylittää 300) alennusvaihteet;
 - e. Tehonsiirron akselijärjestelmät, jotka sisältävät komponentteja komposiittimateriaaleista ja jotka kykenevät siirtämään enemmän kuin 1 MW;
 2. Seuraavat aluksissa käytettävät potkurit, tehojärjestelmät tai tehonsiirtojärjestelmät:
 - a. Säätiösiipipotkurit ja niiden napakokoonpanot, jotka on mitoitettu yli 30 MW:lle;
 - b. Sisäisesti nestejäähdytetyt sähkö-työntövoimamoottorit, joiden antoteho ylittää 2,5 MW;
 - c. "Suprajohde"-työntövoimamoottorit tai kestopagneetti-työntövoimamoottorit, joiden antoteho ylittää 0,1 MW;
 - d. Tehonsiirron akselijärjestelmät, jotka sisältävät komponentteja "komposiitti"-materiaaleista ja jotka kykenevät siirtämään enemmän kuin 2 MW;
 - e. Tuuletetut tai jäähdytetyt potkurijärjestelmät, jotka on mitoitettu yli 2,5 MW:lle;
 3. Seuraavat melunvaimennusjärjestelmät, joita käytetään 1 000 tonnin tai suuremman uppouman aluksissa:
 - a. Melunvaimennusjärjestelmät, jotka vaimentavat alle 500 Hz:n taajuuksia ja jotka koostuvat akustisista jalustoista dieselmoottoreita, dieselgeneraattoreita, kaasuturbiineita, kaasu-turbiinigenaattoreita, työntövoimamoottoreita tai niiden alennusvaihteita varten, ja jotka on erityisesti suunniteltu melun tai tärinän vaimentamiseen, ja joiden oma massa ylittää 30 % asennettavien laitteiden massasta;
 - b. Aktiiviset äänen vaimennus- tai kumoamisjärjestelmät, tai erityisesti tehonsiirtojärjestelmiin suunnitellut magneettiset laakerit, jotka sisältävät elektronisia ohjausjärjestelmiä, ja jotka kykenevät aktiivisesti vähentämään laitteiden tärinää tuottamalla melun tai tärinän vastasignaaleja suoraan melun tai tärinän lähteeseen;
 - p. Vesisuihkutyöntövoimajärjestelmät, joiden ulostuloteho ylittää 2,5 MW ja jotka käyttävät suunnattavaa suutinta ja virtausta säätelevää siipitekniikkaa parantamaan työntötehoa tai vähentämään koneen aiheuttamaa veden alla leviävää melua.
 - q. Sukeltamiseen ja vedenalaiseen uintiin soveltuvat itsenäiset, suljetun tai puolisoljetun kierron (rebreathing-) laitteet.

Huom.: 8A002.q kohta ei aseta valvonnallaiseksi henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja yksittäisiä laitteita, jotka ovat käyttäjänsä mukana.

8B**Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**

8B001

Vesitunnelit, joiden taustamelu on vähemmän kuin 100 dB (vertailuarvo 1 µPa, 1 Hz) taajuusalueella 0 Hz–500 Hz ja jotka on suunniteltu mittaamaan veden virtauksen synnyttämää akustista kenttää työntövoimajärjestelmien mallien ympärillä.

8C**Materiaalit**

8C001 'Syntaktiset vaahdot' vedenlaiseen käyttöön:

- a. Jotka on suunniteltu yli 1 000 m:n syvyyksille; ja
- b. Joiden tiheys on vähemmän kuin 561 kg/m^3 .

Tekn. huom.:

'Syntaktinen vaahdo' koostuu ontoista muovi- tai lasipalloista, jotka on upotettu hartsimatriisiin.

8D	Ohjelmistot
8D001	"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 8A, 8B tai 8C kohdassa määriteltyjen laitteiden tai materiaalien "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.
8D002	Erityiset "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen melun vähentämiseen tarkoitettujen potkurien "kehittämistä", "tuotantoa", korjausta, huoltoa tai uudistamista (uudelleenkon- neistamista) varten.

8E Teknologia

8E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 8A, 8B tai 8C kohdassa määriteltyjen laitteiden tai materiaalien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

8E002 Seuraava muu "teknologia":

- a. "Teknologia", joka on tarkoitettu erityisesti vedenalaisen melun vähentämiseen suunniteltujen potkurien "kehittämistä", "tuotantoa", korjausta, huoltoa tai uudelleenkonestaamista varten;
- b. "Teknologia", joka on tarkoitettu 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.o tai 8A002.p kohdassa määriteltyjen laitteiden huoltoa tai kunnostamista varten.

RYHMÄ 9**TYÖNTÖVOIMALAITTEET, AVARUUSALUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT LAITTEET**

9A Järjestelmät, laitteet ja komponentit

Huom.: Työntövoimajärjestelmät, jotka on suunniteltu tai mitoitettu neutroni- tai lyhytaikaista ionisoivaa säteilyä vastaan: katso asetarvikeluettelo.

9A001 Seuraavat lentokoneiden kaasuturbiinimoottorit, jotka sisältävät jotain 9E003.a kohdassa määriteltyä "teknologiaa":

Huom.: KATSO MYÖS 9A101 KOHTA.

- a. Joita ei ole hyväksytty käytettäväksi siinä määritelyssä "siviililentokoneessa", jota varten ne on aiottu;
- b. Joita "osallistujavaltion" siviili-ilmailuviranomaiset eivät ole hyväksyneet siviilikäyttöön;
- c. Jotka on suunniteltu lentämään yli 1,2 Machin matkanopeudella pidempään kuin 30 minuuttia.

9A002 Laivojen kaasuturbiinimoottorit, joiden määritely ISO-standardin mukainen jatkuva teho on 24 245 kW tai enemmän ja polttoaineen nimelliskulutus on vähemmän kuin 0,219 kg/kWh 35–100 % tehoalueella, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut kokoonpanot ja komponentit.

Huom.: Termi 'laivojen kaasuturbiinimoottorit' sisältää myös sellaiset kaasuturbiinien teolliset tai ilmailuersiot, joita käytetään laivojen työntövoimajärjestelmissä tai sähköntuotantoon aluksilla.

9A003 Erityisesti suunnitellut kokoonpanot ja komponentit, jotka sisältävät mitä tahansa 9E003.a kohdassa määriteltyä "teknologiaa", seuraavia kaasuturbiinityöntövoima-järjestelmiä varten:

- a. Jotka on määritelty 9A001 kohdassa;
- b. Joiden suunnittelu- tai tuotantoalkuperä ei ole "osallistujavaltiosta" tai on valmistajalle tuntematon.

9A004 Avaruuteen laukaisussa käytettävät kantoraketit tai "avaruusalukset".

Huom.: KATSO MYÖS 9A104 KOHTA.

Huom.: 9A004 kohta ei aseta valvonnallaisiksi hyötykuormia.

Huom.: "Avaruusalusten" hyötykuormiin sisältyvien tuotteiden valvonnallisuuden määrittämiseksi, katso soveltuvat ryhmät.

9A005 Nestemäistä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, jotka sisältävät mitä tahansa 9A006 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä tai komponentteja.

Huom.: KATSO MYÖS 9A105 ja 9A119 KOHTA.

9A006 Seuraavat järjestelmät tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu nestemäistä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiin:

Huom.: KATSO MYÖS 9A106 ja 9A108 KOHTA.

- a. Kryogeeniset jäähdyttimet, lentokeveät dewar-säiliöt, kryogeeniset lämpöputket tai kryogeeniset järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi avaruusaluksissa ja jotka kykenevät rajoittamaan kryogeenisen nesteen hukan vähempään kuin 30 % vuodessa;
- b. Kryogeeniset säiliöt tai suljetun kierron jäähdytysjärjestelmät, jotka kykenevät tuottamaan 100 K (–173 °C) astetta tai alempia lämpötiloja, yli 3 Machin lentonopeutta ylläpitämään tarkoitettuja lentokoneita, kantoraketteja tai "avaruusaluksia" varten;
- c. Nestemäisen vedyn varastointi- tai siirtojärjestelmät;
- d. Korkeapaineiset (yli 17,5 MPa) turbopumput, pumppujen komponentit tai niihin liittyvät kaasugeneraattorit tai laajenemissyklin turbiinimoottorijärjestelmät;
- e. Korkeapaineiset (yli 10,6 MPa) työntökammiot ja niiden suuttimet;
- f. Polttoaineen varastointijärjestelmät, jotka käyttävät kapillaarista säilytystä tai positiivista (esim. joustavilla palkeilla aikaansaatua) poistoperiaatetta;

9A006

(jatkuu)

- g. Erityisesti nestemäistä polttoainetta käyttäville rakettimoottoreille suunnitellut nestemäisen polttoaineen injektorit, joiden yksittäiset suuttimet ovat läpimitaltaan 0,381 mm tai pienemmät (ei-pyöreiden aukojen ala $1,14 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$ tai pienempi);
- h. Yksiosaiset hiili-hiili palokammiot tai yksiosaiset hiili-hiili poistokartiot, joiden tiheydet ylittävät $1,4 \text{ g/cm}^3$ ja murtovetolujuus ylittää 48 MPa.

9A007

Kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joilla on jokin seuraavista:

Huom.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA

- a. Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittää 1,1 MNs;
- b. Ominaisimpulssi on 2,4 kNs/kg tai enemmän kun suutinvirtausta laajennetaan siten, että kammion paine on 7 MPa (suhteutettuna merenpinnan tasolle);
- c. Vaiheiden massaosamäärät ylittävät 88 % ja kiinteän polttoaineen täyttösuhde ylittää 86 %;
- d. Jonkin 9A008 kohdassa määritellyistä komponenteista; tai
- e. Eristeen ja polttoaineen välillä on sidosjärjestelmät, joissa käytetään suoraanliitettyä moottorirakennetta muodostamaan 'vahva mekaaninen sidos' tai este kemialliselle kulkeutumiselle kiinteän polttoaineen ja kotelon eristysmateriaalin välille.

Tekn. huom.:

9A007.e kohdassa tarkoitetaan 'vahvalla mekaanisella sidoksella' vähintään polttoaineen vahvuista sidosta.

9A008

Seuraavat erityisesti kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiä varten suunnitellut komponentit:

Huom.: KATSO MYÖS 9A108 KOHTA.

- a. Eristeen ja polttoaineen väliset sidosjärjestelmät, joissa käytetään vuorausta muodostamaan 'vahva mekaaninen sidos' tai este kemialliselle kulkeutumiselle kiinteän polttoaineen ja kotelon eristysmateriaalin välille;

Tekn. huom.:

9A008.a kohdassa tarkoitetaan "vahvalla mekaanisella sidoksella" vähintään polttoaineen vahvuista sidosta.

- b. Kuidusta kiedotusta "komposiitti" materiaalista valmistetut moottorikotelot, joiden läpimitta ylittää 0,61 m tai joiden 'rakenteellinen tehokkuussuhde (PV/W)' ylittää 25 km;

Tekn. huom.:

'Rakenteellinen tehokkuussuhde (PV/W)' on puhkeamispaineen (P) ja astian tilavuuden (V) tulo jaettuna paineastian kokonaispainolla (W).

- c. Suuttimet, joiden työntövoimataso ylittää 45 kN tai joiden kaulan kulumisnopeus on vähemmän kuin 0,075 mm/s;
- d. Liikkuvan suuttimen tai sekundäärisen polttoaineen ruiskutuksen työntövektorin ohjausjärjestelmät:
1. Jotka kykenevät yli ± 5 asteen liikkeeseen akselinsa ympäri;
 2. Joiden kulmavektoria voidaan kääntää 20 astetta sekunnissa tai enemmän; tai
 3. Joiden kulmavektorikihtiävyys on 40 astetta/s² tai enemmän.

9A009

Hybridipolttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joiden:

Huom.: KATSO MYÖS 9A109 ja 9A119 KOHTA.

- a. Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittää 1,1 MNs; tai
- b. työntövoima ylittää tyhjöolosuhteissa 220 kN.

9A010 Seuraavat kantoraketteja tai kantoraketien työntövoimalaitteita tai "avaruusaluksia" varten erityisesti suunnitellut komponentit, järjestelmät ja rakenteet:

Huom.: KATSO MYÖS 1A002 ja 9A110 KOHTA.

- a. Kaikki 10 kg ylittävät komponentit ja rakenteet, jotka on erityisesti suunniteltu 1C007 tai 1C010 kohdassa määriteltyjä metalli "matriiseja", "komposiitteja", orgaanisia "komposiitteja", keraamisia "matriiseja" tai metallivahvistettuja materiaaleja käyttäen valmistettuja laukaisulaitteita varten;

Huom.: Painorajoitus ei ole olennainen kärkikartioille.

- b. Komponentit ja rakenteet, jotka on erityisesti suunniteltu 9A005–9A009 kohdassa määriteltyihin laukaisulaitteiden työntövoima-järjestelmiin, ja jotka on valmistettu 1C007 tai 1C010 kohdassa määriteltyjä metallimatriiseja, komposiitteja, orgaanisia komposiitteja, keraamisia komposiitteja tai metallivahvistettuja materiaaleja käyttäen;
- c. Rakenteellisia komponentteja ja eristäviä järjestelmiä, jotka on erityisesti suunniteltu aktiivisesti ohjaamaan "avaruusaluksen" rakenteiden dynaamisia reaktioita tai muodonmuutoksia;
- d. Nestemäistä polttoainetta käyttävät sykäysrakettimoottorit, joiden työntö/paino suhde on 1 kN/kg tai enemmän ja vasteaika (aika, joka tarvitaan saavuttamaan 90 % mitoitetusta työntövoimasta käynnistyksestä) on vähemmän kuin 30 ms.

9A011 Patoputki- (ramjet), ahtoputki- (scramjet) tai yhdistelmäahtimoottorit ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit.

Huom.: KATSO MYÖS 9A111 ja 9A118 KOHTA.

9A012 Miehitettävät lentolaitteet, joissa on jokin seuraavista:

- a. Riippumaton lennonhallinta- ja suunnistuskyyky (esim. inertiasuunnistusjärjestelmällä varustettu automaattiohjain); tai
- b. Kyyky suorittaa johdettu lento suoran näköetäisyyden ulkopuolelle operaattorin avustuksella (esim. televisuaalinen kauko-ohjaus).

9A101 Seuraavat muut kuin 9A001 kohdassa määriteltyt keveät suihkuturbiini- ja ohivirtausmoottorit (mukaan lukien yhdistelmäturbiinimoottorit), joita voidaan käyttää "ohjuksissa":

- a. Moottorit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

1. Maksimi (asentamattomana saavutettu) työntövoiman arvo on suurempi kuin 400 N lukuun ottamatta hyväksytyjä siviilimoottoreita, joiden maksimi (asentamattomana saavutettu) työntövoiman arvo on suurempi kuin 8 890 N; ja
2. Ominaispolttoaineen kulutus (jatkuvalle maksimiteholla merenpinnan tasolla vakio- ja normaaliolosuhteissa) on 0,15 kg/N/h tai vähemmän;

- b. Moottorit, jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi "ohjuksissa".

9A104 Luotainraketit, jotka kykenevät vähintään 300 km:n kantomatkkaan.

Huom.: KATSO MYÖS 9A004 KOHTA.

9A105 Seuraavat nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit:

Huom.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.

- a. Muut kuin 9A005 kohdassa määriteltyt nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 1,1 MNs tai suurempi;
- b. Muut kuin 9A005 tai 9A105.a kohdassa määriteltyt nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit, joita voidaan käyttää kantomatkaltaan 300 km:n täydellisissä rakettijärjestelmissä tai miehitettävissä ilma-aluksissa ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 0,841 MNs tai suurempi.

9A106 Seuraavat muut kuin 9A006 kohdassa määriteltyt nestemäistä polttoainetta käyttäviin raketteihin erityisesti suunnitellut järjestelmät ja komponentit, joita voidaan käyttää ohjuksissa:

- a. Työntövoima- ja palokammioiden kuluvat vuoraukset;
- b. Rakettien suuttimet;

9A106

(jatkuu)

c. Työntövoimavektorin ohjauksen alajärjestelmät;

Tekn. huom.:

Esimerkkejä tavoista, joilla saavutetaan 9A106.c kohdassa määritelty työntövoimavektorin ohjaus:

1. Taipuisa suutin;
2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
3. Liikkuva moottori tai suutin;
4. Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
5. Työntövoimalaipat.

d. Nestemäisen ja lietemäisen ajoaineen (myös hapettimien) ohjausjärjestelmät sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, jotka on suunniteltu tai muunneltu toimimaan yli 10 g:n rms ja 20–2 000 Hz:n värinäolosuhteissa.

Huom.: Ainoat servoventtiilit ja pumput, jotka on määritelty 9A106.d kohdassa ovat seuraavat:

- a. Servoventtiilit, jotka on suunniteltu 24 litran minuutissa tai suuremmille virtausnopeuksille, 7 MPa tai suuremmalle absoluuttipaineelle ja joiden toimilaitteen vasteaika on vähemmän kuin 100 ms;
- b. Pumput nestemäisiä polttoaineita varten, joiden akselinopeudet ovat yhtäsuuria tai suurempia kuin 8 000 rpm tai joiden poistumispaaineet ovat yhtäsuuria tai suurempia kuin 7 MPa.

9A107

Muut kuin 9A007 kohdassa määritelty kiinteää polttoainetta käyttävät rakettimootorit, joita voidaan käyttää kantomatkaltaan 300 km:n täydellisissä raketijärjestelmissä tai miehittämättömissä ilma-aluksissa ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 0,841 MNs tai suurempi.

Huom.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.

9A108

Seuraavat muut kuin 9A008 kohdassa määritelty komponentit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja jotka on erityisesti suunniteltu kiinteää polttoainetta käyttävien raketien työntövoimajärjestelmiä varten:

- a. Rakettimoottorien kotelot, niiden "sisäpinnanvuoraukset" ja "eristykset";
- b. Raketien suuttimet;
- c. Työntövoimavektorin ohjauksen alajärjestelmät.

Tekn. huom.:

Esimerkkejä tavoista, joilla saavutetaan 9A108.c kohdassa määritelty työntövoimavektorin ohjaus:

1. Taipuisa suutin;
2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
3. Liikkuva moottori tai suutin;
4. Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
5. Työntövoimalaipat.

9A109

Muut kuin 9A009 kohdassa määritelty hybridirakettimootorit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit.

Huom.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.

9A110

Muut kuin 9A010 kohdassa määritelty komposiittirakenteet, -laminaatit ja niistä tehdyt valmisteet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi 9A004 kohdassa määriteltyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määriteltyissä luotainraketeissa tai 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106–9A108, 9A116 tai 9A119 kohdassa määriteltyissä alajärjestelmissä.

Huom.: KATSO MYÖS 1A002 KOHTA.

9A111

Pulssisuihkumootorit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa", sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Huom.: KATSO MYÖS 9A011 ja 9A118 KOHTA.

9A115

Seuraavat laukaisuapulaitteet:

- a. Kojeet ja laitteet käsittelyä, hallintaa, aktivointia tai laukaisua varten suunniteltu tai muunneltu 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja, 9A012 kohdassa määriteltyjä miehittämättömiä ilma-aluksia tai 9A104 kohdassa määriteltyjä luotainraketteja varten;
- b. Ajoneuvot kuljetusta, käsittelyä, hallintaa, aktivointia tai laukaisua varten suunniteltu tai muunneltu 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja tai 9A104 kohdassa määriteltyjä luotainraketteja varten.

- 9A116 Seuraavat "ohjuksissa" käyttökelpoiset ilmakehään palaamaan suunnitellut alukset sekä niitä varten suunnitellut tai muunnetut laitteet:
- a. Ilmakehään palaamaan suunnitellut alukset;
 - b. Keraamisista tai sulamalla kuluvista aineista valmistetut lämpösuojukset ja niiden osat;
 - c. Kevyistä, suuren ominaislämmön omaavista aineista valmistetut jäähdytyslevyt ja niiden osat;
 - d. Ilmakehään palaaviin aluksiin erityisesti suunnitellut elektroniset laitteet.
- 9A117 "Ohjuksissa" käyttökelpoiset rakettien vaiheistumekanismit, irrotusmekanismit ja vaiheiden väliset laitteet.
- 9A118 9A011 tai 9A111 kohdassa määritellyissä "ohjuksissa" käyttökelpoisten moottorien palonsäätelylaitteet.
- 9A119 Muut kuin 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 ja 9A109 kohdassa määritellyt yksittäiset rakettien vaiheet, joita voidaan käyttää kantomatkaltaan 300 km:n täydellisissä rakettijärjestelmissä tai miehittämättömissä ilma-aluksissa.

9B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet

9B001 Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet, työkalut tai kiinnittimet kaasuturbiinien lapojen, siipien tai kärki-vaipan valujen valmistamiseen:

a. Laitteet suunnattua kiinteytystä tai yksikidevalua varten;

b. Keraamiset ytimet tai kuoret;

9B002 On-line (tosiaikaiset) -ohjausjärjestelmät, instrumentointi (anturit mukaan lukien) tai automaattiset tiedonkeruu- ja -käsittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 9E003.a kohdassa määriteltyä "teknologiaa" sisältävien kaasuturbiinimoottorien, niiden kokoonpanojen tai komponenttien "kehittämiseen".

9B003 Valmistus- ja testauslaitteet sellaisten kaasuturbiinien harjatiivisteiden tuotantoon, jotka on suunniteltu toimimaan 335 m/s ylittävillä kärkien nopeuksilla ja yli 773 K (500 °C) asteen lämpötiloissa, sekä näiden laitteiden erityisesti suunnitellut osat ja varusteet.

9B004 Työkalut, suulakkeet, tai kiinnittimet "superseoksen", titaanin tai 9E003.a.3 tai 9E003.a.6 kohdassa määriteltyjen metalliyhdisteiden airfoil-to-disk-yhdistelmien mekaaniseen liittämiseen kaasuturbiineita varten.

9B005 On-line (tosiaikaiset) -ohjausjärjestelmät, instrumentointi (anturit mukaan lukien) tai automaattiset tiedonkeruu- ja -käsittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi seuraavissa tuulitunneleissa tai laitteissa:

Huom.: KATSO MYÖS 9B105 KOHTA.

a. Tuulitunnelit, jotka on suunniteltu 1,2 Machin tai suuremmille nopeuksille; paitsi: Sellaiset, jotka on erityisesti suunniteltu koulutustarkoituksiin, ja joiden 'testauslohkon koko' (lateraalisesti mitattuna) on vähemmän kuin 250 mm;

Tekn. huom.:

9B005.a kohdassa 'testauslohkon koko' tarkoittaa ympyrän läpimittaa, neliön sivua tai suorakaiteen pisintä sivua testauslohkon laajimmalla kohdalla mitattuna.

b. Laitteet, joilla simuloidaan virtausympäristöjä yli 5 Machin nopeuksilla, mukaanlukien hot-shot-tunnelit, plasmakaaritunnelit, paineiskuputket, paineiskutunnelit, kaasutunnelit ja kevyet kaasutykit; tai

c. Tuulitunnelit ja laitteet, muut kuin kaksidimensioiset lohkot, joilla voidaan simuloida virtauksia, joiden Reynoldsin luku on yli 25×10^6 .

9B006 Erityisesti suunnitellut akustisen värähtelyn testauslaitteet, joilla voidaan tuottaa 160 dB:n tai suurempia äänenpainetasoja (verrattuna 20 TP:iin), ja joiden nimellinen ulostuloteho on 4 kW tai enemmän testikammion lämpötilan ollessa yli 1 273 K (1 000 °C), astetta, sekä erityisesti niitä varten suunnitellut kvartsikuumentimet.

Huom.: KATSO MYÖS 9B106 KOHTA.

9B007 Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu rakettimoottorien eheyden tutkimiseen käyttäen muita ainetta rikkomattomia testimenetelmiä (NDT) kuin taseröntgeniä tai fysikaalisia tai kemiallisia perusanalyysijä.

9B008 Muuntimet, jotka on erityisesti suunniteltu seinämän pintakitkan suoraan mittaamiseen testausvirtauksella, jonka stagnaatiolämpötila ylittää 833 K (560 °C) astetta.

9B009 Työkalut, jotka on erityisesti suunniteltu sellaisten turbiinimoottorin jauhemetallurgisten roottoriosien tuotantoon, jotka kykenevät toimimaan rasiustasolla, joka on 60 % tai enemmän niiden murtovetolujuudesta (UTS) ja 873 K (600 °C) asteen tai korkeammassa metallin lämpötiloissa.

- 9B105 Mach 0,9 tai suuremmille nopeuksille tarkoitetut tuulitunnelit, joita voidaan käyttää "ohjuksia" tai niiden alajärjestelmiä varten.
- Huom.: KATSO MYÖS 9B005 KOHTA.**
- 9B106 Seuraavat ympäristöolosuhdekammiot tai kaiuttomat huoneet:
- a. Ympäristöolosuhdekammiot, joilla voidaan simuloida seuraavia lento-olosuhteita:
1. 10 g:n rms tai suurempia värinäolosuhteita 20 Hz:n ja 2 000 Hz:n välillä ja 5 kN:n tai suuremmalla värinävoimalla; ja
 2. 15 000 m:n tai suurempia korkeuksia; tai
 3. Vähintään 223 K (– 50 °C) – 398 K (+125 °C) asteen lämpötila-aluetta;
- b. Kaiuttomat huoneet, joilla voidaan simuloida seuraavia lento-olosuhteita:
1. 140 dB:n (verrattuna 20 TP:iin) tai suurempia yleisäänepainetasoja tai 4 kW:n tai suurempaa mitoitettua akustista tehoa; ja
 2. 15 000 m:n tai suurempia korkeuksia; tai
 3. Vähintään 223 K (– 50 °C) – 398 K (+ 125 °C) asteen lämpötila-aluetta.
- 9B115 Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" 9A005–9A009, 9A011, 9A101, 9A105–9A109, 9A111, 9A116 9A119 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä, alajärjestelmiä ja komponentteja varten.
- 9B116 Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja varten tai 9A005–9A009, 9A011, 9A101, 9A104–9A109, 9A111 tai 9A116–9A119 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä, alajärjestelmiä ja komponentteja varten.
- 9B117 Kiinteää tai nestemäistä polttoainetta käyttäviä raketteja tai rakettimoottooreita varten tarkoitetut testauspenkit ja testaustelineet, joilla on seuraavat ominaisuudet:
- a. Ne kestävät yli 90 kN työntövoimia; tai
- b. Niillä voidaan samanaikaisesti mitata kaikkien kolmen akselin työntövoimakomponentteja.

9C**Materiaalit****9C110**

9A110 kohdassa määriteltyjä komposiittirakenteita, -laminatteja ja niistä tehtyjä valmisteita varten tarkoitettut hartsilla kyllästetyt kuitupregit ja metallipinnoitetut kuitupreformat niitä varten, jotka on valmistettu joko orgaanisesta tai metallimatriisista käyttäen kuitu- tai säievahvisteita, joiden "ominaisvetolujuus" on suurempi kuin $7,62 \times 10^4$ m ja "ominaiskimmomoduuli" suurempi kuin $3,18 \times 10^6$ m.

Huom.: KATSO MYÖS 1C010 ja 1C210 KOHTA.

Huom.: Ainoat hartsikyllästetyt kuitupregit, jotka on määritelty 9C110 kohdassa ovat ne, joissa käytetään hartseja, joiden lasittumislämpötila (T_g) vulkanoinnin jälkeen ylittää 418 K (145 C) astetta ASTM D4065 tai vastaavan standardin mukaan määriteltynä.

9D Ohjelmistot

- 9D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A, 9B tai 9E003 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "teknologian" "kehittämistä" varten.
- 9D002 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A tai 9B kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.
- 9D003 Seuraavat "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A kohdassa määriteltyjen työntövoima-järjestelmien "täyden auktoriteetin digitaalisten moottorin ohjausten" ("FADEC") tai 9B kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten:
- "Ohjelmistot" työntövoimajärjestelmien, avaruustestauslaitteistojen, tai ilmaa-hengittävien lentokone-moottorien testauslaitteistojen digitaalielektronisia ohjausjärjestelmiä varten;
 - Vikasetoiset "ohjelmistot", joita käytetään työntövoimajärjestelmien "FADEC"-ohjauksissa ja niihin liittyvissä testauslaitteistoissa.
- 9D004 Seuraavat muut "ohjelmistot":
- 2D- tai 3D-viskoosiset "ohjelmistot", jotka on varmennettu tuulitunneli- tai lentotestitiedoilla, joita tarvitaan moottorivirtauksen yksityiskohtaiseen mallintamiseen;
 - Lentokaasuturbiinimoottoreiden, niiden kokoonpanojen tai komponenttien testaamiseen tarkoitettut "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu keräämään, rajaamaan ja analysoimaan tietoja tosiasassa, ja jotka pystyvät takaisinkytkettyyn säätöön, mukaan lukien testauskohteiden ja testiolosuhteiden dynaaminen muuttaminen testauksen kuluessa;
 - "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu ohjaamaan suunnattua kiinteystystä tai yksikidevalua;
 - "Lähdekoodilla", "kohdekoodilla" tai konekielisellä koodilla toimivat "ohjelmistot", joita tarvitaan roottorihiipien kärkeä varten ohjauksen aktiivisten kompensointijärjestelmien "käytössä".
- Huom.: 9D004.d kohta ei aseta valvonnallaiseksi "ohjelmistoja", jotka on asennettu valvonnan ulkopuolisiin laitteisiin tai joita tarvitaan ylläpitotehtävissä, jotka liittyvät aktiivisesti kompensoivien välyksen ohjausjärjestelmien kalibrointiin, huoltoon tai ajanmukaistamiseen.*
- 9D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9B105, 9B106, 9B116 tai 9B117 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.
- 9D103 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 9A004 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettävien kantorakettien tai 9A104 kohdassa määriteltyjen luotainrakettien tai kohdissa 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106, 9A108, 9A116 tai 9A119 määriteltyjen alajärjestelmien suunnittelun integrointiin.
- Huom.: 9D103 kohdassa määritellyt ohjelmat ovat valvonnallaisia myös yhdistettynä 4A102 kohdassa määritelyihin laitteisiin.*
- 9D104 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c, 9A106.d, 9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 tai 9A118 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.
- 9D105 "Ohjelmistot", joissa sovitetaan yhteen useamman kuin yhden alajärjestelmän toiminta ja jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa määritellyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa tapahtuvaa "käyttöä" varten.

9E Teknologia

Huom.: 9E001 – 9E003 kohdassa määritelty kaasuturbiinimoottorien "kehittämis"- tai "tuotantoteknologia" on valvonnanaista myös silloin, kun sitä käytetään korjauksen, uudistamisen tai huollon yhteydessä. Valvonnan ulkopuolella ovat tekninen tieto, piirustukset tai dokumentaatio sellaisia ylläpitotoimenpiteitä varten, jotka liittyvät suoraan viallisten tai ei-korjattaviksi tarkoitettujen vaihdettavien yksiköiden kalibrointiin, poistoon tai vaihtoon, kokonaiset moottorit tai niiden moduulit mukaan lukien.

9E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, jota "tarvitaan" 9A001.c, 9A004–9A011, 9B tai 9D kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.

9E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, jota "tarvitaan" 9A001.c, 9A004–9A011 tai 9B kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.

Huom.: Valvonnanaisten rakenteiden, laminaattien ja materiaalien korjaukseen tarvittava "teknologia": katso 1E002.f kohta.

9E003 Seuraava muu "teknologia":

a. "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien kaasuturbiinimoottorikomponenttien tai järjestelmien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten:

1. Suunnatusti kiinteitettyistä (DS) tai yksikideseoksista (SC) valmistetut kaasuturbiinien lavat, siivet tai kärkivaipat, jotka on mitoitettu (001 Millerin indeksin suunnassa) vähintään 400 tuntia 1 273 K (1 000 °C) asteen lämpötiloissa ja 200 MPa:n paineessa keskimääräisten ominaisarvojen perusteella;
2. Monikupuiset polttokammiot, joiden polttimeen poistoaukon keskimääräinen lämpötila on yli 1 813 K (1 540 °C) astetta tai polttokammiot, joissa on termisesti erotetut vaipat, ei-metalliset vaipat tai ei-metalliset kuoret;
3. Komponentit, jotka on valmistettu jostakin seuraavista:
 - a. Orgaanisista "komposiitti" materiaaleista, jotka on suunniteltu toimimaan yli 588 K (315 °C) asteen lämpötiloissa;
 - b. 1C007 kohdassa määritellyistä metalli"matriisi" "komposiiteista", materiaaleista, joilla on ke-raaminen "matriisi", metalliyhdisteistä tai lujitetuista metalliyhdisteistä; tai
 - c. "Komposiitti"-materiaaleista, jotka on määritelty 1C010 kohdassa ja valmistettu 1C008 kohdassa määritellyistä hartseista.
4. Jäähdyttämättömät turbiinien lavat, siivet, kärkien vaipat tai muut komponentit, jotka on suunniteltu toimimaan 1 323 K (1 050 °C) asteen tai korkeammassa kaasuvirran lämpötiloissa;
5. Jäähdytetyt turbiinien lavat, siivet tai kärkien vaipat, muut kuin 9E003.a.1 kohdassa kuvatut, jotka joutuvat alttiiksi 1 643 K (1 370 °C) tai korkeammille kaasuvirran lämpötiloille;
6. Lapojen liitokset, joissa kantopinta on yhdistetty roottorin kehään mekaanista liittämistä käyttäen;
7. Kaasuturbiinimoottorien komponentit, joissa on käytetty 2E003.b kohdassa määriteltyä "diffuusio-liittämistä" "teknologiaa";
8. Vauriosietoiset kaasuturbiinimoottorin pyörivät komponentit, joissa on käytetty 1C002.b kohdassa määriteltyä jauhemetallurgisia materiaaleja;
9. "FADEC"-kaasuturbiini- ja yhdistelmätahtimoottoreita varten sekä siihen liittyvät diagnostiikka-komponentit, anturit ja erityisesti suunnitellut komponentit;

9E003 a. (jatkuu)

10. Säädetty virtaustien geometria ja siihen liittyvät ohjausjärjestelmät:

- a. Kaasugeneraattoriturbiineja varten;
- b. Puhallin- tai käyttöturbiineja varten;
- c. Suihkusuuttimia varten;

Huom. 1: Aseteltavaan virtaustien geometriaan ja siihen liittyviin ohjausjärjestelmiin ei 9E003.a.10 kohdassa lueta tuloaukon johdesiipiä, säädettyäsiipisiä puhaltimia, säädettyjä staattoreita eikä ahtimen puhallus-venttiilejä.

Huom. 2: 9E003.a.10 kohta ei aseta valvonnallaiseksi jarrutustyöntövoiman säädettyjen virtaustien geometrian "kehittäminen" - tai "tuotanto" - teknologiaa.

11. Pitkäjänteiset ontot puhaltimien siivet, joilla ei ole osittaista tuentaa;

b. "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien laitteiden "kehittämistä" ja "tuotantoa" varten:

1. Tuulitunnelissa käytettävät mallit, jotka on varustettu pinta-antureilla ja jotka kykenevät lähettämään tietoa antureilta tiedonkeruujärjestelmälle; tai
2. Komposiiteista valmistetut potkurien lavat tai potkurituulettimet, jotka kestävät yli 2 000 kW yli 0,55 Machin lentonopeuksilla;

c. "Teknologia", jota "tarvitaan" kaasuturbiinimootorin komponenttien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten käyttäen "laser"-, vesisuihku- tai ECM/EDM-reiänporausprosesseja, joilla aikaansaadaan reikiä, joilla on jokin seuraavista ominaisuusryhmistä:

1. Kaikki seuraavat:

- a. Syvyys enemmän kuin neljä kertaa niiden läpimitta;
- b. Läpimitta vähemmän kuin 0,76 mm; ja
- c. Kohtauskulma 25 astetta tai vähemmän; tai

2. Kaikki seuraavat:

- a. Syvyys enemmän kuin viisi kertaa niiden läpimitta;
- b. Läpimitta vähemmän kuin 0,4 mm; ja
- c. Kohtauskulma enemmän kuin 25 astetta;

Tekn. huom.:

9E003.c kohdassa kohtauskulma mitataan tasosta, joka sivuaa kantopintaa pisteessä, jossa reiän keskiviiva lävistää kantopinnan.

d. "Teknologia", jota "tarvitaan" helikopterien tehonsiirtojärjestelmien tai kääntöväroottoristen tai kääntöväsiipisten "ilma-alusten" tehonsiirtojärjestelmien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten;

e. "Teknologia", jota "tarvitaan" maakulkuneuvojen työntövoimajärjestelmien sellaisten diesel(mäntä)moottorien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. 'Kotelotilavuus' on 1,2 m³ tai vähemmän;
2. Kokonaisantoteho on enemmän kuin 750 kW 80/1269/EEC:n, ISO 2534:n tai vastaavan kansallisen standardin mukaisesti määritettynä; ja
3. Tehon tiheys on enemmän kuin 700 kW 'kotelotilavuuden' m³:ää kohti;

9E003

e. (jatkuu)

Tekn. huom.:

'Kotelotilavuus' 9E003.e kohdassa on kolmen toisiaan vastaan kohtisuorassa olevan, seuraavalla tavalla mitatun dimension tulo:

Pituus: Kampiakselin pituus etulaipasta vauhtipyörän etusivuun;

Leveys: Suurin seuraavista:

a. Ulkomitta venttiilin kannesta toiseen venttiilin kanteen;

b. Sylinterinkansien ulkoreunojen mitat; tai

c. Vauhtipyörän kotelon läpimitta;

Korkeus: Suurin seuraavista:

a. Kampiakselin keskiviivasta venttiilin kannen päällimmäiseen tasoon (tai sylinterinkanteen) otettu mitta laskettuna yhteen kaksinkertaisen iskunpituuden kanssa; tai

b. Vauhtipyörän kotelon läpimitta.

f. "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien, erityisesti korkeatehoisia dieselmootoreita varten suunniteltujen komponenttien "tuotantoa" varten:

1. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten moottorijärjestelmien "tuotantoa" varten, joiden kaikki seuraavat osat on valmistettu käyttäen 1C007 kohdassa määriteltyjä valvonnanalaisia keraamisia materiaaleja:

a. Sylinteriputket;

b. Männät;

c. Sylinterinkannet; ja

d. Yksi tai useampia muita komponentteja (mukaan lukien pakoaукot, turboahtimet, venttiilien ohjaimet, venttiilikokoonpanot tai eristetyt polttoaineen suihkuttimet;

2. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten turboahdinjärjestelmien tuotantoon, joissa on yksivaiheiset kompressorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Toimivat 4:1 tai suuremmilla painesuhteilla;

b. Massavirtaus on 30–130 kg minuutissa; ja

c. Kompressori- tai turbiiniosan virtausläpimittaa voidaan muuttaa;

3. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten polttoaineen suihkutusjärjestelmien tuotantoon, jotka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan useiden polttoaineiden (esim. diesel- tai suihkumoottoripolttoaineet) käyttö viskositeettialueella, joka ulottuu dieselpolttoaineesta (2,5 cSt 310,8 K (37,8 °C) asteessa) bensiiniin (0,5 cSt 310,8 K (37,8 °C) asteessa), ja joilla on molemmat seuraavista:

a. Suihkutusmäärä ylittää 230 mm³ suihkutusta ja sylinteriä kohti; ja

b. Erityisesti suunnitellut elektroniset ohjaustoiminnot, jotka käyttämällä sopivia antureita vaihtavat polttoaineen ominaisuuksista riippuen automaattisesti säätimen arvoja niin että vääntömomenttiominaisuudet pysyvät samoina;

g. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten korkeatehoisten dieselmootorien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten, joissa käytetään sylinteriseinämän kiinteää, kaasumaista tai nestekalvovoitelua (tai näiden yhdistelmää), joka sallii toiminnan yli 723 K (450 °C) asteen lämpötiloissa (mitattuna männän ylärenkaan liikkeen ylärajalta sylinterin seinämään).

Tekn. huom.:

Korkeatehoisia dieselmootoreita ovat dieselmoottorit, joiden keskimääräiseksi teholliseksi jarrutuspaineeksi on määritetty 1,8 MPa tai enemmän 2 300 rpm:n kierrosnopeudella, edellyttäen että nimellinen kierrosnopeus on 2 300 rpm tai enemmän.

9E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A101, 9A104–9A111 tai 9A115–9A119 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

9E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A004 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettävien kantoraketien tai 9A005–9A011, 9A101, 9A104–9A111, 9A115–9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 tai 9D103 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

LIITE II

YHTEISÖN YLEINEN VIENTILUPA N:o EU001

(asetuksen (EY) N:o 1334/2000 6 artiklassa tarkoitettu)

Myöntävä viranomainen: Euroopan yhteisö

Osa 1

Tämä vientilupa koskee seuraavia tuotteita:

Kaikki tämän asetuksen liitteen I missä tahansa kohdassa mainitut kaksikäyttötuotteet, lukuun ottamatta jäljempänä osassa 2 lueteltuja tuotteita

Osa 2

- Kaikki liitteessä IV tarkoitettut tuotteet
- 0C001 "Luonnonuraani" tai "köyhdytetty uraani" tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista.
- 0C002 Muut kuin liitteessä IV mainitut "erityiset halkeamiskelpoiset materiaalit".
- 0D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ryhmässä 0 määriteltyjen tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten **siltä osin kuin ne liittyvät 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.**
- 0E001 "Teknologia" ydinteknologiahuomautuksen mukaisesti ryhmässä 0 määriteltyjen tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten **siltä osin kuin se liittyy 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.**
- 1A102 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin tarkoitettut toistokyllästetyt pyrolisoidut hiili-hiilikomponentit.
- 1C351 Ihmispatogeenit, zoonootit ja "toksiinit".
- 1C352 Eläinpatogeenit.
- 1C353 Geneettinen materiaali ja geneettisesti muunnetut organismit.
- 1C354 Kasvipatogeenit.
- 7E104 "Teknologia" lennon ohjaus-, ohjautus- ja työntövoimatietojen integrointiin lennonhallintajärjestelmäksi rakettijärjestelmän lentoradan optimoimiseksi.
- 9A009.a. Hybridipolttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joiden kokonaisimpulssikapasiteetti ylittää 1,1 MN
- 9A117 "Ohjuksissa" käyttökelpoiset rakettien vaiheistusmekanismit, irrotusmekanismit ja vaiheiden väliset laitteet.

Osa 3

Tämä vientilupa on voimassa kaikkialla yhteisössä seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

Australia

Kanada

Japani

Uusi-Seelanti

Norja

Sveitsi

Amerikan yhdysvallat

Huom. Osia 2 ja 3 voidaan muuttaa vain niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja sitoumusten mukaisesti, joita kukin jäsenvaltio on hyväksynyt kansainvälisten asetus- ja vientivalvontajärjestelyjen jäsenenä, ja kunkin jäsenvaltion yleisten turvallisuusasetusten mukaisesti sellaisina kuin ne ilmenevät sen vastuussa päättää kaksikäyttötuotteiden vientilupahakemuksista tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tämän luvan käytön edellytykset ja vaatimukset

- 1) Tätä yleislupaa ei saa käyttää, jos viejä on saanut tiedon sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta, että asianomaiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettua käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen tai tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin tai jos viejä tietää, että kyseiset tuotteet ovat tarkoitettua tällaiseen käyttöön.
- 2) Tätä yleislupaa ei saa käyttää, jos viejä on saanut tiedon sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta, että asianomaiset tuotteet ovat tai voivat olla tarkoitettua tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sotilaskäyttöön maassa, johon kohdistuu Euroopan unionin, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tai Yhdistyneiden Kansakuntien asesaarto, tai jos viejä on tietoinen, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu mainitunlaiseen käyttöön.
- 3) Tätä yleislupaa ei saa käyttää, kun kyseiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee luvan kattamassa määräpaikassa.
- 4) Jäsenvaltiot määrittelevät tämän yleisluvan käyttöön liittyvät rekisteröinti- ja ilmoitusvaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia luvan perusteella viedyistä tuotteista. Näiden vaatimusten on perustuttava niihin vaatimuksiin, jotka koskevat niiden jäsenvaltioiden myöntämien yleisten vientilupien käyttöä, joissa säädetään kyseisistä luvista.

LIITE III a

(lomakemalli)

(10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

EUROOPAN YHTEISÖ

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTI (Asetus (EY) N:o ...)

LUPA	1	1. Viejä	N:o	2. Tunnistenumero	3. Viimeinen voimassaolopäivä (tarvittaessa)	
				4. Yhteystiedot		
		5. Vastaanottaja		6. Myöntävä viranomainen		
		7. Asiamies/edustaja (jos toinen kuin viejä)	N:o			
				8. Alkuperämaa (tarvittaessa)	Koodi ⁽¹⁾	
				9. Vastaanottava maa (tarvittaessa)	Koodi ⁽¹⁾	
		10. Loppukäyttäjä (jos toinen kuin vastaanottaja)		11. Tuotteiden nykyinen tai tuleva sijaintijäsenvaltio	Koodi ⁽¹⁾	
				12. Jäsenvaltio, jossa tavara aiotaan asettaa vientimenettelyyn	Koodi ⁽¹⁾	
				13. Lopullinen määrämaa	Koodi ⁽¹⁾	
	1	14. Tavarankuvaus ⁽²⁾			15. Tavarankoodi (tarvittaessa)	
				17. Valuutta ja arvo	18. Tuotteiden määrä (tarvittaessa)	
	19. Loppukäyttö			20. Sopimuksen päivämäärä (tarvittaessa)	21. Vientimenettely	
22. Kansallisen lainsäädännön vaatimia lisätietoja (tarkennettava lomakkeessa)						
Jäsenvaltioiden käytettävissä esipainettuja tietoja varten Myöntävä viranomainen täyttää Allekirjoitus Leima Myöntävä viranomainen Päiväys						

⁽¹⁾ Katso asetus (EY) N:o 1172/95 (EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10), sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna.⁽²⁾ Tarvittaessa kuvaus voidaan esittää yhdellä tai useammalla tämän lomakkeen liitteellä (1 a). Tällöin on tässä kohdassa mainittava liitteiden tarkka lukumäärä.

[illegible]

LIITE III b

YLEISVIENTILUPIA JULKAISTAESSA ANNETTAVAT TIEDOT JA KÄYTETTÄVÄT ILMAISUT

(10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu)

1) Yleisen vientiluvan otsake

2) Luvan myöntävä viranomainen

3) Voimassaolo EY:n alueella. Seuraavaa tekstiä on käytettävä:

"Tämä on asetuksen (EY) N:o 1334/2000 6 artiklan 2 kohdan mukainen yleisvientilupa. Tämä lupa on kyseisen asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti voimassa kaikissa Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa".

4) Tuotteet, joita lupa koskee: seuraavaa johdantoa on käytettävä:

"Tämä vientilupa kattaa seuraavat tuotteet"

5) Määräpaikat, joita lupa koskee: seuraavaa johdantoa on käytettävä:

"Tämä vientilupa on voimassa seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä"

6) Edellytykset ja vaatimukset

LIITE IV

(asetuksen (EY) N:o 1334/2000 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo)

Luettelon kohdissa ei aina ole tuotteen täydellistä kuvausta ja siihen liittyviä, liitteessä I olevia huomautuksia ⁽¹⁾.

Tuotteiden täydellinen kuvaus on vain liitteessä I.

Tuotteen mainitseminen tässä liitteessä ei vaikuta liitteessä I olevia massatuotantotuotteita koskevien säännösten soveltamiseen.

Osa I

(mahdollisuus myöntää kansallinen yleisvientilupa yhteisön sisäistä kauppaa varten)

Häive (Stealth-) tekniikka

1C001 Materiaalit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi sähkömagneettista säteilyä absorboivina aineina, tai itseisjohtavat polymeerit;

HUOM.: KATSO MYÖS 1C101 KOHTA

1C101 Muut kuin 1C001 kohdassa määritelty, "ohjuksissa" ja niiden alajärjestelmissä käyttökelpoiset materiaalit ja laitteet, jotka pienentävät havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta tai ultravioletti-, infrapuna- ja akustista havaittavuutta;

1D103 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu analysoimaan vähennettyä havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta tai ultravioletti/infrapuna- ja akustista havaittavuutta;

1E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C101 tai 1D103 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten;

1E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D103 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten;

6B008 Tutkan kaikupinnan pulssimittausjärjestelmät, joiden pulssinpituus on 100 ns tai vähemmän, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit;

HUOM.: KATSO MYÖS 6B108 KOHTA

6B108 Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tutkapoikkipintojen mittaamiseen ja joita voidaan käyttää "ohjuksissa", ja niiden alajärjestelmät.

Yhteisön strateginen valvonta

1C239 Muut kuin asetarvikeluettelossa määritelty voimakkaat räjähteet tai niitä enemmän kuin 2 painoprosenttia sisältävät seokset tai aineet, joiden kideitiheys on suurempi kuin 1,8 g/cm³ ja räjähdysnopeus yli 8 000 m/s.

1E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C239 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

3A229 Seuraavat laukaisulaitteet ja vastaavat suurvirtapulssigeneraattorit ...

HUOM.: KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO

3A232 Seuraavat sytyttimet ja monipistesytytinjärjestelmät...

HUOM.: KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO

⁽¹⁾ Liitteiden I ja IV sanamuotojen ja soveltamisalojen väliset erot on tekstissä lihavoitu ja kursivoitu.

- 3E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A229 tai 3A232 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.
- 6A001 Akustiikka seuraavasti:
- 6A001.a.1.b. Kohteen havaitsemis- tai paikantamisjärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Lähetystaajuus **alle 5 kHz**;
 6. Suunniteltu kestävä;
- 6A001.a.2.a.1. Hydrofonit... Sisältävät...
- 6A001.a.2.a.2. Hydrofonit... joilla on...
- 6A001.a.2.a.5. Hydrofonit... Suunniteltu...
- 6A001.a.2.b. Hinattavat akustiset hydrofonijärjestelmät...
- 6A001.a.2.c. Hinattavia akustisia hydrofonijärjestelmiä käytettäessä **reaaliaikaisia sovelluksia** varten erityisesti suunnitellut akustiset hydrofonijärjestelmät, jotka ovat "käyttäjän ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- ja taajuusalueen käsittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja säteen muotoilu käyttäen nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai käsittelyjä;
- 6A001.a.2.e. Pohja- tai poukamakaapelijärjestelmä, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Se sisältää hydrofoneja..., tai
 2. Multipleksoituja hydrofoniryhmien signaalimoduleja...
- 6A001.a.2.f. Pohja- tai poukamakaapelijärjestelmien **reaaliaikaisia sovelluksia** varten erityisesti suunnitellut (signaalin) käsittelylaitteet, jotka ovat "käyttäjän ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- tai taajuusalueen käsittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja säteen muotoilu käyttäen nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai käsittelyjä;
- 6D003.a. "Ohjelmistot" akustisen tiedon "tosiaikaiseksi käsittelemiseksi";
- 8A002.o.3. Seuraavat melunvaimennusjärjestelmät, joita käytetään 1 000 tonnin tai suuremman uppouman aluksissa:
- b) Aktiiviset äänen vaimennus- tai kumoamisjärjestelmät, tai erityisesti tehonsiirtojärjestelmiin suunnitellut magneettiset laakerit, jotka sisältävät elektronisia ohjausjärjestelmiä, ja jotka kykenevät aktiivisesti vähentämään laitteiden tärinää tuottamalla melun tai tärinän vastasignaaleja suoraan melun tai tärinän lähteeseen;
- 8E002.a. "Teknologia", joka on tarkoitettu erityisesti vedenalaisen melun vähentämiseen suunniteltujen potkurien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

Yhteisön strateginen valvonta – Salaus – ryhmä 5 – 2 osa

- 5A002.a.2. laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan salauksen analysointitoimintoja.
- 5D002.c.1. ainoastaan ohjelmistot, joilla on kyseisten laitteiden ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat kohdassa 5A002.a.2. mainittujen laitteiden toimintoja.
- 5E002 ainoastaan teknologia edellä kohdassa 5A002.a.2. tai 5D002.c.1. mainittujen laitteiden tai ohjelmien "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

MTCR-tekniikka

- 7A117 "Ohjautuslaitteet", joita voidaan käyttää "ohjuksissa", jotka kykenevät 3,33 %:n tai sitä parempaan järjestelmätarkkuuteen toimintaetäisyydellä (esim. "CEP" on 10 km tai vähemmän 300 km:n matkalla) **lukuun ottamatta "ohjautuslaitteita", jotka on tarkoitettu ohjuksiin, joiden kantama on alle 300 km, tai miehitettyihin ilma-aluksiin.**

7B001 **edellä 7A117 kohdassa** määriteltyjä laitteita varten erityisesti suunnitellut testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteet.

Huom.: 7B001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ylläpitotasojen I tai II testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteita.

7B003 **edellä 7A117 kohdassa** määriteltyjen laitteiden "tuotantoon" erityisesti suunnitellut laitteet.

7B103 **edellä 7A117 kohdassa** määriteltyjä laitteita varten erityisesti suunnitellut "tuotantolaitokset".

7D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu **edellä** 7B003 tai 7B103 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

7E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 7A117, 7B003, 7B103 tai 7D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai ohjelmien "kehittämistä" varten.

7E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 7A117, 7B003 tai 7B103 kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.

7E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 7A117, 7B003, 7B103 tai 7D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai ohjelmien "käyttöä" varten.

9A004 Avaruuteen laukaisussa käytettävät kantoraketit **joita kykenevät vähintään 300 km:n kantomatkkaan vähintään 500 kg:n hyötykuormalla.**

HUOM.: KATSO MYÖS 9A104 KOHTA.

Huom. 1: 9A004 kohta ei aseta valvonnanalaisiksi hyötykuormia.

9A005 Nestemäistä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, jotka sisältävät mitä tahansa 9A006 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä tai komponentteja, **joita voidaan käyttää edellä 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin.**

HUOM.: KATSO MYÖS 9A105 JA 9A119 KOHTA.

9A007.a. Kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, **joita voidaan käyttää edellä 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin**, joilla on jokin seuraavista:

HUOM.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.

a. Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittää 1,1 MNs;

9A008.d. Seuraavat erityisesti kiinteätä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiä varten suunnitellut komponentit:

HUOM.: KATSO MYÖS 9A108.c. KOHTA.

d. Liikkuvan suuttimen tai sekundäärisen polttoaineen ruiskutuksen työntövektorin ohjausjärjestelmät, **joita voidaan käyttää edellä 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin.**

1. Jotka kykenevät yli ± 5 asteen liikkeeseen akselinsa ympäri;

2. Joiden kulmavektoria voidaan kääntää 20 astetta sekunnissa tai enemmän; tai

3. Joiden kulmavektori kiihtyvyys on 40 astetta/s² tai enemmän.

9A104 Luotainraketit, jotka kykenevät vähintään 300 km:n kantomatkkaan **vähintään 500 kg:n hyötykuormalla.**

HUOM.: KATSO MYÖS 9A004 KOHTA.

9A105.a. Seuraavat nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit:

HUOM.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.

a. Muut kuin 9A005 kohdassa määritelty nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 1,1 MNs tai suurempi **lukuun ottamatta nestemäistä polttoainetta käyttäviä huippurakettimoottoreita, jotka on suunniteltu tai muunneltu satelliittisovelluksiin ja joilla on:**

1. Suuttimen halkaisija 20 mm tai vähemmän;

2. Palokammion paine 15 bar tai vähemmän.

- 9A106.c. Seuraavat muut kuin 9A006 kohdassa määritellyt nestemäistä polttoainetta käyttäviin raketteihin erityisesti suunnitellut järjestelmät ja komponentit, joita voidaan käyttää ohjuksissa:
- c. Työntövoimavektorin ohjauksen alajärjestelmät **lukuun ottamatta niitä, jotka on suunniteltu rakettijärjestelmille, jotka eivät kykene vähintään 300 km:n kantomatkkaan vähintään 500 kg:n hyötykuormalla.**
- Tekn. huom.:
- Esimerkkejä tavoista, joilla saavutetaan 9A106.c kohdassa määritelty työntövoimavektorin ohjaus:
1. Taipuisa suutin;
 2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
 3. Liikkuva moottori tai suutin;
 4. Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
 5. Työntövoimalaipat.
- 9A108.c. Seuraavat muut kuin 9A008 kohdassa määritellyt komponentit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja jotka on erityisesti suunniteltu kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiä varten:
- c. Työntövoimavektorin ohjauksen alajärjestelmät **lukuun ottamatta niitä, jotka on suunniteltu rakettijärjestelmille, jotka eivät kykene vähintään 300 km:n kantomatkkaan vähintään 500 kg:n hyötykuormalla.**
- Tekn. huom.:
- Esimerkkejä tavoista, joilla saavutetaan 9A108.c kohdassa määritelty työntövoimavektorin ohjaus:
1. Taipuisa suutin;
 2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
 3. Liikkuva moottori tai suutin;
 4. Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
 5. Työntövoimalaipat.
- 9A116 Seuraavat "ohjuksissa" käyttökelpoiset ilmakehään palaamaan suunnitellut alukset sekä niitä varten suunnitellut tai muunnetut laitteet, **paitsi aseistamattomia hyötykuormia varten suunnitellut:**
- a. Ilmakehään palaamaan suunnitellut alukset;
 - b. Keraamisista tai sulamalla kuluviista aineista valmistetut lämpösuojukset ja niiden osat;
 - c. Kevyistä, suuren ominaislämmön omaavista aineista valmistetut jäähdytyslevyt ja niiden osat;
 - d. Ilmakehään palaaviin aluksiin erityisesti suunnitellut elektroniset laitteet.
- 9A119 Muut kuin **edellä** 9A005 tai 9A007.a kohdassa määritellyt yksittäiset rakettien vaiheet, joita voidaan käyttää **vähintään 500 kg:n hyötykuormalla** 300 km:n kantomatkkaan täydellisissä rakettijärjestelmissä tai miehittämättömissä ilma-aluksissa.
- 9B115 Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" **edellä** 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 tai 9A119 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä, alajärjestelmiä ja komponentteja varten.
- 9B116 Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja varten tai **edellä** 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 tai 9A119 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä, alajärjestelmiä ja komponentteja varten.
- 9D101 Ohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu **edellä** 9B116 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.
- 9E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115, 9B116 tai 9D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.

- 9E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 tai 9B116 kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.

Huom.: Valvonnanaalaisten rakenteiden, laminaattien ja materiaalien korjaukseen tarvittava teknologia: katso 1E002.f kohta.

- 9E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 tai 9A119 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

- 9E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 tai 9D101 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettävien kantorakettien "käyttöä" varten.

— Poikkeukset:

Liitteen IV mukaan seuraava MTCR-tekniikka ei ole valvonnan alaista:

- 1) tuotteet, jotka siirretään Euroopan avaruusjärjestön (ESA) sopimussuhteen mukaisesta määräyksestä tai jotka ESA siirtää virallisten tehtäviensä hoitamiseksi,
- 2) tuotteet, jotka siirretään jäsenvaltion kansallisen avaruusjärjestön sopimussuhteen mukaisesta määräyksestä tai jotka se siirtää virallisten tehtäviensä hoitamiseksi,
- 3) tuotteet, jotka siirretään kahden tai useamman eurooppalaisen hallituksen allekirjoittaman yhteisön avaruuteen laukaisua koskevan kehittämis- ja tuotanto-ohjelman yhteydessä annetun sopimussuhteen mukaisen määräyksen perusteella,
- 4) tuotteet, jotka siirretään valtion valvomalle avaruuteenlaukaisupaikalle jäsenvaltion alueella, paitsi jos kyseinen jäsenvaltio valvoo kyseisiä siirtoja tämän asetuksen ehtojen mukaisesti.

Osa II

(ei kansallista yleisvientilupaa yhteisön sisäistä kauppaa varten)

Kemiallisten aineiden kieltoasetus

1C351.d.4 Risiini

1C351.d.5 Saxitoksiini

NSG-tekniikka

Liitteen I **ryhmä 0 kokonaisuudessaan** sisältyy liitteeseen IV, **lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja:**

— 0C001: tämä kohta **ei** sisälly liitteeseen IV;

— 0C002: 0C002 kohta sisältyy liitteeseen IV **ainoastaan** seuraavien erityisten halkeamiskelpoisten materiaalien osalta:

a. erotettu plutonium;

b. isotoopeilla 233 tai 235 yli 20-prosenttiseksi rikastettu uraani.

— 0D001 (ohjelmistot) **sisältyvät** liitteeseen IV, **paitsi siltä osin kuin ne liittyvät 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.**

— 0E001 (teknologia) **sisältyy** liitteeseen IV, **paitsi siltä osin kuin se liittyy 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.**

Huom.: Kohdat **0C003** ja **0C004** ainoastaan "ydinreaktorissa" käyttöä varten (0A001.a kohdan puitteissa).

- 1B226 Sähkömagneettiset isotooppierottimet, jotka on suunniteltu toimimaan tai varusteltu yhdellä tai useilla ionilähteillä, joilla voidaan saada aikaan 50 mA:n tai suurempi ionisuihkun kokonaisvirta.
- Huom.: 1B226 kohta sisältää erottimet:
- Jotka pystyvät rikastamaan pysyviä isotooppeja;
 - Joissa ionilähteet ja -kerääjät ovat kummatkin magneettikentässä, sekä ne konfiguraatiot, joissa ne ovat kentän ulkopuolella.
- 1C012 Seuraavat materiaalit:
- Tekn. huom.:
- Näitä materiaaleja käytetään tyypillisesti ydinlämpölähteissä
- "Aiemmin erotettu" neptunium-237 missä tahansa muodossa.
- Huom.: 1C012.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi toimituksia, joissa neptunium-237 sisältö on 1 g tai vähemmän.
- 1B231 Seuraavat tritiumlaitokset ja -tehtaat ja niissä käytettävät laitteet:
- Laitokset tai tehtaat, joissa tuotetaan, otetaan talteen, uutetaan, rikastetaan tai käsitellään tritiumia,
 - Tritiumlaitosten tai -tehtaiden laitteet seuraavasti:
 - Vedyn tai heliumin jäähdytysyksiköt, joissa lämpötila saadaan lasketuksi 23 K (– 250 °C) asteeseen tai alhaisemmaksi ja joiden lämmönpoistokyky on suurempi kuin 150 W;
 - Vetyisotooppien varastointi- ja puhdistusjärjestelmät, joissa varastointiin tai puhdistukseen käytetään metallihydridejä.
- 1B233 Litiumisotooppien erotukseen käytettävät laitokset tai tehtaan ja niissä käytettävät laitteet seuraavasti:
- Laitokset tai tehtaat litiumisotooppien erottamiseen;
 - Laitteet litiumisotooppien erottamiseen seuraavasti:
 - Erityisesti litiumamalgaameja varten suunnitellut pakatut neste-neste erotuskolonnit,
 - Elohopea- tai litiumamalgaamipumput,
 - Litiumamalgaamielektrolyysikennot,
 - Haihduttimet väkeviä litiumhydroksiliuoksia varten.
- 1C233 Litium, joka on rikastettu 6-isotoopilla (⁶Li) suurempaan kuin luonnolliseen isotooppipitoisuuteen sekä rikastettua litiumia sisältävät tuotteet tai laitteet, seuraavasti: seokset (lejeeringit), yhdisteet, litiumia sisältävät seokset, näistä tehdyt valmisteet, sekä kaikesta edellä mainitusta syntyvä jäte tai romu.
- Huom.: 1C233 ei aseta valvonnanalaiseksi termoluminesenssiannosmittareita.
- Tekn. huom.:
- Litiumin 6-isotoopin pitoisuus luonnossa on noin 6,5 painoprosenttia (7,5 atomiprosenttia).
- 1C235 Tritium, tritiumyhdisteet ja tritiumia sisältävät seokset, joissa tritiumatomien lukumääräsuhte vetyatomeihin ylittää 1:1000 sekä mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet ja laitteet.
- Huom.: 1C235 ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita ja laitteita, joissa on vähemmän kuin $1,48 \times 10^3$ GBq (40 Ci) tritiumia.
- 1E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C012 b kohdassa määriteltyjen tuotteiden tai materiaalien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.
- 1E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 tai 1C235 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

- 3A228 Seuraavat kytkinlaitteet:
- a. Kylmäkatodiputket, olivatpa ne sitten kaasutäytteisiä tai ei, jotka toimivat kipinävälin tavoin ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Ne sisältävät kolme tai useampia elektrodeja;
 2. Huippuanodijännitteen nimellisarvo on 2,5 kV tai enemmän;
 3. Huippuanodivirran nimellisarvo on 100 A tai enemmän; ja
 4. Anodin viiveaika on 10 µs tai lyhyempi;
- Huom.:* 3A228 kohtaan sisältyvät kaasukryptonputket ja tyhjöspryttronputket.
- b. Liipaistavat kipinävälit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Anodiviiveaika on 15 µs tai lyhyempi; ja
 2. Huippuvirran nimellisarvo 500 A tai enemmän;
- 3A231 Neutronigeneraattorijärjestelmät, mukaan lukien putket, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
- a. Ne on suunniteltu toimimaan ilman ulkoista tyhjöjärjestelmää; ja
- b. Hyväksikäyttävät sähköstaattista kiihdytystä tritium-deuteriumydinreaktion synnyttämiseen.
- 3E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A228.a, 3A228.b tai 3A231 kohdassa määriteltujen laitteiden "käyttöä" varten.
- 6A203 Seuraavat muut kuin 6A003 kohdassa määritellyt kamerat ja komponentit:
- a. Seuraavat mekaaniset pyöriväpeiliset kamerat ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
1. Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden tallennusnopeus on suurempi kuin 225 000 kuvaa/s;
 2. Juovakamerat, joiden piirtonopeus on suurempi kuin 0,5 mm/s;
- Huom.:* 6A203.a kohdassa näiden kameroiden komponentteihin sisältyvät niiden synkronointi-elektroniikkayksiköt sekä turbiineista, peileistä ja laakereista koostuvat roottorikokoonpanot.
- 6A225 Nopeusinterferometrit yli 1 km/s nopeuksien mittaamiseksi lyhyemmän kuin 10 mikrosekunnin aikajakson kuluessa
- Huom.:* 6A225 kohtaan sisältyvät sellaiset nopeusinterferometrit kuten VISAR:it ja DLI:t (dopplerlaserinterferometrit).
- 6A226 Seuraavat paineanturit:
- a. Manganiini-anturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita;
- b. Kvartsipaineanturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita.
-